

# 英飞凌 128 Mb (16 MB) / 256 Mb (32 MB) FS-S 闪存存储器

## SPI Multi-I/O, 1.8 V

### 特性

- 密度
  - S25FS128S - 128 Mbits (16 MB)
  - S25FS256S - 256 Mbits (32 MB)
- 串行外设接口 (SPI)
  - SPI 时钟极性和相位模式 0 和 3
  - 具有双倍数据速率 (DDR) 选项
  - 扩展寻址: 24 位或 32 位地址选项
  - 串行指令子集和封装与 S25FL-A、S25FL-K、S25FL-P 和 S25FL-S SPI 系列兼容
  - 多线 I/O 指令子集和封装与 S25FL-P 和 S25FL-S SPI 系列兼容
- Read
  - 指令: 正常、快速、双线 I/O、四线 I/O、DDR 四线 I/O
  - 模式: 回卷突发、持续突发 (XIP)、QPI
  - 串行闪存可发现参数 (SFDP) 和通用闪存接口 (CFI), 用于配置信息
- 编程
  - 256 或 512 字节的页编程缓冲区
  - 编程暂停和恢复
  - 自动 ECC - 内部硬件 1 位纠错功能
- 擦除
  - 混合扇区选项
    - 8 个 4 KB 扇区和 1 个 32 KB 扇区的物理配置位于地址空间的顶部或底部, 其他扇区均为 64 KB 或
    - 8 个 4 KB 扇区和 1 个 224 KB 扇区的物理配置位于地址空间的顶部或底部, 其他扇区均为 256 KB
  - 统一扇区选项
    - 统一的 64 KB 或 256 KB 块, 可与更高容量和未来产品实现软件兼容
  - 擦除暂停并恢复
  - 擦除状态评估
  - 最低 100,000 次编程-擦除周期
  - 数据保留时间至少 20 年
- 加密特性
  - 1024 字节的一次性写入 (OTP) 空间
  - 功能块保护:
    - 状态寄存器位用于控制对连续扇区范围的编程或擦除保护
    - 硬件和软件控制选项
  - 高级扇区保护 (ASP)
    - 由引导代码或密码控制的单独扇区保护
    - 读取访问的密码控制选项
- 技术
  - 采用 Eclipse 架构的 65 纳米 MIRRORBIT™ 技术
- 供电电压
  - 1.7 V 至 2.0 V

本数据手册的原文使用英文撰写。为方便起见, 英飞凌提供了译文; 由于翻译过程中可能使用了自动化工具, 英飞凌不保证译文的准确性。为确认准确性, 请务必访问 [infineon.com](http://infineon.com) 参考最新的英文版本 (控制文档)。

---

**特性**

- 温度范围/等级
  - 工业级 (–40°C ~ +85°C)
  - 扩展的工业级 (–40°C ~ +105°C)
  - 汽车级, AEC-Q100 3 级 (–40°C ~ +85°C)
  - 汽车级, AEC-Q100 2 级 (–40°C ~ +105°C)
  - 汽车级, AEC-Q100 1 级 (–40°C ~ +125°C)
- 封装 (全部无铅)
  - 8-lead SOIC 208 mil (SOC008) –仅 FS128S 提供
  - WSON 6 × 5 mm (WND008) — 仅 FS128S 提供
  - WSON 6 × 8 mm (WNH008)
  - 16-lead SOIC 300 mil (SO3016 — 仅 FS256S 提供)
  - BGA-24 6 × 8 mm
    - 5 × 5 ball (FAB024) 封装
    - 4 × 6 ball (FAC024) 封装
  - 已知良好芯片和已知测试过的芯片

## 性能总结

## 性能总结

## 最大读取速率

Command	Clock rate (MHz)	MBps
Read	50	6.25
Fast read	133	16.5
Dual read	133	33
Quad read	133	66

## 最大读取速率 DDR

Command	Clock rate (MHz)	MBps
DDR Quad I/O read	80	80

## 典型编程和擦除速率

Operation	KBps
Page programming (256-bytes page buffer)	712
Page programming (512-bytes page buffer)	1080
4-KB physical sector erase (hybrid sector option)	16
64-KB physical sector erase (hybrid sector option)	275
256-KB sector erase (uniform logical sector option)	275

## 典型消耗电流 (–40 °C 至 +85 °C)

Operation	Current (mA)
Serial read 50 MHz	10
Serial read 133 MHz	20
Quad read 133 MHz	60
Quad DDR read 80 MHz	70
Program	60
Erase	60
Standby	0.025
Deep power-down	0.006

## 目录

## 目录

特性.....	1
性能总结.....	3
目录.....	4
1 概述 .....	6
1.1 概述.....	6
1.2 迁移说明.....	7
2 具有多路输入/输出的SPI (SPI-MIO) .....	10
3 信号说明.....	11
3.1 输入/输出简介 .....	11
3.2 多路输入/输出 (MIO) .....	12
3.3 串行时钟 (SCK) .....	12
3.4 片选 (CS #) .....	12
3.5 串行输入 (SI) /IO0.....	12
3.6 串行输出 (SO) /IO1.....	12
3.7 写保护 (WP#) /IO2 .....	13
3.8 IO3 / RESRT # .....	13
3.9 电源电压(VCC).....	13
3.10 电源和信号地 (V <sub>SS</sub> ) .....	13
3.11 未连接 (NC) .....	13
3.12 保留以供将来使用 (RFU) .....	14
3.13 请勿使用 (DNU) .....	14
3.14 框图.....	14
4 信号协议.....	16
4.1 SPI时钟模式 .....	16
4.2 命令协议.....	17
4.3 接口状态.....	22
4.4 配置寄存器对接口的影响.....	26
4.5 数据保护.....	26
5 电气规格参数.....	27
5.1 绝对最大额定值 .....	27
5.2 热阻抗.....	27
5.3 门锁特性.....	27
5.4 工作范围.....	28
5.5 上电和断电.....	29
5.6 直流特性.....	31
6 时序规范.....	33
6.1 波形切换.....	33
6.2 交流测试条件.....	33
6.3 RESET(复位).....	34
6.4 SDR AC 特性.....	37
6.5 DDR AC 特性.....	40
7 物理接口.....	42
7.1 SOIC 16引脚封装.....	42
7.2 8-connector 封装 .....	44
7.3 FAB024 24-ball BGA 封装.....	48
7.4 FAC024 24-ball BGA封装 .....	50
8 地址空间映射 .....	52
8.1 概述.....	52
8.2 闪存存储器阵列.....	52
8.3 ID-CFI 地址 空间.....	57
8.4 JEDEC JESD216 串行闪存可发现参数 (SFDP) 空间 .....	57

## 目录

8.5 OTP地址空间.....	57
8.6 寄存器.....	59
<b>9 数据保护.....</b>	<b>81</b>
9.1 安全硅区(OTP) .....	81
9.2 写使能指令.....	82
9.3 功能块保护.....	82
9.4 高级扇区保护.....	84
9.5 建议的保护流程 .....	89
<b>10 命令.....</b>	<b>90</b>
10.1 命令集汇总.....	92
10.2 器件识别命令.....	99
10.3 寄存器访问指令.....	101
10.4 读取闪存阵列命令 .....	116
10.5 编程闪存存储器阵列指令 .....	125
10.6 擦除闪存存储器指令.....	128
10.7 一次性编程区域指令 .....	138
10.8 高级扇区保护命令.....	139
10.9 复位命令.....	146
10.10 DPD命令.....	148
<b>11 嵌入式算法性能表 .....</b>	<b>150</b>
<b>12 数据完整性.....</b>	<b>151</b>
12.1 擦除耐久性.....	151
12.2 数据保留.....	151
12.3 串行闪存设备可发现参数 (SFDP) 地址分布 .....	151
12.4 器件ID和通用闪存接口 (ID-CFI) ASO映射 .....	155
12.5 出厂状态.....	180
<b>13 订购信息.....</b>	<b>181</b>
13.1 订购部件编号 .....	181
13.2 有效组合— 标准.....	182
13.3 有效组合— 汽车级/AEC- Q100 .....	183
<b>修订记录.....</b>	<b>184</b>

## 概述

# 1 概述

## 1.1 概述

S25FS-S系列产品是闪存非易失存储器产品，使用：

- MIRRORBIT™技术 - 在每个存储器晶体管中存储两个数据位
- Eclipse 架构 - 显著提高编程和擦除性能
- 65 纳米工艺光刻

S25FS-S系列通过串行外设接口（SPI）连接主控系统。支持传统SPI串行输入和输出（单线 I/O 或 SIO）以及可选的 2 线（双 I/O 或 DIO）和 4 线 四 I/O（QIO）或四线外设接口（QPI）串行指令。这种多位宽接口称为 SPI multi-I/O 或 MIO。此外，QIO 和 QPI 还具有双倍数据率（DDR）读取指令，可在时钟的两个沿上传输地址和读取数据。

FS-S Eclipse 架构具有配备页写入缓冲器，在单次操作中最多可写入512字节，与标准SPI写入操作相比，有效编程时间更短。

直接从闪存执行代码通常称为就地执行（XIP）。通过使用支持更高时钟速率的 S25FS-S 系列器件，配合 Quad 或 DDR Quad 指令，读取指令速率可以达到或超过传统并行接口、异步、NOR flash，同时明显地减少信号引脚数。

S25FS-S系列产品具有高容量，高灵活性且高传输速率特点，适用于各种移动或嵌入式应用。该产品系列为在空间，信号连接数，功耗方面有限制的系统提供了一个理想的存储解决方案。它们是将代码映射到 RAM、直接执行代码、XIP 以及存储可重新编程数据的理想选择。

## 概述

## 1.2 迁移说明

## 1.2.1 功能比较

S25FS-S 系列的指令子集和封装与上一代 FL-S、FL-K 和 FL-P 系列兼容。但是电源和接口电压标称值为 1.8V。

表 1 SPI 系列比较

Parameter	FS-S	FL-S	FL-K	FL-P
Technology node	65-nm	65-nm	90-nm	90-nm
Architecture	MIRRORBIT™ Eclipse	MIRRORBIT™ Eclipse	Floating Gate	MIRRORBIT™
Density	128 Mb, 256 Mb	128 Mb, 256 Mb, 512 Mb, 1 Gb	4 Mb–128 Mb	32 Mb–256 Mb
Bus width	x1, x2, x4	x1, x2, x4	x1, x2, x4	x1, x2, x4
Supply voltage	1.7 V–2.0 V	2.7 V–3.6 V / 1.65 V–3.6 V $V_{IO}$	2.7 V–3.6 V	2.7 V–3.6 V
Normal Read speed (SDR)	6 MBps (50 MHz)	6 MBps (50 MHz)	6 MBps (50 MHz)	6 MBps (40 MHz)
Fast Read speed (SDR)	16.5 MBps (133 MHz)	17 MBps (133 MHz)	13 MBps (104 MHz)	13 MBps (104 MHz)
Dual Read speed (SDR)	33 MBps (133 MHz)	26 MBps (104 MHz)	26 MBps (104 MHz)	20 MBps (80 MHz)
Quad Read speed (SDR)	66 MBps (133 MHz)	52 MBps (104 MHz)	52 MBps (104 MHz)	40 MBps (80 MHz)
Quad Read speed (DDR)	80 MBps (80 MHz)	80 MBps (80 MHz)		
Program buffer size	256B / 512B	256B / 512B	256B	256B
Erase sector size	64 KB / 256 KB	64 KB / 256 KB	4 KB / 32 KB / 64 KB	64 KB / 256 KB
Parameter sector size	4 KB (option)	4 KB (option)	4 KB	4 KB
Sector erase rate (typ.)	500 KBps	500 KBps	136 KBps (4 KB) 437 KBps (64 KB)	130 KBps
Page programming rate (typ.)	0.71 MBps (256B) 1.08 MBps (512B)	1.2 MBps (256B) 1.5 MBps (512B)	365 KBps	170 KBps
OTP	1024B	1024B	768B (3x256B)	506B
Advanced sector protection	Yes	Yes	No	No
Auto Boot mode	No	Yes	No	No
Erase suspend/resume	Yes	Yes	Yes	No
Program suspend/resume	Yes	Yes	Yes	No
Deep power-down	Yes	No	Yes	Yes
Operating temperature	–40°C to +85°C / +105°C / +125°C	–40°C to +85°C / +105°C	–40°C to +85°C	–40°C to +85°C / +105°C

## 注：

- 256B 写入页选项仅适用于 128-Mb 和 256-Mb 容量的 FL-S 器件。
- FL-P 列表示 FL129P MIO SPI 器件（适用于 128-Mb 容量），FL128P 不支持 MIO、OTP 或 4-KB 扇区。
- 64 KB 扇区擦除选项仅适用于 128 Mb/256 Mb 容量 FL-P、FL-S 和 FS-S 器件。
- FL-K 系列器件可以以 32 KB 或 64 KB 为组擦除 4 KB 扇区。
- 512 Mb/1 Gb FL-S 器件仅支持 256 KB 扇区。
- 仅 128 Mb/256 Mb 容量 FL-S 器件具有 4 KB 参数扇区选项。
- 请参阅各个 datasheets 以了解更多详细信息。

## 概述

## 1.2.2 与前几代产品的差异

### 1.2.2.1 错误报告

如果在受保护的扇区上尝试进行编程或擦除，FL-K 和 FL-P 存储器要么没有错误状态位，要么不置位它们。FS-S 和 FL-S 系列具有针对编程和擦除操作的错误报告状态位。当出现内部编程或擦除故障，或者试图对受保护的扇区进行编程或擦除时，这些状态位会被置位。在这些情况下，编程或擦除操作没有按照指令的要求完成。P\_ERR 或 E\_ERR 位以及 WIP 位将被置位且 SR1V 位保持为‘1’。必须发送清除状态寄存器命令来清除错误并使设备返回待机状态。

### 1.2.2.2 安全硅区 (OTP)

一次性编程区域的 FS-S 大小和格式（地址映射）与 FL-K 和 FL-P 代不同。保护 OTP 区域各部分的方法也不同。有关更多详细信息，请参阅“[安全硅区域 \(OTP\)](#)”，位于分页 81。

### 1.2.2.3 配置寄存器冻结位

配置寄存器 1 冻结位 CR1V[0]，锁定功能块保护位 (SR1NV[4:2] 和 SR1V[4:2])、TBPARAM\_O 位 (CR1NV[2]) 和 TBPROT\_O 位 (CR1NV[5]) 的状态，与前几代一样。在 FS-S 和 FL-S 系列中，冻结位还锁定配置寄存器 1 BPNV\_O 位 (CR1NV[3]) 和安全硅区域 (OTP) 区域的状态。

### 1.2.2.4 扇区擦除命令

仅支持在 FS-S 器件地址空间的顶部或底部 4-KB 参数扇区上使用 4-KB 扇区擦除指令。

不支持 8 KB 区域（两个 4 KB 扇区）擦除指令。

不支持 32 KB 区域（八个 4 KB 扇区）擦除指令。

当选择统一 64 KB 扇区的配置选项或者使用 4 KB 参数扇区与 64 KB 扇区的混合配置选项时，支持 FS-S 64 KB 扇区的擦除指令 (SE)。当使用混合扇区选项时，64-KB 擦除指令可用于与八个 4-KB 扇区组地址相邻的 32-KB 地址空间。在这种情况下，64 KB 擦除命令将擦除由八个 4 KB 扇区组部分覆盖的 64 KB 扇区，而不会影响 4 KB 扇区。这提供了对 32 KB 地址空间的擦除控制，而无需强制擦除 4 KB 扇区。这与 FL-S 系列中实现的行为不同。在 FL-S 系列中，64 KB 扇区擦除命令可应用于 4 KB 扇区的 64 KB 块，以在一次操作中擦除整个参数扇区块。在 FS-S 中，参数扇区并不能填满整个 64-KB 块，因此仅使用 4-KB 参数扇区擦除指令 (20h) 来擦除参数扇区。

当使用 256 KB 统一逻辑扇区的配置选项时，256 KB 扇区的擦除命令将取代 64 KB 擦除命令。

### 1.2.2.5 深度掉电模式

FS-S 系列设备支持深度掉电 (DPD) 功能。

### 1.2.2.6 WRR 单个寄存器写入

在某些传统 SPI 设备中，仅包含一个数据字节的写入寄存器 (WRR) 命令将更新状态寄存器 1 并清除配置寄存器 1 中的某些位，包括四线模式位。这可能会导致意外退出四线模式。S25FS-S 系列提供单个字节仅更新状态寄存器 1。在这种情况下，配置寄存器 1 不会被修改。

## 概述

### 1.2.2.7 不支持其他旧传统指令

- 自动启动相关指令
- Bank地址相关指令
- 双线输出读取
- 四线输出读取
- 四线页写入 (QPP) - 在 QPI 模式下被页写入取代
- DDR 快速读取
- DDR 双线I/O 读取

### 1.2.2.8 新特性

FS-S 系列为SPI类别存储器引入了新功能：

- 单个 1.8 V 电源为内核和 I/O 电压供电。
- 可配置初始读取延时（虚拟周期数）以获得更快的初始读取时间或更高的时钟速率读取指令
- 四线外设接口（QPI，4-4-4）读取模式，其中所有传输均为 4 位宽，包括指令
- JEDEC JESD216 标准、串行闪存式存储器可发现参数 (SFDP)，提供器件特性和配置信息。
- 评估擦除状态指令以确定扇区上的最后一个擦除操作是否成功完成。该命令可用于检测由于断电或其他原因导致的不完全擦除。该指令有助于flash文件系统软件在掉电后进行文件系统恢复。
- 高级扇区保护 (ASP) 永久保护。在 ASP 寄存器中增加一位控制位，以提供对持久保护位 (PPB) 进行永久保护的选项。此外，当选择两种 ASP 保护模式中的一种时，寄存器中的所有 OTP 配置位都受到保护，不能进一步编程，从而所有 OTP 配置设置都变为永久的。OTP 地址空间不受选择 ASP 保护模式的保护。冻结位 (CR1V[0]) 可用于保护 OTP 地址空间。

具有多路输入/输出的 SPI (SPI-MIO)

## **2 具有多路输入/输出的 SPI (SPI-MIO)**

许多存储设备通过各自的并行控制线、地址线和数据信号线连接到其主控系统，需要大量的信号连接和更大的封装尺寸。由于大量信号交换，因此信号连接的数量越多，功耗也越高；较大的封装尺寸会增加成本。

S25FS-S 系列通过 4 到 6 个信号将所有控制、地址和数据信息串行传输给主机系统，因此可以减少信号连接的数量。这样可以降低存储器封装的成本和信号交换的功耗，减少主机信号连接的数量，主机可以节省连接以供其他功能使用。

S25FS-S 系列使用行业标准串行外设接口 (SPI)，还支持 2 位（双线）和 4 位（四线）宽串行传输的可选扩展指令。这种多位宽接口称为 SPI 多线 I/O 或 SPI-MIO。

## 信号说明

### 3 信号说明

#### 3.1 输入/输出简介

表2 信号列表

Signal name	Type	Description
SCK	Input	<b>Serial Clock.</b>
CS#	Input	<b>Chip Select.</b>
SI / IO0	I/O	<b>Serial Input</b> for single bit data commands or IO0 for Dual or Quad commands.
SO / IO1	I/O	<b>Serial Output</b> for single bit data commands. IO1 for Dual or Quad commands.
WP# / IO2	I/O	<b>Write Protect</b> when not in Quad Mode (CR1V[1] = 0 and SR1NV[7] = 1). <b>IO2</b> when in Quad Mode (CR1V[1] = 1). The signal has an internal pull-up resistor and may be left unconnected in the host system if not used for Quad commands or write protection. If write protection is enabled by SR1NV[7] = 1 and CR1V[1] = 0, the host system is required to drive WP# high or low during a WRR or WRAR command.
IO3 / RESET#	I/O	<b>IO3</b> in Quad-I/O mode, when Configuration Register 1 QUAD bit, CR1V[1] = 1, and CS# is LOW. <b>RESET#</b> when enabled by CR2V[5] = 1 and not in Quad I/O mode, CR1V[1] = 0, or when enabled in Quad Mode, CR1V[1] = 1 and CS# is HIGH. The signal has an internal pull-up resistor and may be left unconnected in the host system if not used for Quad commands or RESET#.
V <sub>CC</sub>	Supply	<b>Power Supply.</b>
V <sub>SS</sub>	Supply	<b>Ground.</b>
NC	Unused	<b>Not Connected.</b> No device internal signal is connected to the package connector nor is there any future plan to use the connector for a signal. The connection may safely be used for routing space for a signal on a printed circuit board (PCB). However, any signal connected to an NC must not have voltage levels higher than V <sub>CC</sub> .
RFU	Reserved	<b>Reserved for Future Use.</b> No device internal signal is currently connected to the package connector but there is potential future use of the connector for a signal. It is recommended to not use RFU connectors for PCB routing channels so that the PCB may take advantage of future enhanced features in compatible footprint devices.
DNU	Reserved	<b>Do Not Use.</b> A device internal signal may be connected to the package connector. The connection may be used by Infineon for test or other purposes and is not intended for connection to any host system signal. Any DNU signal related function will be inactive when the signal is at V <sub>IL</sub> . The signal has an internal pull-down resistor and may be left unconnected in the host system or may be tied to V <sub>SS</sub> . Do not use these connections for PCB signal routing channels. Do not connect any host system signal to this connection.

## 信号说明

### 3.2 多路输入/输出 (MIO)

传统SPI单独的宽指令 (Single 或 SIO) 仅通过串行输入 (SI) 信号将信息从主控发送到存储器。数据会通过串行输出 (SO) 信号从存储器内串行回送给主机。

双线或四线输入 / 输出 (I/O) 命令只能通过 SI/IO0 信号将指令发送给存储器。地址或数据以 IO0 和 IO1 上的位对或 IO0、IO1、IO2 和 IO3 上的四个位 (半字节) 组的形式从主控发送到存储器。数据同样可以按照双比特一组的方式通过 IO0 和 IO1 从存储器回送给主机, 也可以按照四比特 (半字节) 一组的方式通过 IO0、IO1、IO2 和 IO3 被回送。

QPI 模式允许以四比特 (半字节) 一组的方式将所有指令、地址和数据通过 IO0、IO1、IO2 和 IO3 从主机传送到存储器内。数据返回主控的方式类似 IO0、IO1、IO2、IO3 上的四位半字节。

### 3.3 串行时钟 (SCK)

该输入信号为 SPI 接口提供了同步参考。指令、地址或数据输入被锁存于 SCK 信号的上升沿。在 SDR 指令中, 数据输出在 SCK 的下降沿之后发生变化, 在 DDR 指令中, 数据输出在每个边沿之后发生变化。

### 3.4 片选 (CS#)

片选信号指示命令正在向器件传输信息或从器件传输信息, 包括与存储器器件相关其他信号。

CS# 信号为高逻辑电平时, 不会选择芯片, 所有输入信号均被忽略, 并且所有输出信号均为高阻抗。除非正在进行内部嵌入式操作, 否则器件将处于待机功率模式。嵌入式操作由状态寄存器 1 Write-In-Progress 位 (SR1V[1]) 置位显示为“1”, 直到操作完成。一些嵌入式操作的示例是: 编程、擦除或寄存器写入 (WRR) 操作。

将 CS 输入驱动至逻辑低电平状态将使能器件, 将其置于工作模式。上电后, 必须等到 CS# 的下降沿到来后才能执行其他命令。

### 3.5 串行输入 (SI)/IO0

该输入信号用于将数据串行方式传输到器件中。它接收指令、地址和要写入闪存的数据。各个数值在串行 SCK 时钟信号的上升沿上被锁存。

SI 变成 IO0 - 在执行双线和四线命令过程中, 在执行双线和四线命令过程中, 用于接收指令、地址和写入的数据 (数据在串行 SCK 时钟信号的上升沿时被锁存), 并在 SCK 下降沿时 (若执行 SDR 命令) 移出数据或在任意一个边沿时 (若执行 DDR 命令) 移出数据。

### 3.6 串行输出 (SO)/IO1

该输出信号用于将数据串行方式传输出器件。数据在串行 SCK 时钟信号的下降沿时移出。

SO 变成 IO1 - 双线指令和四线指令期间的输入和输出, 用于接收地址和要编程的数据 (数值在串行 SCK 时钟信号的上升沿时被锁存) 并在 SCK 下降沿时 (若执行 SDR 命令) 移出数据或在任意一个边沿时 (若执行 DDR 命令) 移出数据。

## 信号说明

### 3.7 写保护 (WP#) / IO2

使用WRR或WRAR指令时，WP#为低电平(VIL)，而状态寄存器1(SR1NV[7])，即的状态寄存器写入禁用位(SRWD\_NV)位被置为“1”时，无法写入状态寄存器1或配置寄存器1相关寄存器。在这种情况下，WRR指令被忽略，针对SR1NV、SR1V、CR1NV或CR1V的WRAR指令被忽略，并且没有错误显示。

这样可以防止对保护区域进行任何更改。因此，在WRR或WRAR指令期间，WP#为低电平，且SRWD\_NV位被设置为“1”，被传统块保护的存储器区域中的全部数据字节也受硬件保护，以防止数据修改。

当启用四线模式(CR1V[1]=1)时，WP#功能不可用。在四线模式下，WP#功能被作为输入和输出IO2，用于接收地址和要编程的数据（数值在串行SCK时钟信号的上升沿时被锁存）并在SCK下降沿时（若执行SDR命令）移出数据或在任意一个边沿时（若执行DDR命令）移出数据。

WP#具有内部上拉电阻；未连接时，WP#为高电平(VIH)，如果四线模式、保护功能未使用该引脚，则在主机系统中它可以为不连接状态。

### 3.8 IO3 / RESET#

IO3在四线模式(CR1V[1]=1)下用于输入和输出，用于接收地址和要编程的数据（数值在串行SCK时钟信号的上升沿时被锁存）并在SCK下降沿时（若执行SDR命令）移出数据或在任意一个边沿时（若执行DDR命令）移出数据。

IO3 / RESET#信号也可用于启动复位硬件功能，通过写入配置寄存器2非易失位5(CR2V[5]=1)来使能初始化复位功能。当器件未处于四线I/O模式、CR1V[1]=0或CS#为高电平时，该输入只能被作为RESET#使用。当使用四线I/O模式时，CR1V[1]=1，且器件通CS被置为低电平时，则IO3 / RESET#只能作为IO3进行信息传输。当CS#为高电平时，IO3/RESET#不用于信息传输时，会用作RESET#输入。在四线模式CS为高电平期间，调节复位操作，复位功能在四线模式期间仍然可用。

当系统进入复位状态时，作为复位过程的一部分，CS信号必须被驱动为高电平，并且IO3 / RESET#信号被驱动为低电平。当CS#变为高电平时，IO3 / RESET#输入从IO3转变为RESET#输入。CS保持高电平且IO3 / RESET#信号保持低电平持续 $t_{RP}$ 时间后，会检测到复位条件。如果不需要进行复位操作，则系统必须将IO3/RESET#和CS#驱动为高电平，作为向存储器发送数据的结束操作。在将数据传输到主控制系统之后，存储器在 $t_{CS}$ 期间会把IO3驱动为高电平。确保IO3 / RESET#不会悬空或被内部或外部无源的上拉缓慢拉为高电平。因此，不会由于IO3 / RESET#在 $t_{RP}$ 时间结束之前未被识别为高电平而触发意外复位。

当复位特性被禁用时(CR2V[5]=0)，IO3 / RESET#输入复位功能被禁用。

IO3 / RESET#信号有内部上拉电阻，如果不用于四线模式或复位功能，可以在主控制系统中悬空。主控制系统主动将信号驱动为高电平后，然后停止驱动信号，内部上拉将保持IO3/RESET#为高电平。

注意，如果多个SPI-MIO存储器中有任意一个工作于四线I/O模式，那么它们不能共享IO3/RESET#功能，因为来自一个选定存储器或向其发送的IO3可用作第二个未选定的存储器，且它们共享相同的IO3/RESET#信号。

### 3.9 电源电压 (V<sub>CC</sub>)

VCC是所有器件内部逻辑的电压源。它是用于所有器件内部功能（包括读取、编程和擦除）的单一电压。

### 3.10 电源和信号地 (V<sub>SS</sub>)

VSS器件内核、输入信号接收器和输出驱动器的公共电压开漏和接地参考

### 3.11 未连接 (NC)

没有任何器件内部信号连接到封装连接器，将来也没有计划使用该连接器来传输信号。该连接可安全地用于印刷电路板(PCB)上的信号的布线空间。

信号说明

### 3.12 保留以供将来使用 (RFU)

当前没有任何器件内部信号被连接到封装引脚，预留供将来使用。不建议将 RFU 连接到 PCB 电路板上的任何信号，以便 PCB 可以在尺寸兼容的器件中实现未来的增强型特性。

### 3.13 请勿使用 (DNU)

器件内部信号可能连接到封装连接器。该连接可能被 Infineon 用于测试或其他目的，并不用于连接到任何主控系统信号。DNU 引脚处于低电平（VIL）时，与该引脚相关的所有功能均无效。该信号有内部下拉电阻，可能在主控系统中保持未连接状态，也可能连接到 VSS。请勿将这些信号用于 PCB 信号布线通道。请勿将任何主控系统信号连接到这些引脚。

### 3.14 框图

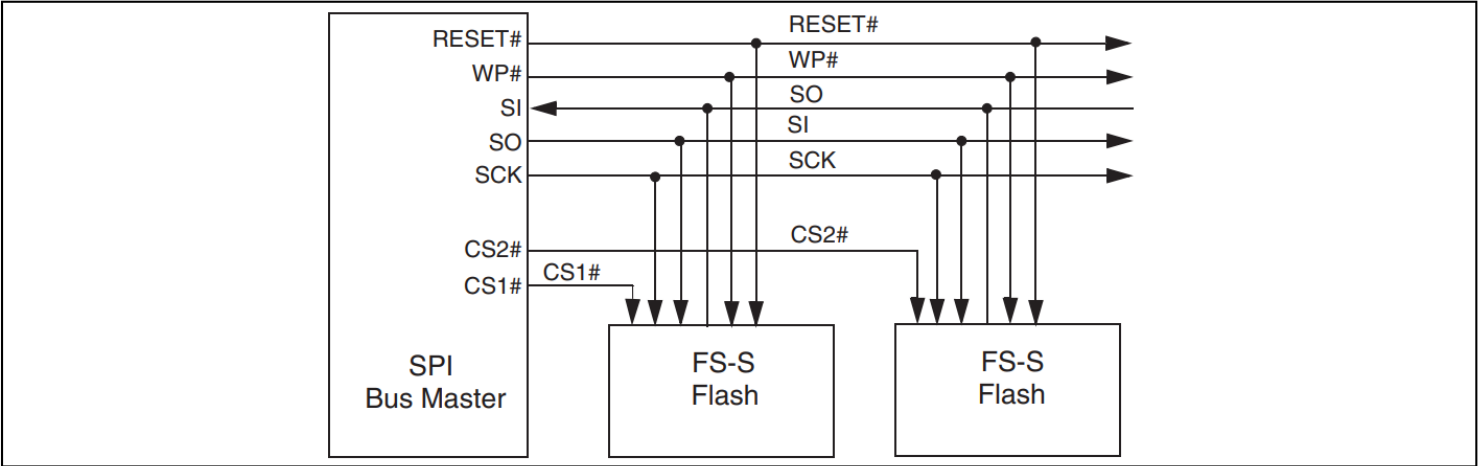


图 1 SPI总线上的总线主控和存储设备 — 单比特数据路径

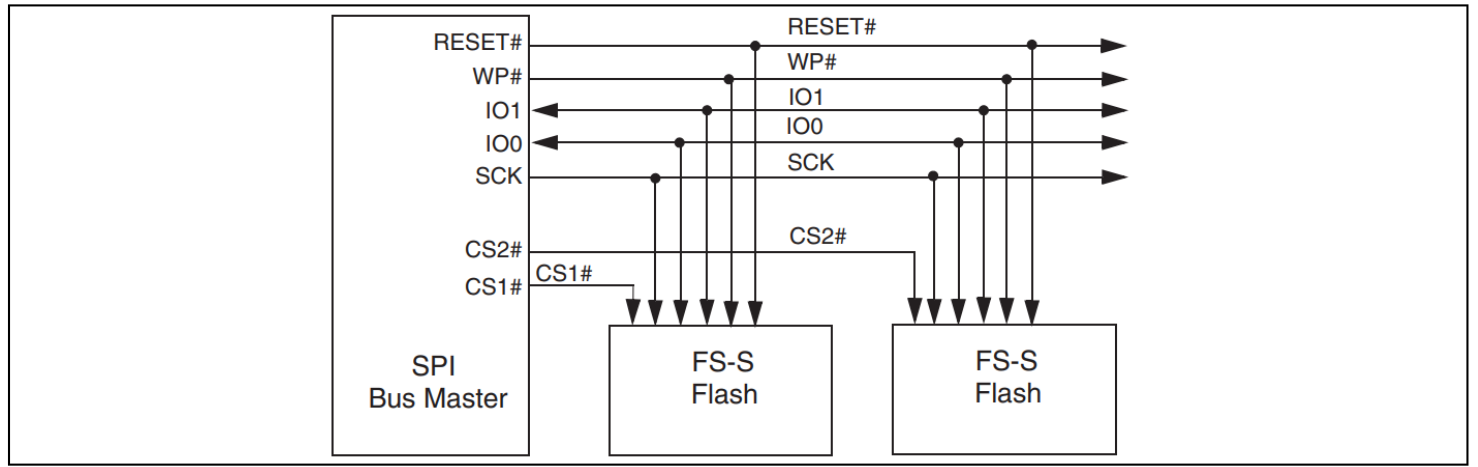


图2 SPI总线上的总线主控和存储设备——双比特数据路径

信号说明

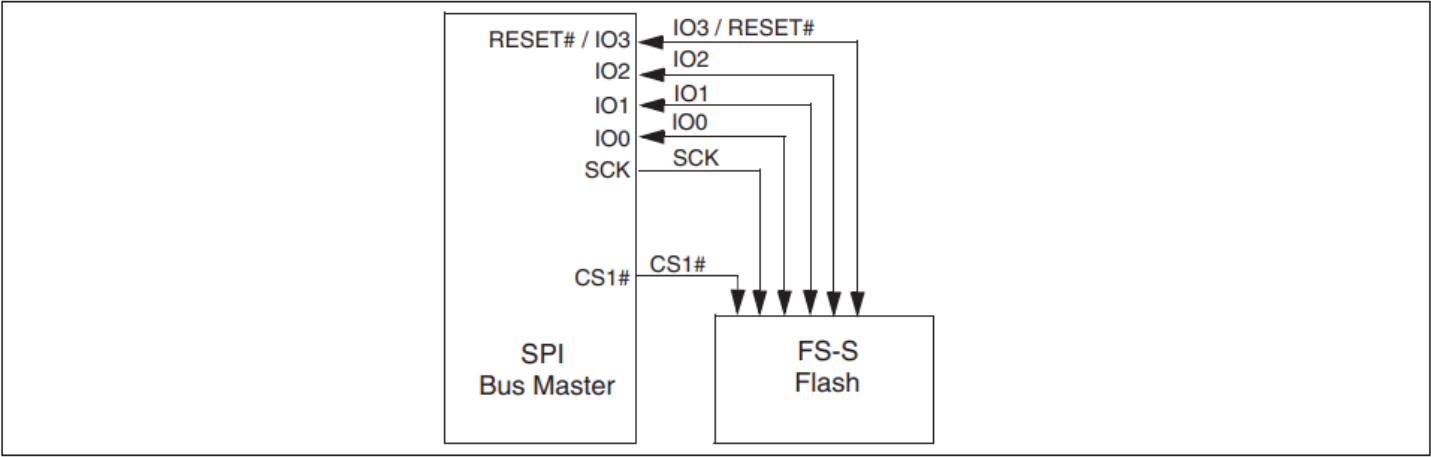


图 3 SPI总线上的总线主控和存储设备 – 四比特数据路径

## 4 信号协议

### 4.1 SPI 时钟模式

#### 4.1.1 单倍数据速率 (SDR)

S25FS-S 系列可用于由嵌入式微处理器（总线主机）以下两种时钟模式任何一种。

- 模式 0，时钟极性 (CPOL) = 0，时钟相位 (CPHA) = 0
- 模式 3，CPOL = 1 且 CPHA = 1

对于这两种模式，输入到器件中的数据始终在 SCK 信号的上升沿时锁存，而输出数据始终在 SCK 时钟信号的下降沿时可用。

两种模式的区别在于总线主机处于待机模式且不传输任何数据时的时钟极性。

- 当 CPOL = 0、CPHA = 0 时，SCK 将保持逻辑低电平状态
- 当 CPOL = 1、CPHA = 1 时，SCK 将保持逻辑高电平状态

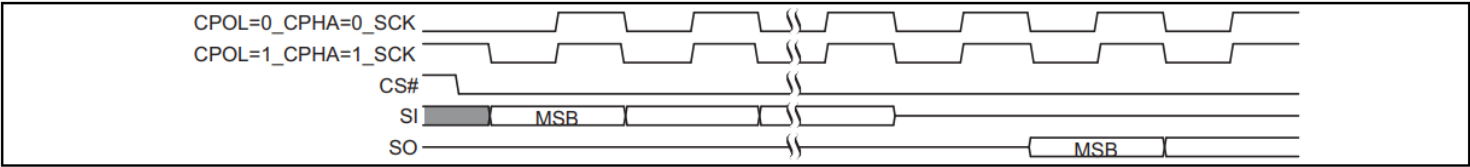


图 4 支持的 SPI SDR 模式

本文档其余部分的时序图通常通过在 CS# 下降时将 SCK 显示为高电平和低电平来显示为模式 0 和模式 3。在某些情况下，时序图可能仅显示模式 0，即在 CS# 下降时 SCK 为低电平。在这种情况下，模式 0 时序仅意味着时钟在 CS 下降沿时为高电平，因此模式 0 不需要 SCK 上升沿建立或 CS 在下降沿的保持时间。

SCK 周期是从一个 SCK 的下降沿到下一个 SCK 的下降沿进行测量（计数）得到的。在模式 0 下，指令中第一个 SCK 周期的开始是从 CS 的下降沿到 SCK 的第一个下降沿来测量的，因为在指令开始时 SCK 已经是低电平。

#### 4.1.2 双倍数据速率 (DDR)

DDR 指令也支持模式 0 和模式 3。与 SDR 指令相同，在 DDR 指令中，指令位总是在时钟的上升沿时被锁存。然而，指令之后的地址和输入数据都会在 SCK 的上升沿时和下降沿时被锁存。最后一个指令位在下降沿时之后，第一位地址位在随后第一个 SCK 上升沿时被锁存。第一个输出数据位则在最后访问延迟（虚拟）周期结束后的下降沿上被发送。

SCK 周期的测量（计数）方式与 SDR 指令相同，从 SCK 的一个下降沿到 SCK 的下一个下降沿。在模式 0 下，指令中第一个 SCK 周期的开始是从 CS 的下降沿到 SCK 的第一个下降沿来测量的，因为在指令开始时 SCK 已经是低电平。

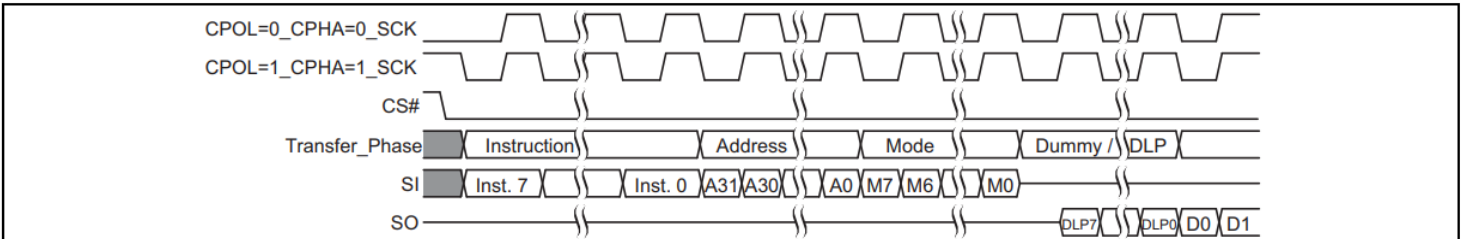


图 5 支持的 SPI DDR 模式

## 4.2 命令协议

主控系统与S25FS-S系列存储器件之间的所有通讯均以命令为单位。

所有命令都以一个 8 位指令开始，该指令选择要执行的信息传输类型或器件操作。命令可能也具有一个地址、指令修饰符、延时周期、传送到存储器，或者是从存储器传送的数据。所有指令、地址和数据信息在主控系统和存储器器件之间连续传输。

命令协议也通过字符命名法进行分类，使用三个字符来标记三个指令阶段的传输宽度：

- 指令；
- 地址和指令修饰符（连续读取模式位）
- Data

单比特命令只通过 SI 信号依次传输指令和地址或数据。数据可以通过 SO 信号串行方式回送到主控。对于单比特宽指令，单比特宽地址和修饰符、单比特数据的结构，被称为 1-1-1 命令协议。

双线或四线输入 / 输出（I/O）命令会按双比特一组的方式通过 IO0 和 IO1 将主机的数据传输给存储器，或按四比特（半字节）一组的方式通过 IO0、IO1、IO2 和 IO3 传输给存储器。数据会送到主控的方式类似于 IO0 和 IO1 上的位对，或者 IO0、IO1、IO2 和 IO3 上的四位（半字节）组。对于双线 I/O 和四线 I/O 命令，这种结构分别被称为 1-2-2 和 1-4-4 命令协议。

S25FS-S系列还支持QPI模式输入，所有信息都以4位宽度传输，包括指令、地址、修饰符和数据。这被称为 4-4-4 命令协议。

命令结构如下：

- 每个命令都在 CS# 的下降沿开始执行，并在 CS# 的上升沿结束。主机通过一个命令将片选（CS#）信号驱动为低电平，从而能够选择存储器。
- 串行时钟（SCK）标记主控和存储器之间所传输的每位或一组位。
- 每个命令都以 8 位（字节）指令开始。该指令选择要执行的信息传输类型或器件操作。指令传输发生在 SCK 上升沿。然而，一些读取指令被先前的读取命令修改，使得该指令是从先前的指令隐含的。这称为连续读取模式。当器件处于连续读取模式时，指令开头不会传输指令位，因为该指令与启动连续读取模式的读取命令相同。在连续读取模式中，指令将以读取地址开始。因此，连续读取模式从一系列相同类型的读取命令中的每个读取命令中移除八个指令位。
- 该指令可以是独立的，也可以跟随地址位以选择器件中地址空间位置。该指令决定所使用的地址空间。地址可以是 24 位或 32 位、字节边界、地址。地址传输发生在 SDR 指令中的 SCK 上升沿，或 DDR 指令中的每个 SCK 边沿。
- 在传统 SPI 模式下，指令之后的所有传输的位宽均由发送的指令决定。以下表示的可能是其中一种传输类型：仅通过串行输入（SI）或串行输出（SO）信号单比特传输；通过 IO0 和 IO1 信号每次（双线）传输将以双比特的形式进行传输；或通过 IO0-IO3 信号每次（四线）以 4 比特的形式传输。在双比特或四比特组中，最低有效位位于 IO0 上。其他更高有效位则按照权值大小，通过 IO 信号的编号有序放置。单个位或并行位组按照从最高有效位到最低有效位的顺序进行传输。
- 在 QPI 模式下，所有传输的宽度都是 IO0-IO3 信号上的 4 位宽（四线）传输。

## 信号协议

- 双线和四线 I/O 读指令在发送地址后将发送一个指令修饰符（称为连续读取模式位），以指明下一个命令的类型与之前的命令相同，而它并不是明确的命令。这些模式位用于初始化或结束连续读取模式。这些模式位启动或结束连续读取模式。在连续读取模式下，下一个命令不提供指令字节，只提供新地址和模式位。当某个相同命令重复了前序中的命令类型时，会减少发送一个命令所需要的时间。模式位传输发生在 SDR 指令中的 SCK 上升沿，或 DDR 指令中的每个 SCK 边沿。
- 地址或模式位后面可能跟有要存储在存储器器件中的写入数据，或者后面可能是读取数据返回到主控之前的读取等待时间。
- 在 SDR 指令中，写入数据位的传输发生在 SCK 上升沿，或者在 DDR 指令中发生在每个 SCK 沿。
- SCK 在任何读取访问延时期间继续跳变。延时可能是零到几个 SCK 周期（又称为虚拟周期）。在读取延时周期结束时，第一个读取数据位在最后一个读取延时周期结束时的 SCK 下降沿时输出。第一个读取的数据位被作为在下一个 SCK 上升沿时传输到主控端。在 SDR 指令中，后续每次传输都发生在下一个 SCK 上升沿，而在在 DDR 指令中，发生在每个 SCK 跳变沿。
- 如果命令将读取的数据回送给主机，则设备将继续发送数据，直到主机将 CS# 信号置于高电平。在读取数据序列中的任何传输之后，CS# 信号都可以被驱动为高电平。这将终止指令。
- 在没有回送数据的指令结束时，主控将 CS 输入驱动为高电平。在单独指令时或传输的最后一个写入数据字节的第八位之后，CS# 信号必须变为高电平。也就是说，当 CS# 信号驱动为低电平后的位数是八位的整数倍时，CS# 信号必须驱动为高电平。在指令八位边界处或写入数据时，如果 CS 没有准时变为高电平，则命令将被拒绝并且不会执行。
- 所有指令、地址和模式位输入到器件中，先输入最高有效位 (MSB)。数据位从器件输入或输出，先传输最高有效位 (MSB)。所有数据都以字节为单位传输，并且最先发送最低地址字节。以下数据字节按从最低到最高字节地址的顺序发送，即字节地址递增。
- 在编程、擦除或写入周期（嵌入式操作）期间读取闪存阵列的所有尝试都将被忽略。嵌入的操作将继续执行，不会受到任何影响。嵌入操作期间只能接受非常有限的指令集。这些信息在独立的指令描述中进行了介绍。
- 根据指令不同，执行时间也不同。一条命令可以从正在执行的指令中读取命令执行状态信息，用于确定命令执行完成情况以及这条命令是否执行成功。

信号协议

4.2.1 指令时序示例

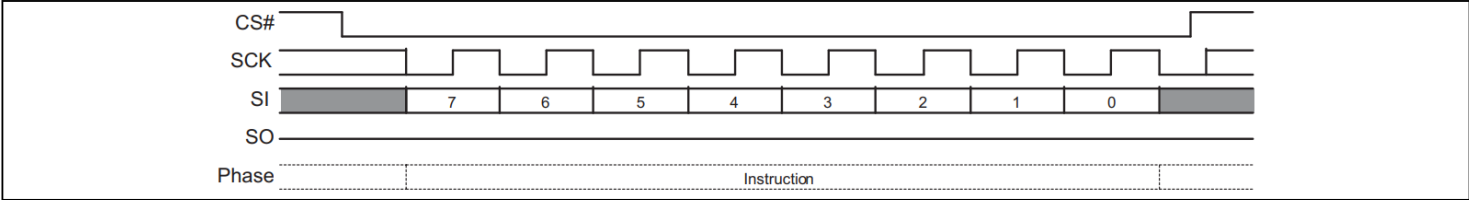


图 6 单独指令命令

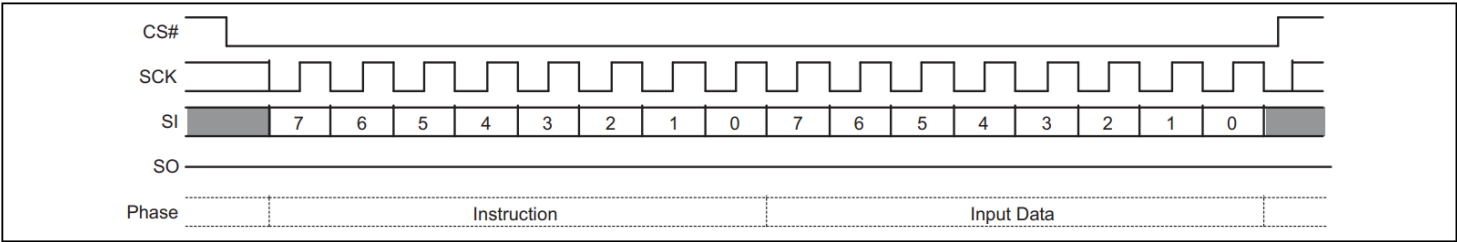


图 7 单线位宽输入命令

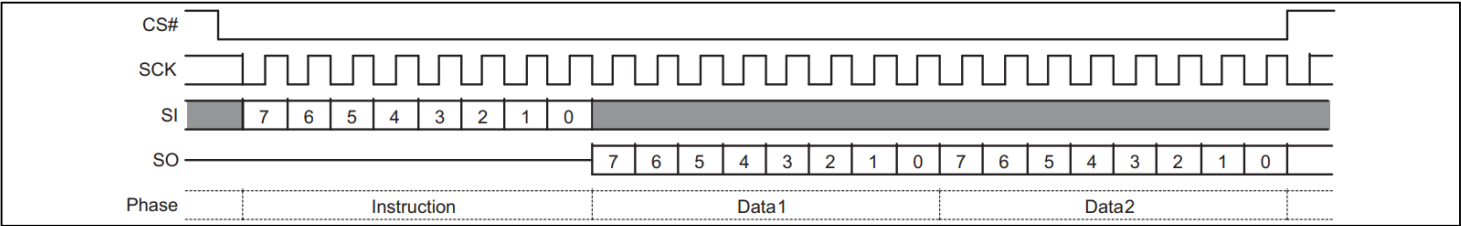


图 8 单线位宽输出命令

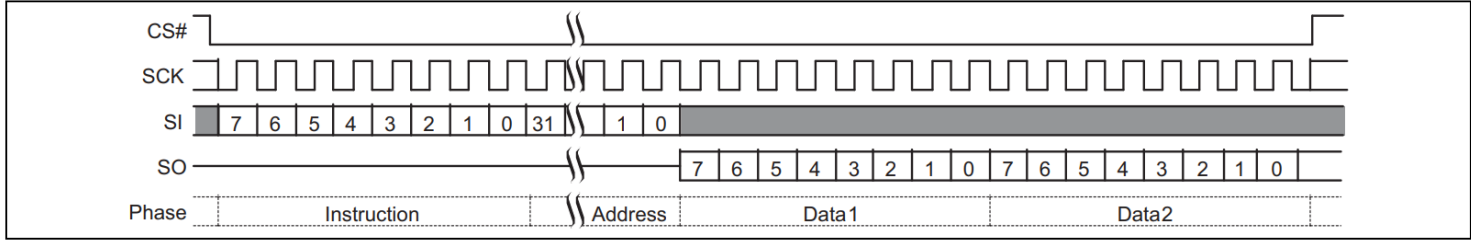


图 9 无延时的单线位宽的I/O 命令

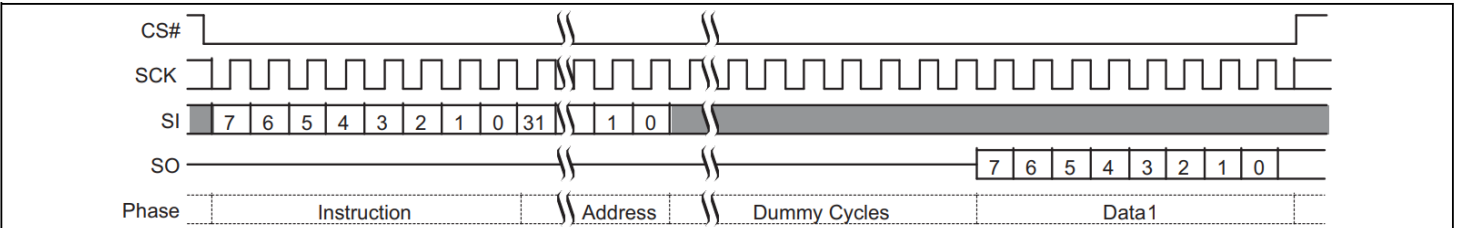


图 10 带延时的单线位宽的I/O 命令

信号协议

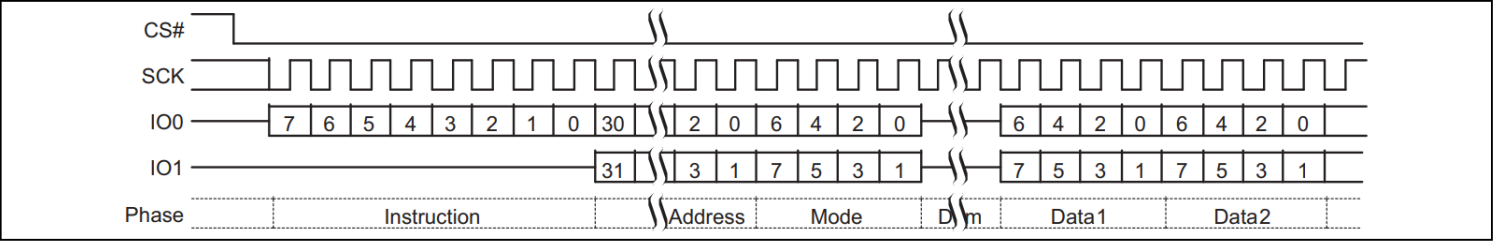


图 11 双线I/O 命令

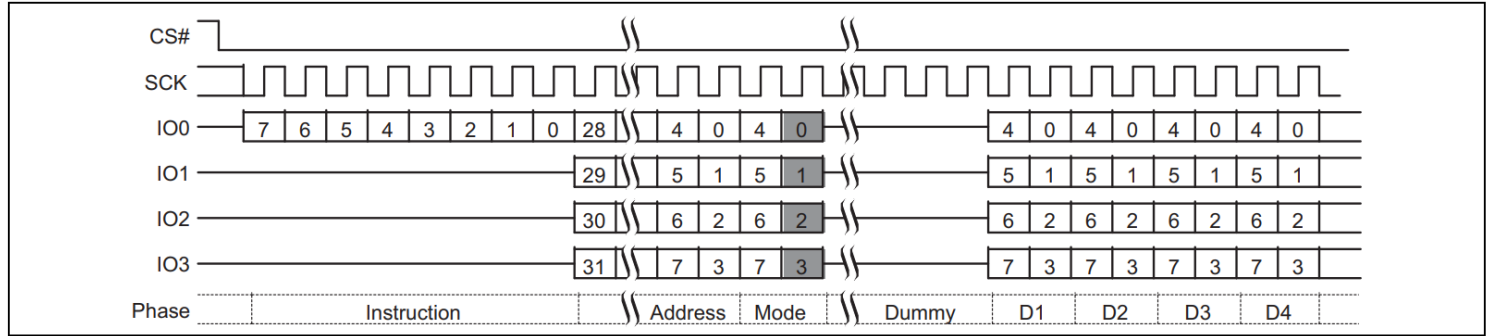


图 12 四线 I/O 命令

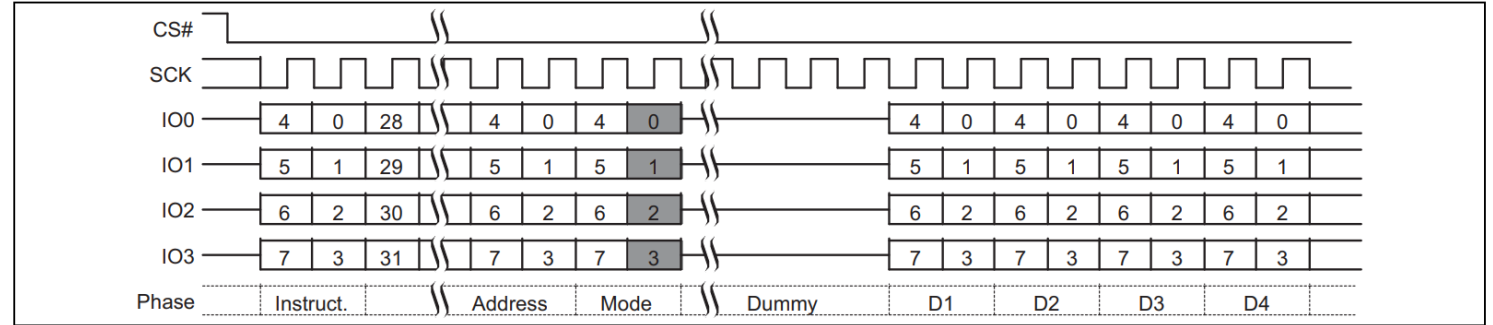


图 13 QPI 模式下的四线 I/O 读取命令

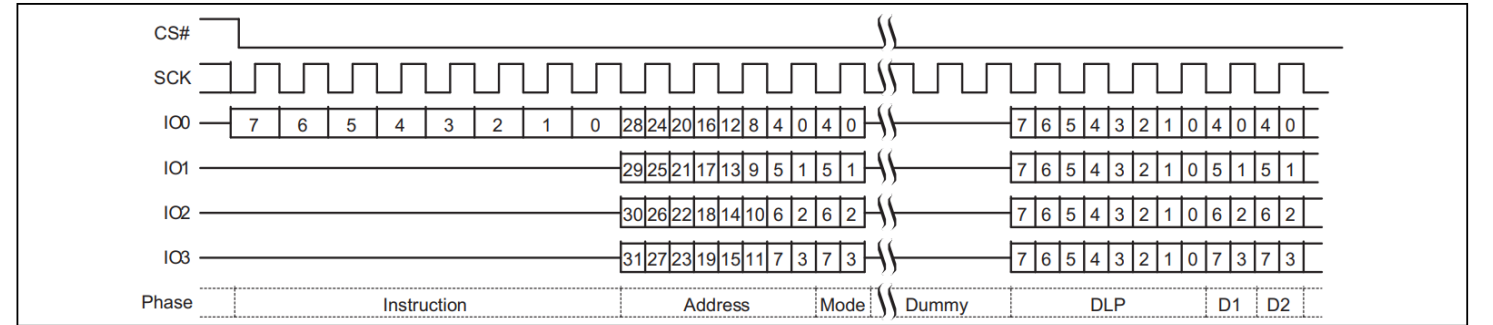


图 14 DDR 四线 I/O 读取

信号协议

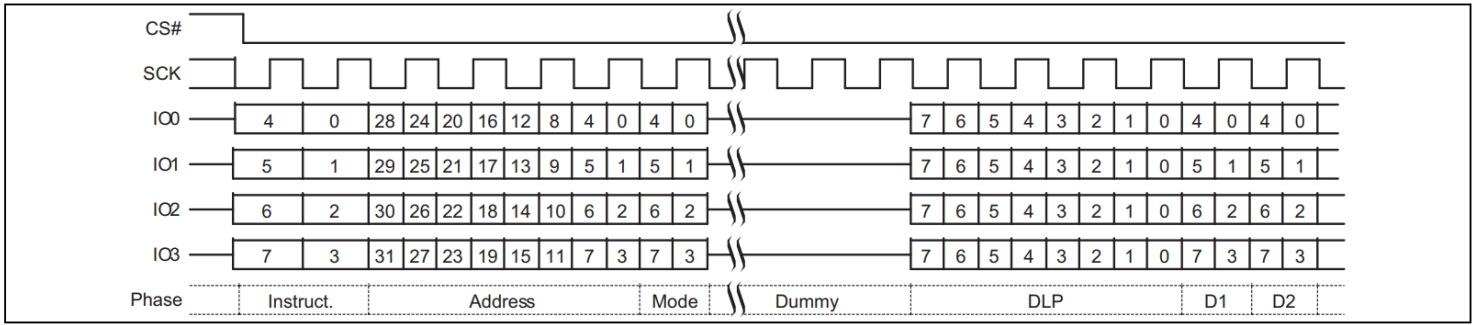


图 15 QPI 模式下的 DDR 四线 I/O 读取

每个命令的具体附加时序图在90页的“命令”中提供。

## 信号协议

### 4.3 接口状态

本节介绍与 SPI 接口行为相关的输入和输出信号电平。

**表 3 接口状态汇总**

Interface state	V <sub>CC</sub>	SCK	CS#	IO3 / RESET#	WP# / IO2	SO / IO1	SI / IO0
Power-Off	<V <sub>CC</sub> (low)	X	X	X	X	Z	X
Low-Power Hardware Data Protection	<V <sub>CC</sub> (cut-off)	X	X	X	X	Z	X
Power-On (Cold) Reset Interface States Summary	≥V <sub>CC</sub> (min)	X	HH	X	X	Z	X
Hardware (Warm) Reset Non-Quad Mode	≥V <sub>CC</sub> (min)	X	X	HL	X	Z	X
Hardware (Warm) Reset Quad Mode	≥V <sub>CC</sub> (min)	X	HH	HL	X	Z	X
Interface Standby	≥V <sub>CC</sub> (min)	X	HH	X	X	Z	X
Instruction Cycle (Legacy SPI)	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	HH	HV	Z	HV
Single Input Cycle Host to Memory Transfer	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	HH	X	Z	HV
Single Latency (Dummy) Cycle	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	HH	X	Z	X
Single Output Cycle Memory to Host Transfer	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	HH	X	MV	X
Dual Input Cycle Host to Memory Transfer	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	HH	X	HV	HV
Dual Latency (Dummy) Cycle	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	HH	X	X	X
Dual Output Cycle Memory to Host Transfer	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	HH	X	MV	MV
Quad Input Cycle Host to Memory Transfer	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	HV	HV	HV	HV
Quad Latency (Dummy) Cycle	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	X	X	X	X
Quad Output Cycle Memory to Host Transfer	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	MV	MV	MV	MV
DDR Quad Input Cycle Host to Memory Transfer	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	HV	HV	HV	HV
DDR Latency (Dummy) Cycle	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	MV or Z	MV or Z	MV or Z	MV or Z
DDR Quad Output Cycle Memory to Host Transfer	≥V <sub>CC</sub> (min)	HT	HL	MV	MV	MV	MV

#### 图文说明

Z = 无驱动 - 悬空信号

HL = 主控驱动 V<sub>IL</sub>

HH = 主控驱动 V<sub>IH</sub>

HV = HL 或 HH

X = HL 或 HH 或 Z

HT = HL 和 HH 之间切换

ML = 存储器驱动 V<sub>IL</sub>

MH = 存储器驱动 V<sub>IH</sub>

MV = ML 或 MH

### 4.3.1 掉电

当核心供电电压等于或低于 $V_{CC(Low)}$ 电压时，器件被认为掉电。器件不会对外部信号做出反应，也无法执行任何编程或擦除操作。

### 4.3.2 低电压时硬件数据保护

当 $V_{CC}$ 小于 $V_{CC}$  (截止)时，存储器器件将忽略指令，以确保当核心供电电压超出工作范围时，编写和擦除操作无法启动。

### 4.3.3 上电（冷）复位

当核心电压源保持等于或低于  $V_{CC}$  (低电平) 电压的时间  $\geq t_{PD}$ ，然后上升到  $\geq V_{CC}$  (最小值) 时，器件将开始上电复位 (POR) 流程。POR 持续到  $t_{PU}$  结束。在  $t_{PU}$  期间，器件不对外部输入信号作出反应，也不驱动任何输出。 $t_{PU}$  结束后，器件切换到接口待机状态并可以接受指令。有关POR的更多信息，请参阅“上电（冷）复位”第 34 页。

### 4.3.4 硬件（热）复位

当器件不处于四线模式或处于四线模式且 CS 为高电平时，提供了一个配置选项，允许 IO3 用作硬件复位输入。当 IO3 / RESET# 被驱动为低电平并持续  $t_{RP}$  时间时，器件开始硬件复位流程。该流程持续  $t_{RPH}$  时间。在  $t_{RPH}$  结束和 RESET# 变高电平复位保持时间  $t_{RH}$  结束后，器件将切换至接口待机状态并可接受指令。有关硬件复位的更多信息，请参阅“复位”第34页。

### 4.3.5 接口待机

当 CS# 为高电平时，SPI 接口处于待机状态。RESET# 之外的输入将被忽略。接口等待新指令的开始。当 CS# 变为低电平以开始新命令时，下一个接口状态是指令周期。

在接口待机状态时，如果没有任何嵌入式算法正在进行，则存储器器件会消耗待机电流 ( $I_{SB}$ )。如果嵌入式运算正在进行中，则会消耗相关的电流，直到运算结束，此时整个器件返回到待机电流消耗状态。

FS-S 系列设备支持深度掉电 (DPD) 模式。如果器件已通过 DPD (B9h) 指令置于 DPD 模式，则接口待机电流为  $I_{DPD}$ 。仅当器件未执行嵌入式操作时，才接受 DPD 指令，如状态寄存器 1 易失性写入标志位 (WIP) 位清零 (SR1V[0] = 0) 所示。在 DPD 模式下，器件会忽略除释放 DPD (RES ABh) 指令，该指令将在  $t_{RES}$  延时后使器件返回到接口待机状态。

### 4.3.6 指令周期（传统 SPI 模式）

当主控驱动指令的最高有效位且 CS# 变为低电平时，在 SCK 的下一个上升沿时，器件捕获开始新命令并捕获新指令的指令的 MSb（最高有效位）。在每个后续的 SCK 上升沿时，该器件依次捕获 8 位指令的下一个较低有效位。主机保持 CS 低电平，并根据指令需要驱动写保护 (WP#) 和 IO3 / RESET# 信号。但是，WP# 仅在 WRR 或 WRAR 命令的指令周期内相关，否则会被忽略。器件未处于四线模式 (CR1V[1] = 0) 或 QPI 模式 (CR2V[6] = 0) 且不需要硬件复位时，IO3/RESET# 被驱动为高电平。

每条指令选择操作的地址空间，和使用的传输格式在命令其他部分。传输格式可以是单线 I/O、双线 I/O、四线 I/O 或 DDR 四线 I/O。预期的下一个接口状态取决于收到的指令。

有些指令是单独的，不需要存储器地址或传输的数据。对应该指令中的第八位的 SCK 的上升沿之后，主控返回 CS# 为高电平。在这种情况下，下一个接口状态是接口待机。

### 4.3.7 指令周期 (QPI 模式)

在 QPI 模式下, 当 CR2V[6] = 1 时, 指令每周期传输 4 位。在此模式下, 指令周期与四线输入周期相同。请参阅“四线输入输入周期- 主控到存储器传输”在第25页。

### 4.3.8 单线输入周期-主控到存储器的传输

命令的信息传输是指令通过单个串行输入 (SI) 信号从主控制器发送到存储器器件。主控保持 RESET# 为高电平, CS 为低电平, 并根据指令的需要驱动 SI。内存存储器不驱动串行输出 (SO) 信号。

预期的下一个接口状态取决于指令。一些指令使用额外的单线输入周期继续向存储器发送地址或数据。其他可能转换为单线延时, 或直接转换为单线、双线或四线输出周期状态。

### 4.3.9 单线延时 (虚拟) 周期

在从闪存器件读取数据的传输中, 读命令可能有零到几个的延时周期。延时周期数由配置寄存器 (CR2V[3:0]) 中的延时编码决定的。在延时周期内, 主控保持 RESET# 为高电平, CS 为低电平。写保护 (WP#) 信号被忽略。主控可能会在这些周期内驱动 SI 信号, 或者主控可能会让 SI 处于悬空状态。在延时周期内, 存储器不使用 SI / IO0 或其他 I/O 信号上驱动的任何数据。在延时周期内, 存储器不会驱动串行输出 (SO) 或 I/O 信号。

下一个接口状态取决于指令结构, 即延时周期数, 以及读取是单线、双线还是四线。

### 4.3.10 单线输出周期-存储器到主控的传输

多个命令通过单个串行输出 (SO) 信号将信息传回主控。主控保持 RESET# 为高电平, CS 为低电平。写保护 (WP#) 信号被忽略。存储器忽略串行输入 (SI) 信号。存储器用数据驱动 SO。

下一个接口状态继续为单线输出周期, 直到主控将 CS 返回为高电平结束指令。

### 4.3.11 双线输入周期 - 主控至存储器的传输

双线读取 I/O 指令在每个周期传输两位地址或模式位到存储器。主控保持 RESET# 为高电平, CS 为低电平。写保护 (WP#) 信号被忽略。主控驱动地址位于 SI / IO0 和 SO / IO1。

地址和模式位传送之后的下一个接口状态是双延时周期 (有延时要求); 如果不需要延时, 则为双线输出周期。

### 4.3.12 双线延时 (虚拟) 周期

在从闪存器件读取数据的传输中, 读命令可能有零到几个的延时周期。延时周期数由配置寄存器 (CR2V[3:0]) 中的延时编码决定的。在延时周期内, 主控保持 RESET# 为高电平, CS 为低电平。写保护 (WP#) 信号被忽略。主控可能会在这些周期内驱动 SI / IO0 和 SO / IO1 信号, 或者主控可能会让 SI / IO0 和 SO / IO1 处于浮动状态。延时周期期间, 存储器不使用 SI / IO0 上驱动的任何数据在 SO / IO1 上。在最后一个延时周期结束时的下降沿时, 主控必须停止驱动 SI / IO0 和 SO / IO1。建议主控在所有延时周期内停止驱动它们, 以便在延时周期结束时, 存储器开始驱动之前有足够的时间让主控驱动关闭。这样可以防止信号跳变时, 主控与存储器的驱动相互冲突。存储器在延时周期内不会驱动 SI / IO0 和 SO / IO1 信号。

最后一个延时周期之后的下一个接口状态是双线输出周期。

#### 4.3.13 双线输出周期-存储器到主控的传输

双线读取输出和线读取 I/O 在每个周期向主控返回两位数据。主控保持 RESET# 为高电平，CS 为低电平。写保护 (WP#) 信号被忽略。存储器在双线输出周期内驱动 SI/IO0 和 SO/IO1 信号上的数据。

下一个接口状态继续为双线输出循环，直到主控将 CS 返回为高电平结束指令。

#### 4.3.14 四线输入周期 - 主控至存储器的传输

四线 I/O 读取命令在每个周期将四个地址位或模式位传输到存储器。在 QPI 模式下，四路线 I/O 读取和页编程命令在每个周期（包括指令周期）向存储器传输四个数据位。主控保持 CS 低电平，驱动 IO 信号。

对于四线 I/O 读取，在传送地址位和模式位之后下一个接口状态，如果需要延时周期则为四线延时周期，如果不需要延时则为四线输出周期。对于 QPI 模式页编程命令，主控在传送要写入的数据后，返回 CS# 为高电平，且接口返回待机状态。

#### 4.3.15 带延时的四线（虚拟）周期

在从主控从闪存器件读去数据的传输中，读命令可能有零到几个的延时周期。延时周期数由配置寄存器 (CR2V[3:0]) 中的延时编码决定的。在延时周期内，主控保持 CS 低电平。主控可能会在这些周期内驱动 IO 信号，或者主控可能会让 IO 处于浮动状态。在延时周期内，存储器不使用任何通过 IO 驱动的数据。主机必须在最后一个延时周期结束时的下降沿停止驱动 IO 信号。建议主控在所有延时周期内停止驱动它们，以便在延时周期结束时，存储器开始驱动之前有足够的时间让主控驱动关闭。这样可以防止信号跳变时，主控与存储器的驱动相互冲突。存储器在延迟周期内不会驱动 IO 信号。

最后一个延时周期之后的下一个接口状态是四线输出周期。

#### 4.3.16 四线输出周期-存储器到主控的传输

四线 I/O 读取在每个周期向主控返回四位数据。主机保持 CS 低位。存储器在四线输出周期期间通过 IO0–IO3 信号驱动数据。

下一个接口状态继续为四线输出循环，直到主控将 CS 返回为高电平并结束指令。

#### 4.3.17 DDR 四线输入周期 - 主控至存储器的传输

DDR 四线 I/O 读取命令通过所有 IO 信号将地址和模式位发送到存储器。在每个周期中，SCK 的上升沿传输 4 位，下降沿传输 4 位。主机保持 CS 低位。

传送地址位和模式位之后的下一个接口状态是 DDR 延时周期。

#### 4.3.18 DDR 延时周期

在从存储器阵列传输到主控读取数据之前，DDR 读取命令可能有一到几个延时周期。延时周期数由配置寄存器 (CR2V[3:0]) 中的延时编码决定的。在延时周期内，主控保持 CS 低电平。主控可能不会在这些周期内驱动 IO 信号。这样在存储器开始驱动之前，主机驱动器就有足够的时间停止传输操作。这样可以防止信号跳变时，主控与存储器的驱动相互冲突。存储器有一个选项，可以在最后 4 个延时周期内加载数据学习模式 (DLP) 驱动所有 IO 信号。延时周期少于 5 个时，不应启用 DLP 选项，以便在存储器开始驱动 DLP 之前至少有一个高阻态周期用于 IO 信号的转变。延迟周期超过 4 个时，存储器直到最后 4 个延时周期才会驱动 IO 信号。

最后一个延时周期之后的下一个接口状态是 DDR 单线输出周期或四线输出周期，取决于指令。

#### **4.3.19 DDR 四线输出周期 - 存储器到主控的传输**

DDR 四线I/O 读取命令将所有 IO 信号上的位返回至主控。在每个周期中，SCK 的上升沿传输 4 位，下降沿传输 4 位。主机保持CS低位。

下一个接口状态继续为 DDR 四线输出周期，直到主控将 CS 返回为高电平并结束指令。

#### **4.4 配置寄存器对接口的影响**

配置寄存器 2 易失性位 3 至 0 (CR2V[3:0]) 用于除读取指令和读取 SDFP (RSFDP)指令之外的所有读取指令的延时。读取指令始有0延时周期。RSFDP有 8 个延时周期。可变延时也用于 OTPR、ECCRD 和 RDAR 指令。

配置寄存器位 1 (CR1V[1]) 选择是使能四线模式，以将 WP# 切换到 IO2 功能，将 RESET# 切换到 IO3 功能，从而允许四线 I/O 读取和 QPI 模式命令。DDR 四线I/O 读取命令必须选择四线模式。

#### **4.5 数据保护**

一些防止对存储数据进行意外更改的基本保护完全由硬件设计提供和控制。下面将对此进行描述。其他软件管理保护方法在文档的软件部分讨论。

##### **4.5.1 上电**

当核心供电电压等于或低于 $V_{CC(LOW)}$ 电压时，器件被认为掉电。器件不会对外部信号做出反应，也无法执行任何编程或擦除操作。

在上电复位 (POR) 期间，编程和擦除操作将继续受到阻止，因为直到从 POR 退出到接口待机状态时才会接受任何命令。

##### **4.5.2 低功耗**

当 $V_{CC}$ 小于 $V_{CC(cut-off)}$ 时，存储器器将忽略指令，以确保当核心供电电压超出工作范围时，编写和擦除操作无法启动。

##### **4.5.3 时钟脉冲计数**

器件在执行之前验证所有非易失的存储器和寄存器数据修改指令是否由时钟计数组成，该计数是八位传输（字节边界）的倍数。不以 8 位 (字节) 边界结尾的命令将被忽略，并且该命令不会设置任何错误状态。

##### **4.5.4 深度掉电模式 (DPD)**

在 DPD 模式下，器件仅响应 DPD 释放指令 (RES ABh)。在 DPD 模式期间，所有其他命令都会被忽略，从而保护内存免受写入和擦除操作的影响。

## 电气规格参数

## 5 电气规格参数

### 5.1 绝对最大额定值

表 4 最大绝对额定值

Storage temperature plastic packages	-65°C to +150°C
Ambient temperature with power applied	-65°C to +125°C
$V_{CC}$	-0.5 V to +2.5 V
Input voltage with respect to Ground ( $V_{SS}$ ) <sup>[8]</sup>	-0.5 V to $V_{CC} + 0.5$ V
Output short circuit current <sup>[9]</sup>	100 mA

### 5.2 热阻抗

表 5 热阻

Parameter	Description	Device	SOC008	SO3016	WNH008	FAB024	FAC024	Unit
Theta JA	Thermal resistance (Junction to ambient)	S25FS128S	63	–	32	38	38	°C/W
		S25FS256S	–	38	33	35	35	°C/W
Theta JB	Thermal resistance (Junction to board)	S25FS128S	37	–	21	10	10	°C/W
		S25FS256S	–	9	12	19	19	°C/W
Theta JC	Thermal resistance (Junction to case)	S25FS128S	30	–	13	12	12	°C/W
		S25FS256S	–	10	9	11	11	°C/W

### 5.3 闩锁特性

表 6 闩锁规范

Description	Min	Max	Unit
Input voltage with respect to $V_{SS}$ on all input only connections	-1.0	$V_{CC} + 1.0$	V
Input voltage with respect to $V_{SS}$ on all I/O connections	-1.0	$V_{CC} + 1.0$	V
$V_{CC}$ current	-100	+100	mA

#### 注:

- 信号传输期间允许的最大值请参阅第28页的“输入信号过冲”。
- 每一次只能有一个输出对地短接。短接时间不能超过一秒。
- 如果使用大于最大绝对额定值中所列出的数值，可能对器件造成永久性损害。这只是压力额定值；并不意味着器件在这些值或者在此数据手册操作部分所示值之上的任何其他情形下不能正常运行。如果让器件长时间在绝对最大额定值情况下运行，会影响器件的可靠性。
- 不包括电源  $V_{CC}$ 。测试条件： $V_{CC} = 1.8$  V，每次测试一个连接，未测试的连接位于  $V_{SS}$ 。

电气规格参数

### 5.4 工作范围

运行范围定义了一些限值，在这些限值之间可保证器件正常运行。

#### 5.4.1 供电电压

表 7 电源电压

$V_{CC}$	1.7 V to 2.0 V
----------	----------------

#### 5.4.2 温度范围

表 8 温度范围

Parameter	Symbol	Device	Spec		Unit
			Min	Max	
Ambient temperature	$T_A$	Industrial (I)	-40	+85	°C
		Industrial Plus (V)	-40	+105	°C
		Automotive, AEC-Q100 grade 3 (A)	-40	+85	°C
		Automotive, AEC-Q100 grade 2 (B)	-40	+105	°C
		Automotive, AEC-Q100 grade 1 (M)	-40	+125	°C

#### 5.4.3 输入信号过冲

在直流条件下，输入或 I/O 信号应保持相等或介于  $V_{SS}$  和  $V_{CC}$  之间。在电压传输期间，输入或 I/O 可能会超过  $V_{SS}$  至 -1.0 V 或超过  $V_{CC} + 1.0 V$ ，持续时间最长为 20 ns。

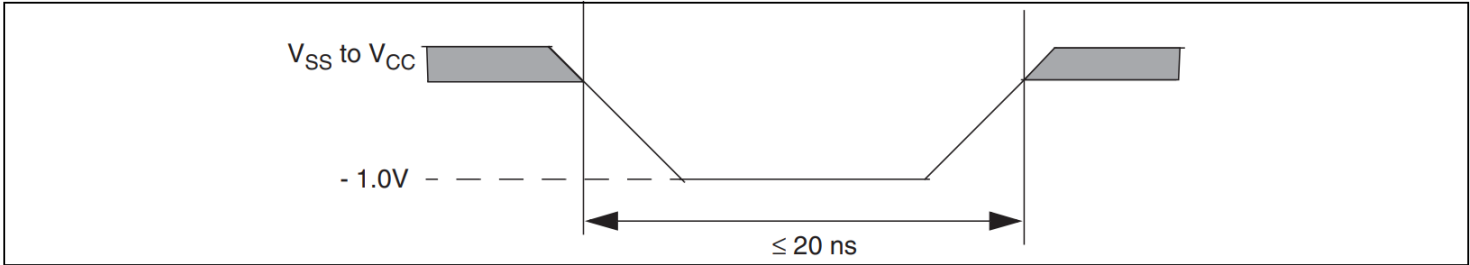


图16 最大负极过冲波形

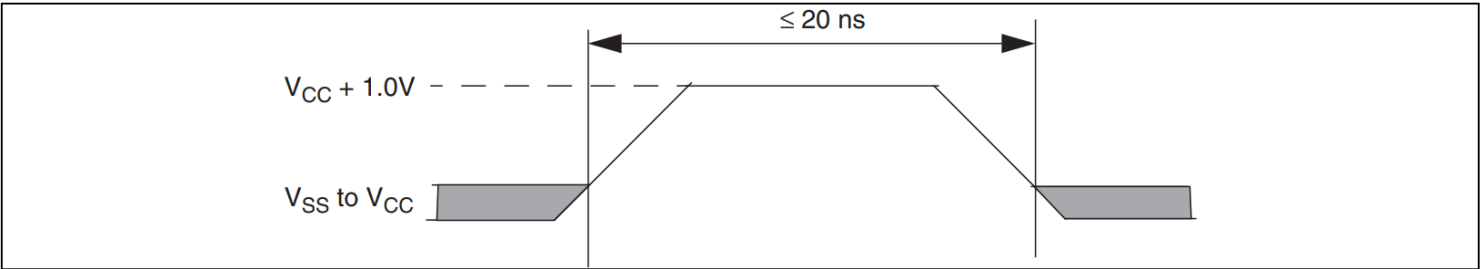


图 17 最大正极过冲波形

注：

12. 工业 Plus 的操作和性能参数将由器件特性决定，并且可能与本规范中显示的标准工业温度范围设备有所不同。

电气规格参数

## 5.5 上电和断电

在上电或电源下降时一定不要选择该器件（即 CS 必须遵循在 VCC 上的电压），直到 VCC 达到如下正确的值：

- 上电时为  $V_{CC}(\min)$ ，然后再延迟  $t_{PU}$  时间
- VSS 在掉电

通常在片选（CS#）上的使用简单的上拉电阻，可用于确保安全和完整的上电和掉电。

在  $V_{CC}$  上升到最低 VCC 阈值之后，器件会忽略所有指令，直到经过  $t_{PU}$  时间延时（见图 18）。但是，如果  $V_{CC}$  在  $t_{PU}$  期间回落到  $V_{CC}(\min)$  以下，则无法保证器件的正确操作。在  $t_{PU}$  结束之前，不应向器件发送任何命令。

器件在  $t_{PU}$  期间电流为 IPOR。上电 ( $t_{PU}$ ) 后，器件处于待机模式，是正常 CMOS 待机电流 (ISB)，且 WEL 位复位。

在掉电或电压降至  $V_{CC}$ （截止）以下时，电压必须降至  $V_{CC}$ （低电平）以下并持续  $t_{PD}$  时间，以使器件在上电时正确初始化（见图 19）。如果在降压过程中  $V_{CC}$  保持在  $V_{CC}(\text{截止})$  以上，则部件将保持初始化状态，并在  $V_{CC}$  再次高于  $V_{CC}(\text{最小})$  时可以正常工作。如果上电后上电复位未正确完成，则应使用 RESET# 信号或接收软件复位指令（复位命令）将重新启动 POR 流程。

必须采取正常的预防措施来对电源轨进行去耦，以稳定器件的  $V_{CC}$  电源。系统中的每个器件都应通过靠近封装电源连接的合适电容对  $V_{CC}$  轨进行去耦（该电容通常为 0.1  $\mu\text{F}$  量级）。

表 9 FS-S 上电/掉电的电压和时序

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
$V_{CC}(\min)$	$V_{CC}$ (minimum operation voltage)	1.7	–	V
$V_{CC}(\text{cut-off})$	$V_{CC}$ (cut Off where re-initialization is needed)	1.5	–	V
$V_{CC}(\text{low})$	$V_{CC}$ (low voltage for initialization to occur)	0.7	–	V
$t_{PU}$	$V_{CC}(\min)$ to Read operation	–	300	$\mu\text{s}$
$t_{PD}$	$V_{CC}(\text{low})$ time	10.0	–	$\mu\text{s}$

电气规格参数

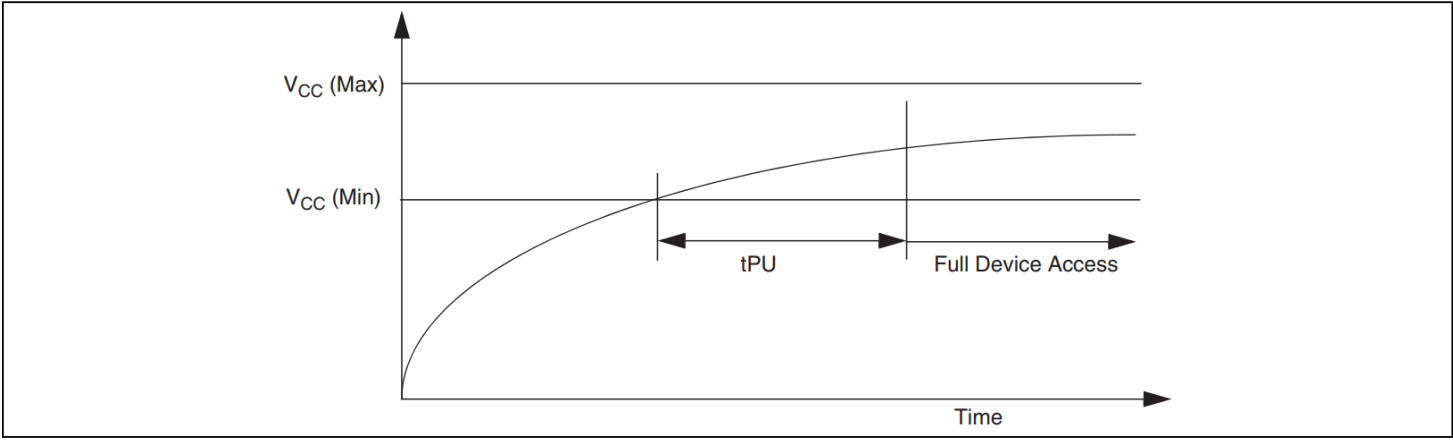


图 18 上电

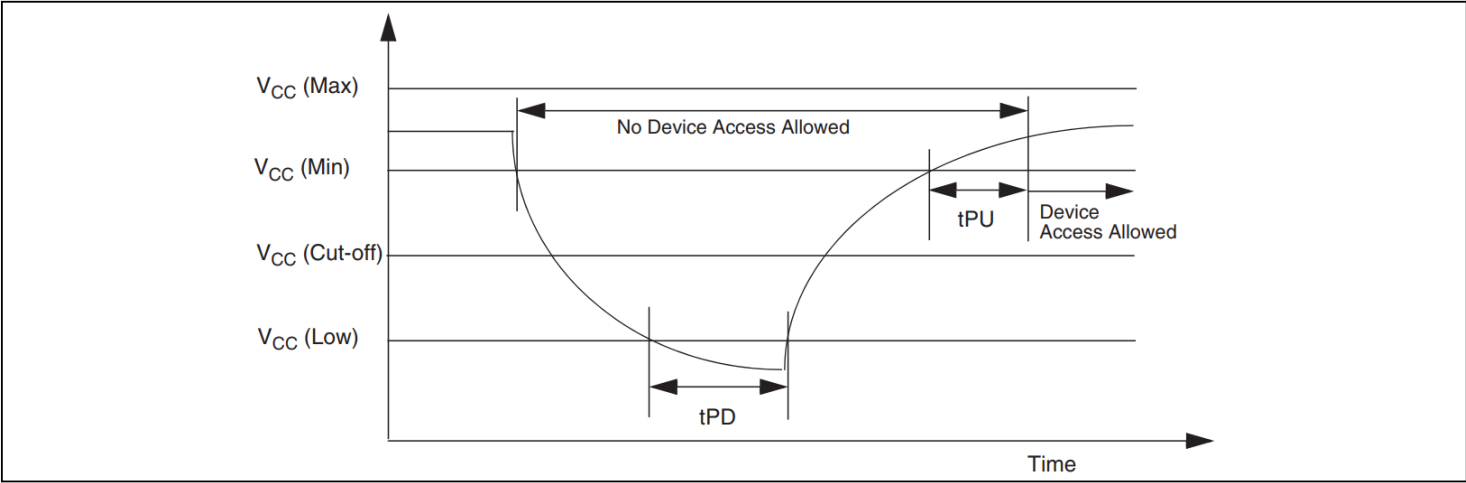


图19 掉电或电压下降

## 电气规格参数

## 5.6 直流特性

适用于操作范围内。

表 10 FS-S DC参数

Symbol	Parameter	Test conditions	Min	Typ <sup>[13]</sup>	Max	Unit
$V_{IL}$	Input low voltage	–	–0.5	–	$0.3 \times V_{DD}$	V
$V_{IH}$	Input high voltage	–	$0.7 \times V_{DD}$	–	$V_{CC} + 0.4$	V
$V_{OL}$	Output low voltage	$I_{OL} = 0.1 \text{ mA}$	–	–	0.2	V
$V_{OH}$	Output high voltage	$I_{OH} = -0.1 \text{ mA}$	$V_{CC} - 0.2$	–	–	V
$I_{LI}$	Input leakage current	$V_{CC} = V_{CC} \text{ Max}$ , $V_{IN} = V_{IH} \text{ or } V_{SS}$ , $CS\# = V_{IH}$	–	–	$\pm 2$	$\mu\text{A}$
$I_{LO}$	Output leakage current	$V_{CC} = V_{CC} \text{ Max}$ , $V_{IN} = V_{IH} \text{ or } V_{SS}$ , $CS\# = V_{IH}$	–	–	$\pm 2$	$\mu\text{A}$
$I_{CC1}$	Active power supply current (READ) <sup>[14]</sup>	Serial SDR @ 50 MHz Serial SDR @ 133 MHz Quad SDR @ 133 MHz Quad DDR @ 80 MHz	–	10 25 60 70	18 30 65 90	mA
$I_{CC2}$	Active power supply current (Page Program)	$CS\# = V_{CC}$	–	60	100	mA
$I_{CC3}$	Active power supply current (WRR or WRAR)	$CS\# = V_{CC}$	–	60	100	mA
$I_{CC4}$	Active power supply current (SE)	$CS\# = V_{CC}$	–	60	100	mA
$I_{CC5}$	Active power supply current (BE)	$CS\# = V_{CC}$	–	60	100	mA
$I_{SB}$	Standby current	IO3/RESET#, $CS\# = V_{CC}$ ; SI, SCK = $V_{CC}$ or $V_{SS}$ , Industrial temperature/ Automotive, AEC-Q100 grade 3	–	25	100	$\mu\text{A}$
$I_{SB}$	Standby current	IO3/RESET#, $CS\# = V_{CC}$ ; SI, SCK = $V_{CC}$ or $V_{SS}$ , Industrial Plus temperature/ Automotive, AEC-Q100 grade 2	–	25	300	$\mu\text{A}$
$I_{SB}$	Standby current	IO3/RESET#, $CS\# = V_{CC}$ ; SI, SCK = $V_{CC}$ or $V_{SS}$ , Automotive, AEC-Q100 grade 1	–	25	300	$\mu\text{A}$
$I_{DPD}$	Deep power-down current	IO3/RESET#, $CS\# = V_{CC}$ ; SI, SCK = $V_{CC}$ or $V_{SS}$ , Industrial temperature/ Automotive, AEC-Q100 grade 3	–	6	50	$\mu\text{A}$

注:

13. 典型值为  $T_{AI} = 25^\circ\text{C}$  和  $V_{CC} = 1.8 \text{ V}$ .

14. 读取数据返回期间输出未连接。不包括输出开关电流。

电气规格参数

表 10 FS-S DC参数 (续)

Symbol	Parameter	Test conditions	Min	Typ <sup>[13]</sup>	Max	Unit
$I_{DPD}$	Deep power-down current	IO3/RESET#, CS# = $V_{CC}$ ; SI, SCK = $V_{CC}$ or $V_{SS}$ , Industrial Plus temperature/Automotive, AEC-Q100 grade 2	–	6	100	$\mu A$
$I_{DPD}$	Deep power-down current	IO3/RESET#, CS# = $V_{CC}$ ; SI, SCK = $V_{CC}$ or $V_{SS}$ , Automotive, AEC-Q100 grade 1	–	6	170	$\mu A$
$I_{POR}$	Power-on reset current	IO3/RESET#, CS# = $V_{CC}$ ; SI, SCK = $V_{CC}$ or $V_{SS}$	–	–	80	mA

注:

13. 典型值为  $T_{AI} = 25^{\circ}C$  和  $V_{CC} = 1.8 V$ .

14. 读取数据返回期间输出未连接。不包括输出开关电流。

## 5.6.1 工作电源和待机电源模式

当片选 (CS) 为低电平时, 器件被使能并处于工作模式。当 CS 为高电平时, 器件被禁用, 但可能仍处于工作模式, 直到所有编程、擦除和写操作完成。然后器件进入待机功耗模式, 电流降至  $I_{SB}$ 。

## 5.6.2 深度掉电模式

S25FS-S 家族器件支持深度掉电 (DPD) 模式。如果器件已通过 DPD (B9h) 指令置于 DPD 模式, 则接口待机电流为 ( $I_{DPD}$ )。仅当器件未执行嵌入式运算 (如状态寄存器 1 所示) 时, 才接受 DPD 指令如状态寄存器 1 易失性写入标志位 (WIP) 位清零 ( $SR1V[0] = 0$ ) 所示。在 DPD 模式下, 器件将忽略除 DPD 释放 (RES ABh) 指令之外的所有指令, 该指令将在  $t_{RES}$  延时时间后使器件返回到接口待机状态。

表 11 有效的进入 DPD 模式和从 DPD 模式释放的时序

Current mode	CS#	SCK	Command	Next mode	Comments
Active	LOW to HIGH	N/A	N/A	Standby	
Standby	HIGH to LOW	Toggling	B9h Enter DPD	DPD	DPD entered after CS# goes HIGH and after the $t_{DPD}$ duration (see <a href="#">Table 15</a> )
DPD	HIGH to LOW	Not Toggling	N/A	DPD	If SCK is toggling and Command is not ABh, device remains in DPD
		Toggling	Command not ABh		
DPD	HIGH to LOW	Toggling	ABh Release from DPD	Standby	Release from DPD after CS# goes HIGH and after the $t_{RES}$ duration (see <a href="#">Table 15</a> ). After CS# goes HIGH to start the release from DPD, it is an invalid sequence to have a CS# transition when the SCK is not toggling.

时序规范

## 6 时序规范

### 6.1 波形切换

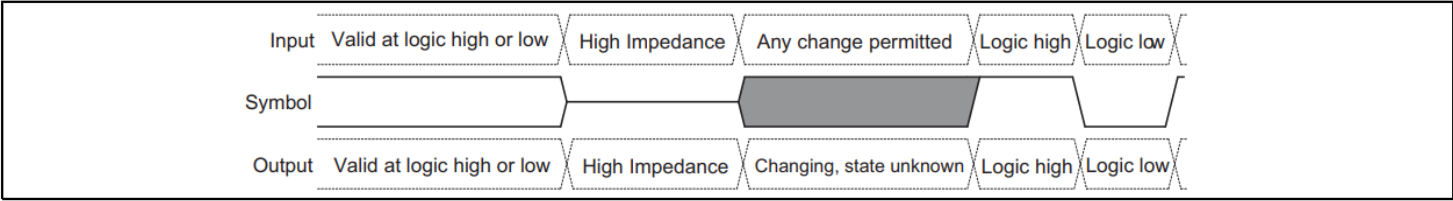


图20 波形元素含义

### 6.2 交流测试条件

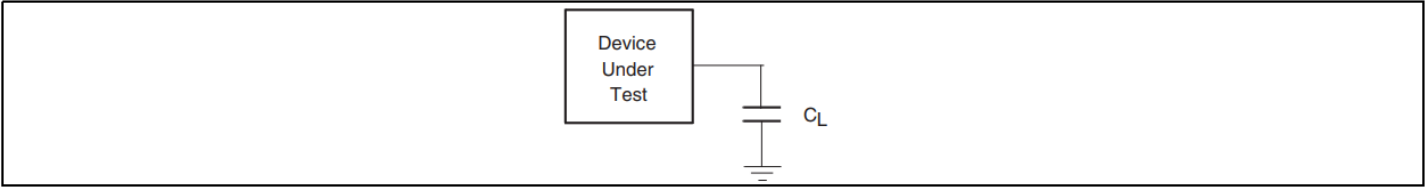


图 21 测试设置

表 12 AC测量条件

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
$C_L$	Load capacitance	–	30	pF
	Input pulse voltage	$0.2 \times V_{CC}$	$0.8 \times V_{CC}$	V
	Input slew rate	0.23	1.25	V/ns
	Input rise and fall times	0.9	5	ns
	Input timing ref voltage	$0.5 \times V_{CC}$		V
	Output timing ref voltage	$0.5 \times V_{CC}$		V

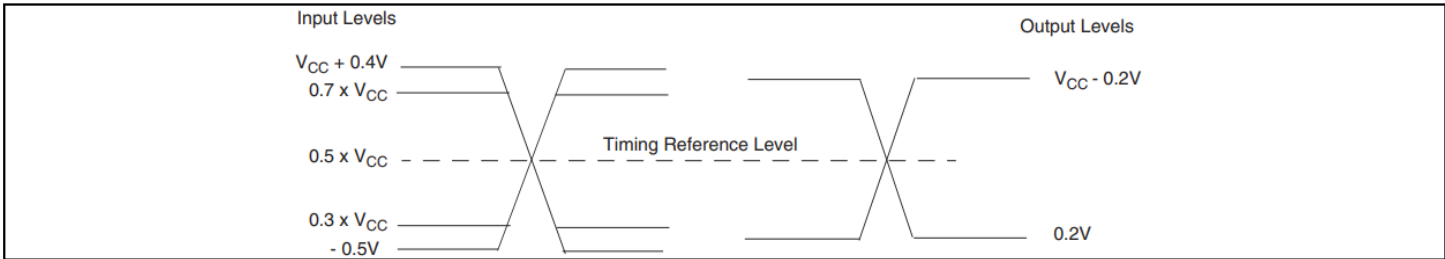


图 22 输入、输出和时序的参考标准

注：

15. 输入斜率是在  $V_{CC}$  最大时从输入脉冲最小值到最大值测量到的。例如：  $(1.9V \times 0.8) - (1.9V \times 0.2) = 1.14V$ ;  $1.14V / 1.25V/ns = 0.9ns$  上升或下降时间。
16. AC特性表假设时钟和数据信号具有相同的斜率（斜率）。

时序规范

### 6.2.1 电容特性

表 13 电容值

Parameter	Description	Test conditions	Min	Max	Unit
$C_{IN}$	Input capacitance (applies to SCK, CS#, IO3/RESET#)	1 MHz	–	8	pF
$C_{OUT}$	Output capacitance (applies to All I/O)	1 MHz	–	8	pF

### 6.3 RESET (复位)

#### 6.3.1 上电 (冷) 复位

器件执行POR流程，直到 $V_{CC}$ 上升到最小 $V_{CC}$ 阈值之后经过  $t_{PU}$ 的时间延时。请参考图 18，和第29页“FS-S 上电/电源下降电压和时序”。

上电 $t_{PU}$ 期间 (CS 随着  $V_{CC}$ 升到高电平)，不能选择该器件，即不能发送任何命令直到 $t_{PU}$ 结束。

当CS处于高电平状态的时间超过  $t_{CS}$ 时间或四线模式未启用时，IO3 / RESET# 信号用作 RESET# 输入。

POR 期间会忽略 RESET#。如果 RESET# 在 POR 期间为低电平，并在  $t_{PU}$ 结束后保持低电平，则 CS# 必须在 RESET# 返回高电平后保持高电平持续 $t_{RH}$ 时间。RESET # 在返回低电平之前，必须返回高电平并持续超过  $t_{RS}$ 才能启动硬件复位。

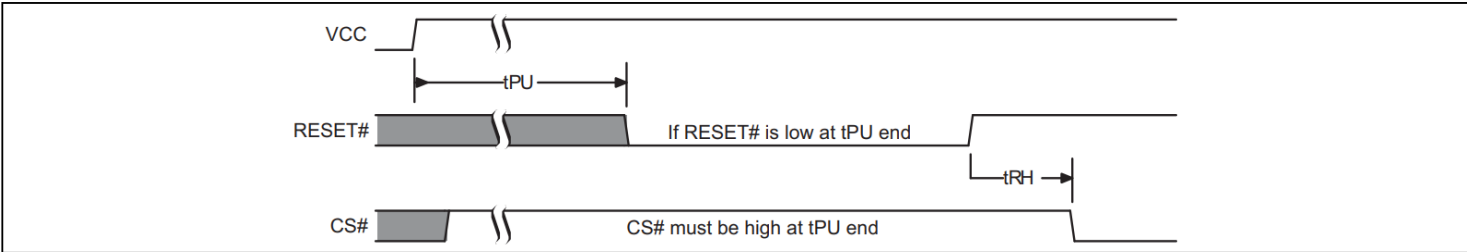


图 23 POR 结束时复位低电平

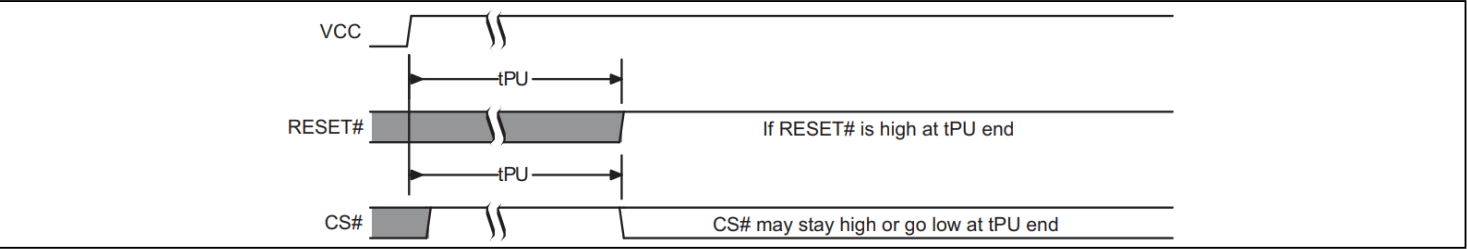


图 24 POR 结束时复位为高电平

注：

17. 参数值尚未经过 100% 测试。欲了解更多详细信息，请参阅 IBIS 模型。

## 时序规范

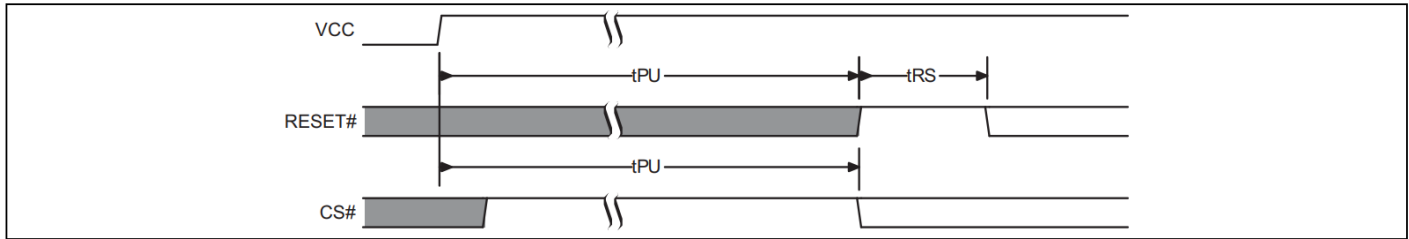


图 25 POR 后进行硬件复位

## 6.3.2 IO3 / RESET# 输入启动硬件（热）复位

当CS#处于高电平状态的时间超过  $t_{CS}$  时间或未启用四线模式的  $CR1V[1] = 0$  时，IO3 / RESET# 信号用作 RESET# 输入。IO3 / RESET# 输入有内部上拉至  $V_{CC}$ ，如果不使用四线模式，则可以悬空。CS变为高电平后延时  $t_{CS}$  时间后，为存储器或主控系统提供了在CS为低电平时，用作四线模式 I/O 信号之后将 IO3 驱动为高电平的时间。内部上拉至  $V_{CC}$  将保持 IO3 / RESET# 为高电平，直到主控系统开始驱动 IO3 / RESET#。当 CS 在  $t_{CS}$  器件保持高电平时，IO3 / RESET# 输入将被忽略，以避免意外的复位操作。如果将CS驱动为低电平以开始新的命令，则 IO3 / RESET# 将用作 IO3。

器件未处于四线模式，CS 为高电平时，IO3 / RESET# 从  $V_{IH}$  转换为  $V_{IL}$  并持续  $> t_{RP}$ ，随后是  $t_{CS}$ ，器件将以与POR相同的方式复位寄存器状态，但不会经历POR期间执行的完整复位过程。硬件复位过程需要  $t_{RPH}$  的时间才能完成。如果POR在上电过程 ( $t_{PU}$ ) 因某种原因未正确完成，则 RESET# 变为低电平将启动完整POR过程，而不是硬件复位过程，并且需要  $t_{PU}$  时间来完成POR过程。

复位指令与 IO3 / RESET# 的状态无关。如果 IO3 / RESET# 为高电平或未连接，并且发出复位指令，器件将执行软件复位。

## 附加 IO3 RESET# 注意事项：

- IO3 / RESET# 再次变为低电平以启动硬件复位之前，必须在  $t_{PU}$  或  $t_{RPH}$  之后的  $t_{RS}$  时间内保持高电平。
- 在  $t_{CS}$  后，IO3 / RESET# 被驱动为低电平至少一段最短时间 ( $t_{RP}$ )，器件终止任何正在进行的操作，使所有输出处于高阻状态，并在  $t_{RPH}$  持续时间内忽略所有读/写指令。器件将接口复位为待机状态。
- 如果Quad Mode 和IO3 / RESET# 特性启用的，主控系统不应在  $t_{CS}$  期间驱动IO3 为低电平，以避免IO3 上的驱动器争用。紧接着在四线模式下将发送数据传输到主控的命令，例如，四线I/O 读取时，存储器在  $t_{CS}$  期间将 IO3/复位驱动为高电平，以避免意外的复位操作。紧接着以四线模式将数据传输到存储器的命令，例如页编程命令，主控系统应在  $t_{CS}$  期间将 IO3 / RESET# 驱动为高电平，以避免意外的复位操作。
- 如果四线模式未启用，并且在 IO3 / RESET# 被置为低电平时 CS 为低电平，则 CS 在  $t_{RH}$  之后再次被用作低电平之前，必须在  $t_{RPH}$  期间返回高电平。

## 注：

18. 上电 ( $t_{PU}$ ) 期间，IO3 / RESET# 低电平被忽略。如果在  $t_{PU}$  结束时 Reset# 被使用，器件将保持复位状态， $t_{RH}$  将决定 CS# 何时可能变为低电平。
19. 如果四线模式启用，则在  $t_{CS}$  期间忽略 IO3/RESET# 低电平。
20.  $t_{RP} + t_{RH}$  的总和不能小于  $t_{RPHO}$

时序规范

表 14 硬件复位参数

Parameter	Description	Limit	Time	Unit
$t_{RS}$	Reset Setup - Prior Reset end and RESET# HIGH before RESET# LOW	Min	50	ns
$t_{RPH}$	Reset Pulse Hold - RESET# LOW to CS# LOW	Min	35	$\mu$ s
$t_{RP}$	RESET# Pulse Width	Min	200	ns
$t_{RH}$	Reset Hold - RESET# HIGH before CS# LOW	Min	50	ns

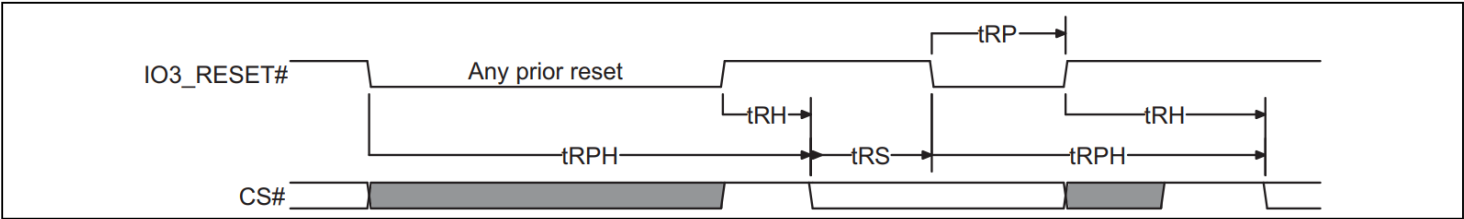


图 26 四线模式未启用且 IO3/Reset# 启用时的硬件复位

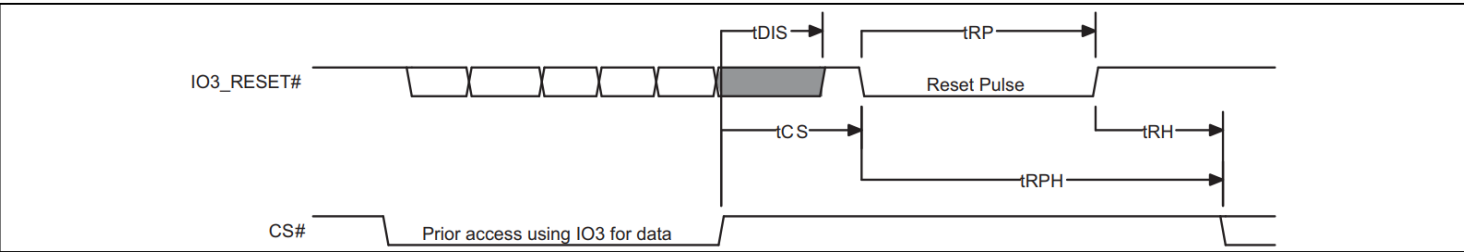


图 27 四线模式和 IO3 / Reset# 启用时的硬件复位

## 时序规范

### 6.4 SDR AC 特性

表 15 AC 特性

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
$F_{SCK, R}$	SCK clock frequency for READ and 4READ instructions	DC	–	50	MHz
$F_{SCK, C}$	SCK clock frequency for FAST_READ, 4FAST_READ, and the following Dual and Quad commands: QOR, 4QOR, DIOR, 4DIOR, QIOR, 4QIOR	DC	–	133	MHz
$F_{SCK, D}$	SCK clock frequency for the following DDR commands: QIOR, 4QIOR	DC	–	80	MHz
$P_{SCK}$	SCK clock period	$1/F_{SCK}$	–	$\infty$	
$t_{WH}, t_{CH}$	Clock high time	$50\% P_{SCK} - 5\%$	–	$50\% P_{SCK} + 5\%$	ns
$t_{WL}, t_{CL}$	Clock low time	$50\% P_{SCK} - 5\%$	–	$50\% P_{SCK} + 5\%$	ns
$t_{CRT}, t_{CLCH}$	Clock rise time (slew rate)	0.1	–	–	V/ns
$t_{CFT}, t_{CHCL}$	Clock fall time (slew rate)	0.1	–	–	V/ns
$t_{CS}$	CS# HIGH time (read instructions) CS# HIGH time (read instructions when reset feature and Quad Mode are both enabled) CS# HIGH time (program/erase instructions)	10 20 <sup>[25]</sup> 50	–	–	ns
$t_{CSS}$	CS# active setup time (relative to SCK)	2	–	–	ns
$t_{CSH}$	CS# active hold time (relative to SCK)	3	–	–	ns
$t_{SU}$	Data in setup time	2	–	–	ns
$t_{HD}$	Data in hold time	3	–	–	ns
$t_V$	Clock low to output valid	–	–	8 <sup>[22]</sup> 6 <sup>[23]</sup>	ns
$t_{HO}$	Output hold time	1	–	–	ns
$t_{DIS}$	Output disable time <sup>[24]</sup> Output disable time (when reset feature and Quad Mode are both enabled)	–	–	8 20 <sup>[25]</sup>	ns
$t_{WPS}$	WP# setup time <sup>[21]</sup>	20	–	–	ns
$t_{WPH}$	WP# hold time <sup>[21]</sup>	100	–	–	ns
$t_{DPD}$	CS# HIGH to Power-down Mode	–	–	3	μs
$t_{RES}$	CS# HIGH to Standby Mode without Electronic Signal Read	–	–	30	μs

#### 注:

21. 仅适用于当 SRWD 置位为‘1’时对 WRR 或 WRAR 指令的约束。
22. 完整  $V_{CC}$  范围和  $CL = 30$  pF。
23. 完整  $V_{CC}$  范围和  $CL = 15$  pF。
24. 数据不再被驱动时输出高阻抗。
25. 当复位特性和四线模式启用时 ( $CR2V[5] = 1$  且  $CR1V[1] = 1$ )， $t_{CS}$  和  $t_{DIS}$  需要额外的时间。

## 时序规范

### 6.4.1 时钟时序

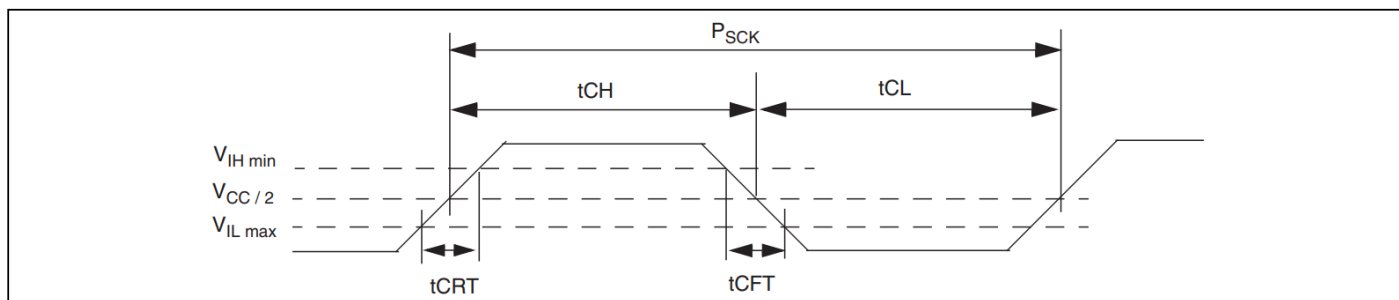


图28 时钟时序

### 6.4.2 输入/输出时序

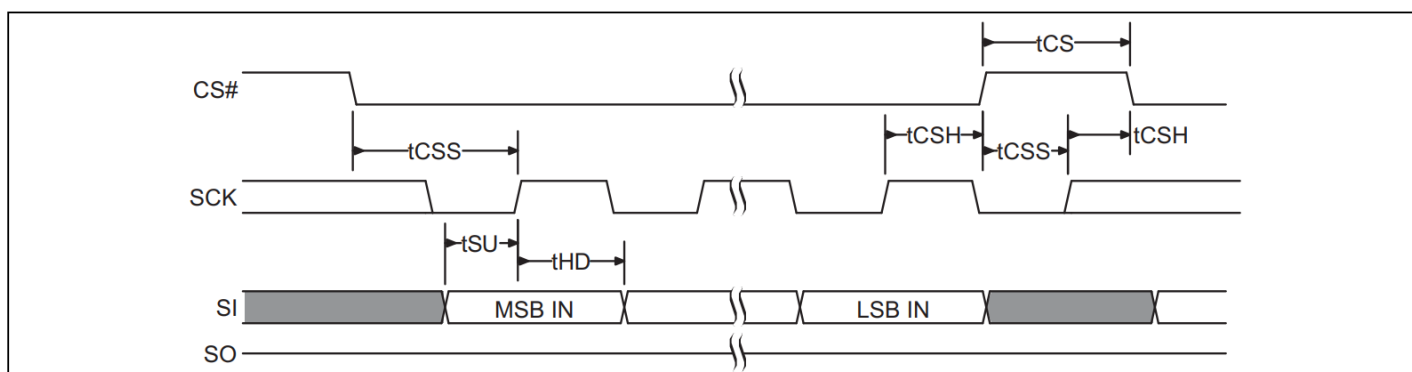


图 29 SPI单线输入时序

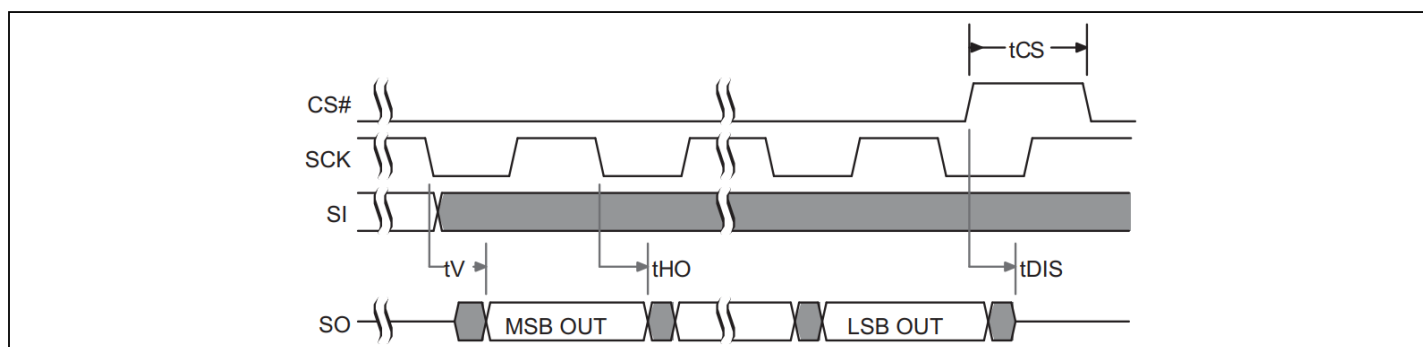


图 30 SPI单线输出时序

时序规范

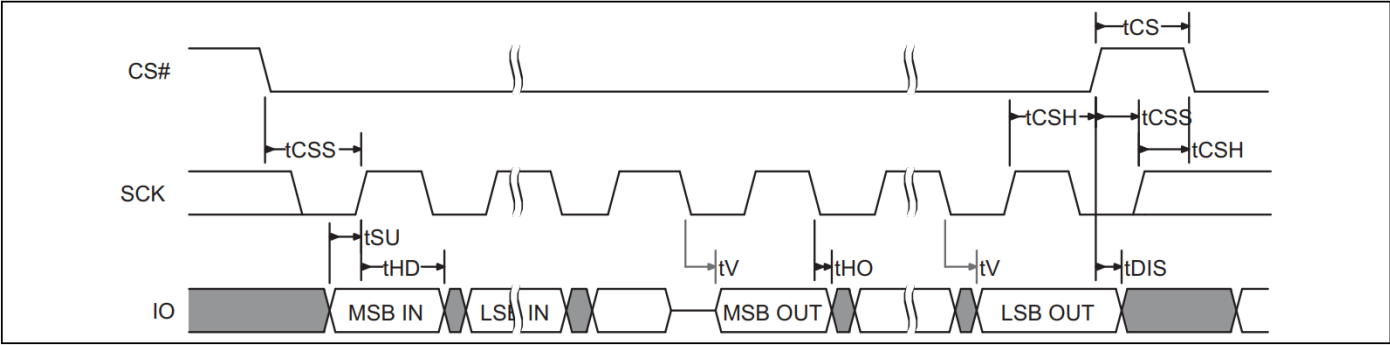


图 31 SPI SDR MIO 时序

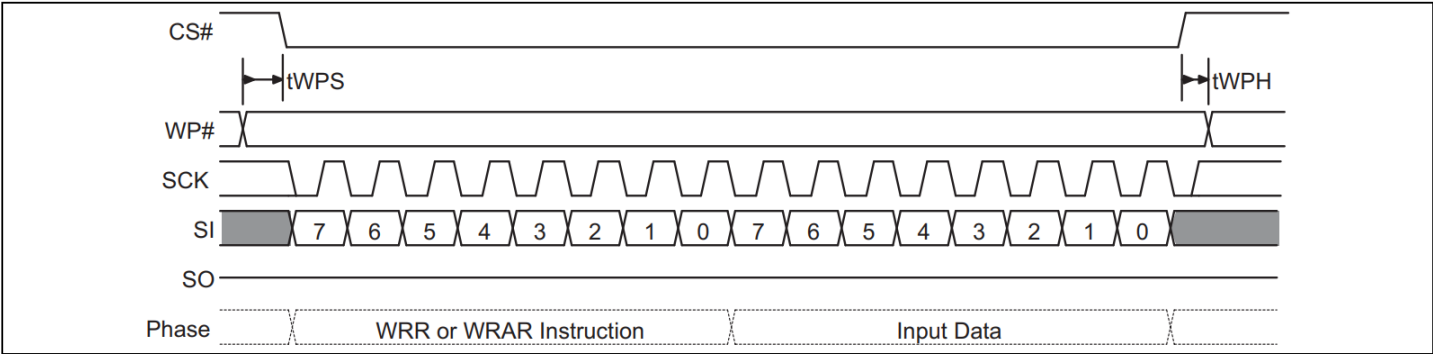


图32 WP#输入时序

## 时序规范

### 6.5 DDR AC 特性

表 16 AC 特性

Symbol	Parameter	Min	Typ	Max	Unit
$F_{SCK, R}$	SCK clock frequency for DDR READ instruction	DC	–	80	MHz
$P_{SCK, R}$	SCK clock period for DDR READ instruction	$1/F_{SCK}$	–	$\infty$	ns
$t_{WH}, t_{CH}$	Clock high time	$45\% P_{SCK}$	–	–	ns
$t_{WL}, t_{CL}$	Clock low time	$45\% P_{SCK}$	–	–	ns
$t_{CS}$	CS# HIGH time (read instructions) CS# HIGH time (read instructions when Reset feature is enabled)	10 20	–	–	ns
$t_{CSS}$	CS# active setup time (relative to SCK)	2	–	–	ns
$t_{CSH}$	CS# active hold time (relative to SCK)	3	–	–	ns
$t_{SU}$	IO in setup time	1.5	–	–	ns
$t_{HD}$	IO in hold time	1.5	–	–	ns
$t_V$	Clock low to output valid	1.5	–	$6^{[26]}$	ns
$t_{HO}$	Output hold time	1.5	–	–	ns
$t_{DIS}$	Output disable time Output disable time (when Reset feature is enabled)	–	–	8 20	ns
$t_{O\_SKEW}$	First Output to last Output data valid time	–	–	600	ps
$t_{DPD}$	CS# HIGH to Power-Down Mode	–	–	3	$\mu$ s
$t_{RES}$	CS# HIGH to Standby Mode without Electronic Signal Read	–	–	30	$\mu$ s

#### 6.5.1 DDR 输入时序

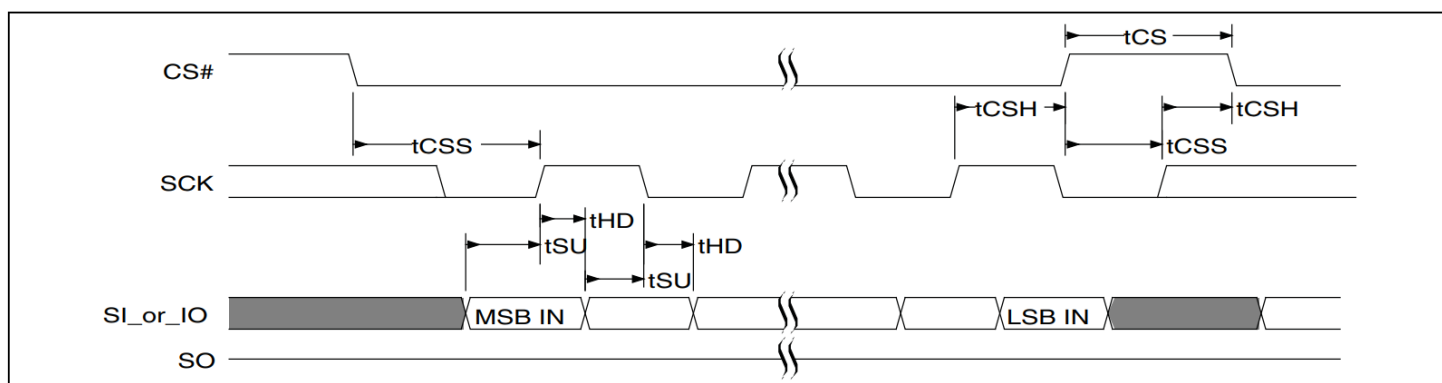


图33 SPI DDR输入时序

注：  
26.CL = 15 pF.

## 时序规范

## 6.5.2 DDR 输出时序

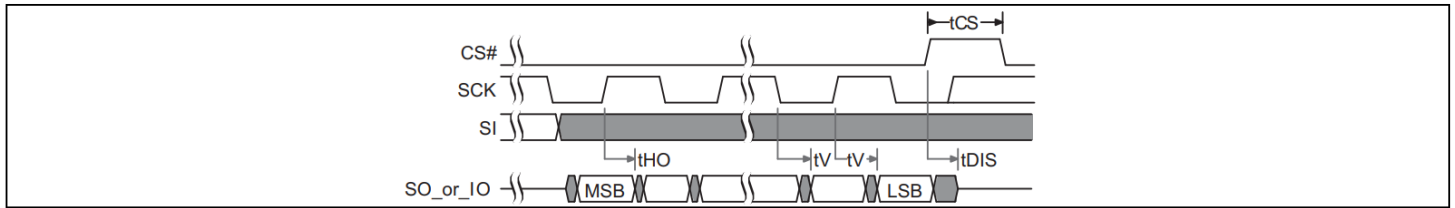


图34 SPI DDR输出时序

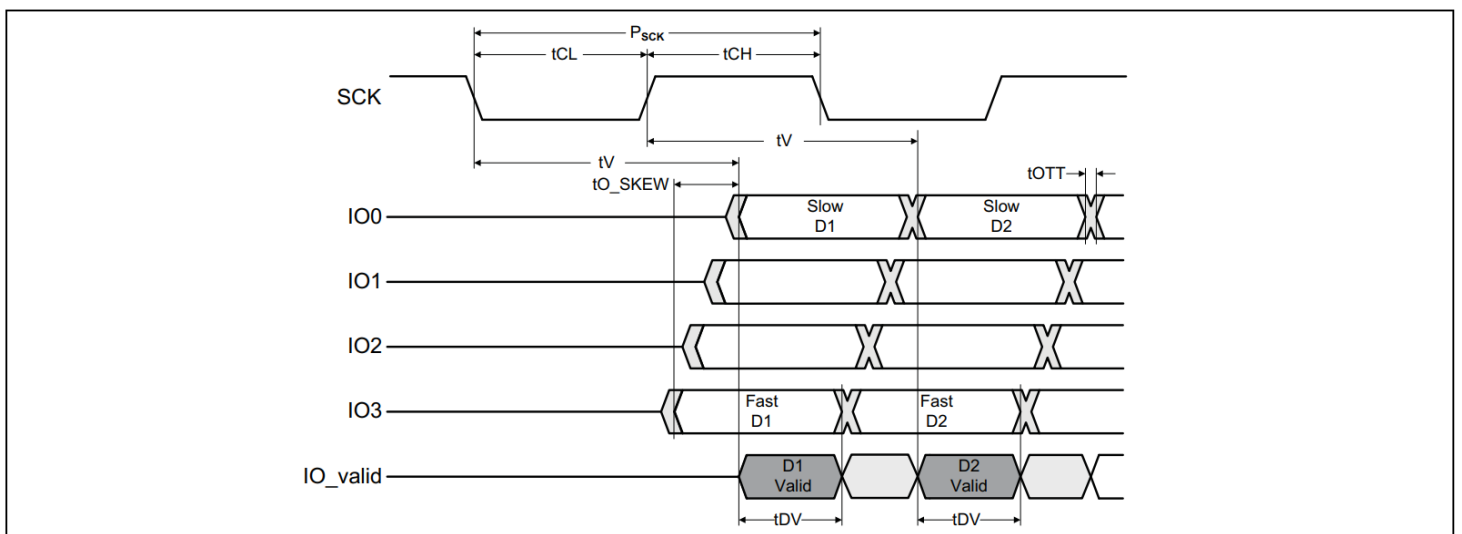


图 35 SPI DDR数据有效观察窗口

## 注：

27.  $t_{CLH}$  是  $t_{CL}$  或  $t_{CH}$  中较短的持续时间。
28.  $t_{O\_SKEW}$  是所有 IO 信号的最小和最大  $t_V$  (输出有效) 之间的最大差异 (增量)。
29.  $t_{OTT}$  是每个 IO 上从一个有效数据值到下一个有效数据值的最大输出转换时间。
30.  $t_{OTT}$  取决于系统级别考虑因素, 包括:
  - a. 存储器器件输出阻抗 (驱动强度)
  - b. 系统级 IO 上的寄生效应 (主要是总线电容)
  - c. 主控存储控制器输入  $V_{IH}$  和  $V_{IL}$  电平, 在 0 到 1 和 1 到 0 的转换中的识别
  - d. 举例来说, 假设上述考虑导致存储器输出斜率为 2 V/ns, 并且主控需要 1.8 V 的转换 (从 1 到 0 或从 0 到 1), 则  $t_{OTT}$  为:
    - i.  $t_{OTT} = 1.8 \text{ V} / (2 \text{ V/ns}) = 0.9 \text{ ns}$
  - e.  $t_{OTT}$  不是经过英飞凌测试的规格, 它依赖于系统, 必须由系统设计人员根据上述考虑来推导。
31. 最小数据有效窗口 ( $t_{DV}$ ) 可按下式计算:
  - a. 举例来说, 假设:
    - i. 80 MHz 时钟频率 = 12.5 ns 时钟周期
    - ii. DDR 操作的占空比规定为 45% 或更高
    - iii.  $t_{CLH} = 0.45 \times PSCK = 0.45 \times 12.5 \text{ ns} = 5.625 \text{ ns}$
    - iv.  $t_{O\_SKEW} = 400 \text{ ps}$
    - v.  $t_{OTT} = 0.9 \text{ ns}$
  - b.  $t_{DV} = t_{CLH} - t_{O\_SKEW} - t_{OTT}$
  - c.  $t_{DV} = 5.625 \text{ ns} - 400 \text{ ps} - 0.9 \text{ ns} = 4.125 \text{ ns}$

物理接口

7 物理接口

7.1 SOIC 16 引脚封装

7.1.1 SOIC 16 连接图

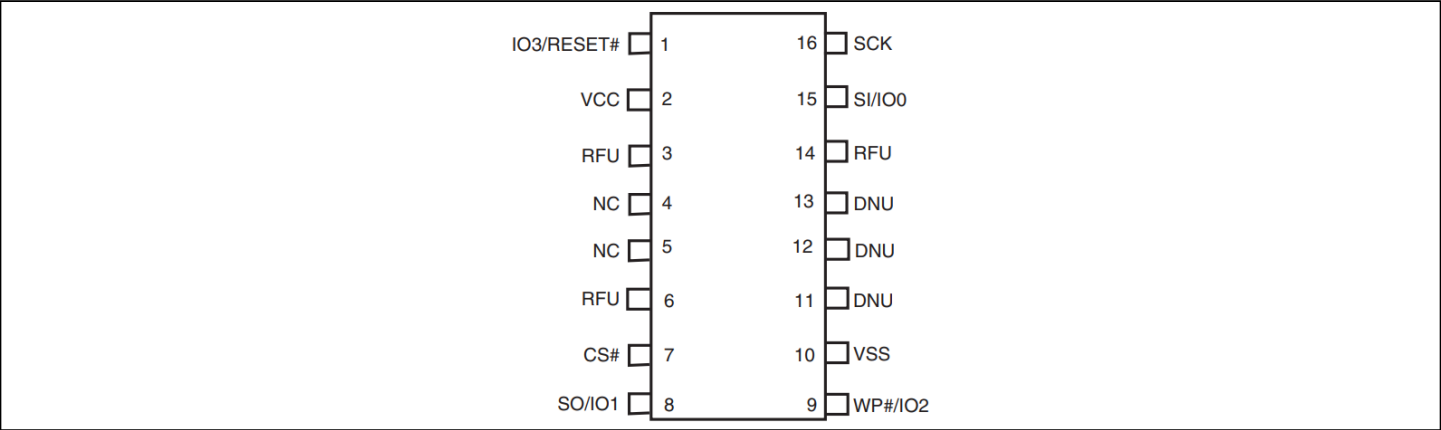


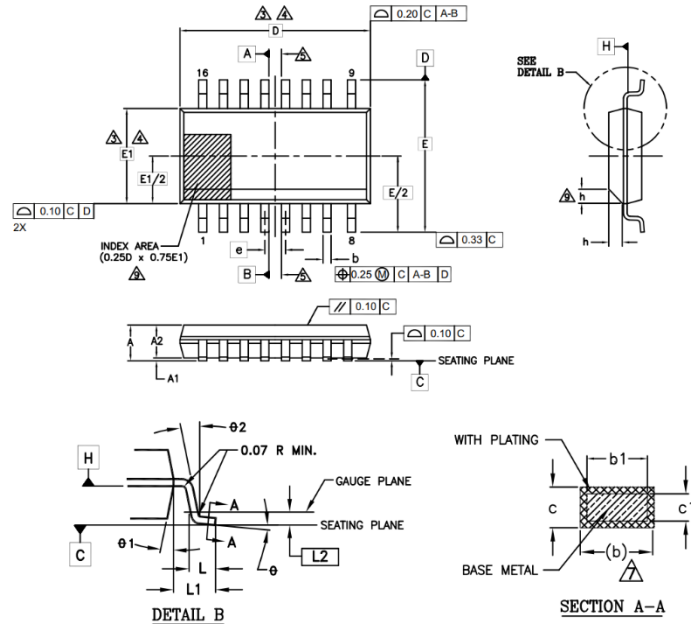
图 36 16 引脚 SOIC 封装 (S03016) , 顶部视图<sup>[32]</sup>

注:

32. RESET# 输入具有内部上拉电阻, 如果未使用四线模式和硬件复位, 则可以在系统中保持未连接状态。

物理接口

## 7.1.2 SOIC 16实物图



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	2.35	-	2.65
A1	0.10	-	0.30
A2	2.05	-	2.55
b	0.31	-	0.51
b1	0.27	-	0.48
c	0.20	-	0.33
c1	0.20	-	0.30
D	10.30 BSC		
E	10.30 BSC		
E1	7.50 BSC		
e	1.27 BSC		
L	0.40	-	1.27
L1	1.40 REF		
L2	0.25 BSC		
N	16		
h	0.25	-	0.75
θ	0°	-	8°
θ1	5°	-	15°
θ2	0°	-	-

NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
- DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M - 1994.
- DIMENSION D DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15 mm PER END. DIMENSION E1 DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25 mm PER SIDE. D AND E1 DIMENSIONS ARE DETERMINED AT DATUM H.
- THE PACKAGE TOP MAY BE SMALLER THAN THE PACKAGE BOTTOM. DIMENSIONS D AND E1 ARE DETERMINED AT THE OUTMOST EXTREMES OF THE PLASTIC BODY EXCLUSIVE OF MOLD FLASH, TIE BAR BURRS, GATE BURRS AND INTERLEAD FLASH, BUT INCLUSIVE OF ANY MISMATCH BETWEEN THE TOP AND BOTTOM OF THE PLASTIC BODY.
- DATUMS A AND B TO BE DETERMINED AT DATUM H.
- "N" IS THE MAXIMUM NUMBER OF TERMINAL POSITIONS FOR THE SPECIFIED PACKAGE LENGTH.
- THE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10 TO 0.25 mm FROM THE LEAD TIP.
- DIMENSION "b" DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.10 mm TOTAL IN EXCESS OF THE "b" DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION. THE DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OF THE LEAD FOOT.
- THIS CHAMFER FEATURE IS OPTIONAL. IF IT IS NOT PRESENT, THEN A PIN 1 IDENTIFIER MUST BE LOCATED WITHIN THE INDEX AREA INDICATED.
- LEAD COPLANARITY SHALL BE WITHIN 0.10 mm AS MEASURED FROM THE SEATING PLANE.

002-15547 \*A

图 37 16 引脚 SOIC 10.30×7.50×2.65 mm SO3016/SL3016/SS3016, 封装外形 (PG-DSO-16)

物理接口

## 7.2 8-connector packages

### 7.2.1 8-connector diagrams

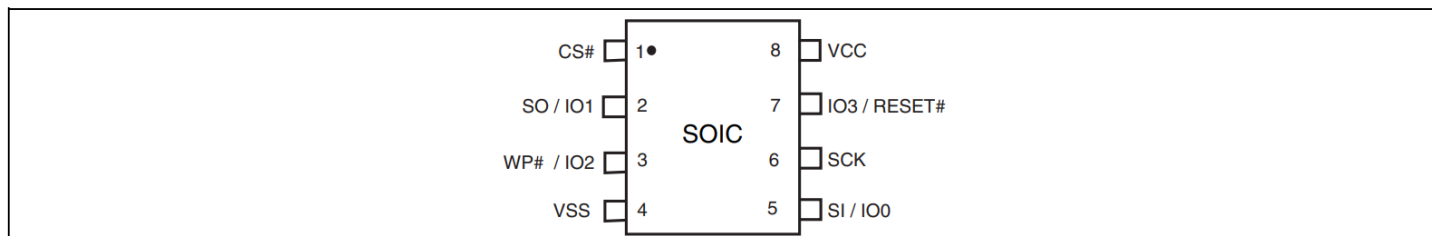


图 38 8 引脚塑料小型封装 (SOIC8)

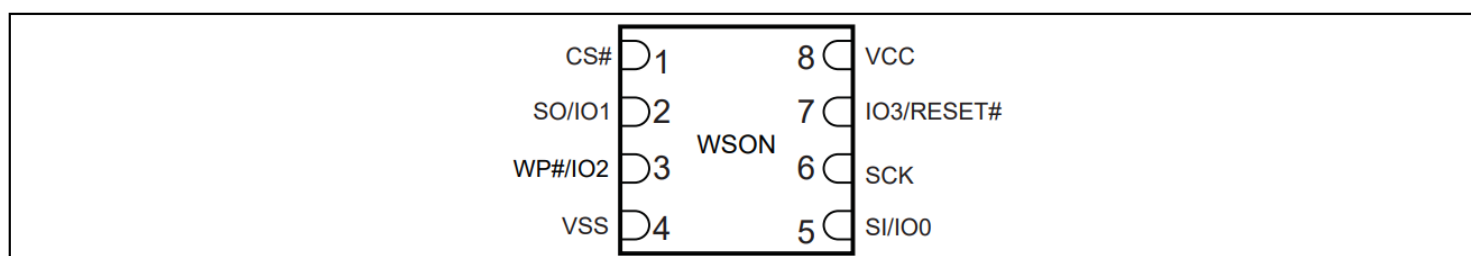


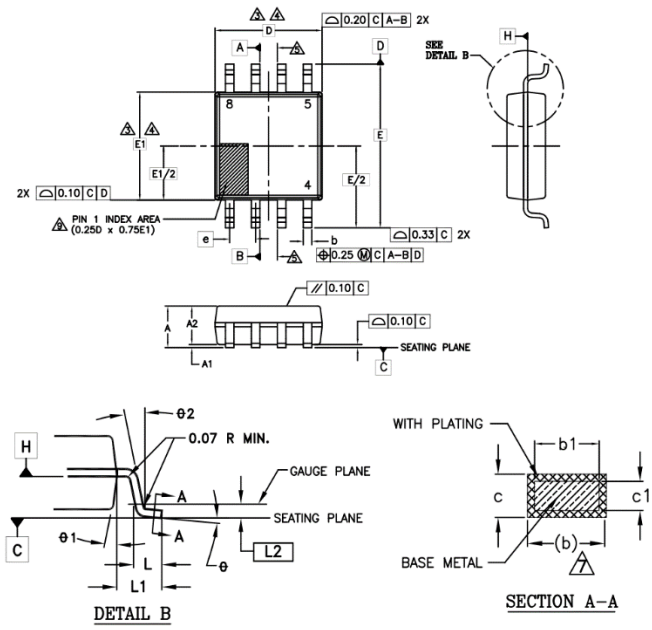
图 39 8-connector封装 (WSON 6 x 5)，顶视图<sup>[33]</sup>

注：

33. RESET# 输入具有内部上拉电阻，如果未使用四线模式和硬件复位，则可以在系统中保持未连接状态。

物理接口

# 7.2.2 8-connector 物理图



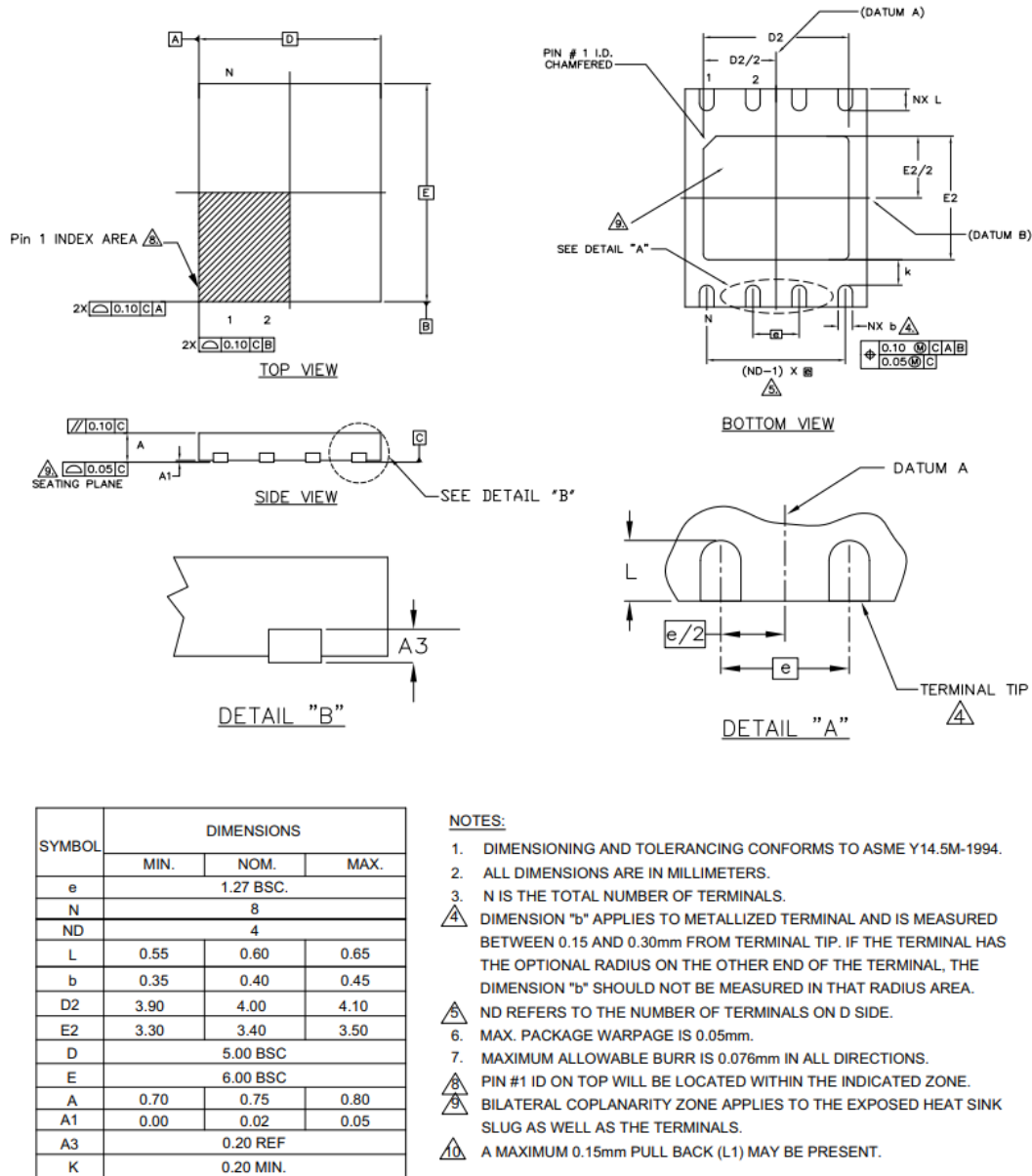
SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	1.75	-	2.16
A1	0.05	-	0.25
A2	1.70	-	1.90
b	0.36	-	0.48
b1	0.33	-	0.46
c	0.19	-	0.24
c1	0.15	-	0.20
D	5.28 BSC		
E	8.00 BSC		
E1	5.28 BSC		
e	1.27 BSC		
L	0.51	-	0.76
L1	1.36 REF		
L2	0.25 BSC		
N	8		
θ	0°	-	8°
θ 1	5°	-	15°
θ 2	0-8° REF		

- NOTES:
- ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
  - DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M - 1994.
  - DIMENSION D DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.15 mm PER END. DIMENSION E1 DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION. INTERLEAD FLASH OR PROTRUSION SHALL NOT EXCEED 0.25 mm PER SIDE. D AND E1 DIMENSIONS ARE DETERMINED AT DATUM H.
  - THE PACKAGE TOP MAY BE SMALLER THAN THE PACKAGE BOTTOM. DIMENSIONS D AND E1 ARE DETERMINED AT THE OUTMOST EXTREMES OF THE PLASTIC BODY EXCLUSIVE OF MOLD FLASH, TIE BAR BURRS, GATE BURRS AND INTERLEAD FLASH, BUT INCLUSIVE OF ANY MISMATCH BETWEEN THE TOP AND BOTTOM OF THE PLASTIC BODY.
  - DATUMS A AND B TO BE DETERMINED AT DATUM H.
  - "N" IS THE MAXIMUM NUMBER OF TERMINAL POSITIONS FOR THE SPECIFIED PACKAGE LENGTH.
  - THE DIMENSIONS APPLY TO THE FLAT SECTION OF THE LEAD BETWEEN 0.10 TO 0.25 mm FROM THE LEAD TIP.
  - DIMENSION "b" DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.10 mm TOTAL IN EXCESS OF THE "b" DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION. THE DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER RADIUS OF THE LEAD FOOT.
  - THIS CHAMFER FEATURE IS OPTIONAL. IF IT IS NOT PRESENT, THEN A PIN 1 IDENTIFIER MUST BE LOCATED WITHIN THE INDEX AREA INDICATED.
  - LEAD COPLANARITY SHALL BE WITHIN 0.10 mm AS MEASURED FROM THE SEATING PLANE.

002-15548 \*\*

图 40 8 引脚 SOIC 5.28x5.28x2.16 mm SOC008, 封装外形 (PG-DSO-8)

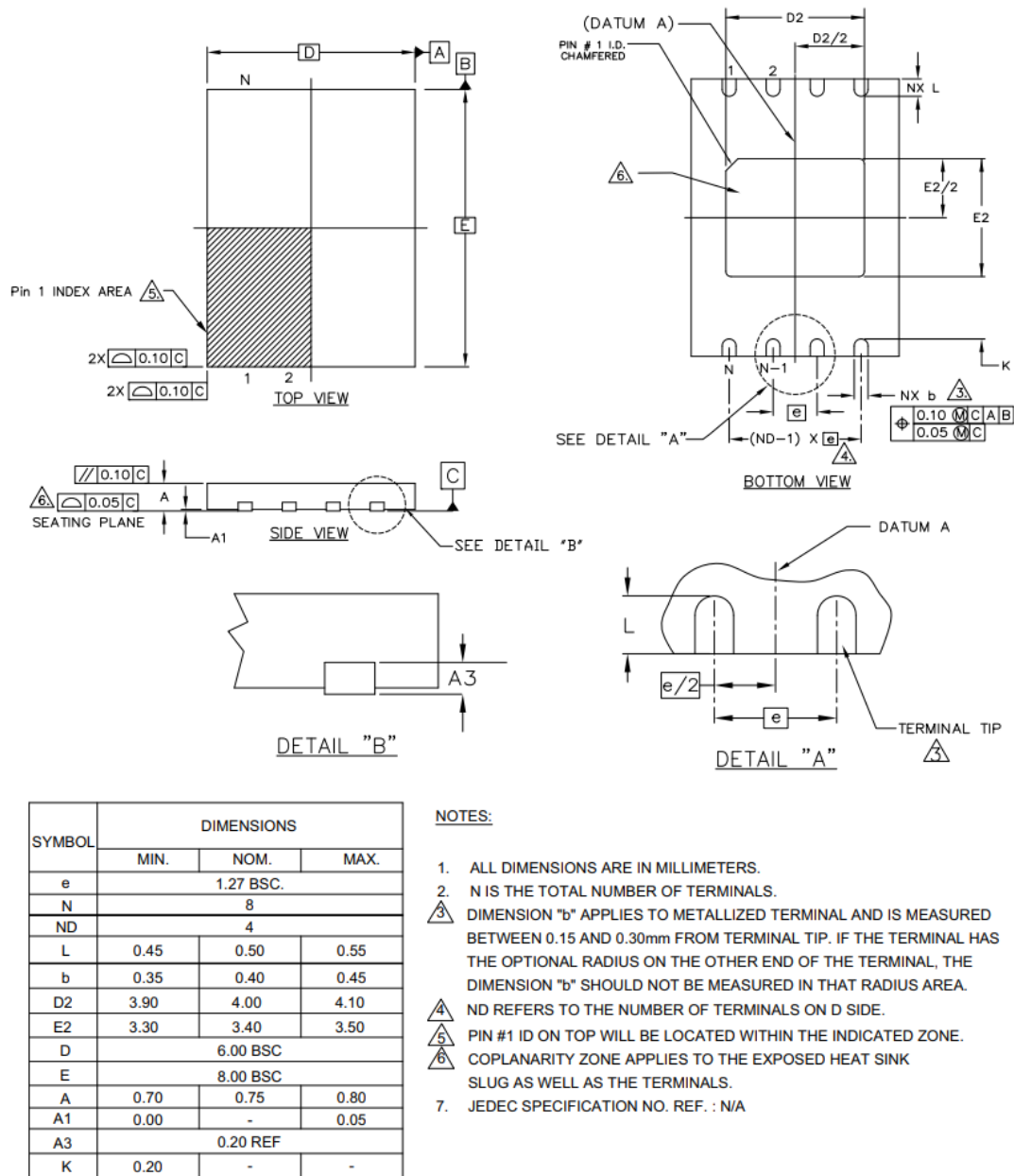
物理接口



002-18755 \*\*

图 41 8 引脚 DFN 5.0x6.0x0.8 mm WND008 4.0x3.4mm EPAD (SAWN)、封装外形 (PG-WSO-8)

## 物理接口



002-15552 \*A

图 42 8 引脚 DFN 6.0x8.0x0.8 mm WNH008 4.0x3.4mm EPAD (SAWN)、封装外形 (PG-WSO-8)

物理接口

### 7.3 FAB024 24-ball BGA 封装

#### 7.3.1 连接图

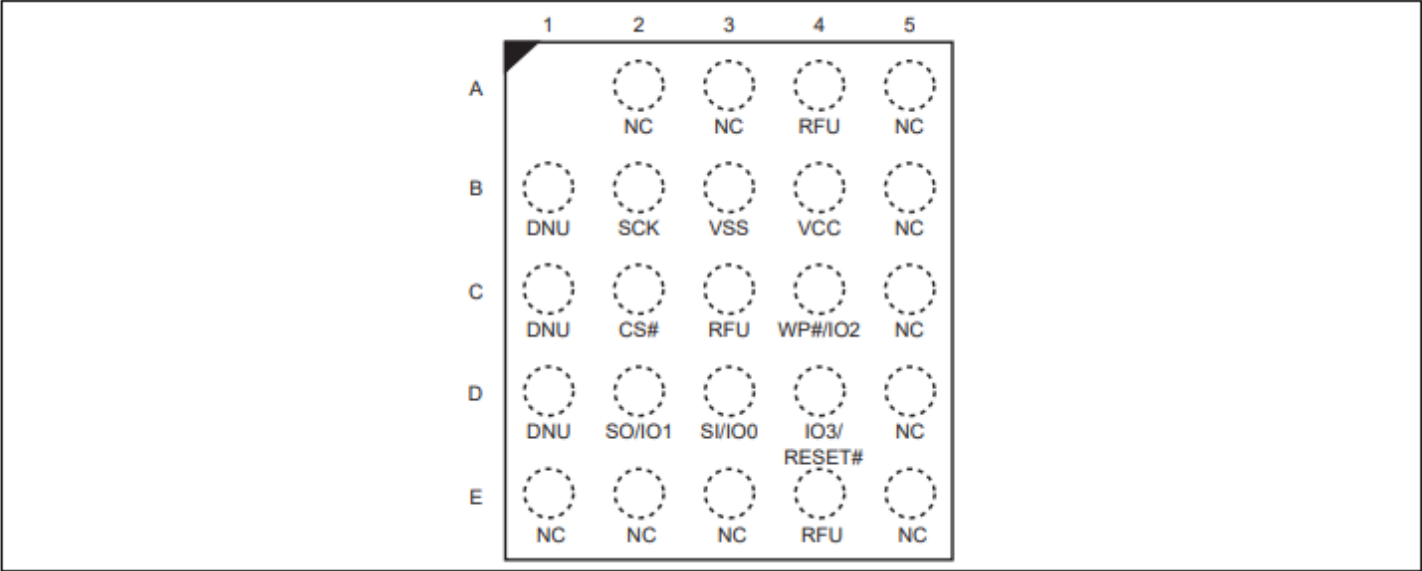


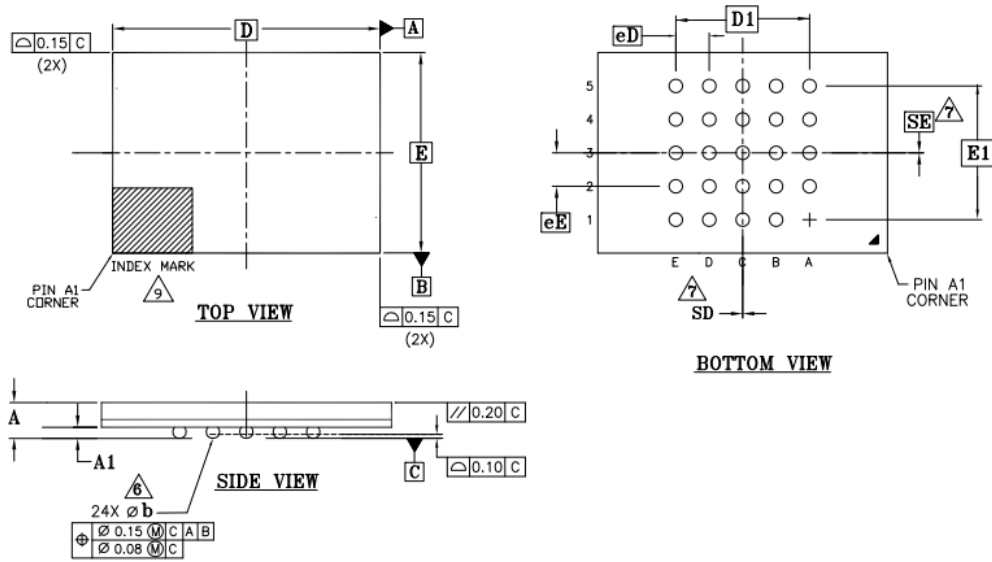
图 43 24-ball BGA, 5 x 5 球封装 (FAB024), 顶部视图<sup>[34, 35]</sup>

**注:**

- 34. 信号连接与 FAC024 BGA 处于相同的相对位置, 从而允许单个 PCB 封装使用任一封装。
- 35. RESET# 输入具有内部上拉电阻, 如果未使用四线模式和硬件复位, 则可以在系统中保持未连接状态。

物理接口

7.3.2 物理图



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	1.20
A1	0.20	-	-
D	8.00 BSC		
E	6.00 BSC		
D1	4.00 BSC		
E1	4.00 BSC		
MD	5		
ME	5		
N	24		
Ø b	0.35	0.40	0.45
eE	1.00 BSC		
eD	1.00 BSC		
SD	0.00 BSC		
SE	0.00 BSC		

- NOTES:
- DIMENSIONING AND TOLERANCING METHODS PER ASME Y14.5M-1994.
  - ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
  - BALL POSITION DESIGNATION PER JEP95, SECTION 3, SPP-020.
  - e** REPRESENTS THE SOLDER BALL GRID PITCH.
  - SYMBOL "MD" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "D" DIRECTION.  
SYMBOL "ME" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "E" DIRECTION.  
N IS THE NUMBER OF POPULATED SOLDER BALL POSITIONS FOR MATRIX SIZE MD X ME.
  - DIMENSION "b" IS MEASURED AT THE MAXIMUM BALL DIAMETER IN A PLANE PARALLEL TO DATUM C.
  - "SD" AND "SE" ARE MEASURED WITH RESPECT TO DATUMS A AND B AND DEFINE THE POSITION OF THE CENTER SOLDER BALL IN THE OUTER ROW.  
WHEN THERE IS AN ODD NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW, "SD" OR "SE" = 0.  
WHEN THERE IS AN EVEN NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW, "SD" = eD/2 AND "SE" = eE/2.
  - "+" INDICATES THE THEORETICAL CENTER OF DEPOPULATED BALLS.
  - A1 CORNER TO BE IDENTIFIED BY CHAMFER, LASER OR INK MARK, METALLIZED MARK INDENTATION OR OTHER MEANS.

002-15534 \*\*

图 44 24 球 FBGA 8.0x6.0x1.2 mm FAB024, 封装外形 (PG-TFBGA-24)

物理接口

## 7.4 FAC024 24 - ball BGA 封装

### 7.4.1 连接图

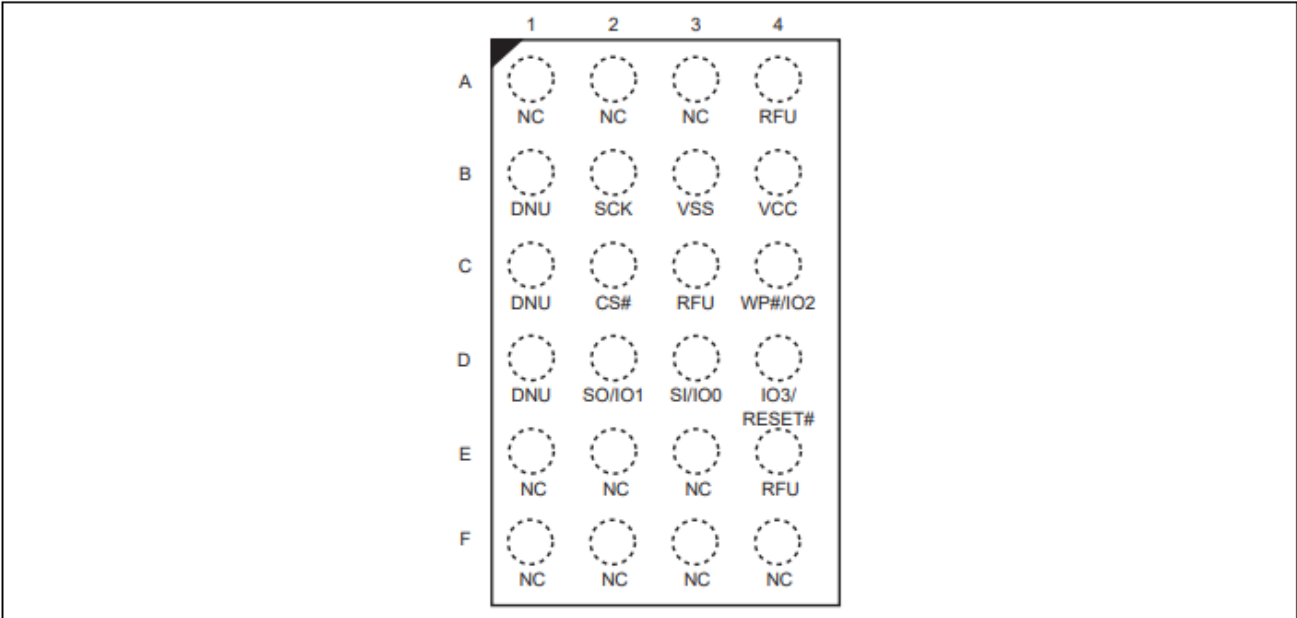


图 45 24-ball BGA、4 x 6 球封装（FAC024），顶部视图<sup>[36, 37]</sup>

**注：**

- 36. 信号连接与 FAB024 BGA 处于相同的相对位置，允许单个 PCB 封装使用任一封装。
- 37. RESET# 输入具有内部上拉电阻，如果未使用四线模式和硬件复位，则可以在系统中保持未连接状态。

## 物理接口

### 7.4.2 物理图

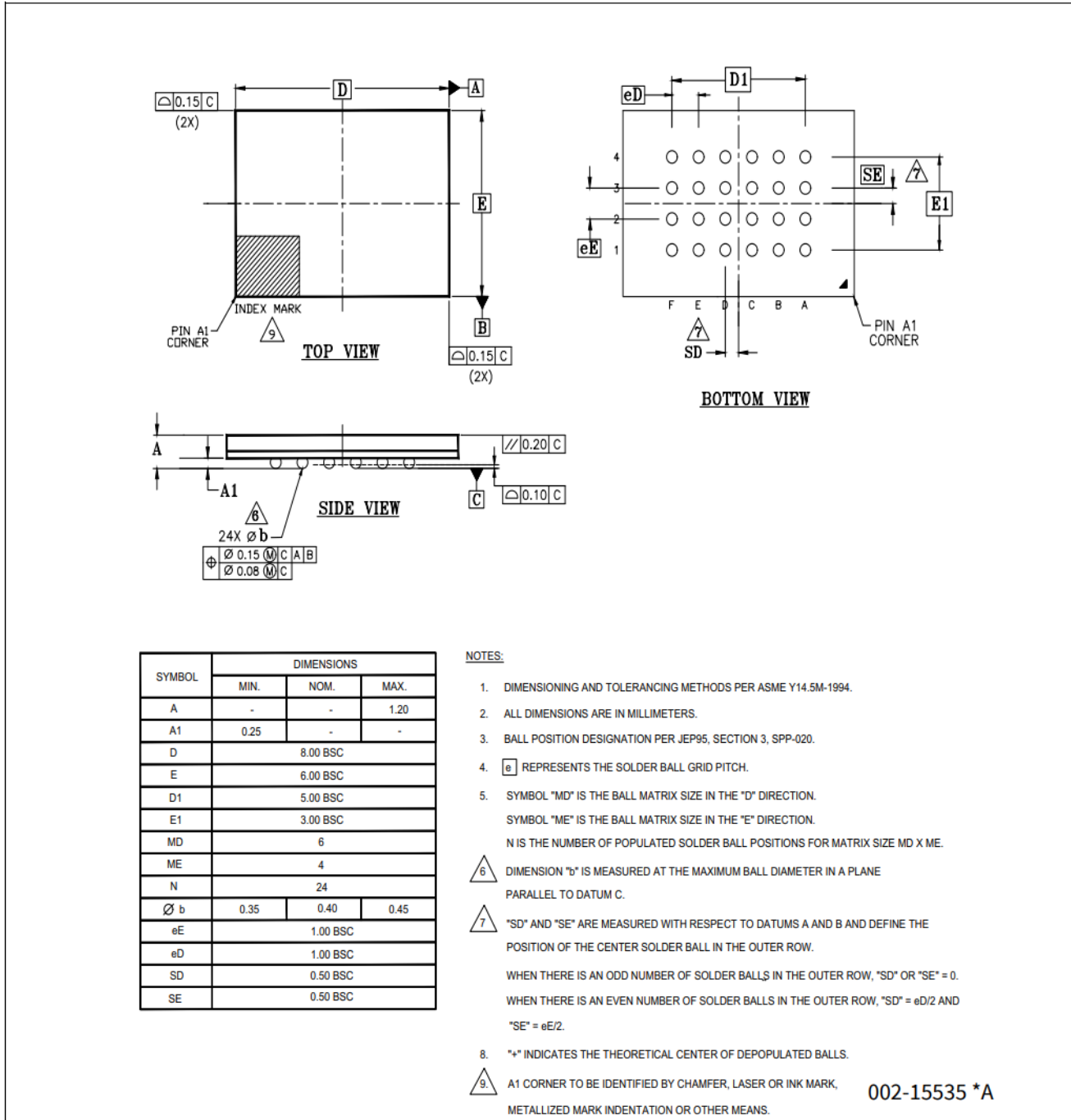


图46 24 球 FBGA 8.0x6.0x1.2 mm FAC024, 封装外形 (PG-TFBGA-24)

### 7.4.3 关于FBGA封装的特殊处置说明

如果使用超声波清洁方法，FBGA封装的闪存器件可能被损坏。如果封装体长时间暴露在 150°C 以上的温度下，封装和/或数据完整性可能会受到损害。

## 8 地址空间映射

### 8.1 概述

#### 8.1.1 扩展地址

S25FS-S 系列支持 32 位（4 字节）地址，从而能够支持比上一代（传统）SPI 设备（仅支持 24 位（3 字节）地址）更高容量的设备。24 位字节分辨率地址最大只能访问 16 MB (128 Mbits) 的最大容量。32 位字节分辨率地址允许直接寻址最多 4 Gbytes（32 Gbits）的地址空间。

为了实现向后软件兼容性，传统指令继续支持 24 位地址。扩展 32 位地址有两种实现方式：

- 扩展地址模式 — 通过主控系统对易失性配置寄存器位操作，可将所有旧指令更改为 32 位地址。
- 4 字节地址指令 — 执行旧功能和新功能，始终需要 32 位地址。

上电或复位后，扩展地址模式的默认条件由非易失性配置位控制。默认扩展地址模式可能被配置为 24 位或 32 位地址。这使得传统软件能够兼容器件的前 128 Mbit 的存取，或者使器件能够直接以 32 位地址模式启动。

S25FS-S 系列的 128 Mbit 容量产品以相同的方式支持扩展地址功能，但本质上忽略任何地址的位 31 至 24，因为闪存存储器阵列仅需要 24 位地址。这使得从 128 Mb 容量到更高容量设备的简单迁移成为可能，而无需改变软件的地址处理方面。

#### 8.1.2 多个地址空间

许多命令操作都在闪存存储器阵列上。地址空间上的一些指令操作与闪存存储器阵列独立的。每个单独的地址空间都使用完整的 24 位或 32 位地址，但可能仅定义可用地址空间的一小部分。

### 8.2 闪存存储器阵列

主要的闪存存储器阵列被分为以物理扇区为擦除单位。

FS-S 系列物理扇区可配置为地址空间顶部或底部的 8 个 4 KB 参数扇区的混合组合，除这些些扇区之外其余扇区的所有扇区大小一致。由于 8 个 4 KB 参数扇区组总体上比一个统一的扇区小，因此该组 4 KB 物理扇区分别覆盖（替换）最高或最低地址统一扇区的顶部或底部 32 KB。

必须使用参数扇区擦除命令（20h 或 21h）来单独擦除 4 KB 扇区。扇区（统一功能块）指令（D8h 或 DCh）必须用于擦除任何剩余的扇区，包括未被参数扇区覆盖的最高或最低地址扇区的部分。统一的功能块擦除命令对参数扇区没有影响。

配置寄存器 1 的非易失性位 2 (CR1NV[2]) 等于 '0' 时，参数扇区会覆盖最低地址统一扇区的底部。

CR1NV[2] = 1 时，参数扇区会覆盖最高地址统一扇区的顶部。更多信息请参见第 59 页上的“寄存器”。

还有一个配置选项可以从地址映射中删除 4 KB 参数扇区组，以便所有扇区都是统一大小。配置寄存器 3 易失性位 3 (CR3V[3]) 等于 '0' 表示选择具有 4 KB 参数扇区的混合扇区架构。CR3V[3] = 1 选择没有参数扇区的统一扇区架构。FS128S 和 FS256S 中的统一物理扇区为 64 kB。

## 地址空间映射

两个设备还可以配置为使用扇区（统一功能块）指令来保存 256 KB 逻辑块，而不是独立的 64 KB 物理扇区。此配置选项（CR3V[1] = 1）允许低容量设备模拟与使用 256 KB 物理内存的家族中高容量产品相同的扇区擦除行为。这可以简化向家族中更高容量产品的软件迁移。

表 17 S25FS256S 扇区地址分布图，底部 4 KB 扇区，64 KB 物理统一扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
4	8	SA00	00000000h–00000FFFh	Sector starting address
		:	:	
		SA07	00007000h–00007FFFh	
32	1	SA08	00008000h–0000FFFFh	—
64	511	SA09	00010000h–0001FFFFh	
		:	:	
		SA519	01FF0000h–01FFFFFFh	Sector ending address

表 18 S25FS256S 扇区地址分布图，顶部 4 KB 扇区，64 KB 物理统一扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
64	511	SA00	0000000h–000FFFFh	Sector starting address
		:	:	
		SA510	01FE0000h–01FEFFFFh	
32	1	SA511	01FF0000h–01FF7FFFh	—
4	8	SA512	01FF8000h–01FF8FFFh	
		:	:	
		SA519	01FFF000h–01FFFFFFh	Sector ending address

地址空间映射

表 19 S25FS256S 扇区地址分布图，统一 64 KB 物理扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (8-bit)	Notes
64	512	SA00	0000000h~000FFFFh	Sector starting address
		:	:	—
		SA511	1FF0000h~1FFFFFFh	Sector ending address

表 20 S25FS256S 扇区地址分布图，底部 4 KB 扇区，256 KB 逻辑统一扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
4	8	SA00	00000000h~00000FFFh	Sector starting address
		:	:	
		SA07	00007000h~00007FFFh	
224	1	SA08	00008000h~0003FFFFh	—
256	127	SA09	00040000h~0007FFFFh	
		:	:	
		SA135	01FC0000h~01FFFFFFh	Sector ending address

表 21 S25FS256S 扇区地址分布图，顶部 4 KB 扇区，256 KB 逻辑统一扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
256	127	SA00	0000000h~003FFFFh	Sector starting address
		:	:	
		SA126	01F80000h~01FBFFFFh	
224	1	SA127	01FC0000h~01FC7FFFh	—
4	8	SA128	01FF8000h~01FF8FFFh	
		:	:	
		SA135	01FFF000h~01FFFFFFh	Sector ending address

表 22 S25FS256S 扇区地址分布图，统一 256 KB 逻辑扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (8-bit)	Notes
256	128	SA00	00000000h~0003FFFFh	Sector starting address
		:	:	—
		SA127	01FC0000h~01FFFFFFh	Sector ending address

地址空间映射

表 23 S25FS128S 扇区和内存地址分布图，底部 4 KB 扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
4	8	SA00	00000000h–00000FFFh	Sector starting address
		:	:	—
		SA07	00007000h–00007FFFh	
32	1	SA08	00008000h–0000FFFFh	
64	255	SA09	00010000h–0001FFFFh	Sector ending address
		:	:	
		SA263	00FF0000h–00FFFFFFh	

表 24 S25FS128S 扇区和内存地址分布图，顶部 4 KB 扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
64	255	SA00	0000000h–000FFFFh	Sector starting address
		:	:	—
		SA254	00FE0000h–00FEFFFFh	
32	1	SA255	00FF0000h–00FF7FFFh	
4	8	SA256	00FF8000h–00FF8FFFh	Sector ending address
		:	:	
		SA263	00FFF000h–00FFFFFFh	

表 25 S25FS128S 扇区和内存地址分布图，统一的 64 KB 块

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
64	256	SA00	0000000h–0000FFFFh	Sector starting address
		:	:	—
		SA255	00FF0000h–0FFFFFFh	Sector ending address

地址空间映射

表 26 S25FS128S 扇区地址分布图，底部 4 KB 扇区，256 KB 逻辑统一扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
4	8	SA00	00000000h-00000FFFh	Sector starting address
		:	:	—
		SA07	00007000h-00007FFFh	
224	1	SA08	00008000h-0003FFFFh	
256	63	SA09	00040000h-0007FFFFh	Sector ending address
		:	:	
		SA71	00FC0000h-00FFFFFFh	

表 27 S25FS128S 扇区地址分布图，顶部 4 KB 扇区，256 KB 逻辑统一扇区

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
256	63	SA00	00000000h-0003FFFFh	Sector starting address
		:	:	—
		SA62	00F80000h-00FBFFFFh	
224	1	SA63	00FC0000h-00FF7FFFh	
4	8	SA64	00FF8000h-00FF8FFFh	Sector ending address
		:	:	
		SA71	00FFF000h-00FFFFFFh	

表 28 S25FS128S 扇区和内存地址分布图，统一的 256 KB 块

Sector size (KB)	Sector count	Sector range	Address range (byte address)	Notes
256	64	SA00	00000000h-0003FFFFh	Sector starting address
		:	:	—
		SA63	00FC0000h-00FFFFFFh	Sector ending address

注：

38. 这些是使用几个扇区作为参考的简明表格。有一些地址范围未明确列出。所有 4-kB 扇区都有地址类型为 XXXX000h-XXXXFFFh。所有 64 kB 扇区的地址类型为 XXX0000h-XXXFFFh。所有 256-kB 扇区的地址类型为 XX00000h-XX3FFFFh、XX40000h-XX7FFFh、XX80000h-XXCFFFh 或 XXD0000h-XXFFFFh。

地址空间映射

### 8.3 ID-CFI 地址空间

RDID 指令 (9Fh) 从单独的硬件地址空间读取器件标识 (ID) 和公共硬件接口 (CFI) 信息的信息。参见第155页“器件ID和常见的闪存存储器接口 (ID-CFI) 地址分布”在用于定义 ID-CFI 地址空间内容的表。ID-CFI 地址空间由英飞凌写入，对于主控系统是只读的。

### 8.4 JEDEC JESD216串行闪存可发现参数(SFDP)空间

RSFDP 指令 (5Ah) 从单独的存储器地址空间读取器件标识、特点和配置信息的信息，符合串行存储器可发现参数的JEDEC JESD216 标准。ID-CFI 地址空间被合并为 SFDP 参数之一。参见第151页“串行闪存存储器可发现参数 (SFDP) 地址分布图”在分用于定义 SFDP 地址空间内容的表。SFDP 地址空间由英飞凌写入，对于主控系统是只读的。

### 8.5 OTP 地址空间

每个 FS-S 系列存储器器件都有一个 1024 字节一次性编程 (OTP) 地址空间，与闪存存储器阵列分开的。OTP 区域分为 32 个可单独锁定、32 字节对齐和长度的区域。

在从0地址开始的 32 字节区域中：

- 16 个最低地址字节由英飞凌使用 128 位随机数进行写入。只有英飞凌能够在这些字节中编程。这些字节位置中的编程将被忽略，并且不会影响英飞凌写入的值。尝试在这些字节位置中编程任何零都会失败，并且置位 P\_ERR。
- 接下来的 4 个较高地址字节 (OTP 锁定字节) 用于为每个 OTP 区域提供一位，以永久保护每个区域免于编程。从英飞凌发货时这些字节已被擦除。OTP 区域编程后，可以通过在 OTP 锁定字节中编程相关保护位来锁定该区域以防止进一步编程。
- 最低地址区域的接下来的 12 个高字节是保留以备将来使用 (RFU)。这些 RFU 字节中的位可以由主控系统进行编程，但必须理解，未来的器件可能会使用这些位来保护更大的OTP空间。从英飞凌发货时这些字节已被擦除。

剩余区域在从英飞凌发货时被擦除，并且可用于编程额外的永久数据。

请参阅第58页“OTP地址空间”查看OTP存储空间的图示。

OTP存储空间旨在提高系统安全性。OTP值（例如英飞凌编程的随机数）可用于闪存器件电池与系统 CPU/ASIC “配对”，以防止器件替换。

当配置配置寄存器 FREEZE (CR1V[0])为 1 时，可保护整个OTP存储空间，避免对其编程。这允许可信引导代码控制OTP区域的编程，然后设置 FREEZE 位以防止在正常开机系统操作的其余时间期间进一步进行OTP存储空间编程。

地址空间映射

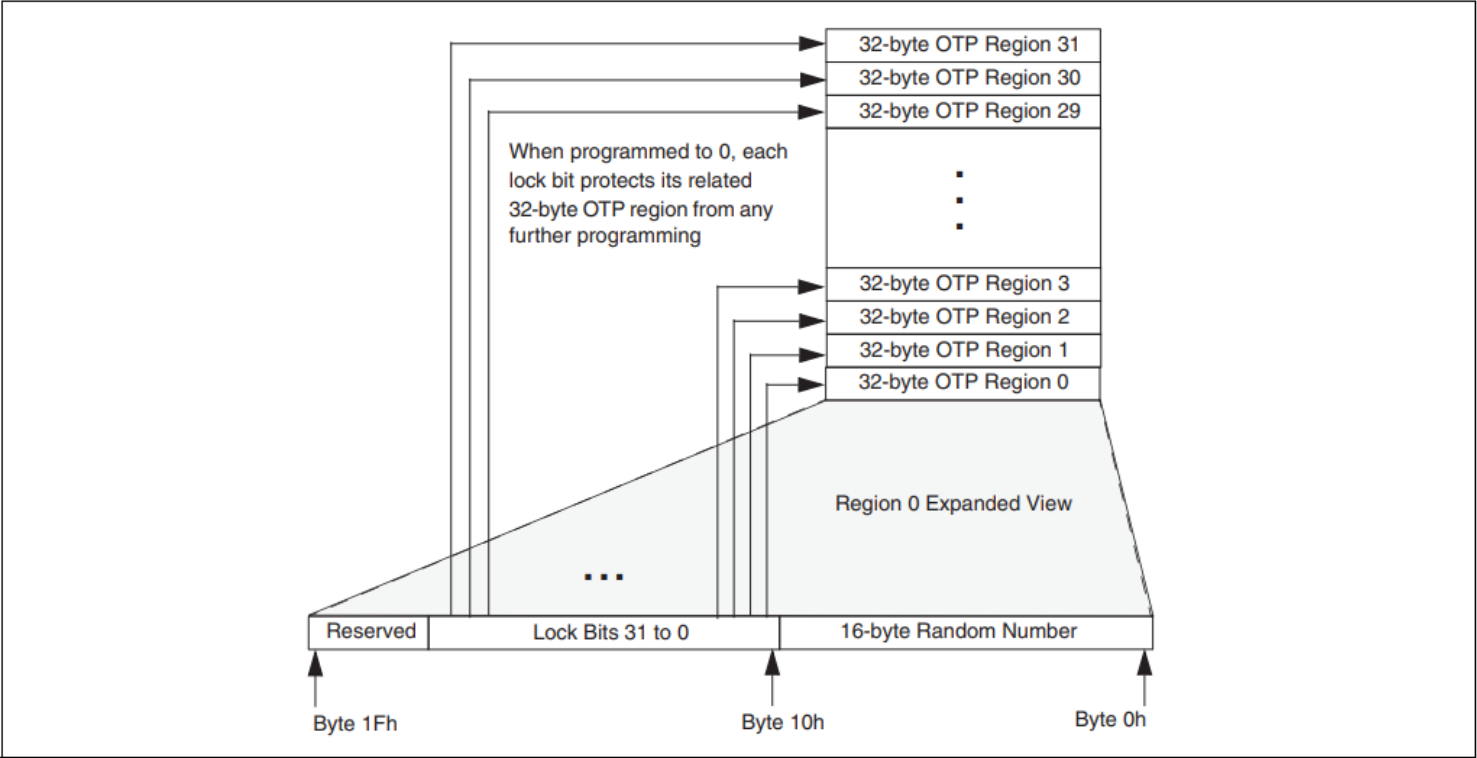


图 47 OTP 地址空间

表29 OTP 地址空间分布图

Region	Byte address range (Hex)	Contents	Initial delivery state (Hex)
Region 0	000	Least Significant Byte of Infineon programmed random number	Infineon programmed random number
	...	...	
	00F	Most Significant Byte of Infineon programmed random number	
	010 to 013	Region Locking Bits Byte 10 [bit 0] locks region 0 from programming when = 0 ... Byte 13 [bit 7] locks region 31 from programming when = 0	All Bytes = FF
	014 to 01F	Reserved for Future Use (RFU)	All bytes = FF
Region 1	020 to 03F	Available for user programming	All bytes = FF
Region 2	040 to 05F	Available for user programming	All bytes = FF
...	...	Available for user programming	All bytes = FF
Region 31	3E0 to 3FF	Available for user programming	All bytes = FF

地址空间映射

## 8.6 寄存器

寄存器是一小组存储单元，用于配置 S25FS-S 系列存储器器件的运行方式或报告器件运行的状态。寄存器通过特定指令访问。每个寄存器使用的命令（和十六进制指令代码）都在每个寄存器描述中注明。

在传统 SPI 存储设备中，各个寄存器位可以是同一寄存器内的易失性、非易失性或一次性可编程 (OTP) 位的混合。在某些配置选项中，寄存器位的类型可能会发生变化，例如从非易失性变为易失性。

S25FS-S 系列使用单独的非易失或易失性存储器单元组（区域）来实现不同的寄存器位类型。但是，为了与旧版软件兼容，传统寄存器和指令仍会继续出现并正常运行。当传统寄存器具有易失性位或者当读取遗留寄存器的指令具有零读取延时，每个遗留寄存器存在非易失和易失性版本。当读取此类寄存器时，将传送该寄存器的易失性版本。在上电复位 (POR)、硬件复位或软件复位期间，寄存器的非易失版本被复制到易失性版本，以提供易失性寄存器的默认状态。当写入非易失性寄存器位时，寄存器的非易失性版本将被擦除并使用新的位值进行编程，而寄存器的易失性版本将使用非易失性版本的新内容进行更新。当对 OTP 位进行编程时，也会对寄存器的非易失性版本进行编程，并在寄存器的易失性版本中更新相应的位。当写入易失性寄存器位时，只有寄存器的易失性版本才会更新相应的位。

每个寄存器描述中都注明了每个位的类型。每个位显示的默认状态是指上电复位、硬件复位或软件复位（如果该位易失性）后的状态。如果位为非易失或 OTP，则默认状态为器件从英飞凌发货时的位值。非易失位具有与存储器阵列相同的擦写寿命。

**表 30 寄存器描述**

Register	Abbreviation	Type	Bit location
Status Register 1	SR1NV[7:0]	Non-volatile	7:0
Status Register 1	SR1V[7:0]	Volatile	7:0
Status Register 2	SR2V[7:0]	Volatile	7:0
Configuration Register 1	CR1NV[7:0]	Non-volatile	7:0
Configuration Register 1	CR1V[7:0]	Volatile	7:0
Configuration Register 2	CR2NV[7:0]	Non-volatile	7:0
Configuration Register 2	CR2V[7:0]	Volatile	7:0
Configuration Register 3	CR3NV[7:0]	Non-volatile	7:0
Configuration Register 3	CR3V[7:0]	Volatile	7:0
Configuration Register 4	CR4NV[7:0]	Non-volatile	7:0
Configuration Register 4	CR4V[7:0]	Volatile	7:0
ECC Status Register	ECCSR [7:0]	Volatile	7:0
ASP Register	ASPR[15:1]	OTP	15:1
ASP Register	ASPR[0]	RFU	0
Password Register	PASS[63:0]	Non-volatile OTP	63:0
PPB Lock Register	PPBL[7:1]	Volatile	7:1
PPB Lock Register	PPBL[0]	Volatile Read Only	0
PPB Access Register	PPBAR[7:0]	Non-volatile	7:0
DYB Access Register	DYBAR[7:0]	Volatile	7:0
SPI DDR Data Learning Registers	NVDLR[7:0]	Non-volatile	7:0
SPI DDR Data Learning Registers	VDLR[7:0]	Volatile	7:0

地址空间映射

## 8.6.1 状态寄存器1

### 8.6.1.1 状态寄存器 1 非易失性 (SR1NV)

相关指令写入寄存器 (WRR 01h)、读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)

表 31 状态寄存器 1 非易失性 (SR1NV)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	SRWD_NV	Status Register Write Disable Default	Non-Volatile	0	1 = Locks state of SRWD, BP, and Configuration Register 1 bits when WP# is LOW by not executing WRR or WRAR commands that would affect SR1NV, SR1V, CR1NV, or CR1V. 0 = No protection, even when WP# is LOW.
6	P_ERR_D	Programming Error Default	Non-Volatile Read Only	0	Provides the default state for the Programming Error Status. Not user programmable.
5	E_ERR_D	Erase Error Default	Non-Volatile Read Only	0	Provides the default state for the Erase Error Status. Not user programmable.
4	BP_NV2	Block Protection Non-Volatile	Non-Volatile	000b	Protects the selected range of sectors (Block) from Program or Erase when the BP bits are configured as non-volatile (CR1NV[3] = 0). Programmed to 111b when BP bits are configured to volatile (CR1NV[3] = 1), after which these bits are no longer user programmable.
3	BP_NV1				
2	BP_NV0				
1	WEL_D	WEL Default	Non-Volatile Read Only	0	Provides the default state for the WEL Status. Not user programmable.
0	WIP_D	WIP Default	Non-Volatile Read Only	0	Provides the default state for the WIP Status. Not user programmable.

**状态寄存器写入非易失 (SRWD\_NV) SR1NV[7]:** 当该位置位为“1”且 WP# 输入驱动为低电平时，将器件置于硬件保护模式。在此模式下，写入寄存器 (WRR) 和写入任何寄存器 (WRAR) 指令（选择状态寄存器 1 或配置寄存器 1）将被忽略且不接受执行，通过将寄存器设为只读，有效锁定状态寄存器 1 和配置寄存器 1 (SR1NV、SR1V、CR1NV 或 CR1V) 位的状态。如果 WP# 为高电平，则状态寄存器 1 和配置寄存器 1 可以通过 WRR 或 WRAR 指令更改。如果 SRWD\_NV 为“0”，则 WP# 无效，并且状态寄存器 1 和配置寄存器 1 可以通过 WRR 或 WRAR 指令更改。WP# 对任何其他寄存器的写入没有影响。SRWD\_NV 位具有与闪存阵列相同的不易丢失的寿命。SRWD (SR1V[7]) 位仅用作 SRWD\_NV 位的副本，以提供 0 延时的读取。

**编程错误默认值 (P\_ERR\_D) SR1NV[6]:** 为 SR1V[6] 中的编程错误状态提供默认状态。此位用户不可编程的。

**擦除错误 (E\_ERR) SR1V[5]:** 为 SR1V[5] 中的擦除错误状态提供默认状态。此位用户不可编程的。

## 地址空间映射

**功能块保护 (BP\_NV2, BP\_NV1, BP\_NV0) SR1NV[4:2]:** 这些位定义闪存存储器阵列区域受到软件保护, 免受写入和擦除指令的影响。BP 位被选择为易失性或非易失性, 取决于配置寄存器 CR1NV[3] 中 BP 非易失位 (BPNV\_O) 的状态。当 CR1NV[3] = 0 时, BP 位 (SR1NV[4:2]) 的非易失版本用于控制功能块保护, WRR 指令写入 SR1NV[4:2] 并将 SR1V[4:2] 更新为相同值。当 CR1NV[3] = 1 时, BP 位 (SR1V[4:2]) 的易失性版本用于控制功能块保护和 WRR 指令写入 SR1V[4:2], 并且不影响 SR1NV[4:2]。当一个或多个 BP 位设置为“1”时, 相关存储区域将受到保护, 避免写入和擦除。仅当 BP 位清除为 0 时, 才能执行 Bulk (BE) 指令。参阅第82页“功能块保护”了解 BP 位值如何选择受保护的闪存阵列区域的描述。非易失版本的BP位具有与闪存阵列相同的非易失寿命。

**写使能锁存默认值 (WEL\_D) SR1NV[1]:** 为 SR1V[1] 中的 WEL 状态提供默认状态。此位由 Infineon 编程, 用户不可编程。

**写入过程中默认值 (WIP\_D) SR1NV[0]:** 为 SR1V[0] 中的 WIP 状态提供默认状态。此位由 Infineon 编程, 用户不可编程。

### 8.6.1.2 状态寄存器 1 易失性 (SR1V)

相关指令: 读状态寄存器(RDSR1 05h)、写寄存器(WRR 01h)、写使能(WREN 06h)、写失效, 不使能(WRDI 04h)、清零/复位状态寄存器(CLSR 30h或82h)、读任何寄存器(RDAR 65h)、写任何寄存器(WRAR 71h)。这个的寄存器通过RDSR1指令显示。

表 32 状态寄存器 1 易失性 (SR1V)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	SRWD	Status Register Write Disable	Volatile Read Only	SR1NV	Volatile copy of SR1NV[7].
6	P_ERR	Programming Error Occurred	Volatile Read Only		1 = Error occurred. 0 = No Error.
5	E_ERR	Erase Error Occurred	Volatile Read Only		1= Error occurred. 0 = No Error.
4	BP2	Block Protection Volatile	Volatile		Protects selected range of sectors (Block) from Program or Erase when the BP bits are configured as volatile (CR1NV[3] = 1). Volatile copy of SR1NV[4:2] when BP bits are configured as non-volatile. User writable when BP bits are configured as volatile.
3	BP1				
2	BP0				
1	WEL	Write Enable Latch	Volatile		1 = Device accepts Write Registers (WRR and WRAR), Program, or Erase commands. 0 = Device ignores Write Registers (WRR and WRAR), Program, or Erase commands. This bit is not affected by WRR or WRAR, only WREN and WRDI commands affect this bit.
0	WIP	Write-In-Progress	Volatile Read Only		1= Device Busy, an embedded operation is in progress such as Program or Erase. 0 = Ready Device is in Standby mode and can accept commands. This bit is not affected by WRR or WRAR, it only provides WIP status.

## 地址空间映射

**状态寄存器写入 (SRWD) SR1V[7]:** SRWD 是 SR1NV[7] 的易失性副本。此位跟踪对此位的非易失性版本的任何更改。

**编程错误(P\_ERR) SR1V[6]:** 编程错误位用作编程操作成功或失败的指示。当编程错误位设置为“1”时，表示上次编程操作出现错误。当用户尝试在受保护的主存储器扇区中编程或在锁定的OTP区域中编程时，该位也会置位。当编程错误位设置为“1”时，可以使用清零，复位状态寄存器(CLSR)指令将该位清除为“0”。这是一个只读位，不受 WRR 或 WRAR 指令的影响。

**擦除错误(E\_ERR) SR1V[5]:** 擦除错误位用作擦除操作成功或失败的指示。当擦除错误位被置为“1”时，表示上次擦除操作出现错误。当用户试图破坏单个受保护的主存储器扇区时，该位也会被置位。如果在指令执行期间发现受保护的扇区，则 Bulk 扇区指令将不会置位 E\_ERR。当擦除错误位被置为“1”时，可以使用清零，复位状态寄存器(CLSR)指令将该位清除为“0”。这是一个只读位，不受 WRR 或 WRAR 指令的影响。

**功能块保护 (BP2, BP1, BP0) SR1V[4:2]:** 这些位定义了闪存阵列区域受到软件保护，避免编程和擦除指令的影响。BP 位被选择为易失性或非易失性，具体取决于配置寄存器CR1NV[3] 中 BP 非易失位 (BPNV\_O) 的状态。当 CR1NV[3] = 0 时，BP 位 (SR1NV[4:2]) 的非易失版本用于控制功能块保护，WRR 指令写入 SR1NV[4:2] 并将 SR1V[4:2] 更新为相同值。当 CR1NV[3] = 1 时，BP 位 (SR1V[4:2]) 的易失性版本用于控制功能块保护和 WRR 指令写入 SR1V[4:2]，并且不影响 SR1NV[4:2]。当一个或多个 BP 位被置位为 '1' 时，相关闪存区域将受到保护，不会被编程和擦除。只有当 BP 位被清除为 0 时，Bulk擦除 (BE) 指令才能执行。请参阅第82页“功能块保护”了解 BP 位值如何选择受保护的闪存阵列区域的描述。

**写使能锁存器 (WEL) SR1V[1]:** WEL 位必须置位为“1”，才能使能编程、写或擦除操作，作为防止无意中更改存储器或寄存器值的一种手段。写使能 (WREN) 指令执行将写使能锁存器设置为“1”，以允许任何编程、擦除或写指令随后执行。写禁止使能 (WRDI) 指令可用于将写使能锁存器从“1”设置为“0”，以防止所有程序、中断和写指令执行。在任何成功的编程、写入或写操作结束时，WEL 位将被清除为“0”。操作失败后，WEL 位可能会保持置位，并且应使用 CLSR 指令后的 WRDI 指令清除。电源掉电/上电序列、硬件复位或软件复位后，写使能锁存器置位为“0”。WRR 或 WRAR 指令不影响该位。

**写进行 (WIP) SR1V[0]:** 显示器件是否正在执行编程、写入、擦除操作或任何其他操作，在此期间新的操作指令将被忽略。当位设置为“1”时，器件正忙于执行操作。当 WIP 为“1”时，仅接受读取状态 (RDSR1 或 RDSR2)、读取任何寄存器 (RDAR)、擦除暂停 (ERSP)、编程暂停 (PGSP)、清零/复位状态寄存器 (CLSR) 和软件复位 (复位) 指令。仅当闪存阵列擦除或编程操作正在进行时，ERSP 和 PGSP 才会被接受。当 WIP = 1 时，状态寄存器 E\_ERR 和 P\_ERR 位会更新。当 P\_ERR 或 E\_ERR 位置位为 '1' 时，WIP 位将保持置位为 '1'，表明器件仍处于忙状态，无法接收新的操作指令。必须接收清零，复位状态寄存器 (CLSR) 指令才能将器件返回到待机模式。当 WIP 位清除为“0”时，无操作正在进行。这位是只读位。

地址空间映射

## 8.6.2 状态寄存器 2 易失性 (SR2V)

相关指令：读取状态寄存器2 (RDSR2 07h)、读取任何寄存器(RDAR 65h)。状态寄存器 2 没有用户可编程的非易失性位，所有定义的位都是易失性只读状态。这些位的默认状态是由硬件置位的。

表 33 状态寄存器 2 易失性 (SR2V)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	RFU	Reserved	–	0	Reserved for Future Use
6	RFU	Reserved	–	0	Reserved for Future Use
5	RFU	Reserved	–	0	Reserved for Future Use
4	RFU	Reserved	–	0	Reserved for Future Use
3	RFU	Reserved	–	0	Reserved for Future Use
2	ESTAT	Erase Status	Volatile Read Only	0	1 = Sector Erase Status command result = Erase Completed 0 = Sector Erase Status command result = Erase Not Completed
1	ES	Erase Suspend	Volatile Read Only	0	1 = In Erase Suspend mode 0 = Not in Erase Suspend mode
0	PS	Program Suspend	Volatile Read Only	0	1 = In Program Suspend mode 0 = Not in Program Suspend mode

**擦除状态 (ESTAT) SR2V[2]：**擦除状态位显示前一个擦除状态指令所选择的扇区是否完成了该扇区上的最后一个擦除指令。必须在读取 SR2V 之前，立即发出擦除指令才能获得有效的命令状态。在编程或擦除挂起期间读取 SR2V 不会提供有效的擦除状态。系统软件可以使用擦除位来检测上次操作失败的扇区。这可以用于检测由于在擦除操作过程中掉电而导致的擦除操作失败。

**擦除挂起 (ES) SR2V[1]：**擦除挂起位用于确定器件何时处于擦除挂起模式。这是一个用户不能写入的状态位。当擦除挂起位被置为“1”时，器件处于擦除挂起模式。当擦除挂起位被清为“0”时，器件不处于擦除挂起模式。请参阅页 134“编程或擦除挂起 (PES 85h, 75h, B0h)”了解有关挂起/恢复指令的详细信息。

**编程挂起 (PS) SR2V[0]：**编程挂起位用于确定器件何时处于编程挂起模式。这是一个用户不能写入的状态位。当 Program Suspend 位被置为'1'时，器件处于编程挂起模式。当 Program Suspend 位被清为“0”时，器件不处于 Pr 编程挂起模式。请参阅页 134“编程或擦除挂起 (PES 85h, 75h, B0h)”了解详情。

地址空间映射

### 8.6.3 配置寄存器 1

配置寄存器 1 控制某些接口和数据保护功能。可以使用具有 16 个输入周期的 WRR 指令或 WRAR 指令来更改寄存器位。

#### 8.6.3.1 配置寄存器 1 非易失性 (CR1NV)

相关指令写入寄存器 (WRR 01h)、读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)。

表 34 配置寄存器 1 非易失性 (CR1NV)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	RFU	Reserved for Future Use	Non-Volatile	0	Reserved
6	RFU			0	
5	TBPROT_O	Configures Start of Block Protection	OTP	0	1 = BP starts at bottom (Low address) 0 = BP starts at top (High address)
4	RFU	Reserved for Future Use	RFU	0	Reserved.
3	BPNV_O	Configures BP2–0 in Status Register	OTP	0	1 = Volatile 0 = Non-Volatile
2	TBPARAM_O	Configures Parameter Sectors location	OTP	0	1 = 4-KB physical sectors at top, (high address) 0 = 4-KB physical sectors at bottom (Low address) RFU in uniform sector configuration
1	QUAD_NV	Quad Non-Volatile	Non-Volatile	0	Provides the default state for the QUAD bit
0	FREEZE_D	FREEZE Default	Non-Volatile Read Only	0	Provides the default state for the Freeze bit. Not user programmable

**顶部或底部保护(TBPROT\_O) CR1NV[5]:** 该位定义寄存器状态中功能块保护位BP2、BP1和BP0的操作。如状态部分所述，BP2-0 位允许用户选择保护一部分阵列，范围从 1/64、1/4、1/2 等直至整个阵列。当 TBPROT\_O 设置为“0”时，功能块保护被定义为从阵列的顶部（最大地址）开始。当 TBPROT\_O 被置为“1”时，功能块保护被定义为从阵列的底部（0地址）开始。从英飞凌发货时，TBPROT\_O 位是OTP，置位为“0”。如果 TBPROT\_O 被编程为‘1’，则将位写入‘0’不会改变该值或置位编程故障位（SR1V[6] 中的 P\_ERR）。

必须在器件制造期间对器件进行初始配置期间选择 TBPROT\_O 的所需状态；在闪存阵列上执行第一个编程或擦除操作之前。在存储器阵列中编程或擦除操作完成后，不得对 TBPROT\_O 进行编程。

**CR1NV[4]:** 保留以供将来使用。

## 地址空间映射

**功能块保护非易失性(BPNV\_O) CR1NV[3]:** BPNV\_O位定义是选择状态寄存器中的BP\_NV 2-0位还是BP 2-0位来控制功能块保护。BPNV\_O 位是OTP，在从 Infineon 出厂时被清除为 0，BP\_NV 位被清除为“000”。当 BPNV\_O 设置为“0”时，状态寄存器中的控制功能块保护位 BP\_NV 2-0 位由 WRR 指令写入。写入 BP\_NV 位所需的时间为  $t_w$ 。当 BPNV 设置为“1”时，状态寄存器中的 BP2-0 位被选择来控制功能块保护，并且 BP\_NV 2-0 位将被编程为二进制“111”。这将导致 BP 2-0 位在POR、硬件复位或指令复位后被设置位二进制 111。当 BPNV 设置为“1”时，WRR 指令仅写入 BP 位的易失性 (SR1V[4:2])。非易失性BP 位 (SR1NV[4:2]) 不再受 WRR 指令影响。这样可以无限次写入 BP 位，因为它们是易失性的，并且写入易失性 BP 位的时间比写入非易失性的时间要快得多。如果将 BPNV\_O 编程为“1”，则将位写入 0 不会更改值或置位编程错误位 (SR1V[6] 中的 P\_ERR)。

**TBPARAM\_O CR1NV[2]:** TBPARAM\_O定义参数功能块的逻辑位置。参数功能块由8个4kB的参数扇区组成，它们处在了最高或最低地址扇区的32kB部分。当TBPARAM\_O置位为'1'时，参数功能块位于闪存阵列地址空间的顶部。当TBPARAM\_O置位为“0”时，参数功能块位于阵列的底部。从 Infineon 出厂时，TBPARAM\_O 是 OTP，置位为“0”。如果 TBPARAM\_O 被编程为“1”，则用 0 写入该位不会更改该值或设置编程错误位 (SR1V[6] 中的 P\_ERR)。

必须在器件制造期间对器件进行初始配置期间选择 TBPARAM\_O 的所需状态；在闪存阵列上执行第一个编程或擦除操作之前。在存储器阵列中编程或擦除操作完成后，不得对 TBPARAM\_O 进行编程。

TBPROT\_O 可独立于 TBPARAM\_O 位被置位或清除。因此，用户可以选择从阵列底部存储参数信息并从阵列顶部开始保护引导代码，反之亦然。或者，用户可以选择从顶部或者底部开始存储和保护参数信息。

当存储器阵列配置为统一扇区时，TBPARAM\_O 位被保留以备将来使用 (RFU)，并且不起作用，因为所有扇区都是统一大小。

**四线数据宽度非易失性 (QUAD\_NV) CR1NV[1]:** 提供 CR1V[1] 中四线位的默认状态。WRR 或 WRAR 指令会影响此位。通过编程 CR2NV[6] = 1 选择 QPI 模式，也可以编程 QUAD\_NV = 1，以将默认状态更改为四线数据宽度模式。当通过 CR2V[6] = 1 选择 QPI 模式时，Quad\_NV 位不能被清除为“0”。

**防冻保护默认值 (FREEZE) CR1NV[0]:** 为 CR1V[0] 中的 FREEZE 位提供默认状态。此位不可由用户编程。

地址空间映射

### 8.6.3.2 配置寄存器 1 易失性 (CR1V)

相关指令：读取配置寄存器 (RDCR 35h)、写入寄存器 (WRR 01h)、读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)。这寄存器是通过RDCR指令显示的。

表 35 配置寄存器 1 易失性 (CR1V)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	RFU	Reserved for Future Use	Volatile	CR1NV	Reserved
6	RFU				Not user writable See CR1NV[5] TBPROT_O
5	TBPROT	Volatile copy of TBPROT_O	Volatile Read Only		Reserved
4	RFU	Reserved for Future Use	RFU		Not user writable See CR1NV[3] BPNV_O
3	BPNV	Volatile copy of BPNV_O	Volatile Read Only		Not user writable See CR1NV[2] TBPARM_O
2	TBPARM	Volatile copy of TBPARM_O	Volatile Read Only		1 = Quad 0 = Dual or Serial The WRR command writes the Nonvolatile Quad bit (CR1NV[1]). See full description below
1	QUAD	Quad I/O Mode	Volatile		Lock current state of Block Protection control bits, and OTP regions 1 = Block Protection and OTP locked 0 = Block Protection and OTP unlocked
0	FREEZE	Lock-Down Block Protection until next power cycle	Volatile		

**TBPROT、BPNV 和 TBPARM CR1V[5,3,2]：**这些位是 CR1NV 相关非易失性位的易失性副本。这些位值会跟随这些位的相关非易失性版本。

**四线数据宽度 (QUAD) CR1V[1]：**当置位为“1”时，该位将器件的数据宽度切换为 4 位的四线模式。也就是说，当 CS 为低电平时，WP# 变为 IO2，IO3 / RESET# 变为有效 I/O 信号，或者当 CS 为高电平时，变为 RESET# 输入。WP# 输入的正常功能不受监控，并且在内部设置为高电平（无效）。串行和双线 I/O 读取的指令仍然可以正常工作，但是，当使用不同的数据数据路径宽度在指令之间切换时，无需驱动这些指令的 WP# 输入。同样，在这些指令期间不需要驱动 IO3/RESET#（当 CS 为低电平时）。当使用四线 I/O 读取、DDR 四线 I/O 读取、QPI 模式 (CR2V[6] = 1) 和读取四线 ID 指令时，QUAD 位必须置位为“1”。当 CR2V[6] = 1 选择 QPI 模式时，Quad 位不能清除为“0”。WRR 指令写入四位 (CR1NV[1]) 的非易失性版本，这也会导致易失性 CR1V[1] 的更新。WRR 指令不能在不影响非易失性 CR1NV[1] 的情况下写入易失性 CR1V[1]。当需要写入易失性四线位 CR1V[1] 而不影响非易失性 CR1NV[1] 时，必须使用 WRAR 指令。

## 地址空间映射

**冻结保护 (FREEZE) CR1V[0]**: 冻结位，当置位为“1”时，锁定功能块保护控制位和OTP区域的当前状态：

- 非易失性状态寄存器 1 (SR1NV[4:2]) 中的 BPNV\_2-0 位
- 易失性状态寄存器 1 (SR1V[4:2]) 中的 BP 2-0 位
- 非易失性配置寄存器 (CR1NV[53, 2]) 中的 TBPROT\_O、TBPARM\_O 和 BPNV\_O 位
- 易失性配置寄存器 (CR1V[5, 3, 2]) 中的 TBPROT、TBPARM 和 BPNV 位受到间接保护，因为它们是跟随相关 CR1NV OTP 位，并且是只读的
- 整个 OTP 存储空间

当 FREEZE = 1 时，任何试图更改上面列出的位的行为都会被阻止：

- WRR 指令不影响列出的位并且不会置位任何错误状态。
- WRAR 指令不影响列出的位并且不会置位任何错误状态。
- 地址位于OTP区域内的 OTPP 指令失败，P-ERR 状态会被置位。

只要 FREEZE 位保持清除为逻辑 0，功能块保护控制位和 FREEZE 都是可写的，并且OTP地址空间是可编程的。

一旦将 FREEZE 位写入逻辑 1，就只能通过断电到上电循环或硬件复位将其清除为逻辑 0。软件复位不会影响 FREEZE 位的状态。

CR1V[0] FREEZE 位是易失性的，上电后的 FREEZE 默认状态来自 CR1NV[0] 中的 FREEZE\_D。FREEZE 位和 CR1V 中的其他值可以通过单个 WRR 或 WRAR 指令更新。

FREEZE 位不会阻止 WRR 或 WRAR 指令更改 SRWD\_NV (SR1NV[7])、Quad\_NV (CR1NV[1]) 或 QUAD (CR1V[1]) 位。

地址空间映射

## 8.6.4 配置寄存器 2

配置寄存器 2 控制某些接口功能。可以使用读取任何寄存器和写入任何寄存器指令来读取和更改寄存器位。寄存器的非易失版本提供了控制的POR、硬件复位或软件复位状态的能力。这些配置位是 OTP 的，在系统配置期间，它们的默认状态只能更改为相反的值一次。寄存器的易失性版本控制正常操作期间的特点行为。

### 8.6.4.1 配置寄存器 2 非易失性 (CR2NV)

相关指令：读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)。

表 36 配置寄存器 2 非易失性 (CR2NV)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	AL_NV	Address Length	OTP	0	1 = 4-byte address 0 = 3-byte address
6	QA_NV	QPI		0	1 = Enabled - QPI (4-4-4) protocol in use. 0 = Disabled - Legacy SPI protocols in use, instruction is always serial on SI.
5	IO3R_NV	IO3 Reset		0	1 = Enabled - IO3 is used as RESET# input when CS# is high or Quad Mode is disabled CR1V[1] = 1 0 = Disabled - IO3 has no alternate function, hardware reset is disabled
4	RFU	Reserved		0	Reserved For Future Use
3	RL_NV	Read Latency		1	0 to 15 latency (dummy) cycles following read address or continuous mode bits Note that bit 3 has a default value of '1' and may be programmed one time to '0' but cannot be returned to '1'.
2				0	
1				0	
0				0	

**地址长度非易失性 CR2NV[7]：**该位控制所有需要命令要求地址固定长度，在POR，硬件复位或软件复位状态预期为3字节或仅4字节（32位）的地址长度的。大多数需要地址的指令都是传统上使用SPI 3字节（24位）地址的传统指令。对于大于128 Mbit的器件容量，需要4字节地址来存取整个存储器阵列。地址长度配置位用于将大多数3字节地址指令更改为期望4字节地址。有关指令地址长度，请参阅94页上的“S25FS-S系列命令集（按功能排序）”。4字节地址长度的使用也适用于S25FS-S系列的128Mbit成员，以便相同的4字节地址硬件和软件接口可以用于所有系列成员以简化不同容量之间的迁移。S25FS-S系列的128 Mbit成员只是忽略第四个高位地址字节的内容。这种非易失的地址长度配置位使器件能够立即以4字节地址模式启动（boot），而不是传统的3字节地址模式。

## 地址空间映射

**QPI 非易失性 CR2NV[6]：**该位控制所有指令的预期指令宽度的POR、硬件复位或软件复位状态。传统SPI指令始终在SI (IO0) 信号上发送一位宽指令（串行 I/O）。S25FS-S系列还支持QPI模式输入，主控系统和存储器之间的所有传输都是4位宽的IO0到IO3，包括所有指令。这种非易失性的 QPI 配置位使器件能够在 QPI 模式而不是传统串行指令模式下立即启动（boot）。

当此位被编程为 QPI 模式时，QUAD\_NV 位也被编程为四线模式 (CR1NV[1] = 1)。移至 QPI 模式的推荐程序是首先使用 WRAR 指令来置位 CR2V[6] = 1，QPI 模式。QPI 模式的易失性寄存器写入具有短暂且明确定义的时间 (tCS)，可将器件接口切换到 QPI 模式。然后可以立即在 QPI 协议中发送以下指令。WRAR 指令可以用于编程 CR2NV[6] = 1，然后轮询 SR1V[0] 以了解编程操作何时完成。同样，要退出 QPI 模式，WRAR 指令用于清零，复位 CR2V[6] = 0。CR2NV[6] 不能擦除为 '0'，因为它是OTP。

**IO3 复位非易失性CR2NV[5]：**该位控制 IO3 信号行为的POR、硬件复位或软件复位状态。由于传统SPI器件封装中可用的信号数量和连接有限，大多数传统SPI设备没有硬件复位输入信号。当 IO3 信号未用于在主控系统和存储器之间传输信息时，S25FS-S 系列提供了使用 IO3 信号作为硬件复位输入的选项。这个非易失性的 IO3 复位配置位使器件能够立即启动（boot），并使用 IO3 使能为 RESET# 信号。

**读取延时非易失性 CR2NV[3:0]：**该位控制所有可变延时读指令中 Read Latency（虚拟周期）延时，在POR、硬件复位或软件复位状态。下面的读命令在地址或模式结束，和读数据开始返回主控之间有一个可变的延时时间：

- 快速读取
- 双线I/O 读取
- 四线 I/O 读取
- DDR 四线 I/O 读取
- OTPR
- ECCRD
- RDAR

此非易失性读取延时配置位设置正在使用的读取延时（虚拟周期）数，以便器件能够以适合主控系统的读取延时立即启动（boot）。

地址空间映射

表 37 延时编码（周期）vs 频率

Latency cycles	Read command maximum frequency (MHz)			
	Fast Read (1-1-1) OTPR (1-1-1) RDAR (1-1-1) RDAR (4-4-4)	Dual I/O (1-2-2)	Quad I/O (1-4-4) QPI (4-4-4)	DDR Quad I/O (1-4-4) DDR QPI (4-4-4) <sup>[42]</sup>
	Mode cycles = 0	Mode cycles = 4	Mode cycles = 2	Mode cycles = 1
0	50	80	40	N/A
1	66	92	53	22
2	80	104	66	34
3	92	116	80	45
4	104	129	92	57
5	116	133	104	68
6	129	133	116	80
7	133	133	129	80
8	133	133	133	80
9	133	133	133	80
10	133	133	133	80
11	133	133	133	80
12	133	133	133	80
13	133	133	133	80
14	133	133	133	80
15	133	133	133	80

**注：**

39. 该系列器件不支持 SCK 频率 > 133 MHz SDR 或 > 80 MHz DDR。
40. Dual I/O、Quad I/O、QPI、DDR Quad I/O 和 DDR QPI 指令协议包括地址后面的连续读取模式位。这些位的时钟周期不计入表中所示的延时周期的一部分。示例：传统的 Quad I/O 指令在地址后面有 2 个连续读取模式周期。因此，没有额外读取延时的传统四线 I/O 指令仅支持表中所示的频率，以实现 0 个周期的读取延时。通过增加可变读取延时，可以提升四线 I/O 指令的频率，允许操作最高支持 133 MHz 频率。
41. 其他读指令有固定的延时，例如 读取指令始有 0 延时周期。RSFDP 始终具有 8 个延时周期。
42. DDR QPI 仅支持延时周期 1 至 5 以及高达 68 MHz 的时钟频率。

地址空间映射

### 8.6.4.2 配置寄存器 2 易失性 (CR2V)

相关指令：读取任何寄存器（RDAR 65h）、写入任何寄存器（WRAR 71h）、4BAM。

表 38 配置寄存器 2 易失性 (CR2V)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	AL	Address Length	Volatile	CR2NV	1 = 4 byte address 0 = 3 byte address
6	QA	QPI			1 = Enabled - QPI (4-4-4) protocol in use 0 = Disabled - Legacy SPI protocols in use, instruction is always serial on SI
5	IO3R_S	IO3 Reset			1 = Enabled - IO3 is used as RESET# input when CS# is HIGH or Quad Mode is disabled CR1V[1] = 1 0 = Disabled - IO3 has no alternate function, hardware reset is disabled
4	RFU	Reserved			Reserved for Future Use
3	RL	Read Latency			0 to 15 latency (dummy) cycles following read address or continuous mode bits
2					
1					
0					

**地址长度 CR2V[7]:** 该位控制所有需要地址长度且不固定为仅 3 字节或仅 4 字节（32 位）地址的指令的预期地址长度。参见94页“S25FS-S 系列命令集（按功能排序）”对于指令地址长度。此易失性地址长度配置位使地址长度能够在正常操作期间更改。4字节地址模式(4BAM)指令直接将该位设置为4字节地址模式。

**QPI CR2V[6]:** 该位控制所有指令的预期指令位宽。此易失性 QPI 配置位使器件能够在正常运行期间进入和退出 QPI 模式。当该位被置位为 QPI 模式时，四线也被置位为四位模式 (CR1V[1] = 1)。当该位被清除为传统SPI模式时，四位不受影响。

**IO3 复位 CR2V[5]:** 此位控制 IO3 / RESET# 信号行为。此易失性 IO3 复位配置位允许在正常运行期间将 IO3 用作 RESET# 输入。

**读取延时 CR2V[3:0]:** 此位控制可变延时读取指令中的读取延时（虚拟周期）时间。这些易失性配置位使用户能够在正常运行期间调整读取延时，以根据需要优化不同指令或不同工作频率下的延时。

地址空间映射

## 8.6.5 配置寄存器 3

配置 3 控制某些指令行为。可以使用读取任何寄存器和写入任何寄存器指令来读取和更改寄存器位。非易失性寄存器提供控制的 POR、硬件复位或软件复位状态。这些配置位是 OTP 的，如果需要，可以在系统配置期间将其编程为相反状态一次。配置寄存器 3 的易失性版本允许在系统运行或测试期间更改配置。

### 8.6.5.1 配置寄存器 3 非易失性 (CR3NV)

相关指令：读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)。

表 39 配置寄存器 3 非易失性 (CR3NV)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	RFU	Reserved	OTP	0	Reserved for Future Use
6	RFU	Reserved		0	Reserved for Future Use
5	BC_NV	Blank Check		0	1 = Blank Check during erase enabled 0 = Blank Check disabled
4	02h_NV	Page Buffer Wrap		0	1 = Wrap at 512 bytes 0 = Wrap at 256 bytes
3	20h_NV	4-KB Erase		0	1 = 4-KB Erase disabled (Uniform Sector Architecture) 0 = 4-KB Erase enabled (Hybrid Sector Architecture)
2	30h_NV	Clear Status / Resume Select		0	1 = 30h is Erase or Program Resume command 0 = 30h is clear status command
1	D8h_NV	Block Erase Size		0	1 = 256-KB Erase 0 = 64-KB Erase
0	F0h_NV	Legacy Software Reset Enable		0	1 = F0h software reset is enabled 0 = F0h software reset is disabled (ignored)

**空检非易失性 CR3NV[5]：**该位控制着空检期间的POR、硬件复位或软件复位状态。

**02h 非易失性 CR3NV[4]：**该位控制页编程缓冲地址回卷的POR、硬件复位或软件复位状态。

**20h 非易失性 CR3NV[3]：**该位控制存储器阵列地址中分布的 4-kB 参数扇区可用性的POR、硬件复位或软件复位状态。

**30h 非易失性 CR3NV[2]：**此位控制使用的 30h 指令代码的 POR、硬件复位或软件复位状态。

**D8h 非易失性 CR3NV[1]：**此位控制配置的 POR、硬件复位或软件复位状态，以确定由 D8h 或 DCh 指令擦除的区域的大小。

**F0h 非易失 CR3NV[0]：**该位控制英飞凌传统 FL-S 系列软件复位指令可用性的POR、硬件复位或软件复位状态。

地址空间映射

### 8.6.5.2 配置寄存器 3 易失性 (CR3V)

相关指令：读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)。

表 40 配置寄存器 3 易失性 (CR3V)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	RFU	Reserved	Volatile	CR3NV	Reserved for Future Use
6	RFU	Reserved			Reserved for Future Use
5	BC_V	Blank Check			1 = Blank Check during erase enabled 0 = Blank Check disabled
4	02h_V	Page Buffer Wrap			1 = Wrap at 512 bytes 0 = Wrap at 256 bytes
3	20h_V	4-KB Erase	Volatile, Read Only		1 = 4-KB Erase disabled (Uniform Sector Architecture) 0 = 4-KB Erase enabled (Hybrid Sector Architecture)
2	30h_V	Clear Status / Resume Select	Volatile		1 = 30h is Erase or Program Resume command 0 = 30h is Clear Status command
1	D8h_V	Block Erase Size			1 = 256-kB Erase 0 = 64-kB Erase
0	F0h_V	Legacy Software Reset Enable			1 = F0h software reset is enabled 0 = F0h software reset is disabled (ignored)

**白检易失性 CR3V[5]:** 该位控制着擦除功能时的空白检查。当这个功能使能时，擦除指令首先评估扇区的擦除状态。如果发现扇区未成功执行其最后一个扇区擦除，则该扇区将被无条件擦除。如果最后一次擦除成功，则读取扇区以确定扇区是否已被擦除（空白）。找到任何编程的0后，立即开始执行操作。如果扇区已经为空白（未找到编程的0位），则跳过扇区擦除操作。当扇区已被擦除时不需要进行扇区擦除操作时，可以大大减少擦除扇区时间。使能的空检功能，可以在参数扇区擦除，扇区擦除和Bulk擦除命令中使用。当空检被禁用时，擦除指令无条件地执行。

**02h 易失性 CR3V[4]:** 该位控制页编程缓冲区地址大小。传统的SPI设备通常使用 256 字节页编程缓冲区，并定义如果数据加载到故障中超出 255 字节位置，则加载额外字节的地址将被回卷到缓冲区的0地址。S25FS-S系列提供了512字节的页编程缓冲区，可以提高编程性能。为了兼容旧版软件，此配置位提供了继续在 256 字节边界处进行回卷行为的选项，或者通过不在 256 字节边界处回卷加载地址来充分利用可用的 512 字节缓冲区。

**地址空间映射**

**20h 易失性 CR3V[3]：**该位控制存储器阵列地址中分布 4-KB 参数扇区的可用性。参数扇区可以处在器件的最高或最低 32-KB 地址范围，也可以从地址分布中移除它们，以便所有扇区大小统一。该位不得写入与 CR3NV[3] 的值不同的值。CR3V[3]的值只能通过写入CR3NV[3]来改变。

**30h 易失性 CR3V[2]：**该位控制 30h 指令代码的使用方式。该指令可用作清零，复位状态指令或替代编程/擦除恢复指令。这使得软件与英飞凌传统SPI设备或备用供应商设备兼容。

**D8h 易失性 CR3V[1]：**此位控制由 D8h 或 DCh 指令擦除的区域。该指令可用于擦除 64 kB 物理扇区或 256 KB 大小和对齐的块。在较低容量成员中擦除 256 KB 块的选项允许在所有容量上实现一致的软件行为，从而简化不同容量之间的迁移。

**F0h 易失性 CR3V[0]：**该位控制英飞凌传统 FL-S 系列软件复位指令的可用性。S25FS-S家族支持业界通用的66h + 99h指令序列进行软件复位。该配置位允许选择继续使用传统的 F0h 单指令进行软件复位。

地址空间映射

## 8.6.6 配置寄存器 4

配置寄存器 4 控制存储器阵列读取指令突发回卷行为。突发回卷配置不会影响从存储器阵列以外的区域读取指令，例如 寄存器或OTP阵列的读取指令。当在POR、硬件复位或软件复位期间将。寄存器的非易失性版本能够复制内容到寄存器的易失性版本来设置控件的启动 (boot) 状态。寄存器的易失性控制正常操作期间的行为。可以使用读取任何寄存器和写入任何寄存器指令来读取和更改寄存器位。寄存器的易失性版本也可以通过置位突发长度 (C0h) 指令写入。

### 8.6.6.1 配置寄存器 4 非易失性 (CR4NV)

相关指令：读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)。

表 41 配置寄存器 4 非易失性 (CR4NV)

Bits	Field name	Function	Type	Default t	Description
7	OI_O	Output Impedance	OTP	0	See <b>Table 42</b>
6				0	
5				0	
4	WE_O	Wrap Enable		1	0 = Wrap Enabled 1 = Wrap Disabled
3	RFU	Reserved		0	Reserved for Future Use
2	RFU	Reserved		0	Reserved for Future Use
1	WL_O	Wrap Length		0	00 = 8-byte wrap 01 = 16-byte wrap 10 = 32-byte wrap 11 = 64-byte wrap
0				0	

**输出阻抗非易失性 CR4NV[7:5]：**这些位控制 IO 信号输出阻抗（驱动强度）的POR、硬件复位或软件复位状态。多种驱动强度可帮助将输出阻抗与系统印刷电路板环境相匹配，以最大限度地减少过冲和振铃。这些非易失的输出阻抗配置位使器件能够以适当的驱动强度立即启动 (boot) 。

表 42 输出阻抗控制

CR4NV[7:5] impedance selection	Typical impedance to $V_{SS}$ ( $\Omega$ )	Typical impedance to $V_{CC}$ ( $\Omega$ )	Notes
000	47	45	Factory default
001	124	105	–
010	71	64	–
011	47	45	–
100	34	35	–
101	26	28	–
110	22	24	–
111	18	21	–

地址空间映射

**回卷使能非易失性 CR4NV[4]:** 该位控制回卷使能的POR、硬件复位或软件复位状态。受 Wrap 使能影响的指令有：Quad I/O Read 和 DDR Quad I/O Read。此配置位使器件能够以回卷突发读取模式立即启动（boot），而不是传统的顺序读取模式。

**回卷长度非易失性 CR4NV[1:0]:** 这些位控制回卷读取长度和对齐的POR、硬件复位或软件复位状态。这些非易失性的配置位使器件能够以回卷突发读取模式而不是传统的顺序读取模式立即启动（boot）。

**8.6.6.2 配置寄存器 4 易失性 (CR4V)**

相关指令：读任何寄存器（RDAR 65h）、写任何寄存器（WRAR 71h）、置位突发长度（SBL C0h）。

表 43 配置寄存器 4 易失性（CR4V）

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7	OI	Output Impedance	Volatile	CR4NV	See Output Impedance Control ( <a href="#">Table 42</a> ) table
6					
5					
4	WE	Wrap Enable			0 = Wrap Enabled 1 = Wrap Disabled
3	RFU	Reserved			Reserved for Future Use
2	RFU	Reserved			Reserved for Future Use
1	WL	Wrap Length			00 = 8-byte wrap 01 = 16-byte wrap 10 = 32-byte wrap 11 = 64-byte wrap
0					

**输出阻抗 CR2V[7:5]:** 这些位控制 IO 信号输出阻抗（驱动强度）。此易失性输出阻抗配置位使用户能够在正常运行期间调整驱动强度。

**回卷使能 CR4V[4]:** 该位控制突发回卷特点。这种易失性配置位使器件能够在正常操作期间进入和退出突发回卷读取模式。

**回卷长度 CR4V[1:0]:** 这些位控制正常操作期间的回卷读取长度和对齐。这些易失性配置位使用户能够在正常操作期间调整突发回卷读取长度。

地址空间映射

### 8.6.7 ECC 状态寄存器 (ECCSR)

相关指令：ECC读取 (ECCRD 18h 或 19h)。ECCSR 没有用户可编程的非易失性位，所有定义的位都是易失性只读状态。这些位的默认状态是由硬件置位的。

每个ECC单元的ECC状态由8位ECC状态寄存器(ECCSR)提供。ECC寄存器读取命令后跟着ECC单位地址。状态寄存器的内容则显示对于所选择的ECC单位，在ECC单元、ECC单元数据是否有错误，或者ECC该ECC单元是否被禁用。

表 44 ECC 状态寄存器 (ECCSR)

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7 to 3	RFU	Reserved		0	Reserved for Future Use
2	EECC	Error in ECC	Volatile, Read only	0	1 = Single Bit Error found in the ECC unit error correction code 0 = No error
1	EECCD	Error in ECC unit data	Volatile, Read only	0	1 = Single Bit Error corrected in ECC unit data 0 = No error
0	ECCDI	ECC Disabled	Volatile, Read only	0	1 = ECC is disabled in the selected ECC unit 0 = ECC is enabled in the selected ECC unit

ECCSR[2] = 1 表示 ECC 中的错误已得到纠正。ECCSR[1] = 1 表示ECC单位/装置数据中的错误已更正。ECCSR[0] = 1 表示 ECC 被禁用。所有这些位的默认状态为“0”，表示没有错误且ECC使能。

ECCSR[7:3]被保留。它们的值（高或低）不确定，每次状态读取的值不一定相同。软件读取状态时，这些位应忽略，而不用考虑。

地址空间映射

## 8.6.8 ASP 寄存器 (ASPR)

相关指令：ASP 读取 (ASPRD 2Bh) 和 ASP 编程 (ASPP 2Fh)、读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)。

ASP 寄存器是一个 16 位 OTP 储存空间，用于永久配置高级扇区保护 (ASP) 功能的行为。ASPR 没有用户可编程的易失性位，所有定义的位都是 OTP。

ASPR 位的默认状态由英飞凌编程。

**表 45 ASP 寄存器 (ASPR)**

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
15 to 9	RFU	Reserved	OTP	1	Reserved for Future Use
8	RFU	Reserved	OTP	1	Reserved for Future Use
7	RFU	Reserved	OTP	1	Reserved for Future Use
6	RFU	Reserved	OTP	1	Reserved for Future Use
5	RFU	Reserved	OTP	1	Reserved for Future Use
4	RFU	Reserved	RFU	1	Reserved for Future Use
3	RFU	Reserved	RFU	1	Reserved for Future Use
2	PWDMLB	Password Protection Mode Lock Bit	OTP	1	0 = Password Protection mode permanently enabled 1 = Password Protection mode not permanently enabled
1	PSTMLB	Persistent Protection Mode Lock Bit	OTP	1	0 = Persistent Protection mode permanently enabled 1 = Persistent Protection mode not permanently enabled
0	RFU	Reserved	RFU	1	Reserved for Future Use

**密码保护模式锁定位 (PWDMLB) ASPR[2]：**当编程为“0”时，将永久选择密码保护模式。

**永久保护模式锁定位 (PSTMLB) ASPR[1]：**当编程为‘0’时，表示永久选择持久保护模式。

PWDMLB (ASPR[2]) 和 PSTMLB (ASPR[1]) 互斥，只能将其中一个编程为 0。

仅当 ASPR[2:1] = 11b 时才可对 ASPR 位进行编程。当 ASPR[2:1] 不为 11b 时尝试对 ASPR 位进行编程将导致编程错误，并且 P\_ERR (SR1V[6]) 置位为“1”。通过编程 ASPR[2:1] = 10b 或 01b 选择 ASP 保护模式后，所有 ASPR 位的状态都将被锁定并永久受到保护，以防止进一步编程。尝试编程 ASPR[2:1] = 00b 将导致编程错误，P\_ERR (SR1V[6]) 置位为‘1’。

类似地，ASP 寄存器描述中列出的 OTP 配置位（请参阅 86 页“ASP 寄存器”），仅当 ASPR[2:1] = 11b 时才可以编程。必须在选择 ASP 保护模式之前选择 OTP 配置。选择 ASP 保护模式后，OTP 配置位将永久受到保护，不会再次更改。在 ASPR[2:1] 不 = 11b 时尝试编程这些 OTP 配置位将导致编程错误，P\_ERR (SR1V[6]) 置位为“1”。

应在系统配置期间选择 ASP 保护模式，以确保不会有非期望的恶意编程的保护模式。通过 ASP 模式选择锁定所有保护配置，可防止恶意编程随后更改保护方法。

地址空间映射

### 8.6.9 密码寄存器 (PASS)

相关指令：密码读取 (PASSRD E7h) 和密码编程 (PASSP E8h)、读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)。PASS 寄存器是一个 64 位 OTP 内存位置，用于永久定义高级扇区保护 (ASP) 特点。PASS 没有用户可编程的易失性位，所有定义的位都是 OTP。PASS 的易失性副本用于满足读取延时要求，但易失性寄存器不是用户可写入的，也没有更深的描述。

**表 46 密码寄存器 (PASS)**

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
63 to 0	PWD	Hidden Password	OTP	FFFFFFFF-FFFFFFFFh	Non-Volatile OTP storage of 64-bit password. The password is no longer readable after the password protection mode is selected by programming ASP register bit 2 to 0.

### 8.6.10 PPB 锁定寄存器 (PPBL)

相关指令：PPB 锁定读取 (PLBRD A7h、PLBWR A6h)、读取任何寄存器 (RDAR 65h)。

PPBL 没有单独的用户可编程非易失性位，所有定义的位都是易失性只读状态。RFU 位的默认状态是由硬件置位。PPBLOCK 位的默认状态由 ASPR[2:1] 中的 ASP 保护模式位定义。PPBL 寄存器没有非易失性版本。

PPBLOCK 位用于保护 PPB 位。当 PPBL[0] = 0 时，PPB 位不可编程。

**表 47 PPB 锁定寄存器 (PPBL)**

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7 to 1	RFU	Reserved	Volatile	00h	Reserved for Future Use
0	PPBLOCK	Protect PPB Array	Volatile Read Only	ASPR[2:1] = 1xb = Persistent Protection Mode = 1 ASPR[2:1] = 01b = Password Protection Mode = 0	0 = PPB array protected 1 = PPB array may be programmed or erased

### 8.6.11 PPB 访问寄存器 (PPBAR)

相关指令：PPB 读取 (PPBRD FCh 或 4PPBRD E2h)、PPB 编程 (PPBP FDh 或 4PPBP E3h)、PPB 擦除 (PPBE E4h)。

PPBAR 没有用户可写的易失性位，所有 PPB 阵列位都是非易失性的。PPB 阵列的默认状态被英飞凌擦除为 FFh。PPBAR 寄存器没有易失性版本。

**表 48 PPB 访问/访问寄存器 (PPBAR)**

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7 to 0	PPB	Read or Program per sector PPB	Non-Volatile	FFh	00h = PPB for the sector addressed by the PPBRD or PPBP command is programmed to '0', protecting that sector from program or erase operations. FFh = PPB for the sector addressed by the PPBRD command is '1', not protecting that sector from program or erase operations.

地址空间映射

### 8.6.12 DYB访问寄存器 (DYBAR)

相关指令：DYB读 (DYBRD FAh 或 4DYBRD E0h) 和DYB写 (DYBWR FBh 或 4DYBWR E1h)。

DYBAR 没有用户可编程的非易失性位，所有位都是 DYB 阵列中易失性位的表示。DYB阵列位的默认状态是硬件置位。DYBAR 寄存器没有非易失性版本。

**表 49 DYB访问寄存器 (DYBAR)**

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7 to 0	DYB	Read or Write per sector DYB	Volatile	FFh	00h = DYB for the sector addressed by the DYBRD or DYBWR command is cleared to '0', protecting that sector from program or erase operations. FFh = DYB for the sector addressed by the DYBRD or DYBWR command is set to '1', not protecting that sector from program or erase operations.

### 8.6.13 SPI DDR 数据学习寄存器

相关指令：编程 NVDLR (PNVDLR 43h)、写入 VDLR (WVDLR 4Ah)、数据学习模型读取 (DLPRD 41h)、读取任何寄存器 (RDAR 65h)、写入任何寄存器 (WRAR 71h)。

数据学习模型 (DLP) 驻留在 8 位非易失性数据学习寄存器 (NVDLR) 和 8 位易失性学习寄存器 (VDLR) 中。从英飞凌出厂时，NVDLR 值为 00h。一旦编程，NVDLR 就不能被重新编程或擦除；NVDLR 中的数据模型的副本也将写入 VDLR。VDLR 可以随时写入，但在复位或上电周期时，数据模型将恢复到 NVDLR 中的内容。在 SPI DDR 模式中描述的学习过程中，DLP 将来自 VDLR。每个 IO 将在每个时钟边沿输出相同的 DLP 值。例如，如果 DLP 为 34h (或二进制 00110100)，则在第一个时钟边期间，所有 IO 将输出 0；随后，沿所有 I/O 的第二个时钟边将输出 0，第三个时钟边将输出 1，依此类推。

当 VDLR 值为 00h 时，DDR 指令中的虚拟阶段期间不会出现前导码数据模型。

**表 50 非易失性数据学习寄存器 (NVDLR)**

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7 to 0	NVDLP	Non-Volatile Data Learning Pattern	OTP	00h	OTP value that may be transferred to the host during DDR read command latency (dummy) cycles to provide a training pattern to help the host more accurately center the data capture point in the received data bits.

**表 51 易失性数据学习寄存器 (VDLR)**

Bits	Field name	Function	Type	Default state	Description
7 to 0	VDLP	Volatile Data Learning Pattern	Volatile	Takes the value of NVDLR during POR or Reset	Volatile copy of the NVDLP used to enable and deliver the Data Learning Pattern (DLP) to the outputs. The VDLP may be changed by the host during system operation.

## 9 数据保护

### 9.1 安全硅区 (OTP)

该器件有一个 1024 字节的 one-time program (OTP) 地址空间，与存储器阵列分开。OTP 区域分为 32 个可单独锁定、32 字节对齐和长度的区域。

OTP 存储空间旨在提高系统安全性。OTP 值可以将闪存器件与 CPU/ASIC 系统“配对”，以防止器件替换。请参阅 57 页“OTP 地址空间”，138 页“OTP 编程 (OTPP 42h)”，以及 138 页“OTP Read (OTPR 4Bh)”。

#### 9.1.1 读取 OTP 空间

OTP 读取命令使用与快速读取相同的协议。有效 1 kB OTP 地址范围之外的 OTP 读取操作将产生不确定的数据。

#### 9.1.2 编程 OTP 存储空间

OTP 编程指令的协议与页编程相同。OTP 编程指令可以多次发出到任何给定的 OTP 地址，但该地址空间永远不能被擦除。

在对每个 16 字节区域进行第一次编程操作时，会自动对 ECC 进行编程。在 16 字节区域内多次编程会禁用 ECC。建议对每个 32 字节区域的每个 16 字节部分编程一次，以便 ECC 保持可用，以提供最佳的数据错误。

OTP 编程的有效地址范围如图 47。有效 OTP 地址范围之外的编程操作将被忽略，SR1V 置位中的 P\_ERR 不会设置为 1。在有效 OTP 地址范围内做编程操作，当 FREEZE = 1 时，将会失败，SR1V 置位中的 P\_ERR 会设置为“1”。OTP 地址空间不受选择 ASP 保护模式的保护。冻结位 (CR1V[0]) 可用于保护 OTP 地址空间。

#### 9.1.3 英飞凌编程随机数

英飞凌的标准做法是使用线性同余随机数方法用 128 位随机数对 OTP 低地址 16 字节（位置 0x0 至 0xF）进行编程。该算法的种子值是一个随机数，与测试器插入的日期和时间连接起来。

#### 9.1.4 锁定字节

每个锁定字节的低字节保护与字节相关的最低地址区域，高字节保护与字节相关的最高地址区域。下一个更高的地址字节同样保护下一个更高的 8 个区域。最低地址锁定字节的低字节位保护最低地址区域的较高地址 16 字节。换句话说，位置 0x10 的低字节保护最低地址区域中的所有锁定字节和 RFU 字节，避免进一步编程。参阅页 57 上的“OTP 地址空间”。

数据保护

## 9.2 写使能指令

写入使能 (WREN) 指令必须在于任何修改非易失数据的指令之前发布。WREN 指令设置写使能锁存器 (WEL) 位。在上电、硬件复位期间或器件完成以下指令后，WEL 位被清除为“0”（禁用写入）：

- RESET (复位)
- 页编程 (PP 或 4PP)
- 参数扇区 4-kB 擦除 (P4E 或 4P4E)
- 扇区擦除 (SE 或 4SE)
- Bulk擦除 (BE)
- 写入禁止 (WRDI)
- 写寄存器 (WRR)
- 写任意寄存器 (WRAR)
- OTP 字节编程 (OTPP)
- 高级扇区保护寄存器编程 (ASPP)
- 持久保护位编程 (PPBP)
- 持久保护位擦除 (PPBE)
- 密码编程 (PASSP)
- 编程非易失性数据学习寄存器 (PNVDLR)

## 9.3 功能块保护

功能块保护位(状态寄存器位BP2、BP1、BP0)与配置寄存器TBPROT\_O位相结合，可用于保护主存储器阵列的地址范围免受编程和擦除操作的影响。范围的大小由 BP 位的值决定，范围的顶部或底部起点由配置寄存器 (CR1NV[5]) 的 TBPROT\_O 位选择。

表 52 顶部阵列起始保护 (TBPROT\_O = 0)

Status register content			Protected fraction of memory array	Protected memory (KB)	
BP2	BP1	BP0		FS128S 128 Mb	FS256S 256 Mb
0	0	0	None	0	0
0	0	1	Upper 64th	256	512
0	1	0	Upper 32nd	512	1024
0	1	1	Upper 16th	1024	2048
1	0	0	Upper 8th	2048	4096
1	0	1	Upper 4th	4096	8192
1	1	0	Upper Half	8192	16384
1	1	1	All sectors	16384	32768

表 53 底部阵列起始保护 (TBPROT\_O = 1)

Status register content			Protected fraction of memory array	Protected memory (KB)	
BP2	BP1	BP0		FS128S 128 Mb	FS256S 256 Mb
0	0	0	None	0	0
0	0	1	Lower 64th	256	512
0	1	0	Lower 32nd	512	1024
0	1	1	Lower 16th	1024	2048
1	0	0	Lower 8th	2048	4096
1	0	1	Lower 4th	4096	8192
1	1	0	Lower Half	8192	16384
1	1	1	All sectors	16384	32768

当功能块保护启用时（即任何BP2-0置位为“1”），高级扇区保护（ASP）仍可用于保护不受功能块保护方案保护的扇区。如果在同一个扇区上同时使用 ASP 和功能块保护，则使用与该扇区相关的 ASP 和功能块保护的逻辑或。

### 9.3.1 冻结位

配置寄存器1 (CR1V[0]) 的0位是FREEZE 位。冻结位，当置位为“1”时，锁定功能块保护控制位和OTP 区域的当前状态，直到下一个上下电周期。更多详细信息请参阅页 66 的“配置寄存器 1 易失性 (CR1V)”。

### 9.3.2 写入保护信号

写保护 (WP#) 输入与状态寄存器写禁止使能 (SRWD) 位 (SR1NV[7]) 相结合，提供硬件输入信号控制保护。当 WP# 为低电平且 SRWD 置位为“1”时，状态寄存器 1 (SR1NV 和 SR1V) 和配置寄存器1 (CR1NV 和 CR1V) 受到保护，不被更改。这可以防止禁用或更改功能块保护位定义的保护。请参阅页60“状态寄存器1”。

## 9.4 高级扇区保护

高级扇区保护 (ASP) 是独立硬件和软件方法，用在任何或所有扇区中单独使用禁止或使能编程或擦除操作的名称。

每个主闪存阵列扇区都有一个与其相关的非易失性持久保护位 (PPB) 和易失性动态保护位 (DYB)。当任一位为“0”时，扇区受到保护，免受编程和擦除操作的影响。当易失性 PPB 锁定位为“0”时，PPB 位受到保护，避免编程和擦除。有两种方法可以管理 PPB 锁定位的状态：密码保护和持久保护。这些方法的概述如图 49 所示。

每个扇区的功能块保护和 ASP 保护设置在逻辑上进行“或”运算以定义每个扇区的保护，即如果任一机制正在保护某个扇区，则该扇区不能被编程或擦除。参阅 82 页“功能块保护”了解 BP2-0 位的完整细节。

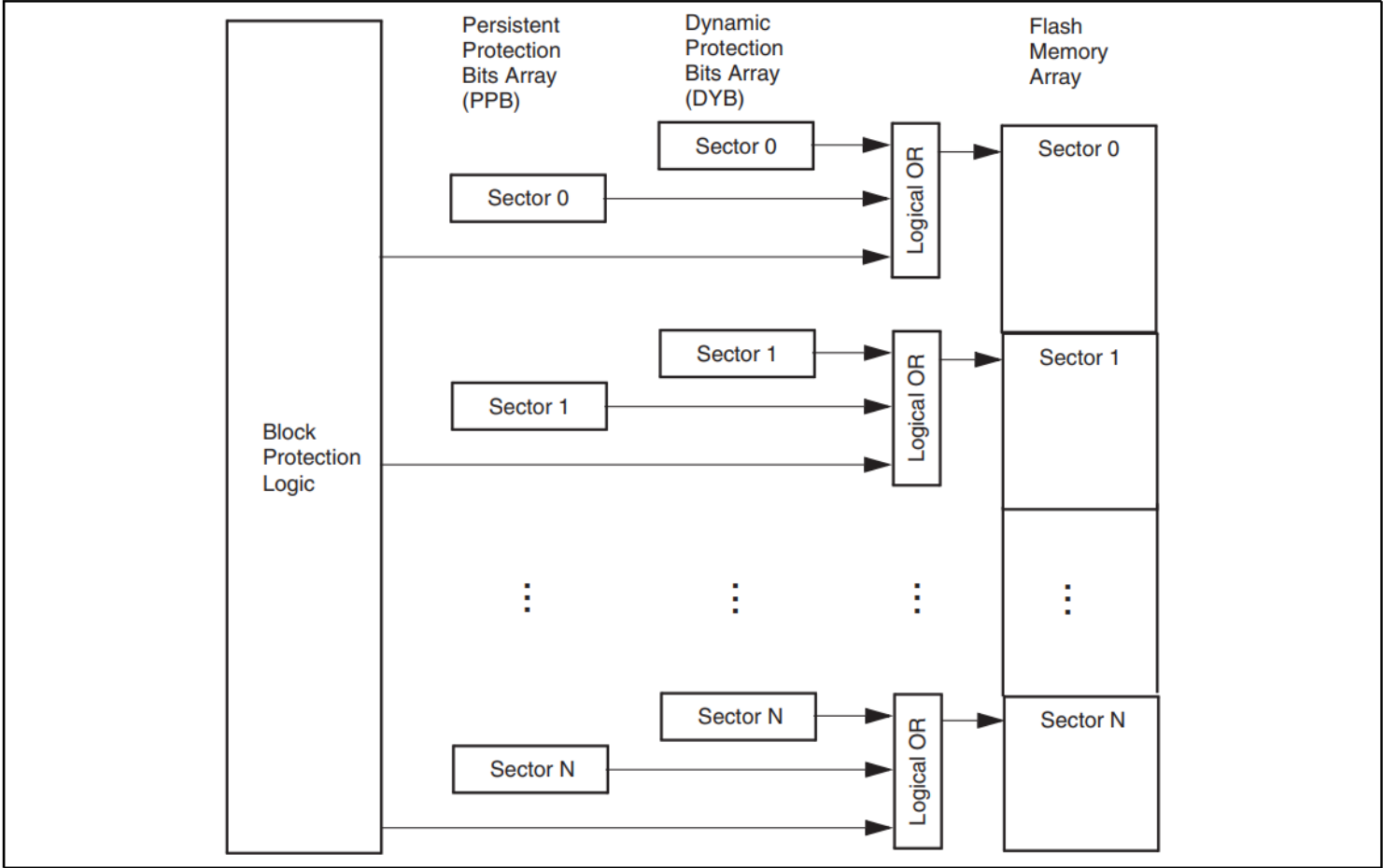


图 48 扇区保护控制

数据保护

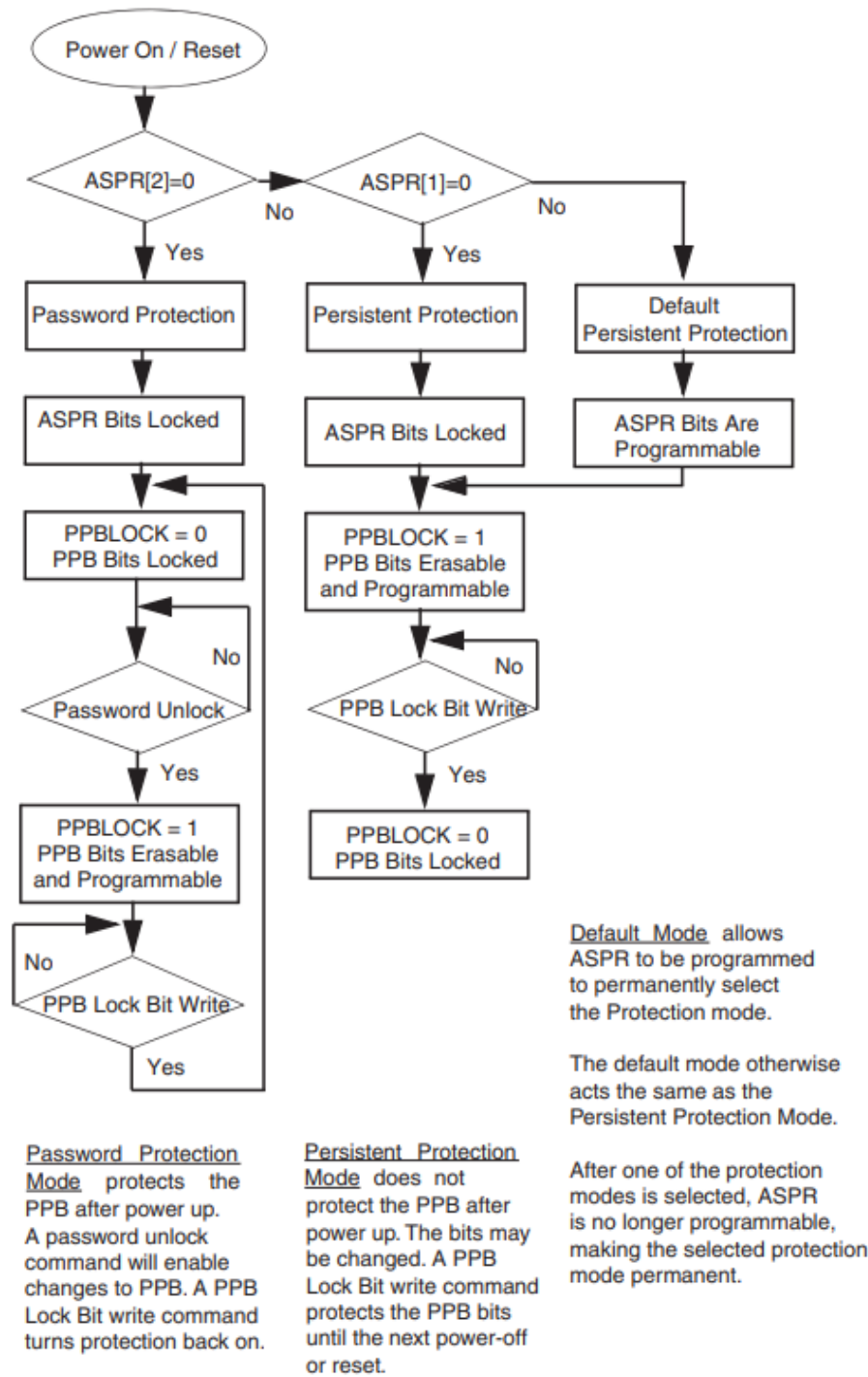


图 49 高级扇区保护概述

## 数据保护

持久保护方法在POR或硬件复位期间将PPB锁定位设为1，因此进行器件复位后PPB位为不保护状态。可以通过一个指令来将PPB锁定位清除为0，以保护PPB。持久保护方法没有任何指令可将PPB锁定位设为1，因此PPB锁定位一直为0，直到下一次下电或硬件复位为止。持久保护方法允许引导代码通过编程或擦除PPB来更改扇区保护，然后通过清除PPB锁定位在正常系统操作的剩余时间内保护PPB，不使其更改。这有时称为引导代码控制的扇区保护。

密码方法在POR或硬件复位期间将PPB锁定位清除为‘0’，以保护PPB。对于密码方法，可以永久地编程并隐藏一个64位密码。通过一个指令来提供一个密码，将其与隐藏密码进行比较。如果密码匹配，则PPB锁定位设为1，以取消PPB保护。PPB锁定位可以通过一个指令来清除为0。此方法需要使用密码来控制PPB保护。

通过编程锁定寄存器中的OTP位，可以永久性选择要使用的PPB锁定位管理方法。

### 9.4.1 ASP 寄存器

ASP 寄存器用于永久配置高级扇区保护 (ASP) 功能的行为。请参阅 78页上的“ASP 寄存器 (ASPR)”。

从工厂出厂时，所有器件在上电时均默认使用持久保护方法，所有扇区均不受保护。器件编程器或主机系统随后可以选择使用哪种扇区保护方法。对一次性可编程的区域，保护模式锁定位进行编程，可将永久地锁定在选定的模式下：

- ASPR[2:1] = “11” = 未选择 ASP 模式，持久保护模式为默认模式。
- ASPR[2:1] = “10” = 永久选择持久保护模式。
- ASPR[2:1] = “01” = 永久选择密码保护模式。
- ASPR[2:1] = “00” 是非法条件，尝试将多个位编程为零会导致编程失败。

ASP寄存器编程规则：

- 如果选择密码模式，必须在设置相应的锁定寄存器位之前编写密码。
- 一旦选择了保护模式，以下 OTP 配置寄存器位将受到永久保护，不能被编程，并且不允许对 OTP 寄存器位进行任何进一步的更改：
  - CR1NV[5:2]
  - CR2NV
  - CR3NV
  - CR4NV
  - ASPR
  - PASS
  - NVDLR
- 选择 ASP 模式后，如果尝试更改上述任何寄存器，操作将失败并且 P\_ERR (SR1V[6]) 将被置位为‘1’。

ASP 寄存器的编程时间与典型的编程时间相同。系统可以通过读取状态寄存器中的 WIP 位来确定 ASP 寄存器编程操作的状态。请参阅60页“状态寄存器1”有关 WIP的信息。参见88页“扇区保护状态概括”。

## 9.4.2 持久保护位 (PPB)

持久保护位 (PPB) 位于单独的非易失性闪存阵列中。为每个扇区分配一个PPB位。当一个PPB位为0时，相应的扇区受到保护，不能对它执行编程和擦除操作。PPB位可单独编程，但必须按组进行擦除。这与字相似，各个字可以在主阵列中单独编程，但整个扇区必须同时擦除。PPB 具有与主闪存阵列相同的编程和擦除耐久性。擦除前的预编程和验证由EAC执行。

编程一个PPB位需要典型的页编程时间。擦除所有PPB需要典型的扇区擦除时间。在 PPB 位编程和 PPB 位擦除期间，可以通过读取状态寄存器来获取状态。读取 PPB 位需要器件的初始读取时间。

## 9.4.3 动态保护位 (DYB)

DYB是易失性位，可以单独更改该位。每个扇区只有一个唯一的DYB。DYB只控制那些已清除PPB的扇区的保护。通过发出DYB写入命令，DYB被清除为'0'或置位为'1'，从而分别将每个扇区置于受保护或不受保护状态。使用该功能，可以轻易保护扇区，避免意外改变相应扇区。另外需要更改时也可以轻易取消对其保护。由于DYB是易失性位，因此可以根据需要随时置位或清除。

## 9.4.4 PPB 锁定位 (PPBL[0])

PPB 锁定位是用于保护所有 PPB 位的易失性位。当设置为 '0' 时，它将锁定所有 PPB；当设置为 '1' 时，它将允许更改 PPB。请参阅79页“PPB 锁定寄存器 (PPBL)”了解更多信息。

PLBWR 用于将PPB锁定位清零。只有当所有PPB位均配置为所需的设置后，才将PPB锁定位清零。

在持久保护模式下，PPB锁定在POR或硬件复位期间被设为1。清除后，所有软件指令序列都不能设置PPB锁定位，只有通过硬件复位或上电才能设置PPB锁定位。

在密码保护模式下，PPB锁定位在POR或硬件复位期间被清除为0。PPB锁定位只能通过密码解锁指令设为1。

### 注：

43. 每个 PPB 都单独编程为“0”，并且所有 PPB 都并行擦除为“1”。
44. 如果PPB锁定位为0，PPB编程或擦除指令不被执行，并且被超时。
45. 可以使用 PPB 读取命令来验证给定扇区的 PPB 状态。

数据保护

### 9.4.5 扇区保护状态汇总

每个扇区均可以处于下面一种保护状态：

- 解锁-扇区不受保护，保护状态可通过一个简单的指令进行更改。该器件从英飞凌发货时，保护状态默认为不受保护。
- 动态锁定-扇区受保护，保护状态可通过一个简单的指令进行更改。在上下电或硬件复位后，保护状态不被保存。
- 持久锁定-扇区受保护，只有将PPB锁定位设置为1时才能更改保护状态。保护状态是非易失性的，在上下电或硬件复位后仍被保存。更改保护状态需要编程或擦除PPB位。

表54 扇区保护状态

Protection bit values			Sector state
PPB lock	PPB	DYB	
1	1	1	Unprotected – PPB and DYB are changeable.
1	1	0	Protected – PPB and DYB are changeable.
1	0	1	Protected – PPB and DYB are changeable.
1	0	0	Protected – PPB and DYB are changeable.
0	1	1	Unprotected – PPB not changeable, DYB is changeable.
0	1	0	Protected – PPB not changeable, DYB is changeable.
0	0	1	Protected – PPB not changeable, DYB is changeable.
0	0	0	Protected – PPB not changeable, DYB is changeable.

### 9.4.6 持久保护模式

持久保护方法在POR或硬件复位期间将PPB锁定位设为1，因此进行器件复位后PPB位为不保护状态。软件复位不会影响PPB锁定位。可以通过一个指令来将PPB锁定位清除为0，以保护PPB。持久保护方法没有指令可设置PPB锁定位，因此PPB锁定位将一直为‘0’，直到下一次关闭电源或硬件复位为止。

### 9.4.7 密码保护模式

PPB密码保护模式使用64位密码来设置PPB锁定，因此能够提供比持久扇区保护模式级别更高的安全性。除了密码要求外，在上电和复位后，PPB锁定还清除为0以确保在上电时提供保护。通过输入整个密码并成功执行密码解锁指令后，PPB锁定将设为1，从而允许修改扇区PPB。

密码保护注意事项：

- 密码编程和验证后，必须设置密码模式锁定位，以防止读取密码。
- 密码编程指令只能编程“0”。在一个cell编程为‘0’之后，编程‘1’会导致cell保留为‘0’，而不会出现编程错误置位。
- 从英飞凌出厂时，密码64位全部是1。它位于自己的存储空间中，可通过使用密码编程和密码读取指令进行访问。
- 所有64位密码组合均为有效密码。

## 数据保护

- 一旦编程了密码模式锁定位，即可防止在数据总线上读取64位密码和进一步写入密码。对密码区域的所有进一步编程和读取指令都被禁用，并且这些指令被忽略或返回未定义的数据。编程了密码保护模式锁定位后，无法验证密码内容。只能在选择密码保护模式前进行密码验证。
- 保护模式锁定位不可擦除。
- 只有输入准确的密码，才能解锁。如果密码解锁指令提供的密码与隐藏的内部密码不匹配，则解锁操作将失败，其失败方式与受保护扇区上的编程操作相同。P\_ERR 位置位为“1”，WIP 位保持置位，PPB 锁定位保持清除为“0”。
- 密码解锁命令的接受频率不能快于每  $100\ \mu\text{s} \pm 20\ \mu\text{s}$  一次。这样，如果黑客试图通过实现所有64位组合来破解匹配密码，需要经过第一段不可思议的超长时间（5800万年）。读取状态寄存器 1 指令可用于读取 WIP 位，以确定器件何时完成密码解锁指令或准备好接受新密码指令。当提供有效密码时，密码解锁指令不会在将 WIP 位 返回为“0”之前插入  $100\ \mu\text{s}$  延迟。
- 如果在设置密码模式锁定位后密码丢失，没有办法可清除PPB锁定。
- 仅可从可读扇区读取 ECC 状态。在读保护模式下，地址被强制为引导扇区地址。ECC状态仅在该扇区内，而读保护模式是启用时的。

## 9.5 建议的保护流程

在系统制造过程中，闪存器件配置应按以下方式定义：

1. 根据需要对 CR1NV[5,3:2]、CR2NV、CR3NV 和 CR4NV 中的 OTP 配置位进行编程。
2. 根据需要对安全硅区域（OTP 区域）进行编程。
3. 根据需要通过 PPBP 指令对 PPB 位进行编程。
4. 如果将在 DDR 读取指令中使用，则对非易失性数据学习模型 (NVDLR) 进行编程。
5. 如果要使用密码保护，请对密码寄存器 (PASS) 进行编程。
6. 根据需要对 ASP 寄存器进行编程，包括选择持久或密码 ASP 保护模式输入 ASPR[2:1]。明确选择保护模式非常重要，这样可以防止以后对 ASP 寄存器和 OTP 配置进行意外或恶意编程。这是为了确保仅使能预期的OTP保护和配置功能。

在系统上电和引导代码执行期间：

1. 可信引导代码可以确定是否需要编程额外的SSR（OTP区域）信息。如果不需要更改SSR，则可以将 FREEZE 位 (CR1V[0]) 置位为“1”，以保护SSR在器件上电期间，正常系统操作其他时间内免受更改。
2. 如果使用持久保护模式，可信引导代码可以确定是否需要通过 PPBP 或 PPBE 指令修改持久 (PPB) 扇区保护。如果不需要更改 PPB，则可以通过 PPBL 将 PPBLOCK 位清除为“0”，以保护 PPB 位在器件上电期间正常系统操作在其他时间内免受更改。
3. 可以根据需要通过 DYBAR 写入动态 (DYB) 扇区保护位。

## 命令

## 10 命令

主控系统与S25FS-S系列存储器件之间的所有通讯均以命令为单位。

所有命令都以一条指令开始，该指令选择要执行的信息传输类型或器件执行操作。命令还可能具有地址、指令修饰符、延时时间、到闪存的数据传输或从闪存的数据传输。所有指令、地址和数据信息在主控系统和存储器件之间顺序传输。

命令协议也通过字符命名法进行分类，使用三个字符来标记三个指令阶段的传输宽度：

- 指令
- 地址和指令修饰符（模式）；
- 数据。

单比特命令只通过 SI 信号依次传输指令和地址或数据。数据可以通过 SO 信号串行发送回主控。对于单比特宽指令，单比特宽地址和修饰符、单比特数据的结构，被称为 1-1-1 命令协议。

双线或四线输入 / 输出 (I/O) 命令会按双比特一组的方式通过 IO0 和 IO1 将主机的数据传输给存储器，或按四比特（半字节）一组的方式通过 IO0、IO1、IO2 和 IO3 传输给存储器。数据返回到主控的方式类似于 IO0 和 IO1 上的位对，或者 IO0、IO1、IO2 和 IO3 上的四位（半字节）组。对于双线 I/O 和四线 I/O 命令，这种结构分别被称为 1-2-2 和 1-4-4 命令协议。

S25FS-S系列还支持QPI模式输入，所有信息都以4位宽度传输，包括指令、地址、修饰符和数据。这被称为 4-4-4 命令协议。

指令结构如下：

- 每个命令都以一个8位（字节）指令开始。但某些读命令被前一个读命令修改，因此该指令要从更早的命令中显示。这种形式被称为连续读取模式。器件处于连续读取模式时，由于该指令和用于初始化连续读取模式的读取命令相同，所以各个指令位不会在开始执行命令时被传输。在连续读取模式中，指令将以读取地址开始。因此，连续读取模式从一系列相同类型的读取命令中的每个读取命令中移除八位指令。
- 该指令可以是独立的，也可以跟随地址位以选择器件中多个地址空间之一内的位置。地址可以是 24 位或 32 位，字节边界，地址。
- 具有多个 IO 的串行外设接口为每次地址和数据信息的传输提供了并行地传输一位、两位或四位的选项。这使得信号连接数量（IO 总线宽度）和信息传输速度之间能够实现平衡。如果主控系统可以支持 2 位或 4 位宽的 IO 总线，则可以通过使用提供并行 2 位（双线）或并行 4 位（四线）传输的指令来提高存储器性能。
- 在传统 SPI 多 IO 模式下，指令之后的所有传输的宽度由发送的指令决定。以下表示的可能是其中一种传输类型：仅通过串行输入（SI）或串行输出（SO）信号单比特传输；通过 IO0 和 IO1 信号每次（双线）传输将以双比特的形式进行传输；或通过 IO0-IO3 信号每次（四线）以 4 比特的形式传输。在双比特或四比特组中，最低有效位位于 IO0 上。其他更高有效位则按照权值大小，通过 IO 信号的编号有序放置。单个位或并行位组按照从最高有效位到最低有效位的顺序进行传输。
- 在 QPI 模式下，所有传输（包括指令）的宽度都以 IO0-IO3 信号上的 4 位宽（四线）传输。
- 双线 I/O 和四线 I/O 读取指令在地址后发送一个称为模式位的指令修饰符，表示下一个命令将与隐含指令（而非显式指令）属于同一类型，并不是明确的命令。下一个命令不提供指令字节，只有新地址和模式位。当某个相同命令重复了前序中的命令类型时，会减少发送一个命令所需要的时间。

## 命令

- 地址或模式位后面可能跟有要存储在存储器器件中的写入数据，或者后面可能是读取数据返回到主控之前的读取延时时间。
- 读取延时可能为0到几个 SCK 周期（也称为虚拟周期）。
- 所有指令、地址、模式和数据信息均以字节为颗粒度传输。地址按最高有效字节首先移入器件中。所有数据都以首先发送最低地址字节的方式进行传输。后续数据字节按从最低到最高字节地址的顺序发送，即字节地址递增进行发送。
- 在编程、擦除或写入周期（嵌入式操作）期间读取闪存阵列的所有尝试都将被忽略。嵌入的操作将继续执行，不会受到任何影响。嵌入操作期间只能接受非常有限的指令集。这些信息在独立的指令描述中进行了介绍。当编程、擦除或写操作正在进行时，建议向器件发出大多数指令之前先检查写入进度（WIP）位是否为“0”，以确保可以接受新指令。
- 根据指令不同，执行时间也不同。一条命令可以从正在执行的指令中读取命令执行状态信息，用于确定命令执行完成情况以及这条命令是否执行成功。
- 虽然在某些情况下主控软件用于直接控制SPI 接口信号，主控系统和存储器器件的硬件接口通常处理信号关系和时序的任务。因此，本文的软件接口重点部分不详细介绍信号关系和时序。相反，重点是每个指令中传输的位的逻辑顺序，而不是信号时序和关系。以下是一些需要了解的常用信号关系描述。有关指令的位电平格式和信号时序关系的更多信息，请参阅第 17 页的“命令协议”。
  - 主控始终控制片选 (CS)、串行时钟 (SCK) 和串行输入 (SI) - SI用于单个的比特位传输。存储器驱动串行输出 (SO) 以进行单个的比特位读取传输。主控和存储器在双线和四线传输期间交替驱动 IO0–IO3 信号。
  - 所有命令都是从主控在驱动CS 为低电平来选择存储器后，SCK 第一个上升沿之前开始的。CS 在整个指令中保持低电平，当 CS 返回高电平时，命令结束。一般来说，CS#保持低电平以八位传输倍数来传输字节颗粒度信息。如果 CS 返回的高电平不在 8 位边界处，则某些指令将不被接受。

## 命令

### 10.1 命令集汇总

#### 10.1.1 扩展地址

为了兼容 128 Mb 以上的寻址，有两种选择：

1. 始终需要 4 字节地址的指令，用于访问最多 32 Gb 的存储器。

**表 55 指令名称和详细信息**

Command name	Function	Instruction (Hex)
4READ	Read	13
4FAST_READ	Read Fast	0C
4DIOR	Dual I/O Read	BC
4QIOR	Quad I/O Read	EC
4DDRQIOR	DDR Quad I/O Read	EE
4PP	Page Program	12
4P4E	Parameter 4-kB Erase	21
4SE	Erase 64/256 kB	DC
4ECCRD	ECC Status Read	18
4DYBRD	DYB Read	E0
4DYBWR	DYBWR	E1
4PPBRD	PPB Read	E2
4PPBP	PPB Program	E3

2. 4 字节地址模式，用于向下兼容 3 字节地址指令。标准的 3 字节指令可与由地址长度配置位 (CR2V[7]) 控制的 4 字节地址模式结合使用。CR2V[7] 的默认值从 CR2NV[7] 加载（上电、硬件复位或软件复位后），以使能默认的 3 字节（24 位）或 4 字节（32 位）寻址。当地址长度 (CR2V[7]) 设置为“1”时，传统命令更改为地址为 4 字节（32 位）地址。以下指令可与 4 字节地址模式配置结合使用，将地址字段从 3 字节切换到 4 字节。

**表 56 指令名称和详细信息**

Command name	Function	Instruction (Hex)
READ	Read	03
FAST_READ	Read Fast	0B
DIOR	Dual I/O Read	BB
QIOR	Quad I/O Read	EB
DDRQIOR	DDR Quad I/O Read)	ED
PP	Page Program	02
P4E	Parameter 4-kB Erase	20
SE	Erase 64 / 256 kB	D8
RDAR	Read Any Register	65
WRAR	Write Any Register	71
EES	Evaluate Erase Status	D0
OTPP	OTP Program	42

命令

表 56 指令名称和详细信息 (续)

Command name	Function	Instruction (Hex)
OTPR	OTP Read	4B
ECCRD	ECC Status Read	19
DYBRD	DYB Read	FA
DYBWR	DYBWR	FB
PPBRD	PPB Read	FC
PPBP	PPB Program	FD

命令

## 10.1.2 按功能分类命令汇总

表 57 S25FS-S 系列命令集 (按功能排序)

Function	Command name	Command description	Instruction value (Hex)	Maximum frequency (MHz)	Address length (Bytes)	QPI
Read Device ID	RDID	Read ID (JEDEC Manufacturer ID and JEDEC CFI)	9F	133	0	Yes
	RSFDP	Read JEDEC Serial Flash Discoverable Parameters	5A	50	3	Yes
	RDQID	Read Quad ID	AF	133	0	Yes
Register Access	RDSR1	Read Status Register 1	05	133	0	Yes
	RDSR2	Read Status Register 2	07	133	0	No
	RDCR	Read Configuration Register 1	35	133	0	No
	RDAR	Read Any Register	65	133	3 or 4	Yes
	WRR	Write Register (Status 1, Configuration 1)	01	133	0	Yes
	WRDI	Write Disable	04	133	0	Yes
	WREN	Write Enable	06	133	0	Yes
	WRAR	Write Any Register	71	133	3 or 4	Yes
	CLSR	Clear Status Register 1 - Erase/Prog. Fail Reset This command may be disabled and the instruction value instead used for a program / erase resume command - see <b>“Configuration Register 3”</b> on page 72	30	133	0	Yes
	CLSR	Clear Status Register 1 (alternate instruction) - Erase/Prog. Fail Reset	82	133	0	Yes
	4BAM	Enter 4-byte Address Mode	B7	133	0	No
	SBL	Set Burst Length	C0	133	0	No
	EES	Evaluate Erase Status	D0	133	3 or 4	Yes
Register Access	ECCRD	ECC Read	19	133	3 or 4	Yes
	4ECCRD	ECC Read	18	133	4	Yes
	DLPRD	Data Learning Pattern Read	41	133	0	No
	PNVDLR	Program NV Data Learning Register	43	133	0	No
	WVDLR	Write Volatile Data Learning Register	4A	133	0	No

注:

46. 如果在器件处于 QPI 模式时发送 QPI 模式下不支持的指令，则会出现未定义的行为。

命令

表 57 S25FS-S 系列命令集 (按功能排序)(续)

Function	Command name	Command description	Instruction value (Hex)	Maximum frequency (MHz)	Address length (Bytes)	QPI
Read Flash Array	READ	Read	03	50	3 or 4	No
	4READ	Read	13	50	4	No
	FAST_READ	Fast Read	0B	133	3 or 4	No
	4FAST_READ	Fast Read	0C	133	4	No
	DIOR	Dual I/O Read	BB	66	3 or 4	No
	4DIOR	Dual I/O Read	BC	66	4	No
	QIOR	Quad I/O Read	EB	133	3 or 4	Yes
	4QIOR	Quad I/O Read	EC	133	4	Yes
	DDRQIOR	DDR Quad I/O Read	ED	80	3 or 4	Yes
	4DDRQIOR	DDR Quad I/O Read	EE	80	4	Yes
Program Flash Array	PP	Page Program	02	133	3 or 4	Yes
	4PP	Page Program	12	133	4	Yes
Erase Flash Array	P4E	Parameter 4-kB Sector Erase	20	133	3 or 4	Yes
	4P4E	Parameter 4-kB Sector Erase	21	133	4	Yes
	SE	Erase 64 kB or 256 kB	D8	133	3 or 4	Yes
	4SE	Erase 64 kB or 256 kB	DC	133	4	Yes
	BE	Bulk Erase	60	133	0	Yes
	BE	Bulk Erase (alternate instruction)	C7	133	0	Yes
Erase /Program Suspend /Resume	EPS	Erase / Program Suspend	75	133	0	Yes
	EPS	Erase / Program Suspend (alternate instruction)	85	133	0	Yes
	EPS	Erase / Program Suspend (alternate instruction)	B0	133	0	Yes
	EPR	Erase / Program Resume	7A	133	0	Yes
	EPR	Erase / Program Resume (alternate instruction)	8A	133	0	Yes
	EPR	Erase / Program Resume (alternate instruction) This command may be disabled and the instruction value instead used for a clear status command - see <a href="#">“Configuration Register 3”</a> on page 72	30	133	0	Yes
One-Time Program Array	OTPP	OTP Program	42	133	3 or 4	No
	OTPR	OTP Read	4B	133	3 or 4	No

注:

46.QPI 模式下不支持的指令如果在器件处于 QPI 模式时发送, 则会出现未定义的行为。

命令

表 57 S25FS-S 系列命令集 (按功能排序)(续)

Function	Command name	Command description	Instruction value (Hex)	Maximum frequency (MHz)	Address length (Bytes)	QPI
Advanced Sector Protection	DYBRD	DYB Read	FA	133	3 or 4	Yes
	4DYBRD	DYB Read	E0	133	4	Yes
	DYBWR	DYB Write	FB	133	3 or 4	Yes
	4DYBWR	DYB Write	E1	133	4	Yes
	PPBRD	PPB Read	FC	133	3 or 4	No
	4PPBRD	PPB Read	E2	133	4	No
	PPBP	PPB Program	FD	133	3 or 4	No
	4PPBP	PPB Program	E3	133	4	No
	PPBE	PPB Erase	E4	133	0	No
	ASPRD	ASP Read	2B	133	0	No
	ASPP	ASP Program	2F	133	0	No
	PLBRD	PPB Lock Bit Read	A7	133	0	No
	PLBWR	PPB Lock Bit Write	A6	133	0	No
	PASSRD	Password Read	E7	133	0	No
	PASSP	Password Program	E8	133	0	No
	PASSU	Password Unlock	E9	133	0	No
Reset	RSTEN	Software Reset Enable	66	133	0	Yes
	RST	Software Reset	99	133	0	Yes
	RESET	Legacy Software Reset	F0	133	0	No
	MBR	Mode Bit Reset	FF	133	0	Yes
DPD	DPD	Enter Deep Power-Down Mode	B9	133	0	Yes
	RES	Release from Deep Power-Down Mode	AB	133	0	Yes

注:

46. 如果在器件处于 QPI 模式时发送 QPI 模式下不支持的指令，则会出现未定义的行为。

## 命令

### 10.1.3 读取器件标识

有多个指令可以读取有关器件制造商、器件类型和器件功能的信息。不同供应商的SPI存储器使用不同的命令和格式来读取有关存储器的信息。S25FS-S系列支持三种器件信息命令。

### 10.1.4 寄存器读取或写入

有多个寄存器用于显示嵌入式操作状态或控制器件配置选项。有用于读取或写入这些寄存器的命令。寄存器包含易失性位和非易失性位。寄存器中的非易失性位单次（写入）操作，将被自动擦除和编程。

#### 10.1.4.1 监测操作状态

主控系统可以通过监测状态寄存器中的WIP位来确定写入、编程、擦除、暂停或其他嵌入式操作何时完成。读取状态寄存器 1 指令或读取任意状态寄存器指令提供 WIP 位的状态。状态寄存器中的编程错误 (P\_ERR) 和擦除错误 (E\_ERR) 位指示最近的编程或擦除指令是否未成功完成。当 P\_ERR 或 E\_ERR 位置位为 '1' 时，WIP 位将保持置位为 1，指示器件仍处于繁忙状态且无法接收最新操作指令。当 P\_ERR 或 E\_ERR 置位为 '1' 时，仅状态读取 (RDSR1 05h)、读取任意寄存器 (RDAR 65h)、状态清零，复位 (CLSR 30h 或 82h) 和软件复位 (RSTEN 66h、RST 99h 或复位 F0h) 是有效指令。必须先发送清零状态寄存器 (CLSR)，然后发送写禁止使能 (WRDI) 指令，才能将器件返回到待机状态。清零状态寄存器清除 WIP、P\_ERR 和 E\_ERR 位。WRDI 清除 WEL 位。或者，可以使用硬件复位或软件复位 (RST 或复位) 将器件返回到待机状态。

#### 10.1.4.2 拓扑结构

有一些指令用于读取、写入和保护寄存器，这些指令控制接口路径位宽、接口地址、接口地址长度以及数据保护的某些方面。

### 10.1.5 读存储器阵列

数据可以从任意字节界限开始从存储器中读取。数据字节按顺序从依次递增的字节地址读取，直到主控通过驱动 CS 输入高电平来结束数据传输。如果字节地址达到内存阵列的最大地址，则将从阵列的 0 地址处继续读取。

有几种不同的读取指令来指定不同的访问延时和数据传输/数据路径位宽。双倍数据速率(DDR) 指令还定义了 SCK 两个边沿的地址和数据位关系：

- 地址读取命令在 SI 信号上的每个 SCK 上升沿时提供一个位，读取数据在 SO 信号上的每个 SCK 下降沿返回一位数据。该指令在地址和返回数据之间具有 0 延时，但最大 SCK 速率限制为 50 MHz。
- 其他读指令在地址和返回数据之间有延时时间，但可以在更高的 SCK 频率下操作。延时取决于配置寄存器读取延时值。
- 快速读取命令在 SI 信号上的每个 SCK 上升沿提供一位，读取数据在 SO 信号上的每个 SCK 下降沿返回一位数据。
- 双线或四线 I/O 读取指令在 SCK 上升沿提供两位或四位地址，读取数据在 IO0–IO3 信号上每个 SCK 下降沿返回两位或四位数据。
- 四线双倍数据速率读取指令为每个 SCK 边沿提供四位地址，读取数据在 IO0–IO3 信号上的每个 SCK 边沿返回四位数据。

## 命令

### 10.1.6 编程闪存阵列

数据编程需要两个指令写入使能 (WREN) 和页编程 (PP)。页编程指令接受 1 字节到 256 或 512 个连续字节的数据 (页) 在一次操作中进行编程。编程意味着位可以保留为“1”，或者从“1”编程为“0”。将位从‘0’更改为‘1’需要执行擦除操作。

### 10.1.7 擦除闪存阵列

参数扇区擦除、扇区擦除或Bulk擦除指令将扇区或整个存储器中的所有位设置为“1”。需要先将某位擦除为“1”，然后编程才能将其更改为“0”。尽管可以单独对位从‘1’编程为‘0’，但将位从‘0’擦除为‘1’必须在扇区或阵列宽 (Bulk) 级别上进行擦除。写使能 (WREN) 指令必须位于擦除指令之前。

### 10.1.8 OTP、功能块保护和高级扇区保护

有一些指令可以读取和编程单独的一次性保护 (OTP) 阵列，以永久保护数据 (例如序列号)。有一些指令可以控制一个连续的扇形区组 (功能块)，这些扇形区受到编程和擦除操作的保护。有指令可以控制某些单独的扇区，针对编程和擦除操作的保护。

### 10.1.9 RESET (复位)

器件上电后有一些指令可将其复位为默认条件。然而，软件复位指令不影响FREEZE 或PPB 锁定位的当前状态。在所有其他方面，软件复位与硬件复位相同。

有一个指令用于读取 (退出) 连续读取模式。

### 10.1.10 DPD

FS-S 系列设备支持深度掉电 (DPD) 模式。如果器件已通过 DPD (B9h) 指令置于 DPD 模式，则接口待机电流为 IDPD。仅当器件未执行指示的嵌入式操作时，才接受 DPD 指令在状态寄存器 1 易失性写入。进度 (WIP) 位置被清零 (SR1V[0] = 0)。在 DPD 模式下，器件忽略除 DPD 释放 (RES ABh) 指令之外的所有指令，该指令将在 tRES延时后使器件返回到接口待机状态。

### 10.1.11 预留

某些指令保留供将来使用。在这一代 S25FS-S 系列中，其中一些指令可能未被使用且不会影响器件操作，有些则可能产生未定义的结果。

保留一些指令是为了确保允许使用传统或替代器件指令不产生任何影响。这使得旧版软件可以发出与当前一代 S25FS-S 系列无关的指令时，保证这些指令不会导致一些意外的操作。

一些指令被保留用于本文档未涉及的 FS-S 特殊版本或未来版本。这使得新的存储控制器设计能够灵活地规划发出这些指令指令。如果已知指令格式，则在发布此文档修订版时定义该格式。

命令

## 10.2 器件识别命令

### 10.2.1 读取标识 (RDID 9Fh)

读取标识 (RDID) 指令提供对制造商标识、器件标识和通用闪存接口 (CFI) 信息的读取访问。制造商标识由 JEDEC 分配。CFI 结构由 JEDEC 标准定义。器件标识和 CFI 值由 Infineon 指定。

JEDEC 通用闪存接口 (CFI) 规范定义了一个器件信息结构，该结构允许供应商指定的软件闪存管理程序 (驱动) 用于整个系列的闪存存储器。软件支持可以与器件无关、与 JEDEC 制造商 ID 无关，并且可以向后兼容指定的闪存器件系列。系统供应商可以通过使用 CFI 值从正在使用的器件的 CFI 信息配置系列驱动来标准化闪存驱动程序，以实现长期软件兼容性。

在编程、擦除或写入周期正在进行时发出的任何 RDID 指令都将被忽略，并且对正在进行的编程、擦除或写循环的执行没有影响。

RDID 指令在 SI 上移位。当 RDID 指令最后一位移入器件后，SO 上将依次移出 1 字节制造商标识、2 字节器件标识、扩展器件标识、CFI 信息。总的来说，该信息称为 ID-CFI。参阅 155 页“器件 ID 和通用的闪存存储器接口：(ID-CFI) 地址分布”，有关 ID-CFI 内容的详细描述。

如果继续将输出移到定义的 ID-CFI 地址空间末尾之外，将会提供未定义的数据。在数据输出期间，随时将 CS 驱动至逻辑高电平状态即可终止 RDID 指令。

RDID 指令的最大时钟频率为 133 MHz。

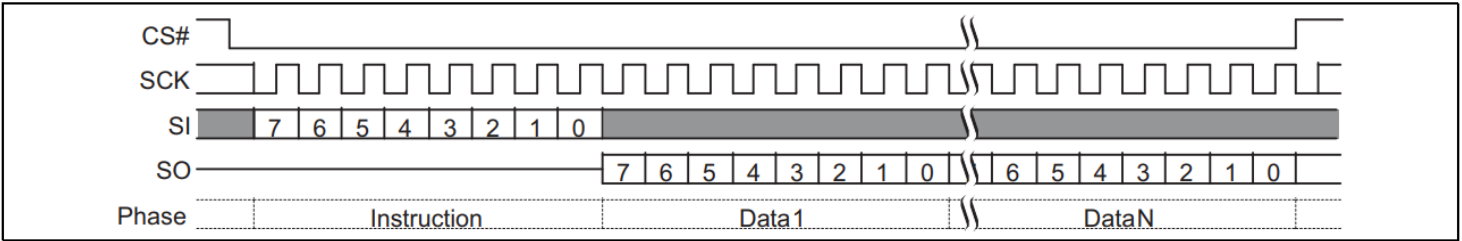


图 50 读取标识 (RDID) 指令时序

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令通过 IO0–IO3 移入，返回数据通过 IO0–IO3 移出。

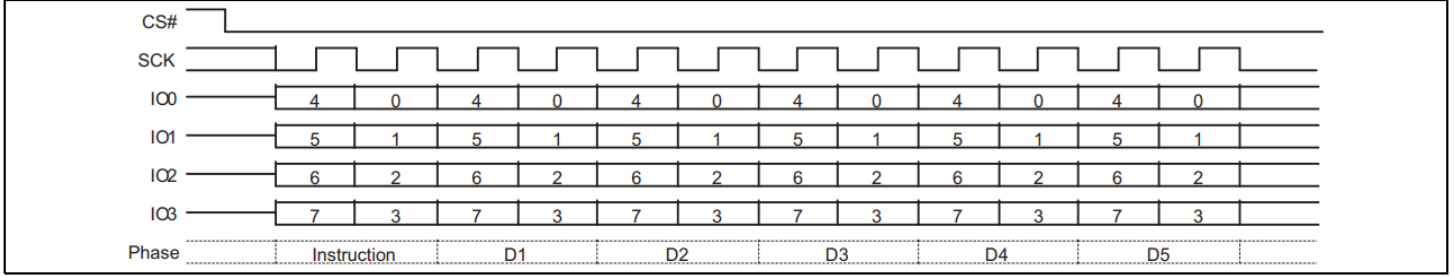


图 51 读取标识 (RDID) QPI 模式指令

命令

### 10.2.2 四线读取标识 (RDQID AFh)

四线读取标识 (RDQID) 指令提供对制造商标识、器件接口标识和通用闪存存储器接口 (CFI) 信息的读取访问。此指令是在 QPI 模式下读取 RDID 指令提供的相同信息的另一种方法。在所有其他方面，该指令的行为与 RDID 指令相同。

仅当器件处于 QPI 模式 (CR2V[6] = 1) 时才能识别该指令。该指令在 IO0–IO3 上移入。当指令的最后一位移入器件后，1 字节制造商标识、2 字节器件标识、扩展器件标识和 CFI 信息将依次从 IO0–IO3 移出。总的来说，该信息称为 ID-CFI。参见“[器件 ID 和 常见的 闪存存储器 接口 \(ID-CFI\) 地址 映射](#)”在 分页 155 有关 ID-CFI 内容的详细描述。

如果继续将输出移到定义的 ID-CFI 地址空间末尾之外，将会提供未定义的数据。在数据输出期间，随时将 CS 驱动至逻辑高电平状态即可终止指令。

该指令的最大时钟频率为 133 MHz。

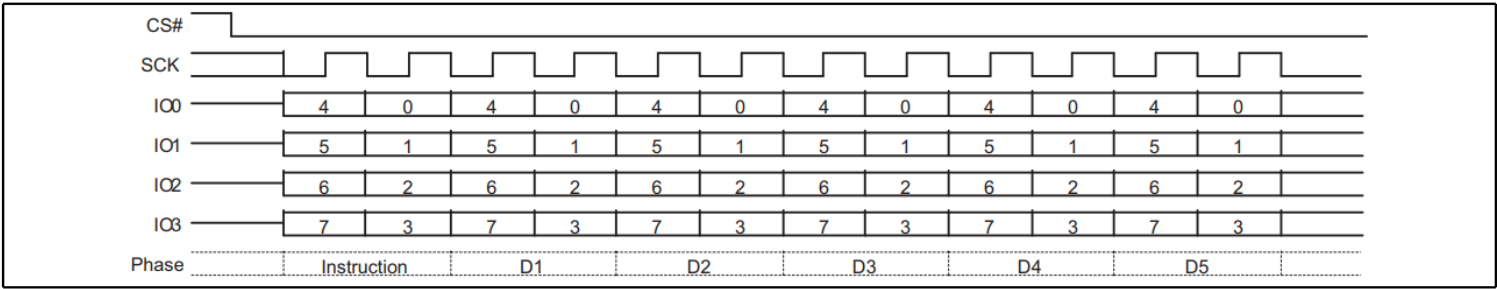


图 52 四线读取识别 (RDQID) 指令时序

### 10.2.3 读取串行闪存可发现参数 (RSFDP 5Ah)

该命令通过在 SI 上移位指令代码“5Ah”来启动，后面跟着 24 位地址 000000h，然后是 8 个虚拟周期。然后，SFDP 字节在虚拟周期之后从 SCK 的下降沿开始在 SO 上移出。SFDP 字节始终以高字节（数据字最左位）先移出。如果将 24 位地址置位为任何其他值，则 SFDP 空间中选定的位置即为数据读取的起点。这使得能够对 SFDP 空间中的任何参数进行随机访问。RSFDP 指令最高支持 50 MHz。

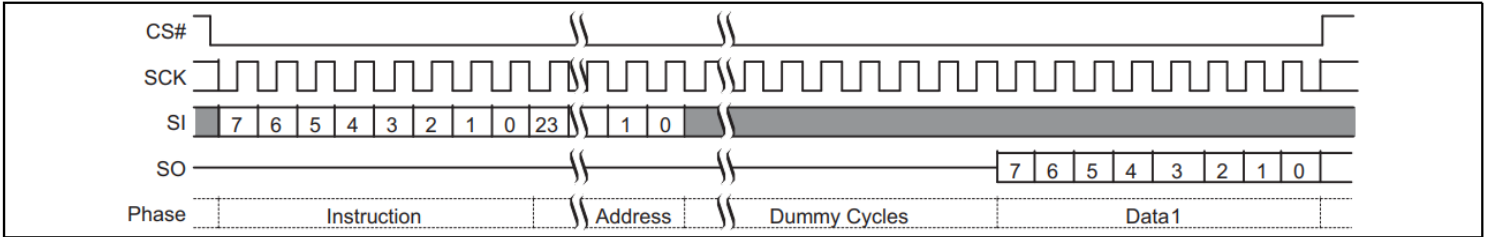


图 53 RSFDP 指令时序

命令

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令通过 IO0–IO3 移入，返回数据通过 IO0–IO3 移出。

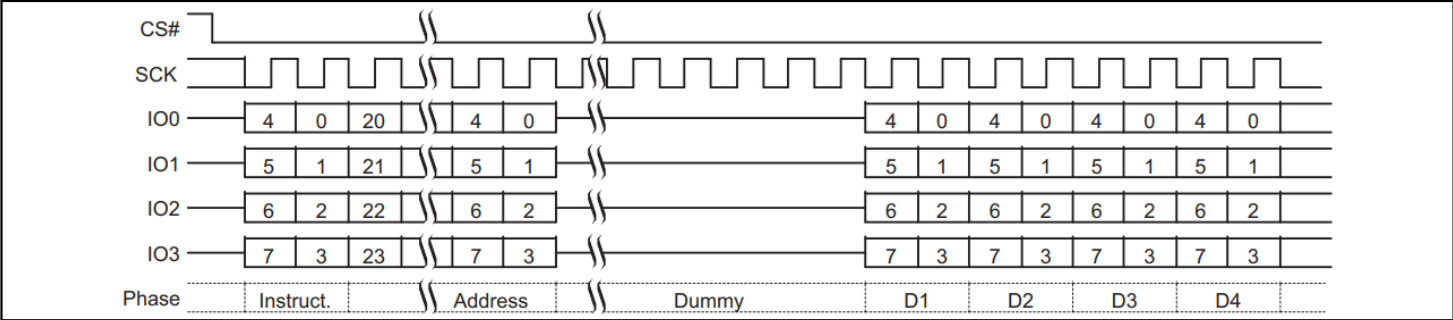


图 54 RSFDP QPI 模式指令时序

### 10.3 寄存器访问指令

#### 10.3.1 读取状态寄存器 1 (RDSR1 05h)

读取状态寄存器 1 (RDSR1) 指令允许从 SO 读取状态寄存器 1 的内容。状态寄存器 1 (SR1V) 内容的易失性版本可随时读取，即使在编程、擦除或写入操作正在进行时也是如此。通过提供八个时钟周期的倍数，可以连续读取状态寄存器 1。每读取八个周期就会更新一次状态。RDSR1 (05h) 指令的最大时钟频率为 133 MHz。

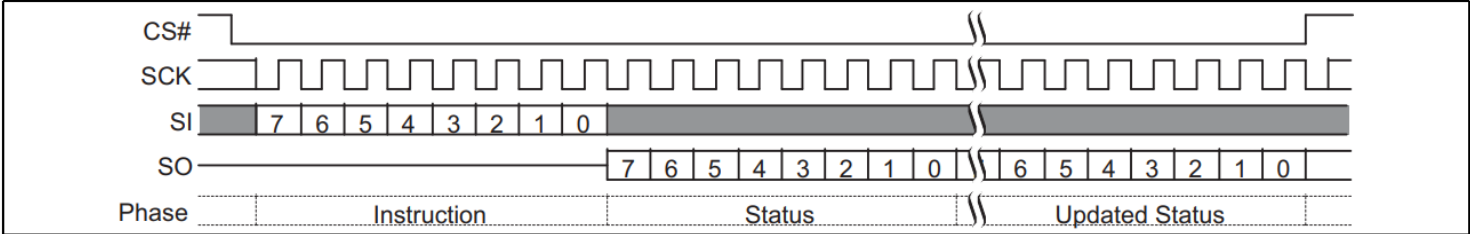


图 55 读取状态寄存器 1 (RDSR1) 指令时序

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0–IO3 上移入，返回数据在 IO0–IO3 上移出，每个字节两个时钟周期。

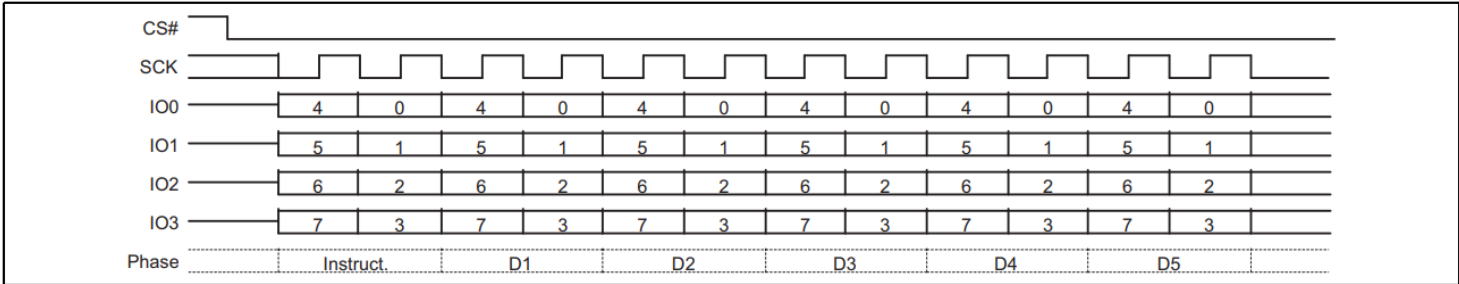


图 56 读取状态寄存器 1 (RDSR1) QPI 模式指令

命令

### 10.3.2 读取状态寄存器 2 (RDSR2 07h)

读取状态寄存器 2 (RDSR2) 指令允许从 SO 读取状态寄存器 2 的内容。状态寄存器 2 的内容可随时读取，即使在编程、擦除或写入操作进行时也是如此。通过提供八个时钟周期的倍数，可以连续读取状态寄存器 2。每读取八个周期就会更新一次状态。RDSR2 指令的最大时钟频率为 133 MHz。

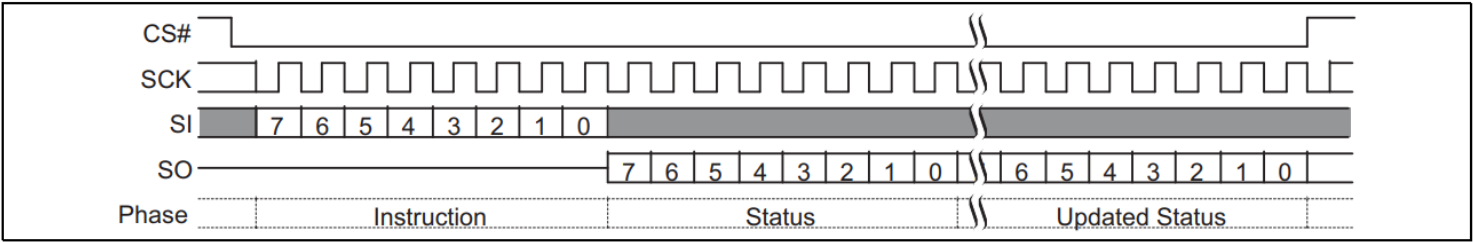


图 57 读取状态寄存器 2 (RDSR2) 指令

在 QPI 模式下，状态寄存器 2 可以通过读取任意寄存器指令读取，参见“[读取任意寄存器 \(RDAR 65h\)](#)”见分页 111。

### 10.3.3 读取配置寄存器 (RDCR 35h)

Read 配置寄存器 (RDCR) 指令允许从 SO 读取易失性配置寄存器 (CR1V) 内容。通过提供八个时钟周期的倍数，可以连续读取 CR1V。可以随时读取配置寄存器的内容，即使在编程、擦除或写入操作进行时也是如此。

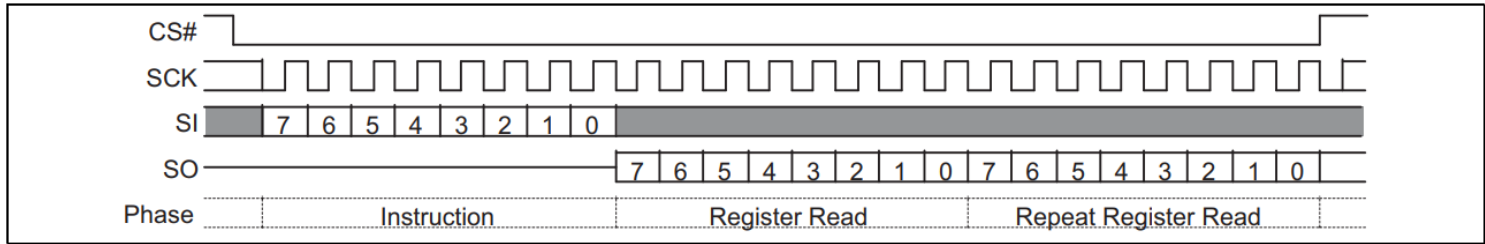


图 58 读取配置寄存器 (RDCR) 指令时序

在 QPI 模式下，可以通过读取任何寄存器指令读取配置寄存器 1，请参阅111页“读取任何寄存器”（RDAR 65h）”。

命令

### 10.3.4 写寄存器 (WRR 01h)

写寄存器 (WRR) 指令允许将新值写入状态寄存器 1 和配置寄存器 1。在器件接受写寄存器 (WRR) 指令之前，必须接收写使能 (WREN) 指令。成功解码写入使能 (WREN) 指令后，器件将在状态寄存器中置位写入使能锁存器 (WEL) 位，以允许任何写入操作。

通过在 SI 上移位指令和数据字节来输入写寄存器 (WRR) 命令。状态寄存器的长度为一个数据字节。

WRR 操作首先擦除寄存器，然后将新值编程为单一操作。如果 WRR 操作失败，写寄存器 (WRR) 指令将置位 P\_ERR 或 E\_ERR 位。参阅61页“状态寄存器易失性 (SR1V)”获取错误位的描述。为将来保留的任何状态或配置地址必须写为“0”。

锁存第八位或第十六位数据后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。如果不是，则不会执行写寄存器 (WRR) 指令。如果 CS# 在第八个周期后被驱动为高电平，则只写入状态寄存器 1；否则，在第十六个周期后，状态寄存器和配置寄存器都会被写入。

一旦 CS# 被驱动为逻辑高电平状态，就会启动自定时写寄存器 (WRR) 操作。当写寄存器 (WRR) 操作正在进行时，仍可读取状态寄存器来检查写入进度 (WIP) 位的值。自定时写寄存器 (WRR) 操作期间，写入进度 (WIP) 位为‘1’，完成时为‘0’。当写寄存器 (WRR) 操作完成后，写能锁存器 (WEL) 被置位为‘0’。WRR 指令的最大时钟频率为 133 MHz。

QPI 模式也支持该指令。在 QPI 模式下，指令和数据在 IO0–IO3 上移入，每个字节两个时钟周期。

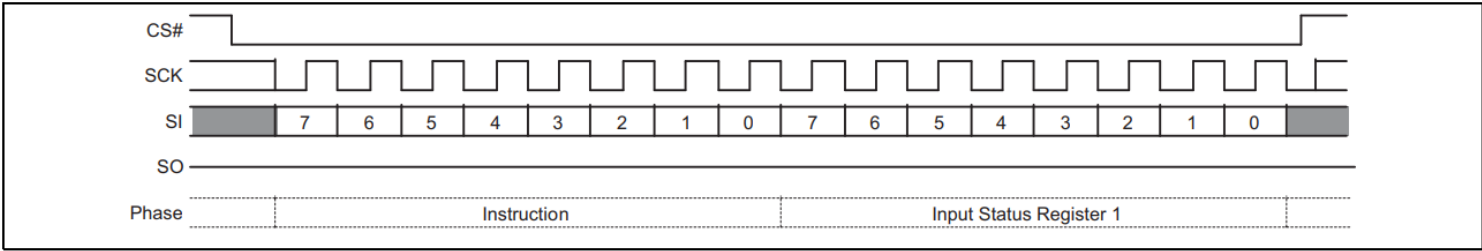


图 59 写寄存器 (WRR) 指令时序 - 8 个数据位

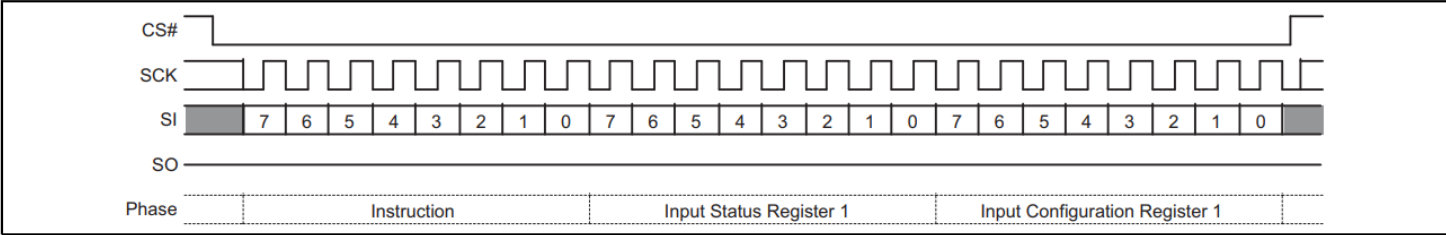


图 60 写寄存器 (WRR) 指令时序 - 16 个数据位

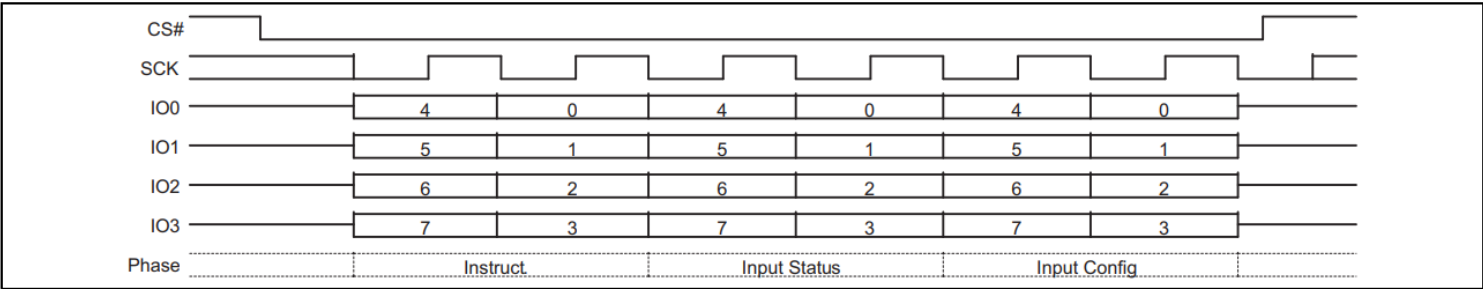


图 61 写寄存器 (WRR) 指令时序 - 16 数据位 QPI 模式

## 命令

写入寄存器 (WRR) 指令读取四位 (CR1NV[1]) 的非易失性版本, 这也会导致易失性版本 CR1V[1] 的更新。

WRR 命令无法在不首先影响非易失性版本 CR1NV[1] 的情况下写入易失性版本 CR1V[1]。当需要写入易失性位 CR1V[1] 而不影响非易失性 CR1NV[1] 时, 必须使用 WRAR 指令。

写入寄存器 (WRR) 指令允许用户更改非易失性状态寄存器 1 或易失性状态寄存器 1 中的功能块保护 (BP2、BP1 和 BP0) 位的值, 以定义将被视为只读的区域的大小。BPNV\_O 位 (CR1NV[3]) 控制 WRR 是否写入状态寄存器 1 的非易失性或易失性。当 CR1NV[3] = 0 时, WRR 写入 SR1NV[4:2]。当 CR1NV[3] = 1 时, WRR 写入 SR1V[4:2]。

写入寄存器 (WRR) 指令还允许用户将状态寄存器写入禁止使能 (SRWD) 位设置为“1”或“0”。状态寄存器写禁止使能 (SRWD) 位和写保护 (WP#) 信号允许 BP 位受到硬件保护。

当状态寄存器的写入禁止使能 (SRWD) 位为“0” (其出厂初始状态) 时, 只要写入使能锁存器 (WEL) 位先前已被写入使能 (WREN) 指令置位, 就可以写入状态寄存器, 无论写入保护 (WP#) 信号是否被驱动为逻辑高电平或逻辑低电平状态。

当状态寄存器的 Write 禁止使能 (SRWD) 位置位为 '1' 时, 需要考虑两种情况, 具体取决于 Write Protect (WP#) 的状态:

- 如果写保护 (WP#) 信号被驱动为逻辑高电平状态, 则可以写入状态和配置寄存器, 前提是已通过启动写使能 (WREN) 指令将写使能锁存器 (WEL) 位先前置位为“1”。
- 如果写保护 (WP#) 信号被驱动为逻辑低电平状态, 则即使之前已通过写使能 (WREN) 指令将写使能锁存器 (WEL) 位设置为“1”, 也无法写入状态和配置寄存器。尝试写入状态和配置寄存器的操作将被拒绝, 不接受执行, 并且不提供任何错误指示。因此, 受状态寄存器的功能块保护 (BP2、BP1、BP0) 位保护的内存区域中的所有数据字节也受到 WP# 的硬件保护。

WP# 硬件保护可以提供:

- 将 Write Protect (WP#) 信号驱动至逻辑低电平状态后, 通过设置状态寄存器禁止使能 (SRWD) 位;
- 或将状态寄存器禁止使能 (SRWD) 位设置为“1”后, 将写保护 (WP#) 信号驱动至逻辑低电平状态。

释放硬件保护的唯一方法是将写保护 (WP#) 信号拉至逻辑高电平状态。如果 WP# 一直处于高电平状态, 则 BP 位的硬件保护就永远不会被激活。

命令

表 58 功能块保护模式

WP#	SRWD bit	Mode	Write protection of registers	Memory content	
				Protected area	Unprotected area
1	1	Software Protected	Status and Configuration Registers are Writable (if WREN command has set the WEL bit). The values in the SRWD, BP2, BP1, and BP0 bits and those in the Configuration Register can be changed.	Protected against Page Program, Sector Erase, and Bulk Erase.	Ready to accept Page Program, and Sector Erase commands.
1	0				
0	0				
0	1	Hardware Protected	Status and Configuration Registers are Hardware Write Protected. The values in the SRWD, BP2, BP1, and BP0 bits and those in the Configuration Register cannot be changed.	Protected against Page Program, Sector Erase, and Bulk Erase.	Ready to accept Page Program or Erase commands.

注:

47. 当器件首次从 Infineon 出厂给客户时，状态寄存器最初显示为 00h。
48. 使能四线模式（CR1V[1] = 1）时，硬件保护被禁用。WP# 变成 IO2；因此无法使用。

命令

### 10.3.5 写入使能 (WREN 06h)

写入使能 (WREN) 指令将状态寄存器 1 (SR1V[1]) 的写入使能锁存器 (WEL) 位设置为“0”。写入使能锁存器 (WEL) 位必须通过发出写入使能 (WREN) 指令置位为“1”以进行写入、编程和擦除指令。

指令字节的第八位被锁存在 SI 上之后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。在指令字节的第八位被锁存到 SI 上之后，如果 CS# 没有被驱动到逻辑高电平状态，则不会执行写入使能操作。

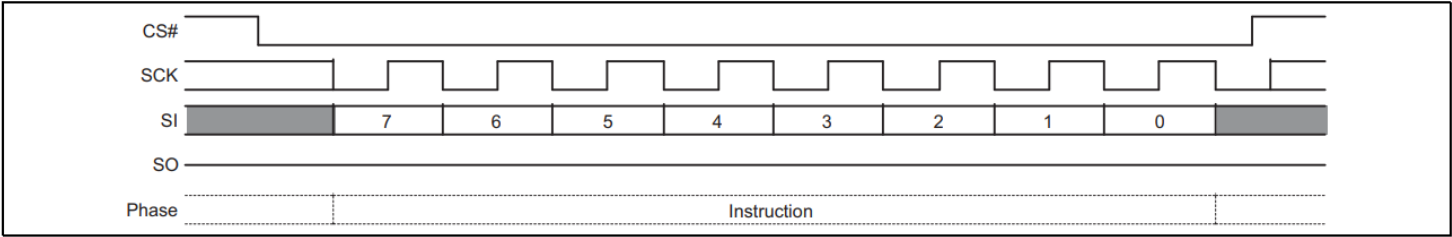


图 62 写入使能 (WREN) 指令时序

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

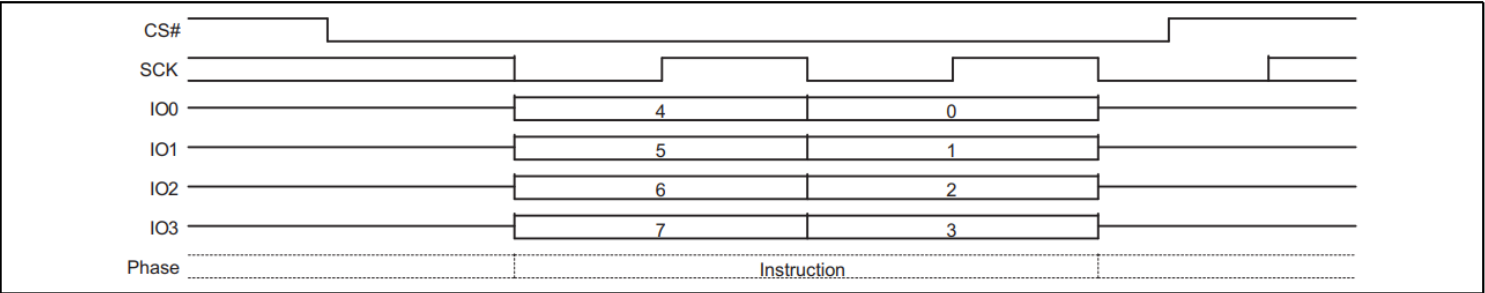


图 63 写使能 (WREN) 指令时序 QPI 模式

命令

### 10.3.6 写禁止使能 (WRDI 04h)

写禁止使能 (WRDI) 指令将状态寄存器 1 (SR1V[1]) 的写使能锁存器 (WEL) 位清除为“1”。

写使能锁存器 (WEL) 位可以通过发出写 OTP，禁止使能 (WRDI) 指令来清除为“0”。用户可以使用 WRDI 指令来保护内存区域，防止意外写入，从而可能损坏内存内容。当 WIP 位 = 1 时，嵌入操作期间会忽略 WRDI 指令。

指令字节的第八位被锁存在 SI 上之后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。在指令的第八位字节被锁存到 SI 上之后，如果 CS 没有被驱动到逻辑高状态，则写禁止使能操作将不会被执行。

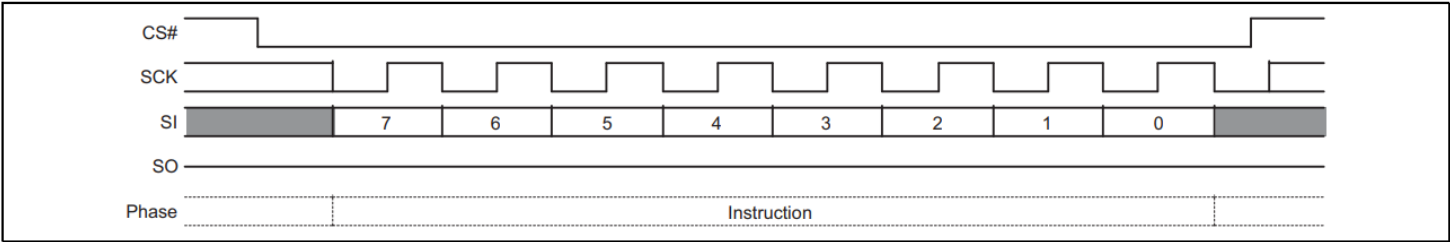


图 64 写禁止使能 (WRDI) 指令时序

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

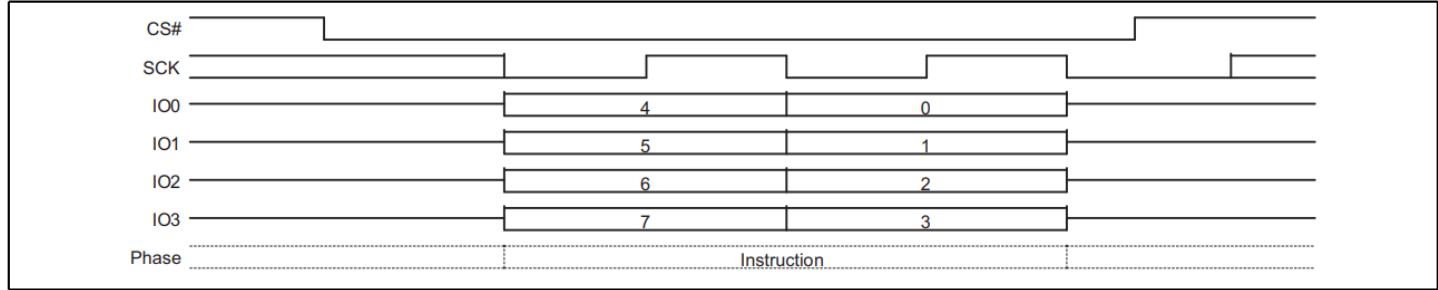


图 65 写禁止使能 (WRDI) 指令时序 QPI 模式

命令

### 10.3.7 清除状态寄存器 (CLSR 30h 或 82h)

清除状态寄存器指令会复位位 SR1V[5]（擦除失败标志）和位 SR1V[6]（编程失败标志）。在执行清除状态寄存器指令之前，无需置位 WEL 位。即使器件保持忙且 WIP 置位为“1”，清除状态寄存器指令也会被接受，因为当任一故障位为置位时器件确实保持忙。该指令执行后，WEL 位不会发生变化。

传统的清除状态寄存器 (CLSR 30h) 指令可能会被禁用，并且 30h 指令值会改为用于编程/擦除指令 - 请参阅72页“配置寄存器3”清除状态寄存器备用指令（CLSR 82h）始终可用于清除状态寄存器

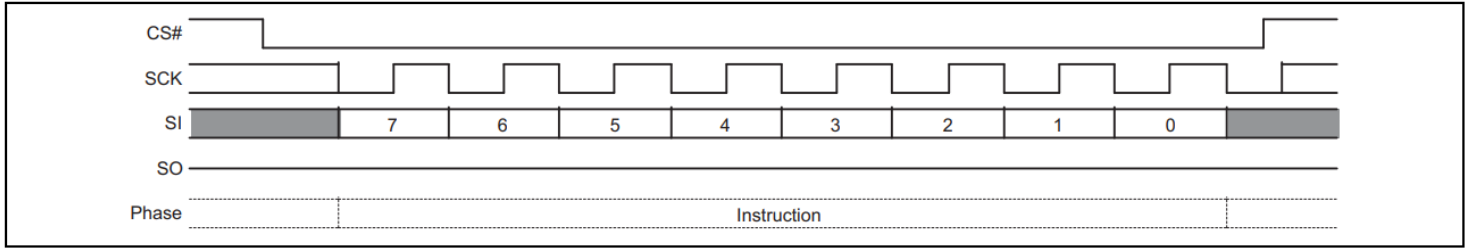


图 66 清除状态寄存器 (CLSR) 指令时序

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

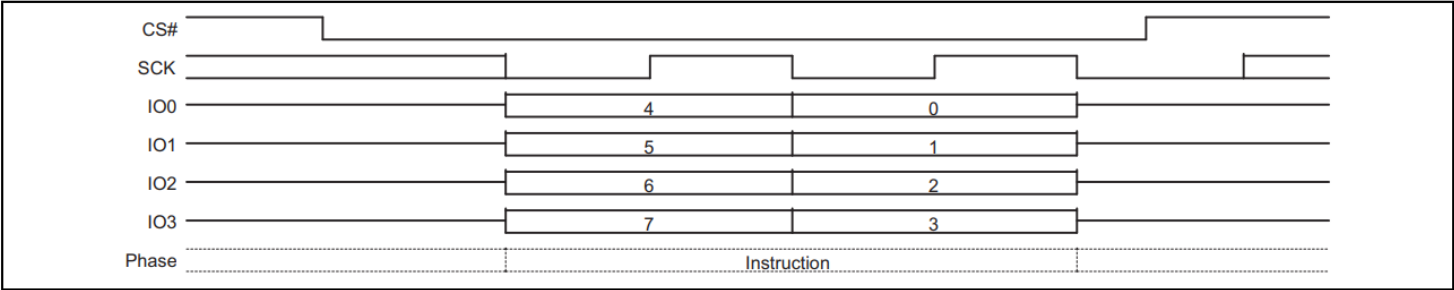


图 67 清除状态寄存器 (CLSR) 指令时序 QPI 模式

命令

### 10.3.8 ECC 状态寄存器读取 (ECCRD 19h 或 4EECRD 18h)

要读取ECC地址状态，指令后面跟着ECC单元地址，该地址的4个最低有效位（低字节/最低有效位）必须置位为零。接下来是通过 CR2V[3:0] 中的读取延时值选择的虚拟周期数。然后，ECC寄存器的8位内容来，选择的ECC单元地址，在 SO 上移出 16 次，ECC单元中每字节移出一。如果 CS 保持低电平，则通过 SO 发送下一个ECC单元状态16 次，ECC单元中每字节一次。ECC读取命令的最大工作时钟频率为 133 MHz。

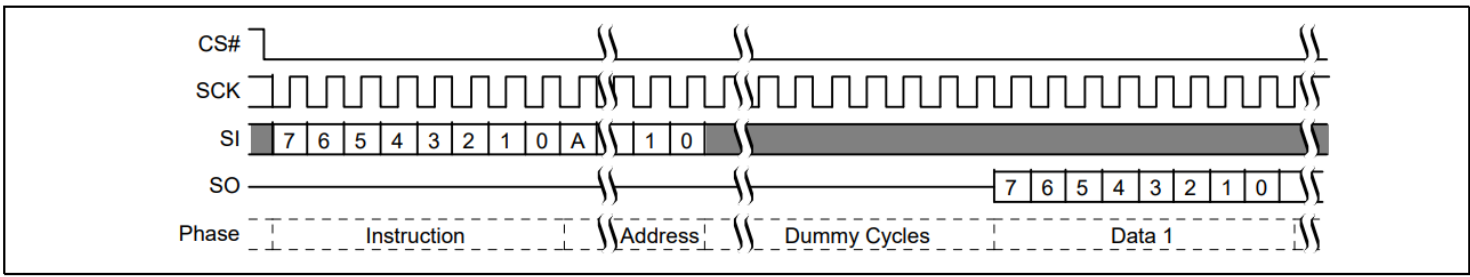


图 68 ECC 状态寄存器读取命令时序<sup>[49, 50]</sup>

QPI模式也支持该指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0–IO3 上移入，每个字节两个时钟周期。

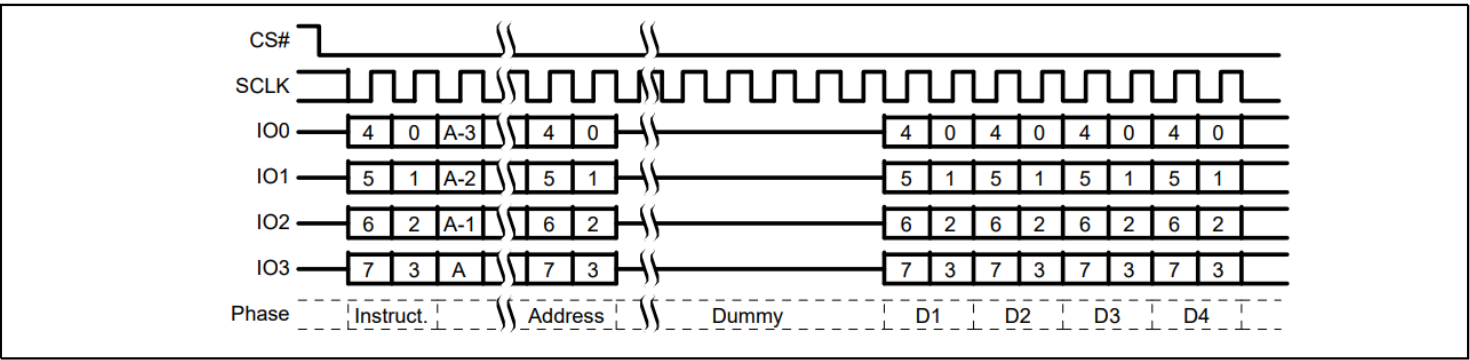


图 69 ECCRD (19h) 或 4EECRD (18h)，QPI 模式，指令时序<sup>[49, 50]</sup>

注：

- 49.A = 地址的最高有效位 = 23 对于地址长度 (CR2V[7] = 0, 或 31 对于 CR2V[7] = 1, 指令为 19h。
- 50.A = 地址的最高有效位 = 31, 指令为 18h。

命令

### 10.3.9 编程 NVDLR (PNVDLR 43h)

在器件接受 Program NVDLR (PNVDLR) 指令之前，器件必须发出 Write 使能 (WREN) 指令并对其进行解码。成功解码写使能 (WREN) 指令后，器件将置位写使能锁存器 (WEL) 以使能 PNVDLR 操作。

PNVDLR 命令是通过将指令和数据字节移位到 SI 上来输入的。

锁存第八位数据后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。如果不是，则不会执行 PNVDLR 指令。一旦 CS# 被驱动至逻辑高电平状态，自定时 PNVDLR 操作就会启动。在 PNVDLR 操作进行过程中，可以读取状态寄存器来检查写入进度 (WIP) 位的值。在自定时 PNVDLR 周期内，写入进度 (WIP) 位为 '1'，否则为 '0'。当它完成时，PNVDLR 操作可以报告状态寄存器的 P\_ERR 位中的编程错误。当 PNVDLR 操作完成后，写使能锁存器 (WEL) 被置位为 '0'。PNVDLR 指令的最大时钟频率为 133 MHz。

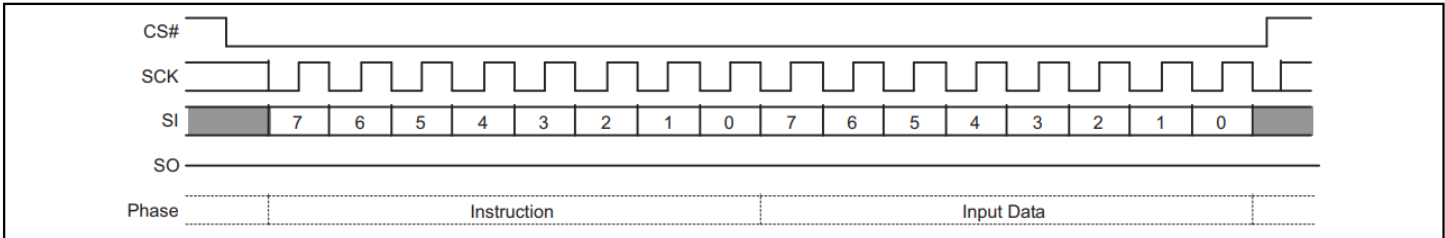


图 70 编程 NVDLR (PNVDLR) 指令时序

### 10.3.10 写入 VDLR (WVDLR 4Ah)

在器件接受 Write VDLR (WVDLR) 指令之前，器件必须发出 Write 使能 (WREN) 指令并对其进行解码。成功解码写使能 (WREN) 指令后，器件将置位写使能锁存器 (WEL) 以使能 WVDLR 操作。

通过在 SI 上移位指令和数据字节来输入 WVDLR 命令。

锁存第八位数据后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。如果不是，则不会执行 WVDLR 指令。一旦 CS# 被驱动到逻辑高电平状态，WVDLR 操作就会立即启动，不会有任何延迟。PNVDLR 指令的最大时钟频率为 133 MHz。

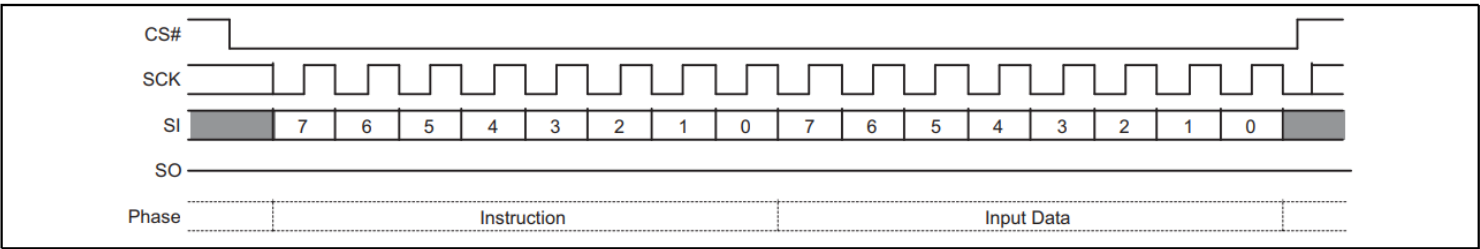


图 71 写入 VDLR (WVDLR) 指令时序

命令

### 10.3.11 数据学习模式读取 (DLPRD 41h)

指令在 SI 上移位，然后 8 位 DLP 在 SO 上移出。通过提供八个时钟周期的倍数，可以连续读取 DLP。DLPRD 指令的最大工作时钟频率为 133 MHz。

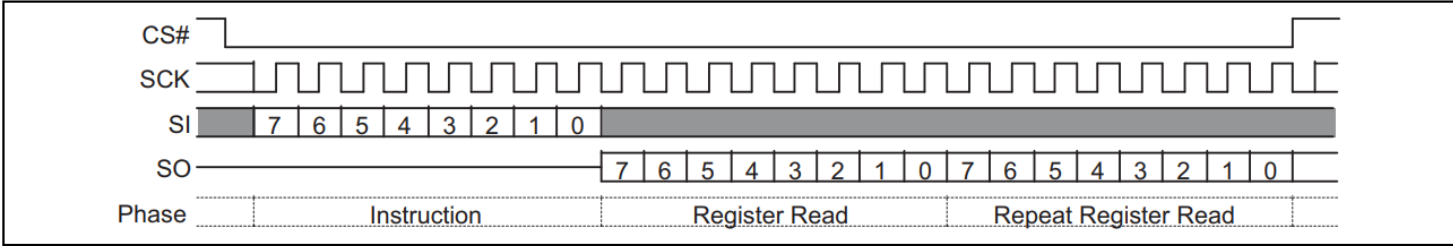


图 72 DLP 读取 (DLPRD) 指令时序

### 10.3.12 进入 4 字节地址模式 (4BAM B7h)

输入 4 字节地址模式 (4BAM) 指令将易失性地址长度位 (CR2V[7]) 设置为“1”，以将大部分 3 字节地址指令更改为需要 4 字节地址。读取 SFDP (RSFDP) 指令是唯一的  
不受 3 字节指令表示地址长度位的影响。JEDEC JESD216 标准要求 RSFDP 始终只有 3 个字节的地址。  
需要硬件或软件复位才能退出 4 字节地址模式。

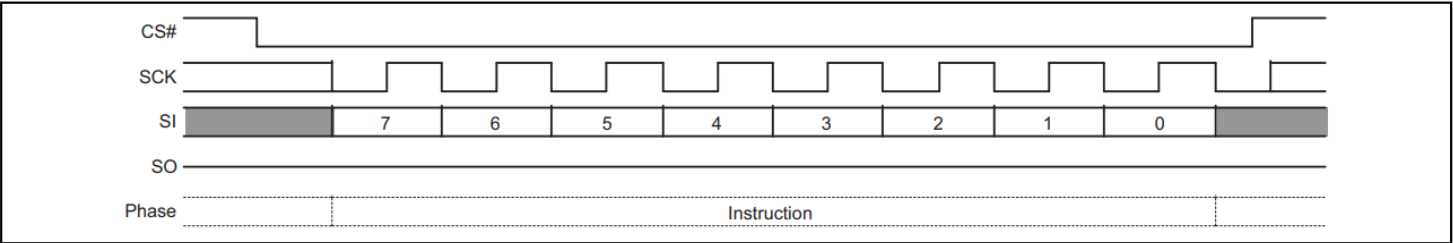


图 73 输入 4 字节地址模式 (4BAM B7h) 指令时序

### 10.3.13 读取任何寄存器 (RDAR 65h)

读取任何寄存器 (RDAR) 指令提供了一种读取所有器件寄存器的方法 - 非易失性和易失性。该指令后跟一个 3 或 4 字节地址（取决于地址长度配置 CR2V[7]），后跟由 CR2V[3:0] 置位的多个延迟（虚拟）周期。然后返回所选寄存器的内容。如果继续读取，则返回相同地址的寄存器内容，直到指令终止 - 每个 RDAR 指令只读取一个寄存器。

读取未定义的位置会提供未定义的数据。

RDAR 指令可以在嵌入式操作期间使用来读取状态寄存器 1 (SR1V)。

RDAR 指令不用于读取作为更大阵列窗口的寄存器：ECCSR、PPBAR 和 DYBAR。需要单独的指令来选择和读取所访问阵列中的位置。

如果通过将 ASPR[2] 编程为“0”来选择 ASP 密码保护模式，则 RDAR 指令将从 PASS 寄存器位置读取无效数据。

命令

表 59 寄存器地址分布

Byte address (Hex)	Register name	Description
00000000	SR1NV	Non-volatile Status and Configuration Registers
00000001	N/A	
00000002	CR1NV	
00000003	CR2NV	
00000004	CR3NV	
00000005	CR4NV	
...	N/A	
00000010	NVDLR	Non-volatile Data Learning Register
...	N/A	
00000020	PASS[7:0]	Non-volatile Password Register
00000021	PASS[15:8]	
00000022	PASS[23:16]	
00000023	PASS[31:24]	
00000024	PASS[39:32]	
00000025	PASS[47:40]	
00000026	PASS[55:48]	
00000027	PASS[63:56]	
...	N/A	
00000030	ASPR[7:0]	Non-volatile
00000031	ASPR[15:8]	
...	N/A	
00800000	SR1V	Volatile Status and Configuration Registers
00800001	SR2V	
00800002	CR1V	
00800003	CR2V	
00800004	CR3V	
00800005	CR4V	
...	N/A	
00800010	VDLR	Volatile Data Learning Register
...	N/A	
00800040	PPBL	Volatile PPB Lock Register
...	N/A	

命令

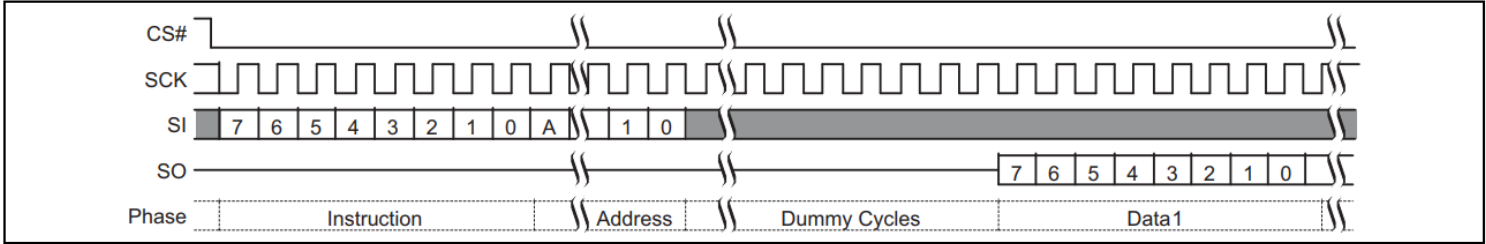


图 74 读取任意寄存器读取命令时序<sup>[51]</sup>

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

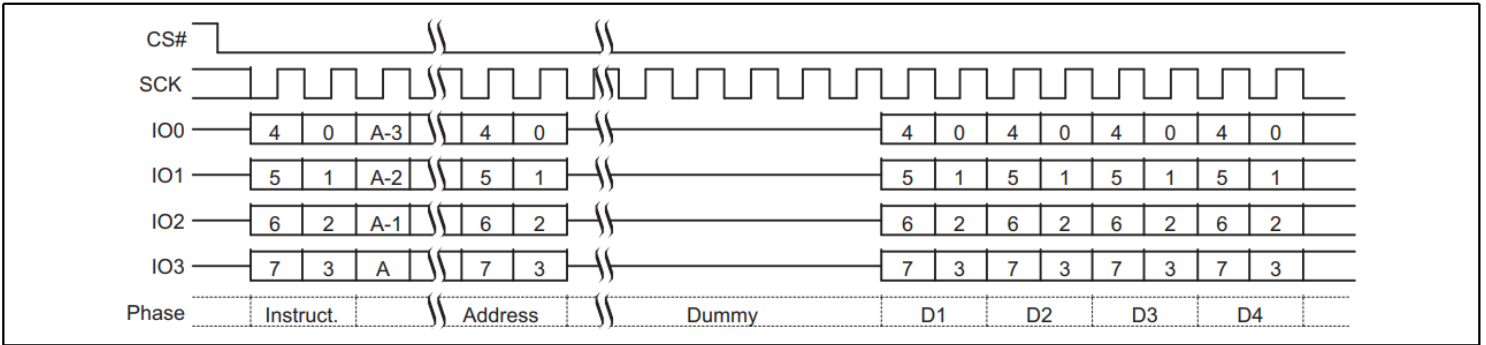


图 75 读取任意寄存器，QPI 模式指令序列<sup>[51]</sup>

注：  
51.A = 地址最高有效位= 23（对于地址长度 CR2V[7] = 0），或 31（对于 CR2V[7] = 1）。

## 命令

### 10.3.14 写入任意寄存器 (WRAR 71h)

写入任意寄存器(WRAR) 指令提供了一种写入任何器件寄存器的方法 - 非易失性或易失性。指令后跟一个 3 或 4 字节地址（取决于地址长度配置 CR2V[7]），后跟要写入地址选定寄存器中的一个字节的数据。

在器件接受 WRAR 指令之前，器件必须发出写使能 (WREN) 指令并对其进行解码，这会设置寄存器状态中的写使能锁存器 (WEL) 以允许任何写操作。可以检查 SR1V 中的 WIP 位来确定操作何时完成。可以检查 SR1V 中的 P\_ERR 和 E\_ERR 位来确定操作期间是否发生任何错误。

一些寄存器混合了多种位类型，并且有单独的规则来控制哪些位可以被修改。有些位是只读的，有些是 OTP 的。

只读位永远不会被修改，并且 WRAR 指令数据字节中的相关位将被忽略，而不会设置编程或擦除错误指示 (SR1V 中的 P\_ERR 或 E\_ERR)。因此，WRAR 数据字节中这些位的值并不重要。

OTP 位只能被编程为与其默认状态相反的电平。将 OTP 位写回到其默认状态的操作将被忽略，并且不会发生任何错误。

由 WRAR 数据改变的非易失性位需要更新非易失性寄存器写入时间 ( $t_w$ )。更新过程涉及到对非易失性寄存器位的编程操作。如果擦除或编程部分失败，SR1V 中的相关故障位和 WIP 将置位为“1”。

WRAR 数据改变的易失性位需要更新易失性寄存器写入时间 ( $t_{cs}$ )。状态寄存器 1 可以被重复读取（轮询）以监测器的写入进度 (WIP) 位 (SR1V[0]) 和错误位 (SR1V[6,5])，以确定寄存器写入何时完成或失败。如果写入失败，则

清除状态指令用于清除错误状态并使器件返回待机状态。

然而，PPBL 寄存器不能通过 WRAR 指令写入。只有 PPB 锁定位写入 (PLBWR) 指令可以写入 PPBL 寄存器。

指令时序和行为与 PP 或 4PP 指令相同，仅提供单个字节的数据。请参阅 126 页上的“页编程 (PP 02h 或 4PP 12h)”。

寄存器的地址分布与 111 页“读任何寄存器 (RDAR 65h)”相同。

### 10.3.15 设置突发长度 (SBL C0h)

设置位 Burst Length (SBL) 指令用于配置 Burst Wrap 特点。在传统 SPI 或 QPI 模式下，突发回卷与四线 I/O 读取和 DDR 四线 I/O 读取结合使用，以访问固定长度和对齐的数据。某些应用程序可以从此特性中受益，从而提高整体系统代码执行性能。突发回卷功能允许使用缓存的应用程序首先从关键地址开始用指令或数据填充缓存行，然后在固定长度 (8/16/32/64 字节) 的数据内填充缓存行的其余部分，而无需发出多个读取命令。

设置位突发长度 (SBL) 指令写入 CR4V 寄存器使能或失效，禁止使能回卷读取功能和设置位回卷边界。当启用读取回卷功能时，相关的读取指令从顺序读取直到指令结束变为在一组字节内顺序回卷读取。

当 CR4V[4] = 1 时，不支持回卷模式，并且执行无限长度的顺序读取。

当 CR4V[4] = 0 时，启用回卷模式，从读取命令提供的字节地址开始读取固定长度且对齐的 8、16、32 或 64 字节组，并在组对齐边界处回卷。

该字节组具有长度并在 8、16、32 或 64 字节边界上对齐。CR4V[1:0] 选择边界。请参阅 分页 76 上的“[配置寄存器 4 易失性 \(CR4V\)](#)”。

读取命令的起始地址选择字节组，返回的第一个数据是寻址的字节。然后按顺序读取字节，直到到达组边界的末尾。如果读取继续，地址将绕回到组的开头并继续按顺序读取。这个回卷的读取序列持续到指令通过 CS 返回 HIGH 来结束。

命令

表 60 突发回卷时序示例

CR4V[4,1:0] value (Hex)	Wrap boundary (Bytes)	Start address (Hex)	Address sequence (Hex)
1X	Sequential	XXXXXX03	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ...
00	8	XXXXXX00	00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 00, 01, 02, ...
00	8	XXXXXX07	07, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 00, 01, ...
01	16	XXXXXX02	02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 00, 01, 02, 03, ...
01	16	XXXXXX0C	0C, 0D, 0E, 0F, 00, 01, 02, 03, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, ...
02	32	XXXXXX0A	0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, ...
02	32	XXXXXX1E	1E, 1F, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 00, ...
03	64	XXXXXX03	03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 00, 01, 02 ...
03	64	XXXXXX2E	2E, 2F, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A, 0B, 0C, 0D, 0E, 0F, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, ...

通过使用 WRAR 指令将 CR4NV 编程为所需值，可以更改上电复位、硬件复位或软件复位默认突发长度。

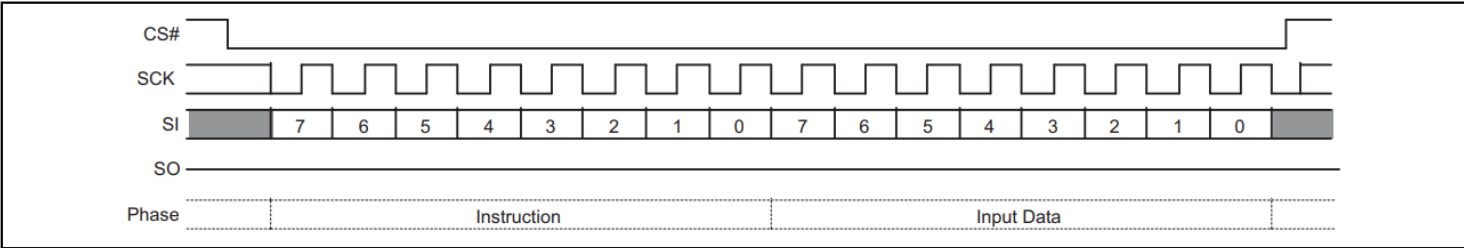


图 76 置位突发长度指令时序

## 命令

## 10.4 读取闪存阵列命令

主要闪存阵列的读取指令为上一代SPI兼容性或增强型性能SPI提供了许多选项：

- 某些指令在 SCK 的每个上升沿传输地址或数据。这些称为单数据率指令 (SDR)。
- 某些SDR指令在每个 SCK 上升沿传送 1 位数据，并在每个 SCK 上升沿返回 1 位数据。这些称为单线指令。
- 一些SDR指令在 SCK 的每个上升沿传输两位或四位地址和数据。对于两位，它们被称为双线I/O；对于四位，它们被称为四线I/O和 QPI。QPI 也在每个上升沿传输四位指令。
- 有些指令在SCK的上升沿和下降沿都传输地址和数据。这些称为双倍数据率 (DDR) 指令。
- 每个 SCK 边沿有 4 位地址或数据的 DDR 指令。这些被称为四线 I/O DDR 和 QPI DDR，用于每个边沿传输四位。

所有这些命令 (QPI 读取除外) 都以指令代码开始，该指令代码在每个 SCK 上升沿传输一位。QPI Read 在每个 SCK 上升沿传输四位指令。指令后面跟着一个在 SDR 或 DDR 上传输的 3 字节或 4 字节地址。每个时钟沿传输地址或数据 2 或 4 位的指令称为多线 I/O (MIO) 指令。对于 256 Mbits 或更高密度的 S25FS-S 系列设备，传统的SPI 3 字节地址无法直接寻址存储器阵列中的所有空间。提供单独的 4 字节地址读取指令用于访问整个地址空间。主控系统可以把这些使用传统的 3 字节地址指令配置为 4 字节地址。传统指令的 4 字节地址模式通过将配置寄存器 2 中的地址长度位设置为 0 来激活。在 FS128S 中，4 字节地址指令中 A23 以上的高阶地址位或使用 4 字节地址模式的指令不相关并被忽略，因为闪存存储器的大小仅为 128 Mbits。

Quad I/O 和 QPI 指令提供了由在地址位之后发送的模式位控制的性能改进选项。模式位先示当前读取结束后的指令是否是另一个相同类型的读取，而在读取开始时没有指令。这些模式位提供了在执行一系列四线读访问时移除指令周期的选项。

某些指令需要地址或模式位后面的延时周期，以允许有时间访问闪存阵列 - 读取延时。延时或读取等待时间周期传统上被称为虚拟周期。存储器会忽略虚拟周期，因此主控在这些周期内提供的任何数据都是“不关心的”，并且主控也可能在虚拟周期内将SI信号保持在高阻态。当使用 MIO 指令时，主控必须在最后一个虚拟周期结束之前停止驱动 IO 信号（输出为高阻态）。当使用 DDR 指令时，主控不得在任何虚拟周期内驱动 I/O 信号。虚拟周期的数量随通过配置寄存器 2 (CR2V[3:0]) 延时编码位选择的 SCK 频率或性能选项而变化。虚拟周期是按 SCK 下降沿到下一个 SCK 下降沿进行计算的。SPI 输出传统上在每个 SCK 的下降沿被驱动为一个新值。0 虚拟周期意味着返回数据由内存在主控停止驱动地址或模式位的同一 SCK 下降沿驱动。

DDR 指令可以选择性地在所有数据输出上、在数据开始之前的虚拟周期中具有由内存驱动的 8 边数据学习模式 (DLP)。DLP 可以帮助主控存储控制器确定 SCK 到数据边缘的相位差，以便存储控制器可以捕获数据眼中心的数据。

当在较高的 SCK 频率 (>50 MHz) 下使用 SDR I/O 指令时，应选择提供一个或多个虚拟周期的 LC，以便在内存开始驱动数据之前为主控提供额外的时间停止驱动，从而最大限度地减少 I/O 驱动器冲突。当使用启用了 DLP 的 DDR I/O 指令时，应选择提供五个或更多虚拟周期的 LC，以便在内存开始驱动 4 周期 DLP 之前，允许主控有一个额外的时间停止驱动。

当数据返回期间的任何时候 CS# 返回高电平时，每个读取命令都结束。在数据返回之前的模式或虚拟周期内，CS 不得返回高电平，因为这可能会导致模式位被错误捕获；从而不确定器件是否保持为连续读取模式。

命令

10.4.1 读取 (READ 03h 或 4READ 13h)

指令

- 03h (CR2V[7] = 0) 后跟 3 字节地址 (A23-A0) 或
- 03h (CR2V[7] = 1) 后跟 4 字节地址 (A31-A0) 或
- 13h 后面跟着 4 字节地址 (A31-A0)

然后将给定地址处的内存内容移出 SO。读取命令的最大工作时钟频率为 50 MHz。

该地址可以从闪存储器阵列的任意字节位置开始。每个数据字节移出后，地址会按依次递增到下一个更高的地址。因此，只需一个读取指令和地址 000000h 即可读出整个存储器。当达到最高地址时，地址计数器将回卷并回滚至 000000h，从而允许读取时序无限期地继续。

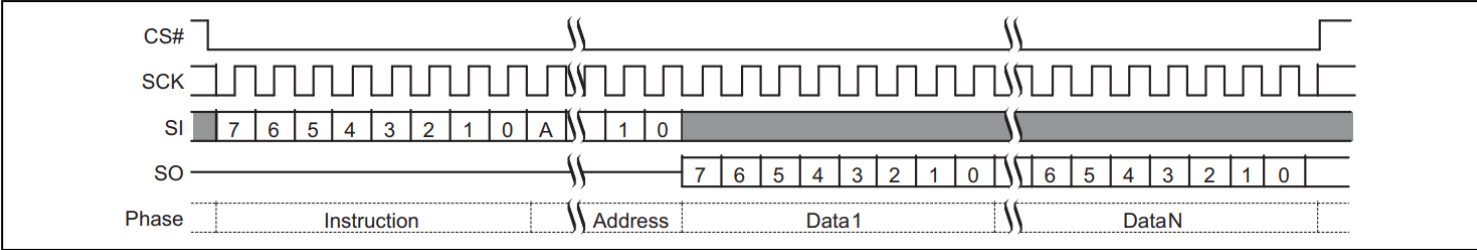


图 77 读取命令时序 (3 字节地址, 03h 或 13h) <sup>[52]</sup>

注:

52.A = 地址最高有效位 = 23 (CR2V[7] = 0) , 或 31 (CR2V[7] = 1 或指令 13h) 。

命令

### 10.4.2 快速读取 (FAST\_READ 0Bh 或 4FAST\_READ 0Ch)

指令

- 0Bh (CR2V[7] = 0) 后跟 3 字节地址 (A23-A0) 或
- 0Bh (CR2V[7] = 1) 后跟 4 字节地址 (A31-A0) 或
- 0Ch 后面跟着 4 字节地址 (A31-A0)

该地址后面是虚拟周期，具体取决于配置寄存器 CR2V[3:0] 中的延时编码值。虚拟周期为器件内部电路提供了额外的时间来访问初始地址位置。在虚拟周期期间，SO 上的数据值为“无关”并且可能为高阻态。然后将给定地址处的内存内容移出 SO。

快速读取命令的最大工作时钟频率为 133 MHz。

该地址可以从闪存储器阵列的任意字节位置开始。每个数据字节移出后，地址会按依次递增到下一个更高的地址。因此，只需一个读取指令和地址 000000h 即可读出整个存储器。当达到最高地址时，地址计数器将回卷并回滚至 000000h，从而允许读取时序无限期地继续。

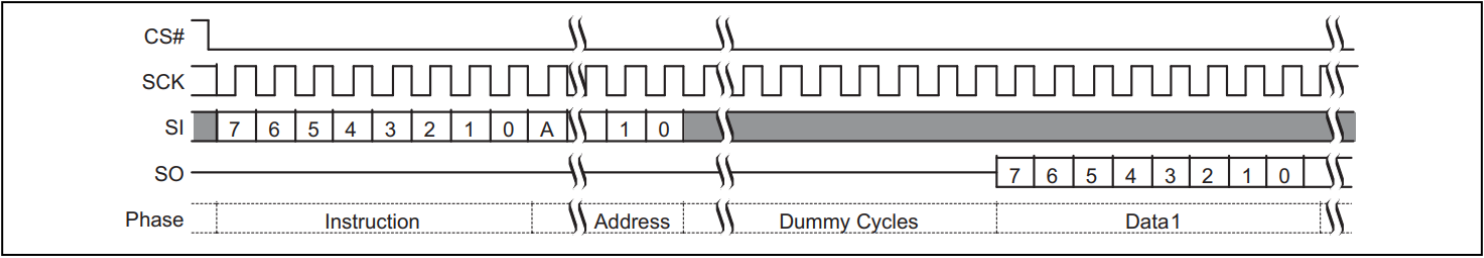


图 78 快速读取 (FAST\_READ) 指令 时序(3-byte 地址, 0Bh [CR2V[7] = 0) <sup>[53]</sup>

注:

53.A = 地址最高有效位 = 23 (CR2V[7] = 0) , 或 31 (CR2V[7] = 1 或指令 0Ch) 。

## 命令

## 10.4.3 双线I/O 读取 (DIOR BBh 或 4DIOR BCh)

## 指令

- BBh (CR2V[7] = 0) 后跟 3 字节地址 (A23-A0) 或
- BBh (CR2V[7] = 1) 后跟 4 字节地址 (A31-A0) 或
- BCh后面跟着4字节地址 (A31-A0)

双 I/O 读取指令通过两个 I/O 信号 — IO0 (SI) 和 IO1 (SO) 来提高吞吐量。此指令接受地址的输入并在每个 SCK 上升沿返回两位读取数据。在某些应用中，减少的地址输入和数据输出时间可能允许代码就地执行 (XIP)，即直接从内存器件执行。

双 I/O 读取的最大工作时钟频率为 133 MHz。

Dual I/O 读取命令具有跟在地址后面的连续读取模式位，因此，在第一个 Dual I/O 读取命令发送 Axh 的模式位后，一系列 Dual I/O Read 指令可能会移除 8 位指令，表明后续指令也将是 Dual I/O 读取命令。系列中的第一个双线 I/O 读取命令以 8 位指令开始，然后是地址，然后是四个周期的模式位，然后是可选的延时周期。如果模式类型码为 Axh，则假定下一个指令不提供指令位的双线 I/O 读取命令。该指令以地址开头，后跟模式位，后跟可选延时。

在模式位移入 SI 和 SO 之后、数据开始移出 IO0 和 IO1 之前，可能会添加可变延时。此延时时间（虚拟周期）允许器件内部电路有足够的时间来访问/初始地址处的数据。在虚拟周期期间，SI 和 SO 上的数据值是“无关”的并且可能为高阻态。虚拟周期的数量由 SCK 的频率决定。延时在 CR2V[3:0] 中配置。

连续读取特点是移除了读取访问序列中指令位的需要，并大大提高了代码执行 (XIP) 性能。模式位的高半字节（位 7-4）通过包含或排除第一个字节指令代码来控制下一个 Dual I/O 读取命令的长度。模式位的低半字节（位 3-0）为“无关”（“x”），可能为高阻态。如果模式位等于 Axh，则器件保持 Dual I/O 连续读取模式，并且可以输入下一个地址（在 CS 升高然后置位低电平之后），而无需 BBh 或 BCh 指令，如图 80 所示；从而减少了 8 个指令序列周期。以下序列将从 Dual I/O 连续读取模式中释放器件；此后，器件可以接受标准 SPI 指令：

1. 在双 I/O 连续读取命令序列期间，如果模式位是除 Axh 之外的任何值，则下次 CS 升高时，该器件将从双 I/O 连续读取模式中释放。
2. 发送 Mode 复位指令。

注意，四个模式位周期是器件内部电路延时时间的一部分，用于在时钟输入 IO0 (SI) 和 IO1 (SO) 的最后一个地址周期之后访问初始地址。

重要的是，I/O 信号应在第一个数据输出时钟的下降沿或之前置位为高阻。在更高的时钟速度下，在存储器件开始驱动（总线切换）之前可用于关闭主控输出的时间减少。这是允许的，并且可能有助于防止 I/O 信号争用，主控系统可以在最后两个“无关”模式周期或任何虚拟周期内关闭 I/O 信号输出（使其成为高阻态）。

在等待时间之后，给定地址的内存内容通过 IO0 (SI) 和 IO1 (SO) 每次移出两位。在 SCK 信号的下降沿，以 SCK 频率移出两位。

该地址可以从闪存储器阵列的任意字节位置开始。每个数据字节移出后，地址会按依次递增到下一个更高的地址。因此，只需一个读取指令和地址 000000h 即可读出整个存储器。当达到最高地址时，地址计数器将回卷并回滚至 000000h，从而允许读取时序无限期地继续。

在模式或虚拟位期间，不应将 CS# 驱动为高电平，因为这可能会使模式位不确定。

命令

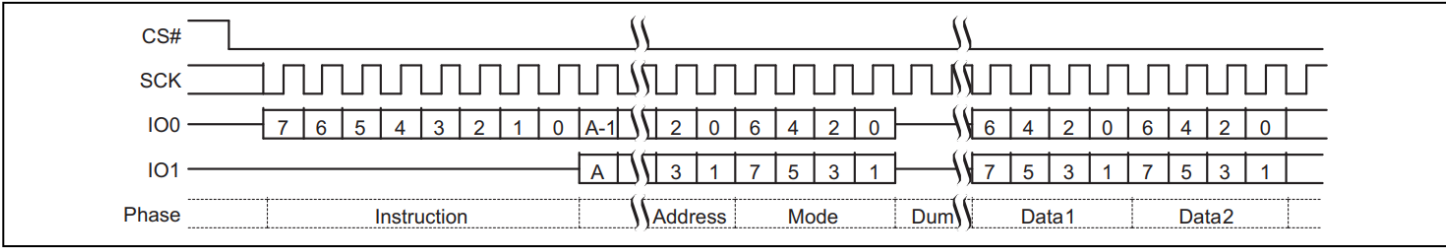


图 79 双线 I/O 读取命令时序 (BBh) [54, 55, 56]

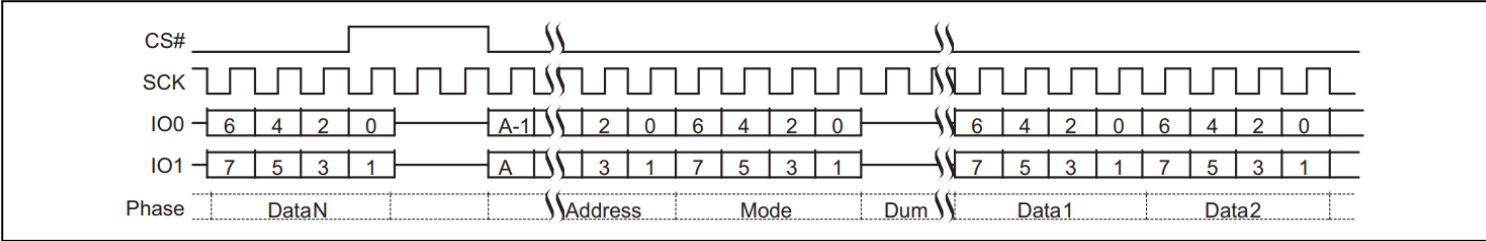


图 80 双线 I/O 连续读取命令时序 (4 字节地址 [CR2V[7] = 1]) [54, 55]

注:

- 54.A = 地址最高有效位 = 23 (对于地址长度 CR2V[7] = 0), 或 31 (对于 CR2V[7] = 1), 带有指令 BBh。
- 55.A = 最高有效位地址 = 31 带有指令 BBh
- 56.模式的最低有效4位是无关紧要的, 主控可以选择驱动这些位。 主控可能会在这些周期内关闭驱动器, 以增加主控的模式位与从内存返回数据之间的总线切换时间。

## 命令

## 10.4.4 四线 I/O 读取 (QIOR EBh 或 4QIOR ECh)

## 指令

- EBh (CR2V[7] = 0) 后跟 3 字节地址 (A23-A0) 或
- EBh (CR2V[7] = 1) 后跟 4 字节地址 (A31-A0) 或
- ECh 后面跟着 4 字节地址 (A31-A0)

四线 I/O 读取命令通过四个 I/O 信号 (IO0-IO3) 来提高吞吐量。它允许每个串行 SCK 时钟输入四位地址位。在某些应用中, 减少的指令开销可能允许直接从 S25FS-S 系列设备执行代码 (XIP)。配置寄存器的 Quad 位必须设置为 (CR1V[1] = 1), 才能启用 S25FS-S 系列设备的四线功能。

四线 I/O 读取的最大工作时钟频率为 133 MHz。

对于四线 I/O 读取命令, 在模式位 (如下所述) 之后, 数据开始移出 IO0-IO3 之前需要有一个延时。该等待时间 (即虚拟周期) 允许器件的内部电路有足够的时间来访问初始地址处的数据。在延时周期内, IO0-IO3 上的数据值是“不关心的”, 并且可能是高阻态。虚拟周期的数量由 SCK 的频率决定。延时在 CR2V[3:0] 中配置。

在延时周期之后, 给定地址处的内存内容通过 IO0-IO3 每次移出四位。每个半字节 (4 位) 以 SCK 频率通过 SCK 信号的下降沿移出。

该地址可以从闪存储器阵列的任意字节位置开始。每个数据字节移出后, 地址会按依次递增到下一个更高的地址。因此, 只需一个读取指令和地址 000000h 即可读出整个存储器。当达到最高地址时, 地址计数器将回卷并回滚至 000000h, 从而允许读取时序无限期地继续。

无需额外的四线 I/O 读取指令即可完成地址跳转。这通过设置模式位 (在地址序列之后, 如图 81 所示) 进行控制。这种增加的特性移除了对指令序列的需要, 并大大提高了代码执行 (XIP)。模式位的高半字节 (位 7-4) 通过包含或排除第一个字节指令代码来控制下一个四线 I/O 指令的长度。模式位的低半字节 (位 3-0) 为“无关” (“x”)。如果模式位等于 Axh, 则器件保持为四线 I/O 高性能读取模式, 并且可以输入下一个地址 (在 CS 升为高电平然后置位低电平之后), 而无需 EBh 或 ECh 指令, 如图 83 所示; 因此, 减少了指令序列的八个周期。以下时序将从四线 I/O 高性能读取模式中释放器件; 之后, 器件可以接受标准 SPI 指令:

1. 在四线 I/O 读取命令序列期间, 如果模式位是 Axh 以外的任何值, 则下次 CS 升高时, 器件将从四线 I/O 高性能读取模式中释放。
2. 发送 Mode 复位指令。

注意, 两个模式位时钟周期和附加等待状态 (即虚拟周期) 允许器件的内部电路延时时间在时钟输入 IO0-IO3 的最后一个地址周期之后访问初始地址。

重要的是, IO0-IO3 信号应在第一个数据输出时钟的下降沿或之前置位为高阻。在更高的时钟速度下, 在存储器器件开始驱动 (总线切换) 之前可用于关闭主控输出的时间减少。这是允许的, 并且可能有助于防止 IO0-IO3 信号争用, 因为主控系统可以在最后一个“无关”模式周期或任何虚拟周期内关闭 IO0-IO3 信号输出 (使其成为高阻态)。

在模式或虚拟位期间, 不应将 CS# 驱动为高电平, 因为这可能会使模式位不确定。

在 QPI 模式 (CR2V[6] = 1) 下, 四线 I/O 指令在每个 SCK 上升沿发送 4 位。指令协议的其余部分与四线 I/O 指令相同。

命令

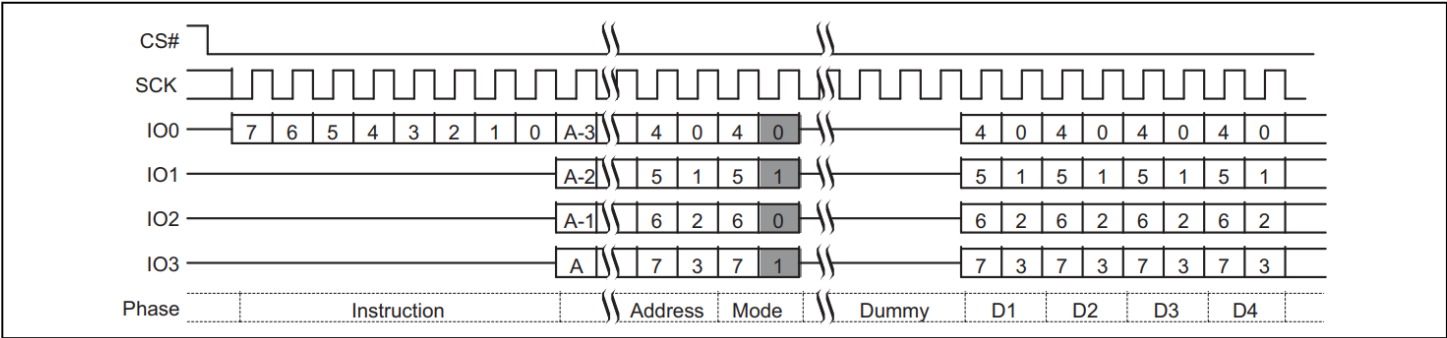


图 81 四线 I/O 读取命令时序 (EBh 或 ECh) [57, 58]

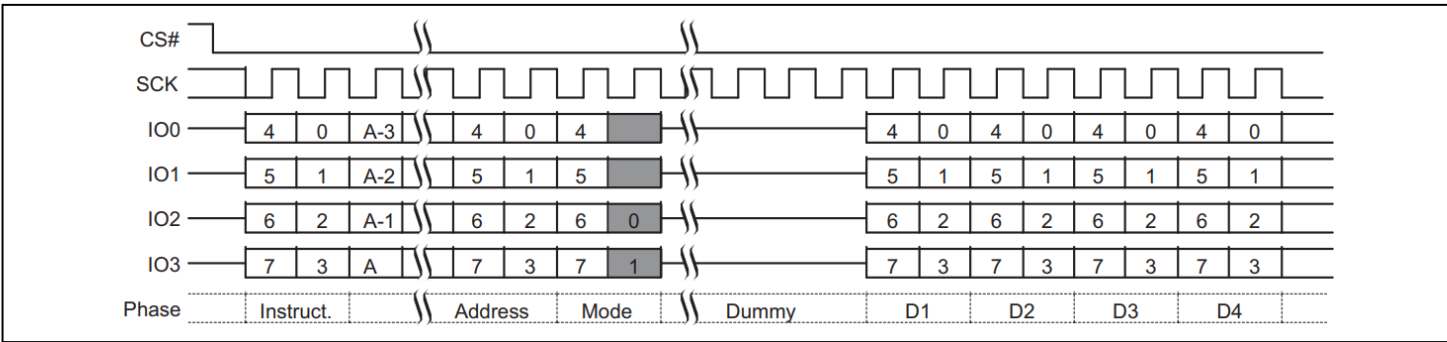


图 82 四线 I/O 读取命令时序 (EBh 或 ECh) , QPI 模式 [57, 58]

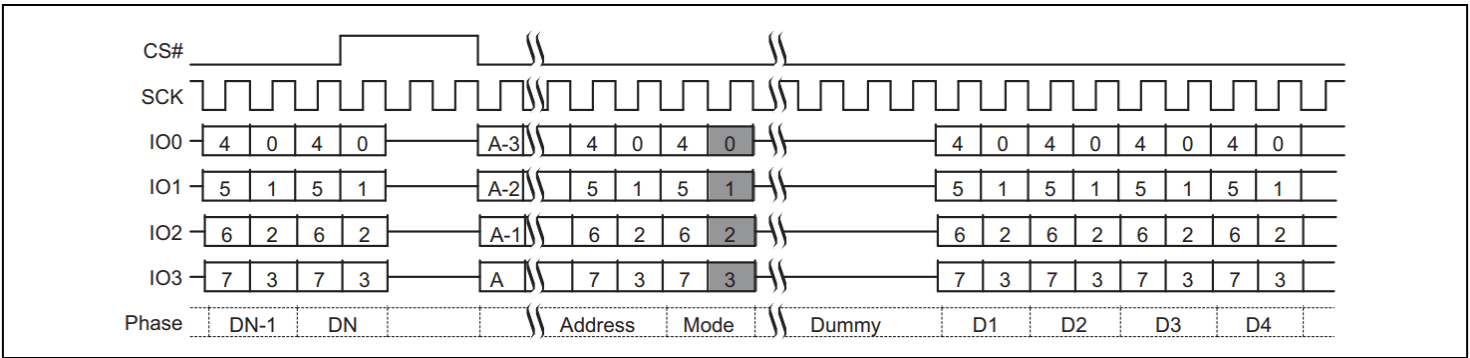


图 83 连续四线 I/O 读取命令时序 (EBh 或 ECh) [59, 60]

注:

- 57.A = 地址最高有效位 = 23 (地址长度 CR2V[7] = 0) , 或 31 (CR2V[7] = 1) , 指令为 EBh。
- 58.A = 地址最高有效位 = 31 , 指令为 ECh。
- 59.A = 地址最高有效位 = 23 (对于地址长度 CR2V[7] = 0) , 或 31 (对于 CR2V[7] = 1) , 指令为 EBh。
- 60.A = 地址最高有效位 = 31 , 指令为 ECh。

## 命令

## 10.4.5 DDR 四线 I/O 读取 (EDh、EEh)

DDR 四线 I/O 读取命令通过四个 I/O 信号 - IO0–IO3 来提高吞吐量。它类似于四线 I/O 读取命令，但允许在时钟的每个边沿输入四位地址。在某些应用中，减少的指令开销可能允许直接从 S25FS-S 系列设备执行代码 (XIP)。配置配置的 Quad 位必须配置 (CR1V[1] = 1) 才能启用四线功能。

## 指令

- EDh (CR2V[7] = 0) 后跟 3 字节地址 (A23–A0) 或
- EDh (CR2V[7] = 1) 后跟一个 4 字节地址 (A31–A0) 或
- EEh 后面跟着 4 字节地址 (A31–A0)

地址后面是模式位。然后，以 DDR 方式将给定地址的内存内容移出，通过 IO0–IO3，每个时钟边沿每次移出四位。

DDR Quad I/O 读取命令的最大工作时钟频率为 80 MHz。

对于 DDR 四线 I/O 读取，在最后一个地址和模式位移入 IO0–IO3 信号之后，数据开始移出 IO0–IO3 之前需要一段延时。该延时周期 (虚拟周期) 允许器件的内部电路有足够的时间来访问初始地址。在这些延时周期内，IO0–IO3 上的数据值是“不关心的”并且可能是高阻态。当数据学习模式 (DLP) 启用时，主控系统不得在虚拟周期期间驱动 IO 信号。主控必须将 IO 信号置于高阻态，以便存储器器件能够在虚拟周期内驱动 DLP。

虚拟周期的数量由 SCK 的频率决定。延时在 CR2V[3:0] 中配置。

模式位允许一系列 Quad I/O DDR 指令在第一个指令发送互补模式位后移除 8 位指令，如图 84 所示。这一特点减少了对 8 位 SDR 指令序列的需要，并显著减少了开始读取时间 (提高了 XIP 性能)。模式位通过包含或不包含第一个字节指令代码来控制下一个 DDR Quad I/O 读取操作的长度。如果模式位的高半字节 (IO[7:4]) 和低半字节 (IO[3:0]) 互补 (即 5h 和 Ah)，器件将转换为 Continuous DDR Quad I/O 读取模式，并且可以进入下一个地址 (在 CS 升高然后断言为低电平之后)，而无需使用 EDh 或 EEh 指令，如图 85 所示，从而从指令序列中减少了八个周期。以下序列将从连续 DDR Quad I/O 读取模式中释放器件；之后，器件可以接受标准 SPI 指令：

1. 在 DDR 四线 I/O 读取命令时序期间，如果模式位不互补，则下次 CS 升高为高电平然后置为低电平时，器件将从 DDR 四线 I/O 读取模式中释放。
2. 发送 Mode 复位指令。

该地址可以从闪存储器阵列的任意字节位置开始。每个数据字节移出后，地址会按依次递增到下一个更高的地址。因此，只需一个读取指令和地址 000000h 即可读出整个存储器。当达到最高地址时，地址计数器将回卷并回滚至 000000h，从而允许读取时序无限期地继续。

在模式或虚拟位期间，不应将 CS# 驱动为高电平，因为这可能会使模式位不确定。注意，存储设备可能会在第一个数据值之前使用前导码来驱动 IO。前导码是数据学习模式 (DLP)，主控控制器使用它来优化更高频率的数据捕获。前导码在数据输出前的四个时钟周期内驱动 IO 总线。主控必须确保在内存开始输出前导码之前停止驱动 IO 总线。

前导码旨在向主控控制器提供关于从主控驱动时钟边沿到相应数据值从存储器器件返回的往返时间的指示。主控控制器将在前导周期内偏移数据捕获点，以优化时序冗余度，然后在剩余的读取操作期间使用相同的偏移时间来捕获数据。优化的捕获点将在每次读操作的前导周期内确定。该优化策略的目的是为了补偿存储器器件和主控控制器的 PVT (工艺、电压、温度) 以及由 PCB 上的飞行时间引起的任何系统电平延时。

命令

尽管数据学习唤醒模式 (DLP) 是可编程的，下面的例子展示了 DLP 34h 的例子。DLP 34h (或 00110100) 将在每个输出 (即所有 4 个 SIO) 上驱动。选择此模式是为了涵盖“直流”和“交流”数据转换场景。两种直流转换场景包括数据低电平持续较长时间 (两个半周期时钟)，接着是高电平转换 (001) 和互补的低电平转换 (110)。两种交流转换场景包括数据低电平持续较短时间 (半个时钟周期)，接着是高电平转换 (101) 和互补的低电平转换 (010)。直流转换的起点通常比交流转换更靠近供电源轨，因为交流转换可能尚未完全稳定在稳态 (直流) 水平。在许多情况下，直流转换将限制数据有效期的开始，交流转换将限制数据有效期的结束。这些转换将允许主控制器识别有效数据眼的开始和结束。一旦确定了数据眼，就可以选择最佳数据捕获点。参见“[SPIDDR 数据学习寄存器](#)”在分页 80 了解更多详情。

在 QPI 模式 (CR2V[6] = 1) 下，DDR 四线 I/O 指令在每个 SCK 上升沿发送 4 位。指令协议的其余部分与 DDR Quad I/O 指令相同。

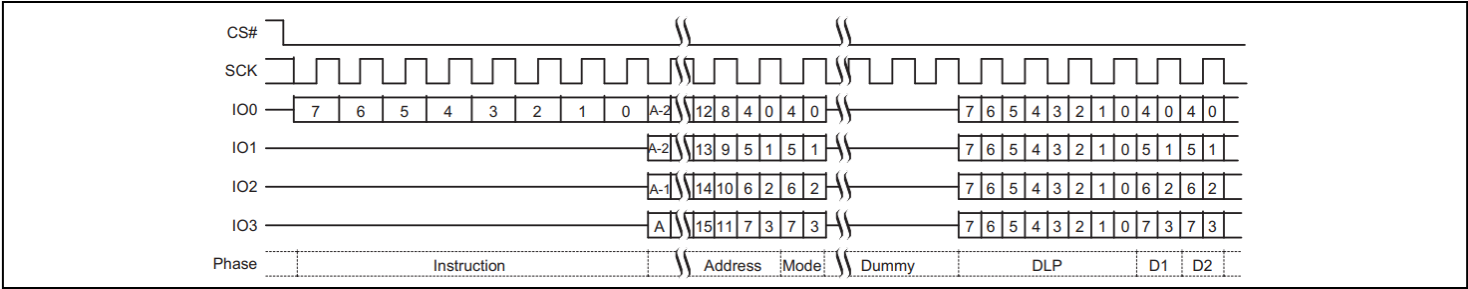


图 84 DDR Quad I/O Read 初始读取 (EDh 或 EEh) [61, 62]

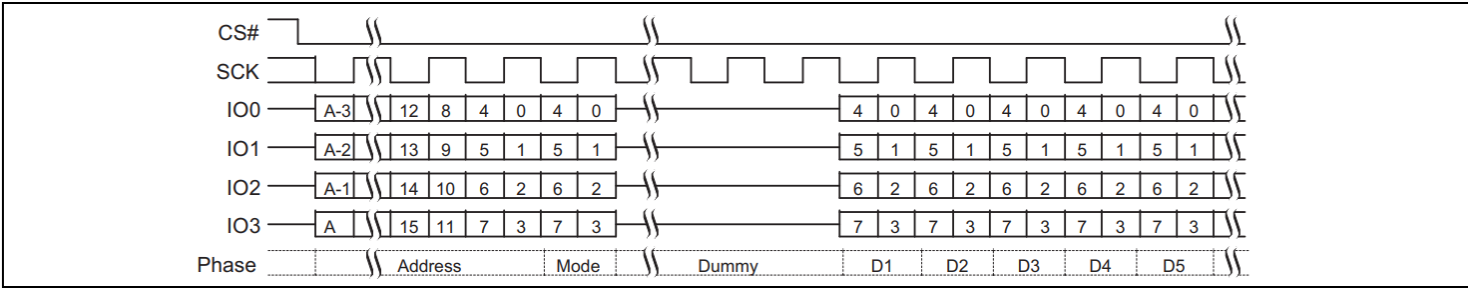


图 85 连续 DDR 四线 I/O 读取后续访问 (EDh 或 EEh) [61, 62]

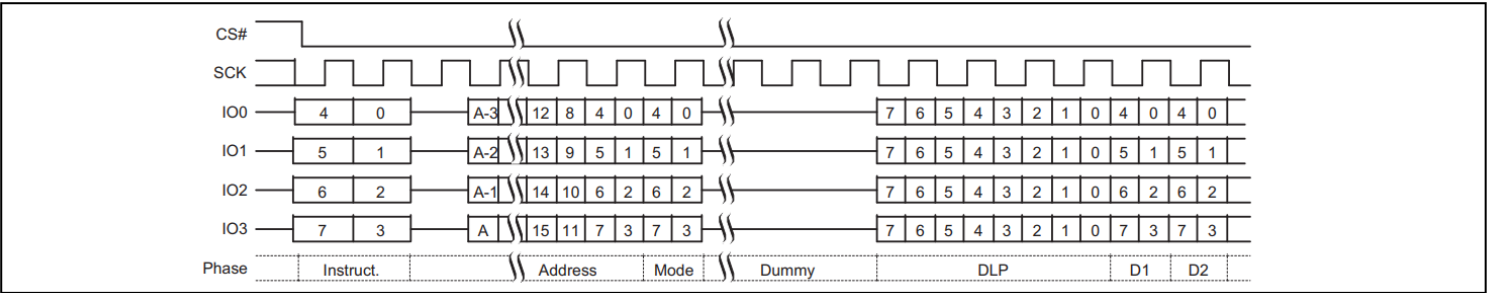


图 86 DDR Quad I/O Read 初始读取 (EDh 或 EEh) ， QPI 模式 [61, 62]

注：

- 61.A = 地址最高有效位 of = 23 地址长度 (CR2V[7] = 0)，或 31 (CR2V[7] = 1)，指令为 EDh。
- 62.A = 地址最高有效位地址 = 31，指令为 EEh。

## 命令

## 10.5 编程闪存存储器阵列指令

### 10.5.1 编程粒度

#### 10.5.1.1 自动ECC

每个16字节对齐、16字节长度的编程功能块都有一个自动纠错码（ECC）值。数据功能块加上ECC形成ECC单元。与EDC逻辑结合，ECC用于检测和纠正读取访问期间发现的任何单比特的错误。当数据首次在ECC单元内编程时，整个ECC单元的ECC值是设置。如果同一ECC单元被编程多次，则ECC值将更改为失效，不能使用EDC函数。需要扇区才能再次擦除该编程功能块上的自动ECC。16字节编程功能块是自动ECC启用的最小编程颗粒度。

这些是对用户透明的自动操作。自动ECC的透明性提高了典型编程操作（即向每个ECC单元写入一次数据）的数据准确性，但是，仍然允许单字节编程和位编程（其中同一个ECC单元被编程多次），从而促进了与前几代FL家族产品的软件兼容性。当ECC单元禁用自动ECC时，不会对从ECC单元位置读取的数据进行EDC。

提供ECC状态寄存器来确定ECC单元上是否启用了ECC，以及是否已在ECC单元数据或ECC中检测并纠正任何错误。ECC状态寄存器读取（ECCRD）指令用于读取任何ECC单元的ECC状态。

错误检测和纠正（EDC）应用于除寄存器之外的闪存存储器地址空间的所有部分。为每组受保护的字节计算一个错误校正码（ECC），并将ECC存储在与该字节组相关的隐藏区域中。受保护的字节组和相关的ECC一起称为ECC单元。

- ECC是按每16字节对齐和长度计算的ECC元
- 单比特的EDC支持每个ECC单元8个ECC位，加上1位ECC失效，禁止使能标志
- 扇区擦除将所有ECC禁止使能标志，使扇区中的标志恢复为默认状态（启用的）
- ECC被编程为标准编程指令操作的一部分
- 如果对同一个ECC单元进行多次编程操作，ECC会自动禁用。
- 允许单字节编程或单比特编程，但第二次编程到相同的16字节ECC单元，ECC会被禁用。
- ECC禁止使能标志是在ECC禁用时编程的
- 要为已禁用的ECC单元重新启用ECC，必须擦除包含ECC单元置的扇区
- 为了确保EDC提供的最佳数据完整性，每个ECC单元只能编程一次，以便为该单元存储ECC并且不会禁用。
- ECC的计算、编程和禁用作为编程操作的一部分自动完成。如果需要，检测和纠错将作为读取操作的一部分自动完成。主控系统只能看到读取操作中更正的数据。
- ECC保护OTP区域—然而，同一个ECC单元上的第二个编程操作将会使ECC永久地在该ECC单元失效（OTP是一次性的，因此禁止重新使能ECC使能位的操作）

## 命令

### 10.5.1.2 页编程

页编程是通过将要编程的数据加载到页缓冲区并发出编程指令将数据从缓冲区移至闪存阵列来完成的。这设置了可使用单个编程指令进行编程的数据量的上限。页编程允许在一次操作中对最多 1 页缓冲区大小（256 或 512 字节）进行编程。页大小由配置寄存器位 CR3V[4] 决定。页在页大小地址边界上对齐。在每个写入缓冲区编程操作中，可以编程 1 位到 512 字节。建议写入 16 字节长度的倍数并对齐的编程块。这确保自动 ECC 不会被禁用。为了获得最佳性能，编程应以 512 字节边界对齐的整页 512 字节进行，并且每个页只编程一次。

### 10.5.1.3 单字节编程

通过允许在存储器阵列中的任何位置对单个字节进行编程，单字节编程允许完全向后兼容传统标准 SPI 页编程 (PP) 指令。虽然支持单字节编程，但这将禁用在 16 字节 ECC 单元上进行自动 ECC。

## 10.5.2 页编程 (PP 02h 或 4PP 12h)

页程序 (PP) 指令允许对闪存中的字节进行编程（将位从“1”更改为“0”）。在器件接受页程序 (pp) 指令之前，器件必须发出写使能 (WREN) 指令并对其进行解码。成功解码写入使能 (WREN) 指令后，器件将状态寄存器中的写入使能锁存器 (WEL) 设置为使任何写入操作有效。

指令

- 02h (CR2V[7] = 0) 后跟 3 字节地址 (A23-A0) 或
- 02h (CR2V[7] = 1) 后跟 4 字节地址 (A31-A0) 或
- 12h 后面跟着 4 字节地址 (A31-A0)

并且 SI 上至少有一个数据字节。根据 CR3V[4]，页大小可以是 256 或 512 字节。使用指令 02h 提供 3 字节地址或使用指令 12h 提供 4 字节地址后，SI 上最多可以提供一页。

如果发送到器件的数据多于起始地址和分页对齐结束边界之间的空间，则数据加载序列将从分页中的最后一个字节绕回到同一分页的 0 字节位置，并开始重写分页中先前加载的任何数据。最后一个分页数据被编程在分页中。这是由于该器件配备了长度仅为分页大小的页编程缓冲区。如果向器件发送的数据少于一页，则这些数据字节将从分页内提供的地址开始按顺序进行编程，而不会对同一分页的其他字节产生任何影响。

使用分页编程 (PP) 指令在分页边界内加载整个分页，与将少于一页加载到编程相比，将节省总体编程时间。

编程过程由内部器件控制逻辑来管理。发出编程指令后，可以使用读取状态指令 1 指令来检查编程操作状态。WIP 位 (SR1V[0]) 将指示编程操作何时完成。P\_ERR 位 (SR1V[6]) 将指示编程操作中是否发生了阻止编程成功完成的错误。这包括尝试对保护区进行编程。

命令

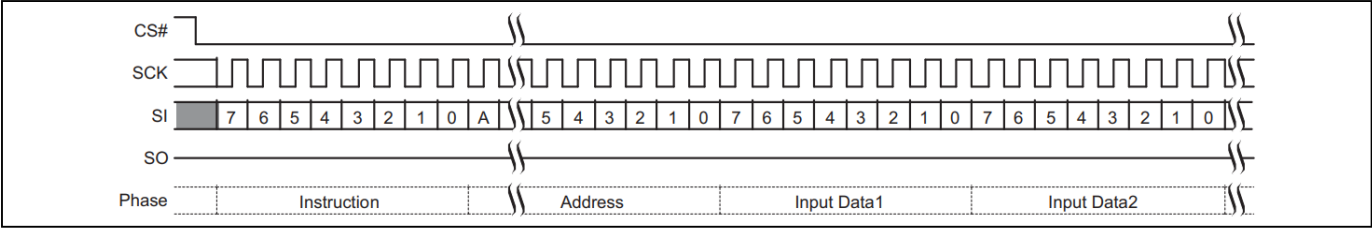


图 87 页程序 (PP 02h 或 4PP 12h) 指令时序<sup>[63]</sup>

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

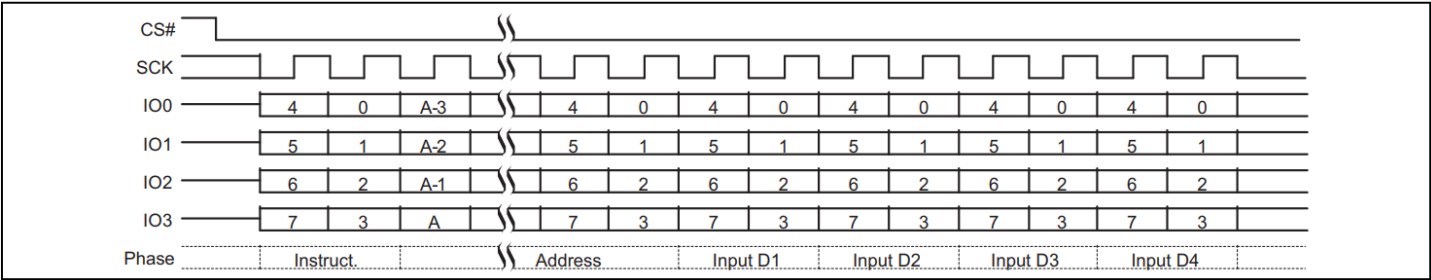


图 88 页编程 (PP 02h 或 4PP 12h) QPI 模式指令时序<sup>[63]</sup>

注：

63.A = 地址的高有效位 = A23（对于 pp 02h），或 A31（对于 4PP 12h）。

命令

## 10.6 擦除闪存存储器指令

### 10.6.1 参数 4 KB 扇区擦除 (P4E 20h 或 4P4E 21h)

主闪存阵列地址分布可以配置为将 4-KB 参数扇区覆盖在最低地址统一扇区的最低地址部分（底部参数扇区）上或覆盖最高地址统一扇区的最高地址部分（顶部参数扇区）。主闪存阵列地址分布也可以配置为仅具有统一大小的扇区。参数扇区配置由配置位 CR3V[3] 控制。当器件仅配置为统一扇区 (CR3V[3] = 1) 时，P4E 和 4P4E 指令将被忽略。

参数 4-KB 扇区指令置位将 4-KB 参数扇区的所有位设置为“1”（所有字节均为 FFh）。在器件接受 P4E 或 4P4E 指令之前，器件必须发出写使能 (WREN) 指令并对其进行解码，这会设置状态寄存器中的写使能锁存器 (WEL) 以允许任何写操作。

指令

- 20h [CR2V[7] = 0] 后跟 3 字节地址 (A23-A0)，或
- 20h [CR2V[7] = 1] 后跟一个 4 字节地址 (A31-A0)，或者
- 21h 后面跟着 4 字节地址 (A31-A0)

地址的第 24 位或第 32 位被锁存在 SI 上之后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。这将启动内部擦除周期的开始，其中包括对闪存阵列选定扇区的预编程和擦除。如果地址的最后一位之后 CS# 没有被驱动为高电平，则不会执行扇区擦除操作。

一旦 CS# 被驱动为高电平，内部擦除周期就会启动。随着内部擦除周期的进行，用户可以读取写入进度 (WIP) 位的值来确定操作何时完成。当擦除周期正在进行时，WIP 位将指示“1”，当擦除周期已完成时，WIP 位将指示“0”。

对已通过功能块保护位或 ASP 进行写保护的扇区应用 P4E 或 4P4E 指令将不会被执行，并且将置位 E\_ERR 状态。应用于大于 4 KB 的扇区的 P4E 指令将不会被执行，并且不会置位 E\_ERR 状态。

命令

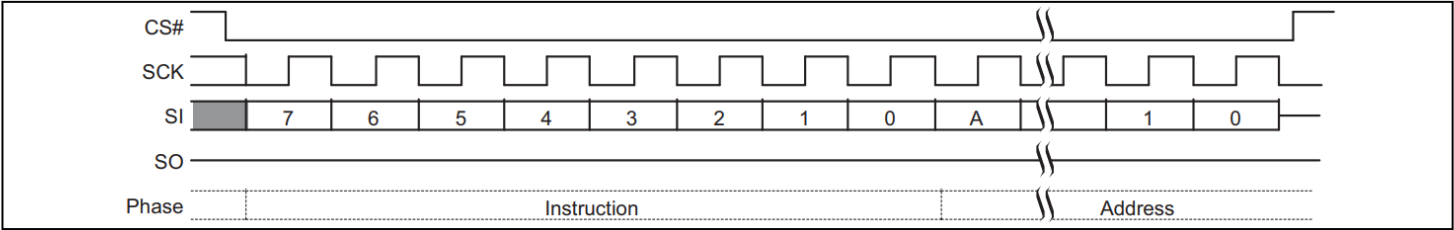


图 89 参数扇区擦除 (P4E 20h 或 4P4E 21h) 指令时序<sup>[64]</sup>

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

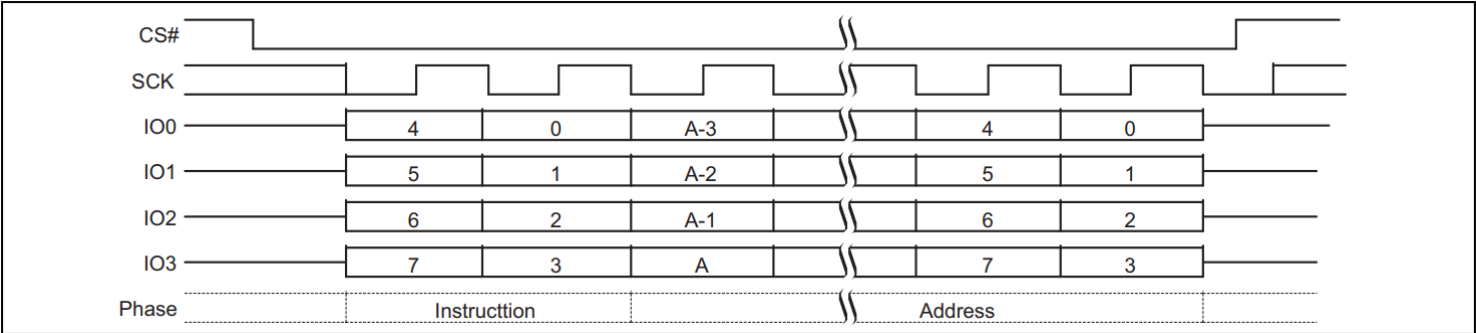


图 90 参数扇区擦除 (P4E 20h 或 4P4E 21h) QPI 模式指令时序<sup>[64]</sup>

注：

64.A = 地址的最高有效位 = A23 (对于 P4E 20h, CR2V[7] = 0) , 或 A31 (对于 P4E 20h, CR2V[7] = 1 或 4P4E 21h) 。

命令

## 10.6.2 扇区擦除 (SE D8h 或 4SE DCh)

扇区 (SE) 指令将寻址扇区中的所有位设置为“1”（所有字节均为 FFh）。在器件接受扇区寄存器 (SE) 指令之前，器件必须发出写使能 (WREN) 指令并对其进行解码，这会设置状态寄存器中的写使能锁存器 (WEL)，以允许任何写操作。

指令

- D8h [CR2V[7] = 0] 后跟 3 字节地址 (A23–A0)，或者
- D8h [CR2V[7] = 1] 后跟一个 4 字节地址 (A31–A0)，或者
- DCh 后面跟着 4 字节地址 (A31–A0)

在地址的第 24 位或第 32 位被锁存在 SI 上之后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。这将启动擦除周期，其中包括所选扇区的预编程和擦除。如果地址的最后一位之后 CS# 没有被驱动为高电平，则不会执行扇区擦除操作。

一旦 CS# 被驱动到逻辑高电平状态，内部擦除周期就会启动。随着内部擦除周期的进行，用户可以读取写入进度 (WIP) 位的值来检查操作是否已完成。当擦除周期正在进行时，WIP 位将指示“1”，当擦除周期已完成时，WIP 位将指示“0”。

应用于已通过功能块保护位或 ASP 写保护的扇区的扇区 (SE) 指令将不会被执行，并将置位 E\_ERR 状态。

器件配置选项 (CR3V[1]) 决定 SE 指令是 64 KB 还是 256 KB。使用此指令始终擦除 256 KB 的选项可确保与更高容量和未来的 S25FS 系列设备的软件兼容性。

器件配置选项 (CR3V[3]) 确定是否使用 4-KB 参数扇区。如果 CR3V[3] = 0，4-KB 参数区扇覆盖器件地址空间的最高或最低地址 32 KB 的一部分。如果将扇区指令应用于被 4 KB 扇区覆盖的 64 KB 扇区，则被覆盖的 4 KB 扇区不受该扇区的影响。仅 64 KB 扇区的可见（非覆盖）部分被擦除。类似地，如果将扇区擦除指令应用于被 4 KB 扇区覆盖的 256 KB 范围，则可见（非覆盖）部分被擦除，4 KB 扇区不受擦除影响。当 CR3V[3] = 1 时，器件地址空间中没有 4-KB 参数扇区，扇区指令始终在完全可见的 64-KB 或 256-KB 扇区上运行。

ASP 为每个物理扇区（包括任何 4 KB 扇区）提供了一个 PPB 和一个 DYB 保护位。如果将扇区擦除指令应用于包含 64 KB 受保护的物理扇区的 256 KB 范围，则扇区不会在 256 KB 范围上执行，并将置位 E\_ERR 状态。

命令

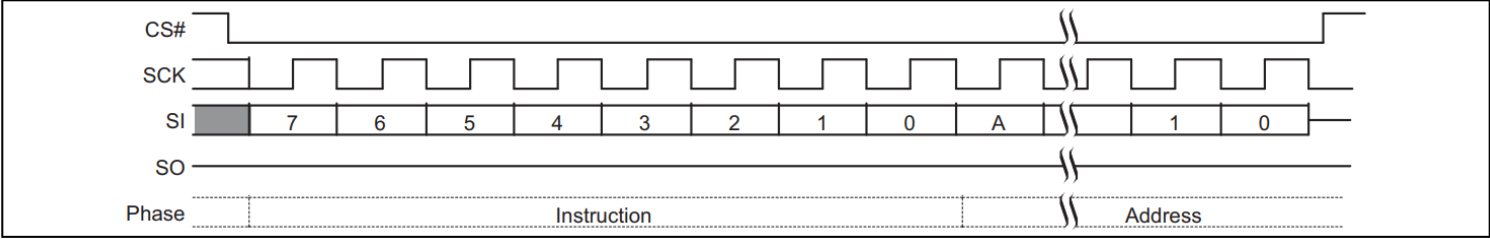


图 91 扇区擦除 (SE D8h 或 4SE DCh) 指令时序<sup>[65]</sup>

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0–IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

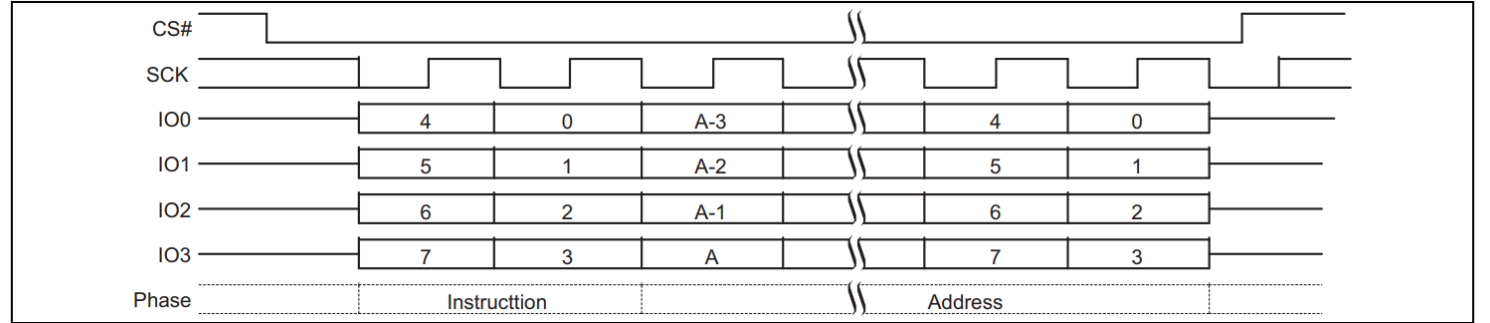


图 92 扇区擦除 (SE D8h 或 4SE DCh) QPI 模式指令时序<sup>[66]</sup>

注：

65.A = 地址的最高有效位 = A23，对于 CR2V[7] = 0 的 SE D8h，A31 对于 CR2V[7] = 1 的 SE D8h 或 4P4E DCh。  
66.A = 地址的最高有效位 = A23（对于 P4E 20h，CR2V[7] = 0），或 A31（对于 P4E 20h，CR2V[7] = 1 或 4P4E 21h）。

命令

### 10.6.3 批量擦除 (BE 60h 或 C7h)

批量擦除 (BE) 指令将整个互连内的所有位设置为“1”（所有字节均为 FFh）。在器件接受 BE 指令之前，器件必须发出写使能 (WREN) 指令并对其进行解码，这会设置状态寄存器中的写使能锁存器 (WEL) 以允许任何写操作。

指令字节的第八位被锁存在 SI 上之后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。这将启动擦除周期，其中涉及整个闪存阵列的预编程和擦除。如果在指令的最后一位之后 CS# 没有被驱动为高电平，则不会执行 BE 操作。

一旦 CS# 被驱动到逻辑高电平状态，擦除周期就会启动。随着擦除周期的进行，用户可以读取写入进度 (WIP) 位的值来确定操作何时完成。当擦除周期正在进行时，WIP 位将指示“1”，当擦除周期已完成时，WIP 位将指示“0”。

仅当功能块保护 (BP2、BP1、BP0) 位设置为 0 时，BE 指令才能执行。如果 BP 位不为 0，则不执行 BE 指令，且 E\_ERR 不置位。BE 指令将跳过任何受 DIB 或 PPB 保护的扇区，并且 E\_ERR 状态将不会被置位。

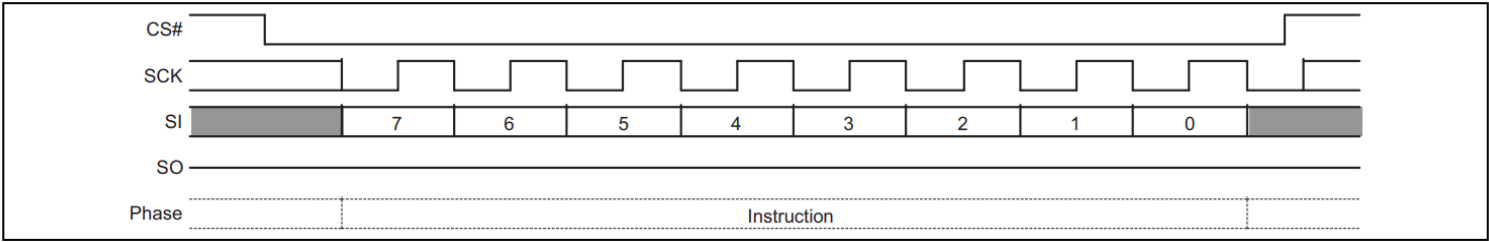


图 93 批量擦除指令时序

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

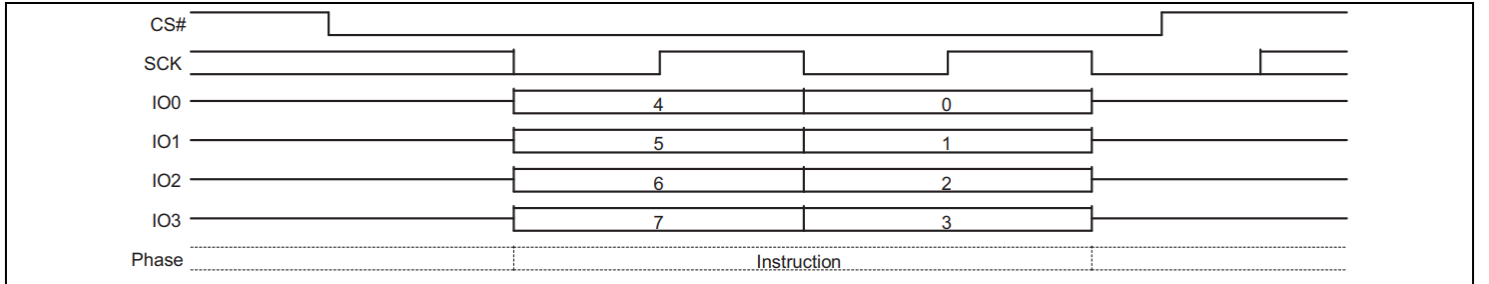


图 94 批量擦除指令时序 QPI 模式

命令

### 10.6.4 评估擦除状态 (EES D0h)

评估擦除状态 (EES) 指令用于验证对已指定地址的扇区进行的擦除操作是否完全成功 (即如果所选扇区已成功擦除, 则状态位 (SR2V[2]) 置位为“1”。如果选定的扇区未被完全擦除, 则 SR2V[2] 为“0”。

使用 EES 指令可以检测擦除操作失败的原因, 原因可能是: 断电、复位或擦除操作过程失败。

EES 指令后跟 3 或 4 字节地址, 具体取决于地址长度配置 (CR2V[7])。EES 指令要求<sub>EES</sub>完成并更新 SR2V 中的擦除状态。可以使用 RDSR1 (05h) 指令读取 WIP 位 (SR1V[0]), 以确定 EES 指令何时完成。然后可以使用 RDSR2 (07h) 或 RDAR (65h) 指令读取 SR2V[2]。如果发现扇区未在 SR2V[2] = 0 的情况下擦除, 必须再次擦除该扇区, 以确保扇区中数据的可靠存储。

在 EES 指令之前不需要 Write 使能指令 (设置为 WEL 位)。但是, WEL 位由器件本身置位, 并在操作结束时清除, 如读取状态时在 SR1V[1] 中可见。

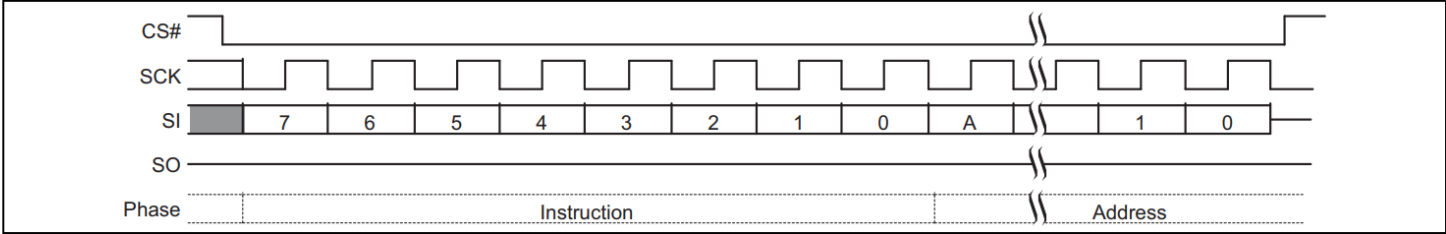


图 95 EES 指令时序<sup>[67]</sup>

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下, 指令在 IO0-IO3 上移位, 每个字节两个时钟周期。

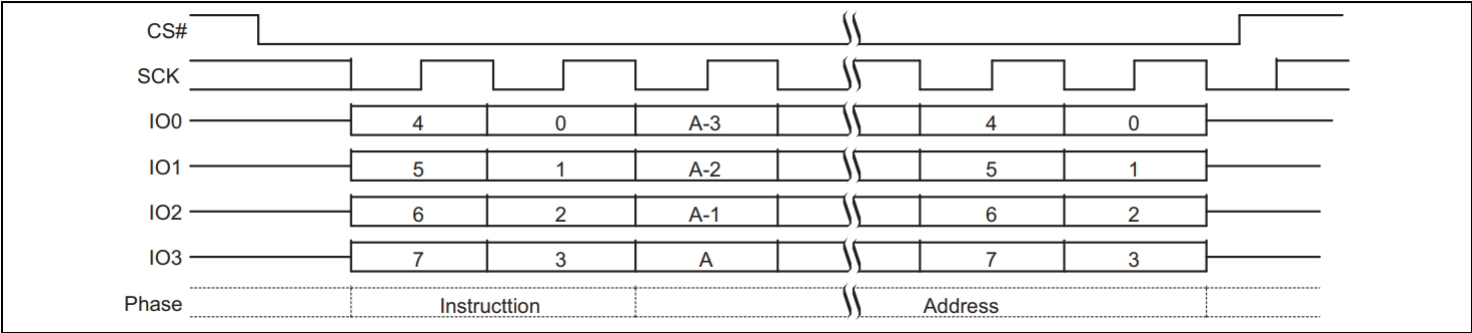


图 96 EES QPI 模式指令时序<sup>[67]</sup>

注:

67.A = 地址的最高有效位 = A23 (CR2V[7] = 0), 或 A31 (CR2V[7] = 1)。

## 命令

### 10.6.5 编程或擦除暂停 (PES 85h、75h、B0h)

有三个用于编程或擦除暂停 (PES) 的指令代码，以实现旧版和备用源软件的兼容性。

PES 指令允许系统中断编程或暂停操作，然后从任何其他非暂停暂停扇区或非程序暂停页面读取。编程或擦除暂停仅在编程或扇区擦除操作期间有效。批量擦除操作无法暂停。

必须检查状态寄存器 1 (SR1V[0]) 中的写入进行中 (WIP) 位才能知道编程或擦除操作何时停止。状态寄存器 2 (SR2[0]) 中的编程暂停状态位可用于确定在 WIP 变为“0”时编程操作是否已暂停或完成。状态寄存器 2 (SR2[1]) 中的擦除暂停状态位可用于确定在 WIP 变为“0”时擦除操作是否已暂停或完成。完成暂停操作所需的时间为  $t_{SL}$ ，请参阅分页 150 上的“[编程和擦除性能](#)”。

可以挂起擦除以允许编程操作或读取操作。在擦除挂起期间，可以读取 DYB 阵列来检查扇区保护，并保护写入，删除，恢复要编程的扇区的。

可以挂起编程操作以允许读取操作。

在已经挂起的擦除或编程操作下不允许进行新的擦除操作。在这种情况下，擦除指令将被忽略。

**表 61 擦除或编程挂起期间允许的指令**

Instruction name	Instruction code (Hex)	Allowed during erase suspend	Allowed during program suspend	Comment
PP	02	X	–	Required for array program during erase suspend. Only allowed if there is no other program suspended program operation (SR2V[0] = 0). A program command will be ignored while there is a suspended program. If a program command is sent for a location within an erase suspended sector the program operation will fail with the P_ERR bit set.
READ	03	X	X	All array reads allowed in suspend.
RDSR1	05	X	X	Needed to read WIP to determine end of suspend process.
RDAR	65	X	X	Alternate way to read WIP to determine end of suspend process.
WREN	06	X	–	Required for program command within erase suspend.
RDSR2	07	X	X	Needed to read suspend status to determine whether the operation is suspended or complete.
4PP	12	X	–	Required for array program during erase suspend. Only allowed if there is no other program suspended program operation (SR2V[0] = 0). A program command will be ignored while there is a suspended program. If a program command is sent for a location within an erase suspended sector the program operation will fail with the P_ERR bit set.
4READ	13	X	X	All array reads allowed in suspend.
CLSR	30	X	–	Clear status may be used if a program operation fails during erase suspend. Note the instruction is only valid if enabled for clear status by CR4NV[2] = 1.

## 命令

表 61 擦除或编程挂起期间允许的指令 (续)

Instruction name	Instruction code (Hex)	Allowed during erase suspend	Allowed during program suspend	Comment
CLSR	82	X	–	Clear status may be used if a program operation fails during erase suspend.
EPR	30	X	X	Required to resume from erase or program suspend. Note the command must be enabled for use as a resume command by CR4NV[2] = 0.
EPR	7A	X	X	Required to resume from erase or program suspend.
EPR	8A	X	X	Required to resume from erase or program suspend.
RSTEN	66	X	X	Reset allowed anytime.
RST	99	X	X	Reset allowed anytime.
FAST_READ	0B	X	X	All array reads allowed in suspend.
4FAST_READ	0C	X	X	All array reads allowed in suspend.
EPR	7A	X	–	Required to resume from erase suspend.
EPR	8A	X	–	Required to resume from erase suspend.
DIOR	BB	X	X	All array reads allowed in suspend.
4DIOR	BC	X	X	All array reads allowed in suspend.
DYBRD	FA	X	–	It may be necessary to remove and restore dynamic protection during erase suspend to allow programming during erase suspend.
DYBWR	FB	X	–	It may be necessary to remove and restore dynamic protection during erase suspend to allow programming during erase suspend.
PPBRD	FC	X	–	Allowed for checking Persistent Protection before attempting a program command during erase suspend.
4DYBRD	E0	X	–	It may be necessary to remove and restore dynamic protection during erase suspend to allow programming during erase suspend.
4DYBWR	E1	X	–	It may be necessary to remove and restore dynamic protection during erase suspend to allow programming during erase suspend.
4PPBRD	E2	X	–	Allowed for checking Persistent Protection before attempting a program command during erase suspend.
QIOR	EB	X	X	All array reads allowed in suspend.
4QIOR	EC	X	X	All array reads allowed in suspend.
DDRQIOR	ED	X	X	All array reads allowed in suspend.
4DDRQIOR	EE	X	X	All array reads allowed in suspend.
RESET	F0	X	X	Reset allowed anytime.
MBR	FF	X	X	May need to reset a read operation during suspend.

命令

在擦除暂停扇区或编程挂起分页内的任何地址读取都会产生不确定的数据。

在擦除或编程挂起期间不允许使用 WRR、WRAR 或 PPB 指令，因此在擦除挂起期间不可能更改功能块保护或 PPB 位。如果有扇区在擦除挂起期间可能需要编程，则这些扇区应该仅受 DYB 位的保护，这些 DYB 位可以在擦除挂起期间关闭。

擦除挂起的编程操作完成后，EAC 返回擦除挂起状态。系统可以通过读取状态寄存器来确定编程操作的状态，就像在执行标准编程操作一样。

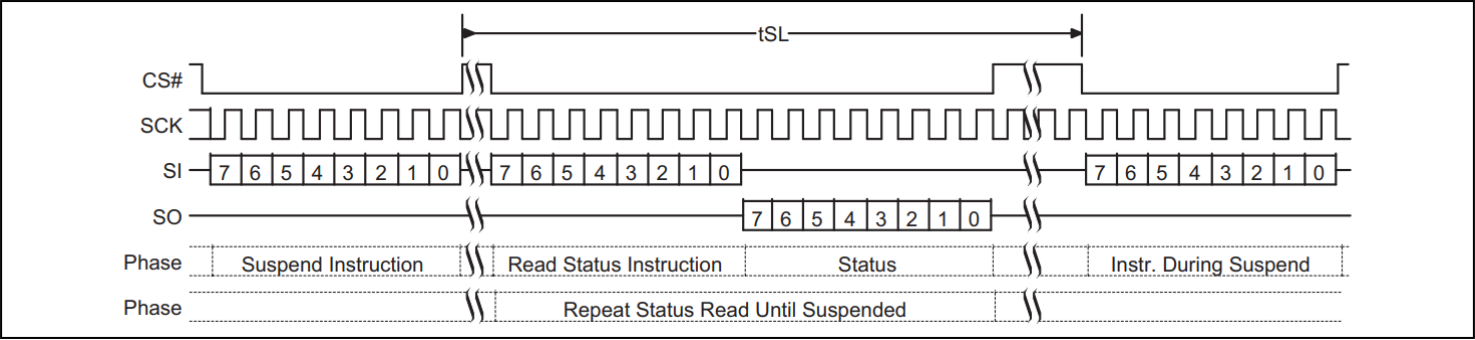


图 97 擦除或编程挂起指令时序

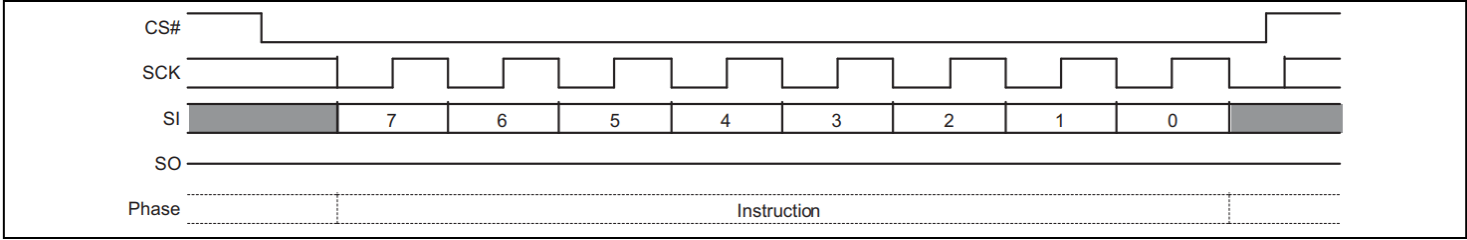


图 98 擦除或编程挂起指令时序

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

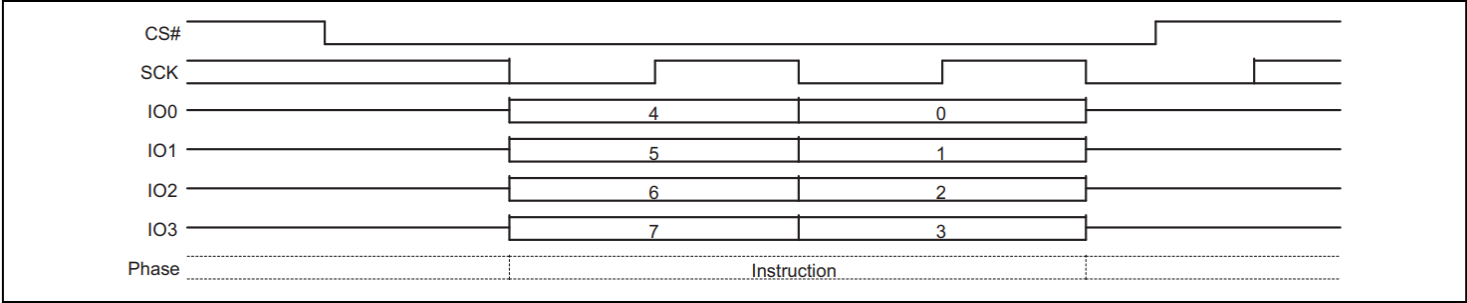


图 99 擦除或编程挂起指令序列 QPI 模式

命令

### 10.6.6 擦除或编程恢复（EPR 7Ah、8Ah、30h）

有三个用于擦除或程序恢复（EPR）的指令代码，以实现旧版和备用源软件的兼容性。

在编程或擦除挂起期间，编程或读取操作完成后，将发送擦除或编程恢复指令以继续挂起的操作。

发出命令擦除或编程恢复指令后，状态寄存器 1 中的 WIP 位将置位为“1”，挂起编程操作将恢复。如果没有挂起编程操作，则挂起的擦除操作将恢复。如果没有擦除或编程挂起的操作，则恢复指令将被忽略。

编程或擦除操作可根据需要随时中断，例如，编程挂起指令可紧跟在程序恢复指令之后，但是为了使编程或擦除操作顺利完成，在恢复和下一个挂起指令之间必须留出大于或等于  $t_{RS}$  的时间间隔。请参阅 第 150 页上的“编程或擦除挂起AC参数”。

必须写入一个擦除或编程恢复指令来恢复挂起的操作。

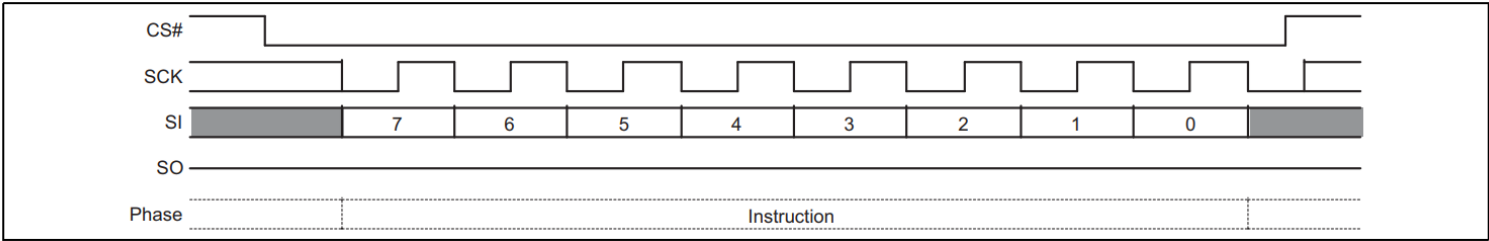


图 100 擦除或编程恢复指令时序

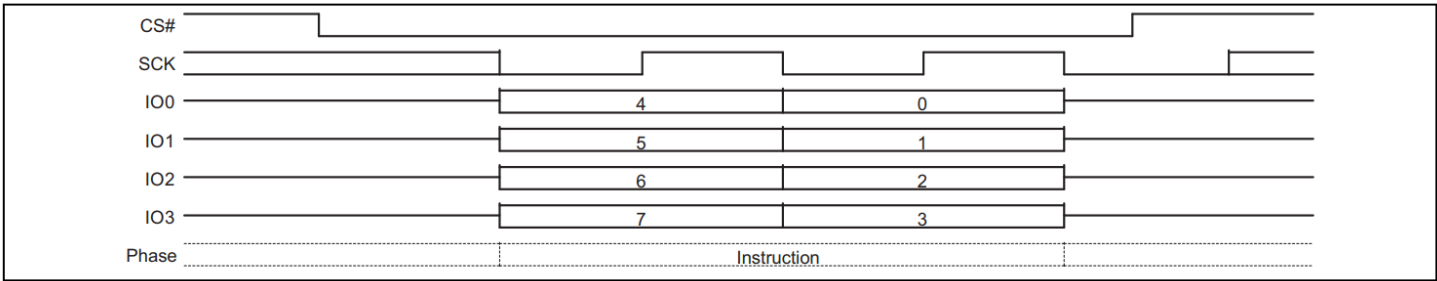


图 101 擦除或编程恢复指令时序 QPI 模式

命令

## 10.7 一次性编程区域指令

### 10.7.1 OTP 编程 (OTPP 42h)

OTP编程指令在一次性编程区域中对数据进行编程，该区域与主阵列数据位于不同的地址空间中。OTP区域为 1024 字节，因此对于该指令，从 A31 到 A10 的地址位必须为 0。请参阅“[OTP 地址空间](#)”在 页 57 有关OTP区域的详细信息。

在器件接受OTP程序指令之前，器件必须发出写使能 (WREN) 指令并对其进行解码，这会设置寄存器状态中的写使能锁存器 (WEL)，以允许任何写操作。可以检查 SR1V 中的 WIP 位来确定操作何时完成。可以检查 SR1V 中的 P\_ERR 位来确定操作期间是否发生任何错误。

为了以位颗粒度对OTP阵列进行编程，数据字节内的其余位可以设置为“1”。

OTP 存储空间中的每个区域都可以被编程一次或多次，前提是该区域未被锁定。若SR1V 置位中的 P\_ERR 位将变为“1”，尝试在已锁定的区域中编程 0 将失败。

编程位置即使在受保护的区域也不会导致错误并且不会置位 P\_ERR。后续的OTP编程仅可对未编程的位（即1个数据）进行。在一个ECC单元内编程一次以上，将会使单元上的ECC失效。

OTP编程指令的协议与页编程指令相同。参见“[分页编程 \(页 02h 或 4PP 12h\)](#)”在 页 126 的指令时序。

### 10.7.2 OTP 读取 (OTPR 4Bh)

OTP读取命令从OTP区域读取数据。OTP区域为1024字节，因此，对于此指令，从A31到A10 OTP地址位必须为零。请参阅“[OTP 地址空间](#)”在 分页 57 有关OTP区域的详细信息。OTP读取命令的协议与Fast读取命令类似，只是OTP地址达到最大值后不会回卷到起始地址；相反，超出最大OTP地址的数据将是未定义的。OTP读取命令的读延时由CR2V[3:0]中的延时值决定。参见“[快速读（快速读取） 0Bh 或者 4快速读取 0Ch](#)” 页 118 指令时序。

命令

## 10.8 高级扇区保护命令

### 10.8.1 ASP 读取 (ASPRD 2Bh)

ASP 读指令 2Bh 在 SCK 信号的上升沿被移入 SI。然后，16 位 ASP 寄存器内容以最低有效字节优先的方式移出到串行输出 SO。每个位都通过 SCK 信号的下降沿以 SCK 频率移出。通过提供 16 个时钟周期的倍数，可以连续读取 ASP 寄存器。ASP 读取 (ASPRD) 指令的最大工作时钟频率为 133 MHz。

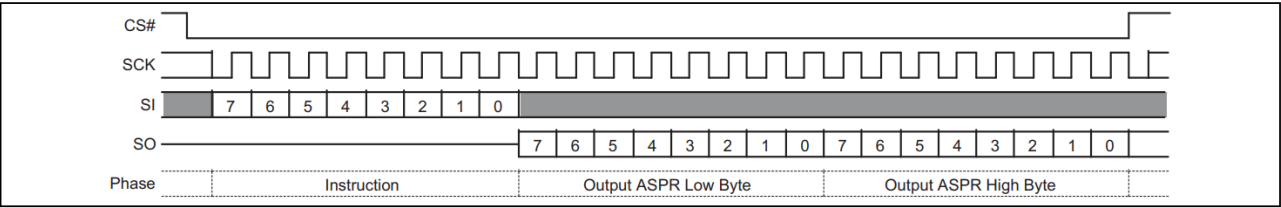


图 102 ASPRD 指令

### 10.8.2 ASP 编程 (ASPP 2Fh)

在器件接受 ASP 程序 (ASPP) 指令之前，必须发出写使能 (WREN) 指令。写使能 (WREN) 指令被解码后，器件会将写使能锁存器 (WEL) 置位在状态寄存器中，以允许任何写操作。

通过将 CS# 驱动至逻辑低电平状态来输入 ASPP 命令，然后在 SI 上输入指令和两个数据字节，低字节在前。ASP 寄存器的长度为两个数据字节。

ASPP 指令以与任何其他编程操作相同的方式影响状态和配置寄存器的 P\_ERR 和 WIP 位。

锁存第十六位数据后，必须将 CS# 输入驱动至逻辑高电平状态。如果不是，则不会执行 ASPP 指令。一旦 CS# 被驱动到逻辑高电平状态，自定时 ASPP 操作就会启动。当 ASPP 操作正在进行时，可以读取状态寄存器来检查写入进度 (WIP) 位的值。自定时 ASPP 操作期间，写入进度 (WIP) 位为‘1’，完成时为‘0’。当 ASPP 操作完成后，Write 使能 Latch (WEL) 被置位为‘0’。

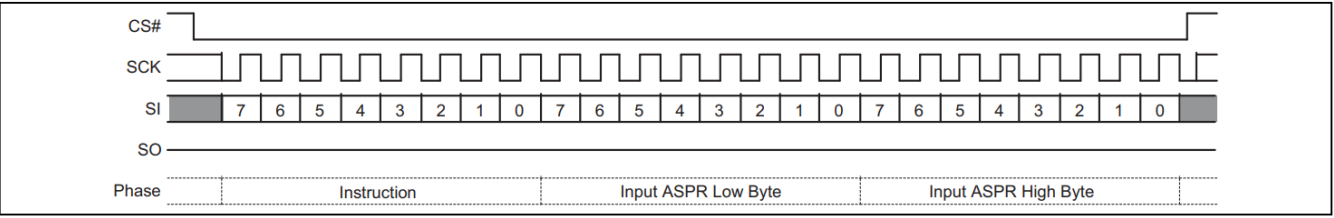


图 103 ASPP 命令

命令

### 10.8.3 DYB 读取 (DYBRD FAh 或 4DYBRD E0h)

该指令由SCK信号的上升沿锁存到SI中。该指令后面跟着 24 位或 32 位地址，具体取决于地址长度配置 CR2V[7]，选择所需扇区内的0位置。注意，特定容量器件未使用的高位地址位必须为零。然后，8 位DYB 访问寄存器的内容通过串行输出 SO 移出。每个位都通过 SCK 信号的下降沿以 SCK 频率移出。通过提供八个时钟周期的倍数，可以连续读取相同的DYB访问寄存器。DYB寄存器的地址不会递增，所以这不是读取整个DYB阵列的方法。必须使用单独的 DYB 读取命令读取每个位置。读取命令的最大工作时钟频率为 133 MHz。

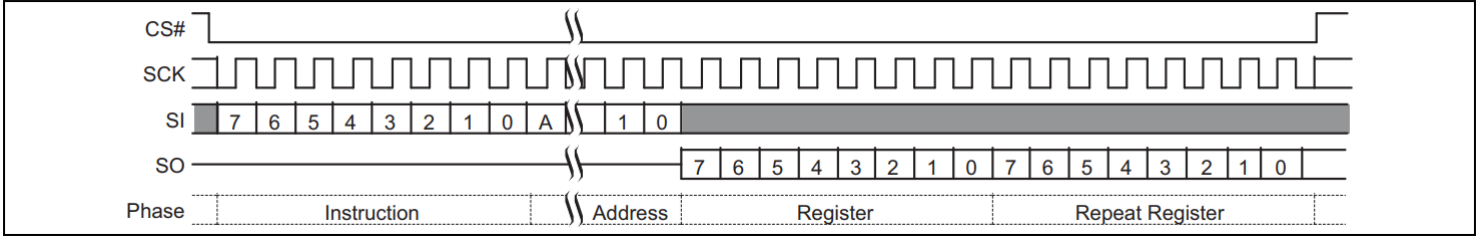


图 104 DYBRD 指令时序<sup>[68, 69]</sup>

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令和地址通过 IO0–IO3 移入，返回数据通过 IO0–IO3 移出。

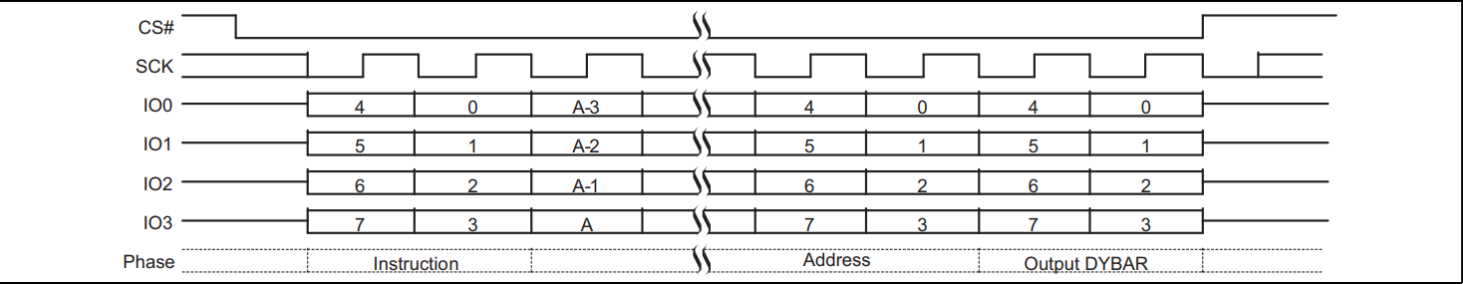


图 105 DYBRD QPI 模式指令时序<sup>[68, 69]</sup>

注：(Note:)

- 68.A = 地址最高有效位 = 23 (地址长度 CR2V[7] = 0) ， 或 31 (CR2V[7] = 1) ， 指令为 FAh。
- 69.A = 地址最高有效位地址 = 31 ， 指令为 E0h。

命令

### 10.8.4 DYB 写入 (DYBWR FBh 或 4DYBWR E1h)

在器件接受DYB写入 (DYBWR) 指令之前，必须发出写入使能 (WREN) 指令。写使能 (WREN) 指令被解码后，器件会将写使能锁存器 (WEL) 置位在状态寄存器中，以允许任何写操作。

通过将 CS 驱动到逻辑低电平状态，然后是指令，然后是 24 位或 32 位地址，具体取决于地址长度配置 CR2V[7]，选择所需扇区内的位置0（注意，特定容量器件未使用的高位地址位必须为零），然后是SI上的数据字节，即可输入 DYBWR 指令。DYB访问寄存器的长度为一数据字节。数据值必须为 00h 才能保护选定扇区，数据值必须为 FFh 才能取消保护选定扇区。

DYBWR 指令以与任何其他编程操作相同的方式影响状态和配置寄存器的 P\_ERR 和 WIP 位。锁存第八位数据后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。一旦 CS# 被驱动为逻辑高电平状态，自定时 DYBWR 操作就会启动。当 DYBWR 操作正在进行时，可以读取状态寄存器来检查写入进度 (WIP) 位的值。自定时 DYBWR 操作期间，写入进度 (WIP) 位为‘1’，完成时为‘0’。当DYBWR操作完成后，Write使能 Latch(WEL)被置位为‘0’。

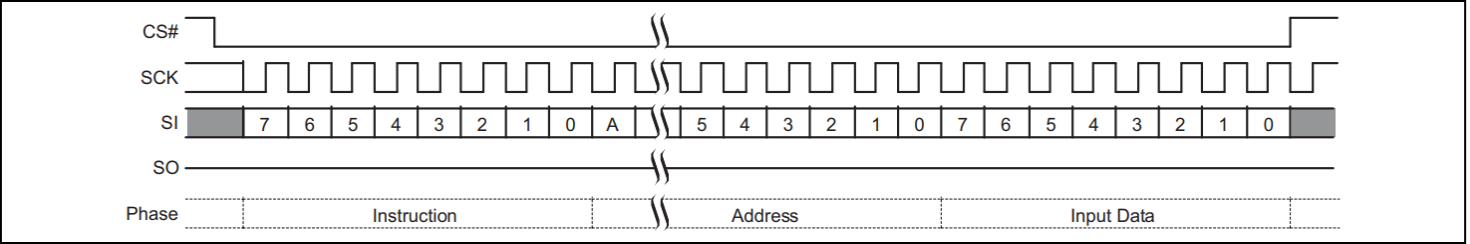


图 106 DYBWR 指令时序<sup>[70, 71]</sup>

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

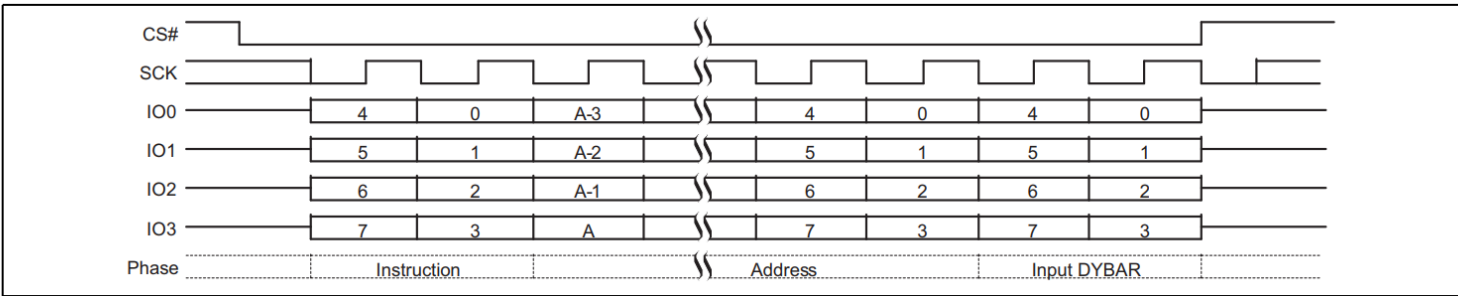


图 107 DYBWR QPI 模式指令时序<sup>[70, 71]</sup>

注：  
70.A = 地址最高有效位 = 23（对于地址长度 CR2V[7] = 0），或 31（对于 CR2V[7] = 1），指令为 FBh。  
71.A = 地址最高有效位 = 31，指令为 E1h。

命令

### 10.8.5 PPB 读取 (PPBRD FCh 或 4PPBRD E2h)

指令 E2h 通过 SCK 信号的上升沿移位到 SI，然后是 24 位或 32 位地址，具体取决于地址长度配置 CR2V[7]，选择所需区域内的位置零（注意，特定容量器件未使用的高位地址位必须为零）。然后，8 位 PPB 访问寄存器内容在 SO 上移出。

通过提供八个时钟周期的倍数，可以连续读取相同的 PPB 访问寄存器。PPB 寄存器的地址不会递增，所以这不是读取整个 PPB 阵列的方法。必须使用单独的 PPB 读取命令来读取每个寄存器。PPB 读取命令的最大工作时钟频率为 133 MHz。

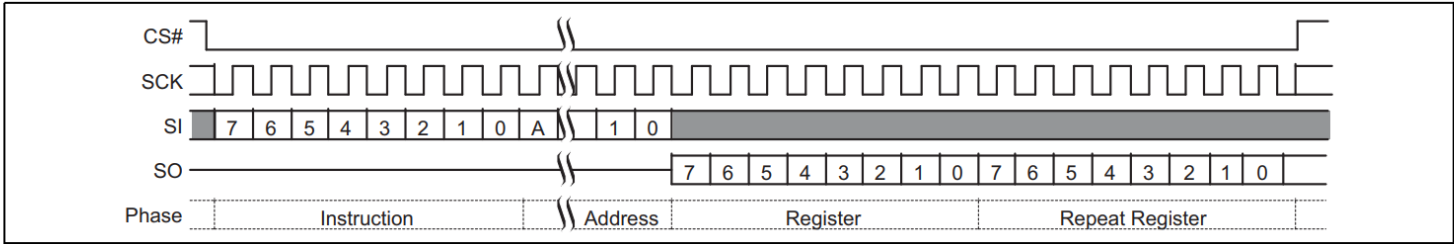


图 108 PPBRD 指令时序<sup>[72, 73]</sup>

### 10.8.6 PPB 编程 (PPBP FDh 或 4PPBP E3h)

在器件接受 PPB 程序 (PPBP) 指令之前，必须发出写使能 (WREN) 指令。写使能 (WREN) 指令被解码后，器件会将写使能锁存器 (WEL) 置位在状态寄存器中，以允许任何写操作。

通过将 CS 驱动到逻辑低电平状态，然后是指令，然后是 24 位或 32 位地址，根据地址长度配置 CR2V[7]，选择所需扇区内的位置零（注意，特定容量器件未使用的高位地址位必须为零）来输入 PPBP 指令。

PPBP 指令以与任何其他编程操作相同的方式影响状态和配置寄存器的 P\_ERR 和 WIP 位。

在地址的最后一位被锁存后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。如果不是，则不会执行 PPBP 指令。一旦 CS# 被驱动至逻辑高电平状态，自定时 PPBP 操作就会启动。当 PPBP 操作正在进行时，可以读取状态寄存器来检查写入进度 (WIP) 位的值。自定时 PPBP 操作期间，WIP 位为 '1'，完成时为 '0'。当 PPBP 操作完成后，Write 使能 Latch (WEL) 被置位为 '0'。

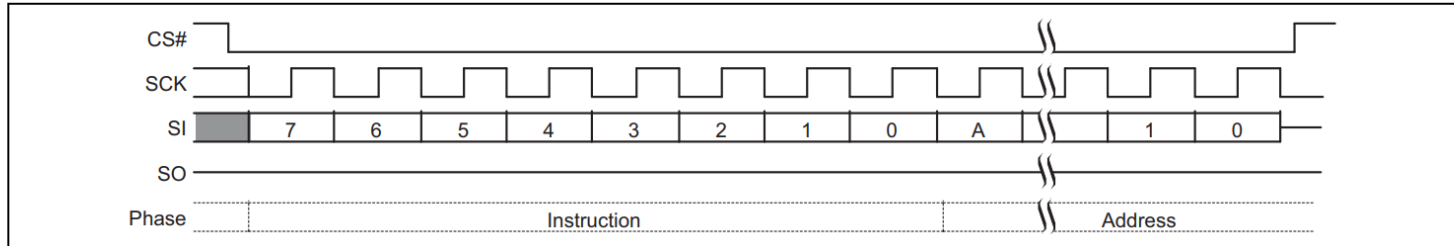


图 109 PPBP 指令时序<sup>[74, 75]</sup>

注：

72.A = 地址最高有效位 = 23（对于地址长度 CR2V[7] = 0），或 31（对于 CR2V[7] = 1），指令为 FCh。

73.A = 地址最高有效位 = 31，指令为 E2h。

74.A = 地址最高有效位 = 23（对于地址长度 CR2V[7] = 0），或 31（对于 CR2V[7] = 1），指令为 FDh。

75.A = 地址最高有效位 = 31，指令为 E3h。

命令

### 10.8.7 PPB 擦除 (PPBE E4h)

PPB 寄存器 (PPBE) 指令将所有 PPB 位设置为 1。在器件接受 PPB 寄存器指令之前，器件必须发出写使能 (WREN) 指令并对其进行解码，这会将状态寄存器中的写使能锁存器 (WEL) 设置为允许任何写操作。

指令 E4h 通过 SCK 信号的上升沿移位到 SI 中。

指令字节的第八位被锁存在 SI 上之后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。这将启动内部擦除周期的开始，其中涉及整个 PPB 存储器阵列的预编程和擦除。如果在指令的第八位之后没有将 CS# 驱动为逻辑高电平状态，则不会执行 PPB 擦除操作。

随着内部擦除周期的进行，用户可以读取写入进度 (WIP) 位的值来检查操作是否已完成。当擦除周期正在进行时，WIP 位将指示“1”，当擦除周期已完成时，WIP 位将指示“0”。PPB 擦除期间不允许擦除挂起。

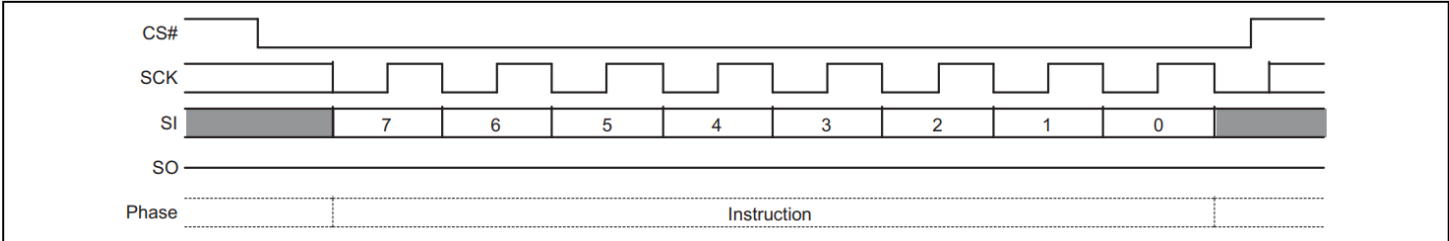


图 110 PPB 指令时序

### 10.8.8 PPB 锁定位读取 (PLBRD A7h)

PPB 锁定位读取 (PLBRD) 指令允许将 PPB 锁定寄存器内通过 SO 信号读取。通过提供八个时钟周期的倍数，可以连续读取 PPB 锁定寄存器。仅当器件处于待机状态且没有其他操作正在进行时，才可以读取 PPB 锁定的内容。建议在向器件发出新指令之前检查寄存器状态的写入进度 (WIP) 位。

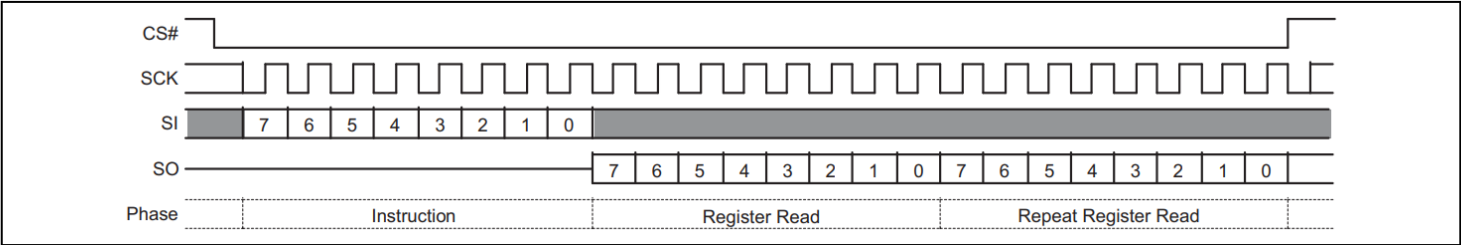


图 111 PPB 锁定寄存器读取命令时序

命令

### 10.8.9 PPB 锁定位写入 (PLBWR A6h)

PPB 锁定位写入 (PLBWR) 指令将 PPB 锁定位清零。在器件接受 PLBWR 指令之前，器件必须发出写使能 (WREN) 指令并对其进行解码，这会设置寄存器状态中的写使能锁存器 (WEL) 以允许任何写操作。

通过将 CS# 驱动至逻辑低电平状态来输入 PLBWR 命令，然后输入指令。

锁存指令的第八位后，必须将 CS# 驱动至逻辑高电平状态。如果不是，则不会执行 PLBWR 指令。一旦 CS# 被驱动到逻辑高电平状态，自定时 PLBWR 操作就会启动。当 PLBWR 操作正在进行时，仍可读取状态寄存器来检查写入进度 (WIP) 位的值。自定时 PLBWR 操作期间，写入进度 (WIP) 位为‘1’，完成时为‘0’。当 PLBWR 操作完成时，Write 使能 Latch (WEL) 被置位为‘0’。PLBWR 指令的最大时钟频率为 133 MHz。

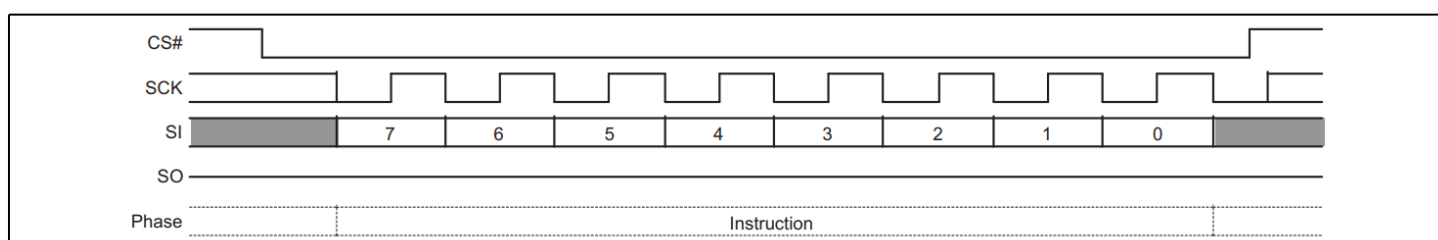


图 112 PPB 锁定位写入命令时序

### 10.8.10 密码读取 (PASSRD E7h)

仅当密码值被编程之后并且通过将 ASP 寄存器 (ASP[2]) 中的密码保护模式位编程为‘0’来选择密码模式之前，才可以读取正确的密码值。选择密码保护模式后，密码不再可读，PASSRD 指令将输出未定义的数据。

PASSRD 指令被移入 SI。然后，64 位密码在串行输出 SO 上移出，首先是最低有效字节，然后是每个字节的最高有效位。每个位都通过 SCK 信号的下降沿以 SCK 频率移出。通过提供 64 个时钟周期的倍数，可以连续读取密码。PASSRD 指令的最大工作时钟频率为 133 MHz。

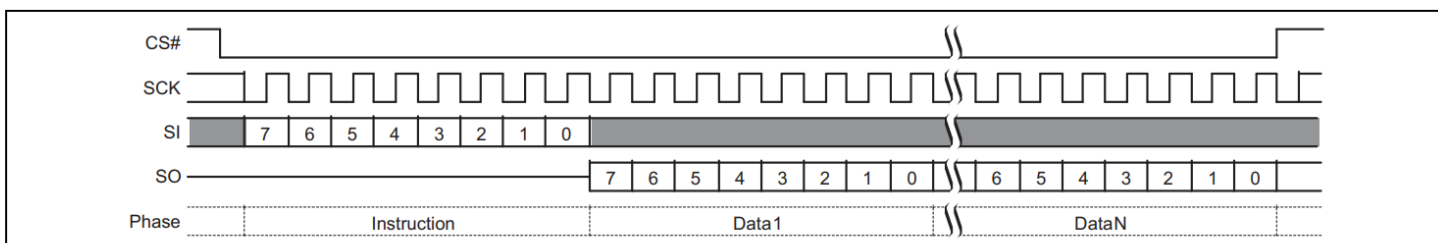


图 113 密码读取命令时序

命令

### 10.8.11 密码编程 (PASSP E8h)

在器件接受密码编程 (PASSP) 指令之前，器件必须发出写使能 (WREN) 指令并对其进行解码。写使能 (WREN) 指令被解码后，器件设置写使能锁存器 (WEL) 来使能 PASSP 操作。

仅可在选择密码模式之前通过将 ASP 寄存器 (ASP[2]) 中的密码保护模式位编程为‘0’来对密码进行编程。选择密码保护模式后，PASSP 指令将被忽略。

通过将 CS 驱动至逻辑低电平状态，然后输入 SI 上的指令和密码数据字节，首先是最低有效字节，然后是每个字节的最高有效位，从而进入 PASSP 指令。密码长度为六十四 (64) 位。

第六十四 (64<sup>th</sup>) 位数据被锁存后，必须将 CS 驱动至逻辑高电平状态。否则，不会执行 PASSP 指令。一旦 CS 被驱动至逻辑高电平状态，就会启动自定时 PASSP 操作。在 PASSP 操作进行中，可以读取状态寄存器以检查写入进度 (WIP) 位的值。写入进度 (WIP) 位在自定时 PASSP 周期内为“1”，完成时为“0”。PASSP 指令可以在状态寄存器的 P\_ERR 位中报告程序错误。PASSP 操作完成后，写使能锁存器 (WEL) 置位为“0”。PASSP 指令的最大时钟频率为 133 MHz。

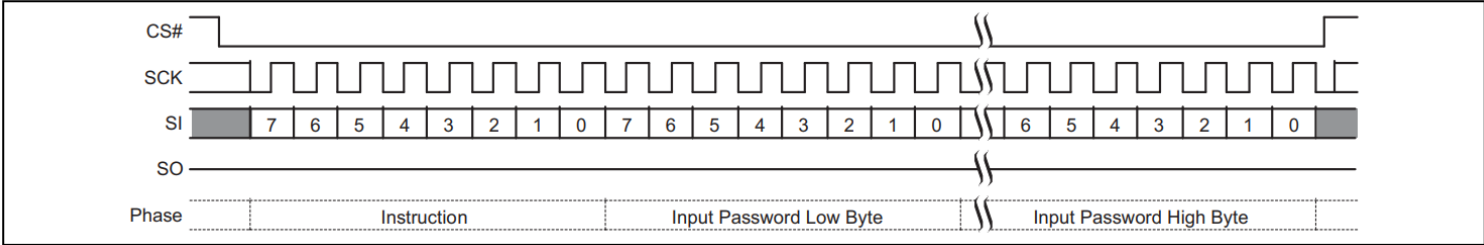


图 114 密码程序指令时序

### 10.8.12 密码解锁 (PASSU E9h)

通过将 CS# 驱动至逻辑低电平状态来输入 PASSU 命令，然后在 SI 上输入指令和密码数据字节，首先是最低有效字节，然后是每个字节的最高有效位。密码长度为六十四 (64) 位。

第六十四 (64<sup>th</sup>) 位数据被锁存后，必须将 CS 驱动至逻辑高电平状态。否则，不会执行 PASSU 指令。一旦 CS 被驱动至逻辑高电平状态，自定时 PASSU 操作就会启动。在 PASSU 操作进行过程中，可以读取状态寄存器来检查写入进度 (WIP) 位的值。写入进度 (WIP) 位在自定时 PASSU 周期内为 1，完成后为 0。

如果 PASSU 指令提供的密码与密码寄存器中的隐藏密码不匹配，则通过将 P\_ERR<sub>x</sub> 设置为“1”来报告错误。状态登记的 WIP 位也保持为“1”。需要使用 CLSR 指令清零，复位状态寄存器，使用复位指令软件复位器件，或者驱动复位#输入低电平来启动硬件复位，以便将 P\_ERR 和 WIP 位返回为‘0’。这会将器件返回到待机状态，为新指令做好准备，例如重试 PASSU 指令。

如果密码匹配，则 PPB 锁定位置设置为“1”。PASSU 指令的最大时钟频率为 133 MHz。

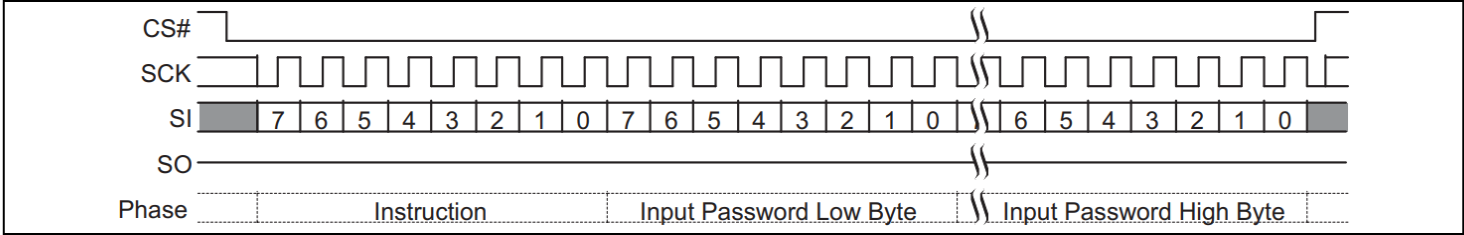


图 115 密码解锁指令时序

命令

## 10.9 复位命令

软件控制的复位指令通过从非易失性默认值重新加载易失性寄存器，将器件恢复到其初始上电状态。但是，配置寄存器 CR1V[0] 中的易失性 FREEZE 位和 PPB 锁定寄存器中的易失性 PPB 锁定位不会通过软件复位进行更改。软件复位不能用于规避其他安全配置位的 FREEZE 或 PPB 锁定位保护机制。冻结位和 PPB 锁定位将在软件复位之前保持其最后值。要清零，复位 FREEZE 位和将 PPB 锁定位设置为其保护模式选择的上电状态，必须执行完整的上电复位时序或硬件复位。

配置寄存器 (CR1NV) 中的非易失性位 TBPROT\_O、TBPARM 和 BPNV\_O 在软件复位后保留其先前的状态。

仅当 FREEZE = 0 时，状态寄存器 (SR1V) 中的功能块保护位 BP2、BP1 和 BP0 才会被复位至其默认值。

复位指令 (RST 或复位) 在指令结束时 CS 变为高电平时执行，需要  $t_{RPH}$  时间来执行。

如果先前的上电复位 (POR) 未能完成，复位指令将触发需要  $t_{PU}$  才能完成的完整上电时序。

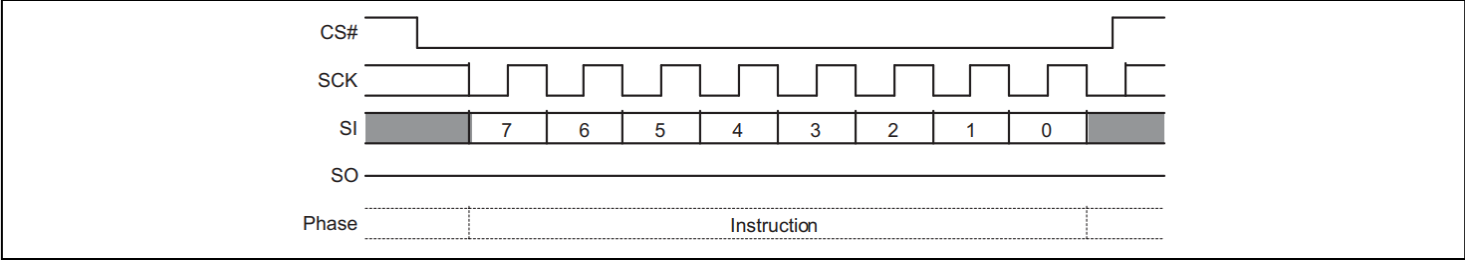


图 116 软件复位指令时序

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0-IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

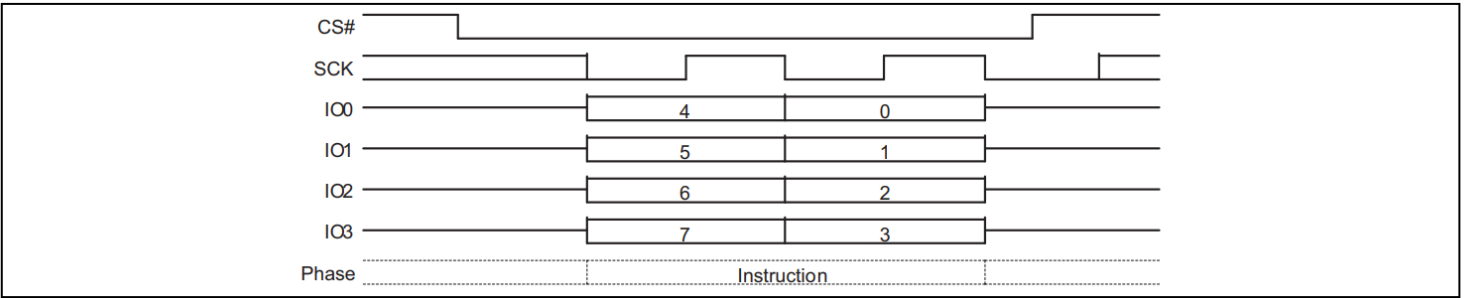


图 117 软件复位指令时序 QPI 模式

命令

### 10.9.1 软件复位使能 (RSTEN 66h)

复位使能 (RSTEN) 指令紧接在复位指令 (RST) 之前，以便软件复位是两个指令的序列。RSTEN 指令后面除 RST 以外的任何指令都将清零，复位复位使能条件，并阻止后面的 RST 指令被识别。

### 10.9.2 软件复位 (RST 99h)

复位 (RST) 指令紧随 RSTEN 指令，启动软件复位过程。

### 10.9.3 传统软件复位 (复位 F0h)

传统软件复位 (RESET) 是启动软件复位过程的单个指令。默认情况下，此指令是禁用的，但可以通过编程 CR3V[0] = 1 来启用它，以实现与英飞凌传统 FL-S 器件的软件兼容性。

### 10.9.4 模式位复位 (MBR FFh)

模式位复位 (MBR) 指令用于将器件从连续高性能读取模式返回到正常待机状态，等待任何新指令。由于某些器件封装缺少硬件复位输入，并且处于连续高性能读取模式的器件可能无法识别任何正常的 SPI 指令，因此该器件可能无法识别系统硬件复位或软件复位指令。当 RESET# 信号不可用时，建议在系统复位之后使用 MBR 指令，或者在发送软件复位之前，以确保器件从连续高性能读取模式中释放。

MBR 指令在 SI 或 IO0 上发送 1，持续 8 个 SCK 周期。在这些周期内，IO1 至 IO3 是“不受关注的”。

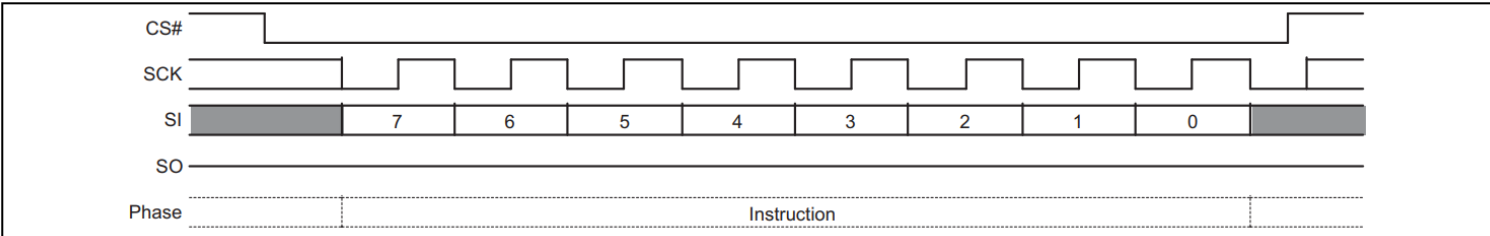


图 118 Mode 位复位指令时序

QPI 模式也支持此指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0–IO3 上移位，每个字节两个时钟周期。

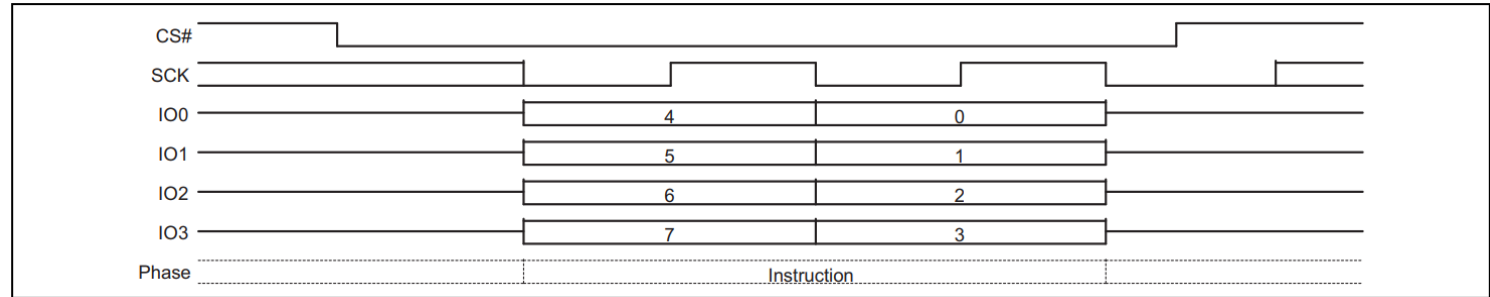


图 119 模式位复位指令时序 QPI 模式

命令

## 10.10 DPD 命令

### 10.10.1 进入深度掉电模式 (DPD B9h)

尽管正常运行期间的待机电流相对较低，但可以使用“深度掉电”指令进一步降低待机电流。较低的功耗使得深度掉电模式 (DPD) 指令对于电池供电的应用特别有用（请参阅“DC 特征”中的  $I_{DPD}$  在 页 31）。

仅当器件未执行嵌入操作（状态寄存器 1 易故障写入进行中 (WIP) 位被清除为零 ( $SR1V[0] = 0$ )）时，才接受 DPD 指令。

该指令通过将 CS 引脚驱动为低电平并移位指令代码“B9h”来启动，如图 120 所示。在第八位被锁存后，CS 引脚必须被驱动为高电平。如果不这样做，深度掉电指令将不会被执行。CS 驱动为高电平后，在  $t_{DPD}$  时间内将进入电源下降状态（参见 页 33 上的“时序规范”）。

当处于掉电状态时，只能通过会深度掉电模式指令会释放，该指令将器件恢复到正常工作状态。所有其他指令都将被忽略。这包括读取寄存器状态指令，该指令在正常操作期间始终可用。忽略除一个指令之外的所有指令也使得关闭状态对于写保护很有用。该器件始终在接口待机状态下上电，待机电流为  $I_{CC1}$ 。

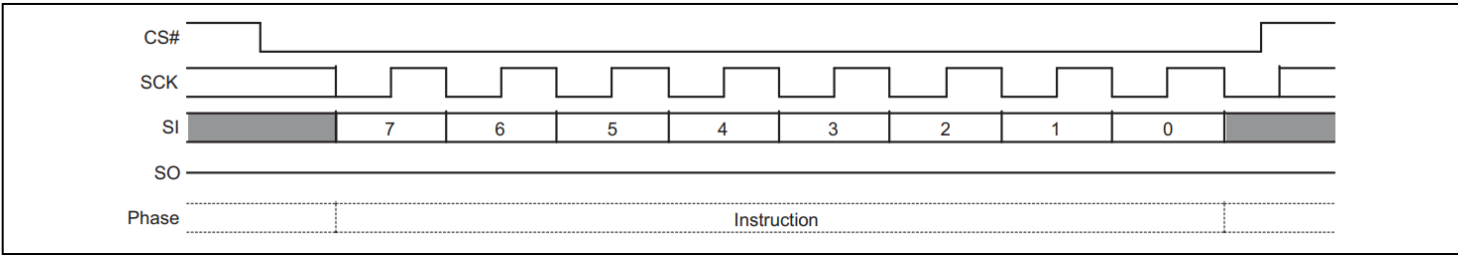


图 120 深度掉电指令时序

QPI模式也支持该指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0–IO3 上移入，每个字节两个时钟周期。

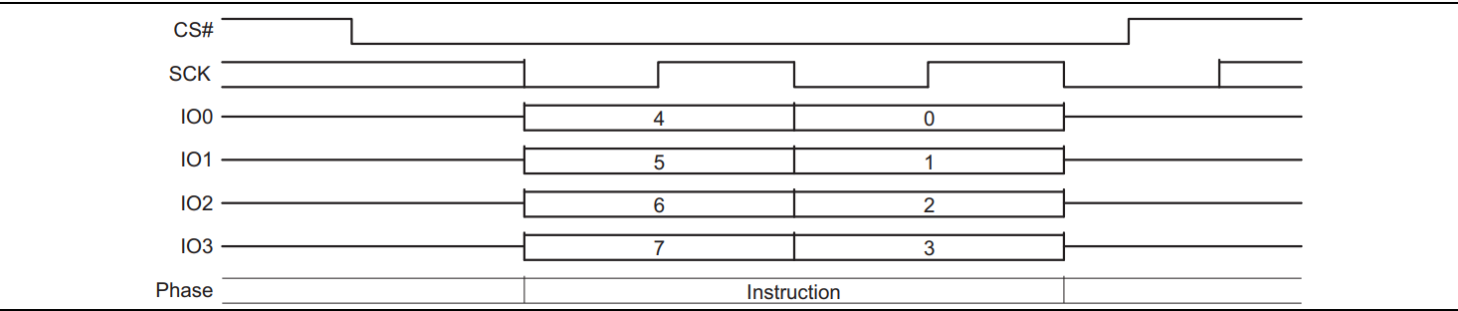


图 121 DPD 指令时序 QPI 模式

命令

### 10.10.2 深度掉电模式释放 (RES ABh)

深度掉电释放命令用于将设备从深度掉电模式下释放。在一些传统的SPI设备中，RES 指令也可以用来获取器件的电子识别 (ID) 号。但是，RES 指令不支持器件 ID 功能。

要将器件从深度掉电模式下释放，可通过将 CS 引脚驱动为低电平、移位指令代码“ABh”并将 CS 驱动为高电平来发出指令，如图122所示。从深度掉电模式下释放将需要  $t_{RES}$  的持续时间（参见“[时序规格](#)”在分页 33）之前器件将恢复正常运行并且其他指令被接受。CS 引脚必须在  $t_{RES}$  时间内保持高电平。作为硬件复位过程的一部分，硬件复位还会将器件从 DPD 状态释放。

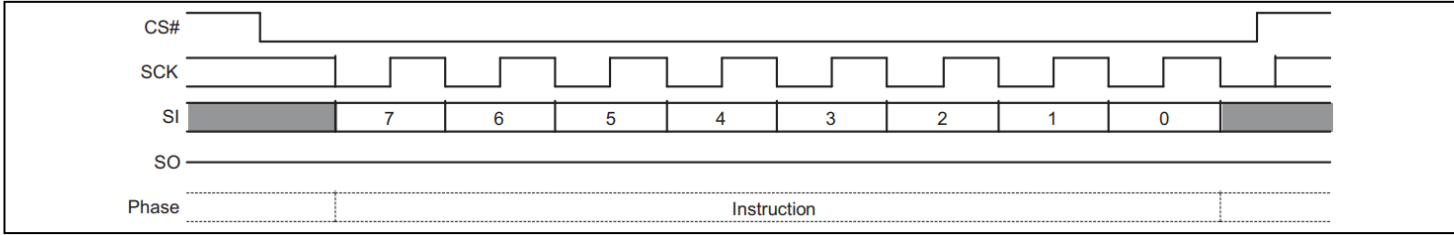


图 122 深度掉电模式下释放指令时序

QPI模式也支持该指令。在 QPI 模式下，指令在 IO0–IO3 上移入，每个字节两个时钟周期。

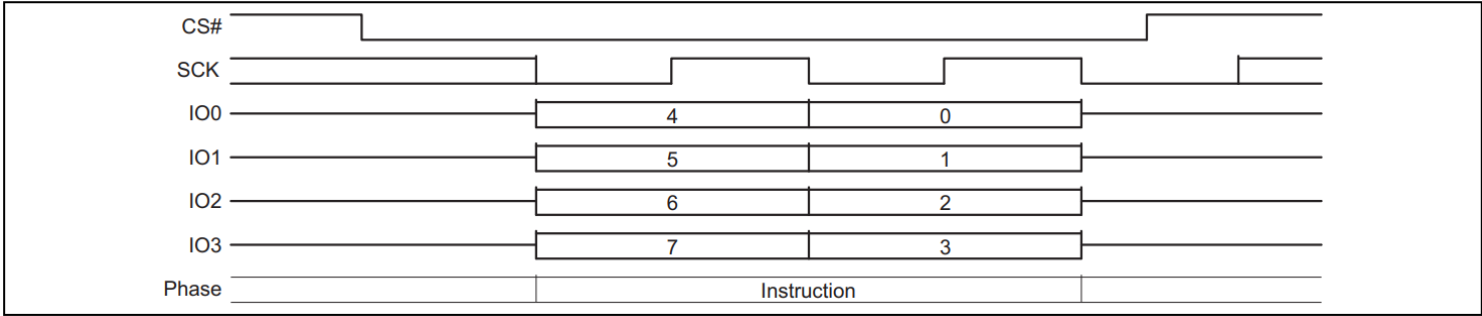


图 123 RES 指令时序 QPI 模式

## 11 嵌入式算法性能表

联合电子器件工程委员会（JEDEC）标准JESD22-A117根据一个合格规范对执行耐久性和保持时间测试的步骤要求进行了定义。该测试的目的在于确定闪存器件在无失败的条件下保持重复的数据更改的能力（编程/擦除耐久性）和在预期时间内保持数据的能力（数据保持）。耐久性和数据保持合格规范在JESD47中指定，也可以通过知识库方法进行开发，如JESD94中所示。

表 62 编程和擦除性能

Symbol	Parameter	Min	Typ <sup>[77]</sup>	Max	Unit
$t_W$	Non-Volatile Register write time	–	240	750	ms
$t_{PP}$	Page programming (512 bytes) Page programming (256 bytes)	–	475 360	2000 2000	$\mu$ s
$t_{SE}$	Sector erase time (64-kB or 4-kB physical sectors)	–	240	725	ms
	Sector erase time (256-kB logical sectors = 4 x 64K physical sectors)	–	930	2900	ms
$t_{BE}^{[76]}$	Bulk erase time (S25FS128S)	–	60	180	sec
$t_{BE}^{[76]}$	Bulk erase time (S25FS256S)	–	120	360	sec
$t_{EES}$	Evaluate erase status time (64-kB or 4-kB physical sectors)	–	20	25	$\mu$ s
	Evaluate erase status time (256-kB physical or logical sectors)	–	80	100	
	Erase per sector	100,000	–	–	cycles

表 63 编程和擦除挂起AC参数

Parameter	Typ	Max	Unit	Comments
Suspend Latency ( $t_{SL}$ )	–	50	$\mu$ s	The time from Suspend command until the WIP bit is 0.
Resume to next Program Suspend ( $t_{RS}$ )	100	–	$\mu$ s	Minimum is the time needed to issue the next Suspend command but $\geq$ typical periods are needed for Program or Erase to progress to completion.

### 注：

76. 并非100%经过了测试。

77. 编程和擦除的典型时间假设使用以下条件：温度 = 25°C，VCC = 1.8 V，使用随机数据图案。

78. 任何OTP 编程指令的编程时间与  $t_{pp}$ 。这包括 OTP 42h、PNVDLR 43h、ASPP 2Fh 和 PASSP E8h。

79. PPBP E3h 指令的编程时间与  $t_{pp}$  相同。PPBE E4h 指令的擦除时间与  $t_{SE}$  相同。

80. 20 年的数据保存期限基于 1k 次或更少的擦除次数。

数据完整性

## 12 数据完整性

### 12.1 擦除耐久性

表 64 擦除周期

Parameter	Minimum	Unit
Program/erase cycles per main Flash array sectors	100K	P/E cycle
Program/erase cycles per PPB array or non-volatile register array <sup>[81]</sup>	100K	P/E cycle

### 12.2 数据保留

表 65 数据保留

Parameter	Test conditions	Minimum time	Unit
Data Retention Time	10K program/erase cycles	20	Years
	100K program/erase cycles	2	Years

有关数据完整性的更多信息，请联系英飞凌销售或 FAE 代表。

### 12.3 串行闪存设备可发现参数 (SFDP) 地址分布

SFDP 地址空间具有从地址零开始的报文头，用于标识 SFDP 数据结构并为每个参数提供指针。JEDEC JESD216B 标准规定了一项基本的闪存设备参数。扇区分布和 4 字节地址指令的两个可选参数表遵循基本闪存表。英飞凌通过指向 ID-CFI 地址空间提供了附加参数，即 ID-CFI 地址空间是 SFDP 地址空间的子集。SFDP 数据结构的参数表部分位于 ID-CFI 地址空间内，因此既是 CFI 参数，又是 SFDP 参数。这样，SFDP 和 ID-CFI 信息都可以通过 RSFDP 或 RDID 指令访问。

表 66 SFDP 概述图

Byte address	Description
0000h	Location zero within JEDEC JESD216B SFDP space – start of SFDP header.
...	Remainder of SFDP header followed by undefined space.
1000h	Location zero within ID-CFI space – start of ID-CFI parameter tables.
...	ID-CFI parameters.
1090h	Start of SFDP parameter tables which are also grouped as one of the CFI parameter tables (the CFI parameter itself starts at 108Eh, the SFDP parameter table data is double word aligned starting at 1090h).
...	Remainder of SFDP parameter tables followed by either more CFI parameters or undefined space.

注：

81. 每一条写入非易失性寄存器的指令都会导致整个非易失性寄存器阵列进入一个编程/擦除周期。OTP 位和寄存器内置一个单独的阵列中，不进行编程/擦除周期。

数据完整性

### 12.3.1 字段定义

表 67 SFDP报文头

SFDP byte address	SFDP Dword name	Data	Description
00h	SFDP Header 1st DWORD	53h	This is the entry point for Read SFDP (5Ah) command i.e. location zero within SFDP space ASCII "S"
01h		46h	ASCII "F"
02h		44h	ASCII "D"
03h		50h	ASCII "P"
04h	SFDP Header 2nd DWORD	06h	SFDP Minor Revision (06h = JEDEC JESD216 Revision B) This revision is backward compatible with all prior minor revisions. Minor revisions are changes that define previously reserved fields, add fields to the end, or that clarify definitions of existing fields. Increments of the minor revision value indicate that previously reserved parameter fields may have been assigned a new definition or entire Dwords may have been added to the parameter table. However, the definition of previously existing fields is unchanged and therefore remain backward compatible with earlier SFDP parameter table revisions. Software can safely ignore increments of the minor revision number, as long as only those parameters the software was designed to support are used i.e. previously reserved fields and additional Dwords must be masked or ignored. Do not do a simple compare on the minor revision number, looking only for a match with the revision number that the software is designed to handle. There is no problem with using a higher number minor revision.
05h		01h	SFDP Major Revision This is the original major revision. This major revision is compatible with all SFDP reading and parsing software.
06h		05h	Number of Parameter Headers (zero based, 05h = 6 parameters)
07h		FFh	Unused
08h	Parameter Header 0 1st DWORD	00h	Parameter ID LSB (00h = JEDEC SFDP Basic SPI Flash Parameter)
09h		00h	Parameter Minor Revision (00h = JESD216) - This older revision parameter header is provided for any legacy SFDP reading and parsing software that requires seeing a minor revision 0 parameter header. SFDP software designed to handle later minor revisions should continue reading parameter headers looking for a higher numbered minor revision that contains additional parameters for that software revision.
0Ah		01h	Parameter Major Revision (01h = The original major revision - all SFDP software is compatible with this major revision.
0Bh		09h	Parameter Table Length (in double words = Dwords = 4 byte units) 09h = 9 Dwords
0Ch	Parameter Header 0 2nd DWORD	90h	Parameter Table Pointer Byte 0 (Dword = 4 byte aligned) JEDEC Basic SPI Flash parameter byte offset = 1090h
0Dh		10h	Parameter Table Pointer Byte 1
0Eh		00h	Parameter Table Pointer Byte 2
0Fh		FFh	Parameter ID MSB (FFh = JEDEC defined legacy Parameter ID)

## 数据完整性

表 67 SFDP 报文头 (续)

SFDP byte address	SFDP Dword name	Data	Description
10h	Parameter Header 1 1st DWORD	00h	Parameter ID LSB (00h = JEDEC SFDP Basic SPI Flash Parameter)
11h		05h	Parameter Minor Revision (05h = JESD216 Revision A) - This older revision parameter header is provided for any legacy SFDP reading and parsing software that requires seeing a minor revision 5 parameter header. SFDP software designed to handle later minor revisions should continue reading parameter headers looking for a later minor revision that contains additional parameters.
12h		01h	Parameter Major Revision (01h = The original major revision - all SFDP software is compatible with this major revision.
13h		10h	Parameter Table Length (in double words = Dwords = 4 byte units) 10h = 16 Dwords
14h	Parameter Header 1 2nd DWORD	90h	Parameter Table Pointer Byte 0 (Dword = 4 byte aligned) JEDEC Basic SPI Flash parameter byte offset = 1090h address
15h		10h	Parameter Table Pointer Byte 1
16h		00h	Parameter Table Pointer Byte 2
17h		FFh	Parameter ID MSB (FFh = JEDEC defined Parameter)
18h	Parameter Header 2 1st DWORD	00h	Parameter ID LSB (00h = JEDEC SFDP Basic SPI Flash Parameter)
19h		06h	Parameter Minor Revision (06h = JESD216 Revision B)
1Ah		01h	Parameter Major Revision (01h = The original major revision - all SFDP software is compatible with this major revision.
1Bh		10h	Parameter Table Length (in double words = Dwords = 4 byte units) 10h = 16 Dwords
1Ch	Parameter Header 2 2nd DWORD	90h	Parameter Table Pointer Byte 0 (Dword = 4 byte aligned) JEDEC Basic SPI Flash parameter byte offset = 1090h address
1Dh		10h	Parameter Table Pointer Byte 1
1Eh		00h	Parameter Table Pointer Byte 2
1Fh		FFh	Parameter ID MSB (FFh = JEDEC defined Parameter)
20h	Parameter Header 3 1st DWORD	81h	Parameter ID LSB (81h = SFDP Sector Map Parameter)
21h		00h	Parameter Minor Revision (00h = Initial version as defined in JESD216 Revision B)
22h		01h	Parameter Major Revision (01h = The original major revision - all SFDP software that recognizes this parameter's ID is compatible with this major revision.
23h		1Ah (128Mb) 1Ah (256Mb)	Parameter Table Length (in double words = Dwords = 4 byte units) OPN Dependent 26 = 1Ah (128Mb) 26 = 1Ah (256Mb)
24h	Parameter Header 3 2nd DWORD	D8h	Parameter Table Pointer Byte 0 (Dword = 4 byte aligned) JEDEC parameter byte offset = 10D8h
25h		10h	Parameter Table Pointer Byte 1
26h		00h	Parameter Table Pointer Byte 2
27h		FFh	Parameter ID MSB (FFh = JEDEC defined Parameter)

数据完整性

表 67 SFDP 报文头 (续)

SFDP byte address	SFDP Dword name	Data	Description
28h	Parameter Header 4 1st DWORD	84h	Parameter ID LSB (00h = SFDP 4 Byte Address Instructions Parameter)
29h		00h	Parameter Minor Revision (00h = Initial version as defined in JESD216 Revision B)
2Ah		01h	Parameter Major Revision (01h = The original major revision - all SFDP software that recognizes this parameter's ID is compatible with this major revision.
2Bh		02h	Parameter Table Length (in double words = Dwords = 4 byte units) (2h = 2 Dwords)
2Ch	Parameter Header 4 2nd DWORD	D0h	Parameter Table Pointer Byte 0 (Dword = 4 byte aligned) JEDEC parameter byte offset = 10D0h
2Dh		10h	Parameter Table Pointer Byte 1
2Eh		00h	Parameter Table Pointer Byte 2
2Fh		FFh	Parameter ID MSB (FFh = JEDEC defined parameter)
30h	Parameter Header 5 1st DWORD	01h	Parameter ID LSB (Infineon Vendor Specific ID-CFI parameter) Legacy Manufacturer ID 01h = AMD / Infineon
31h		01h	Parameter Minor Revision (01h = ID-CFI updated with SFDP Rev B table)
32h		01h	Parameter Major Revision (01h = The original major revision - all SFDP software that recognizes this parameter's ID is compatible with this major revision.
33h		50h (128Mb) 50h (256Mb)	Parameter Table Length (in double words = Dwords = 4 byte units) CFI starts at 1000h, the final SFDP parameter (CFI ID = A5) starts at 111Eh (SFDP starting point of 1090h - 2hB of CFI parameter header), for a length of 8EhB excluding the CFI A5 parameter. The final CFI A5 parameter for 128Mb adds an additional B2hB for a total of 8Eh + B2h = 140hB. 140hB/4 = 50h Dwords The final CFI A5 parameter for 256Mb adds an additional B2hB for a total of 8Eh + B2h = 140hB. 140hB/4 = 50h Dwords
34h	Parameter Header 5 2nd DWORD	00h	Parameter Table Pointer Byte 0 (Dword = 4 byte aligned) Entry point for ID-CFI parameter is byte offset = 1000h relative to SFDP location zero.
35h		10h	Parameter Table Pointer Byte 1
36h		00h	Parameter Table Pointer Byte 2
37h		01h	Parameter ID MSB (01h = JEDEC JEP106 Bank Number 1)

数据完整性

## 12.4 器件ID和通用闪存接口 (ID-CFI) ASO映射

### 12.4.1 字段定义

表 68 制造商和器件ID

Byte address	Data	Description
00h	01h	Manufacturer ID for Infineon
01h	20h (128 Mb) 02h (256 Mb)	Device ID Most Significant Byte - Memory Interface Type
02h	18h (128 Mb) 19h (256 Mb)	Device ID Least Significant Byte - Density
03h	4Dh	ID-CFI Length - number bytes following. Adding this value to the current location of 03h gives the address of the last valid location in the ID-CFI legacy address map. The legacy CFI address map ends with the Primary Vendor-Specific Extended Query. The original legacy length is maintained for backward software compatibility. However, the CFI Query Identification String also includes a pointer to the Alternate Vendor-Specific Extended Query that contains additional information related to the FS-S family.
04h	00h (Uniform 256-kB physical sectors) 01h (Uniform 64-kB physical sectors)	Physical Sector Architecture The S25FS-S family may be configured with or without 4-kB parameter sectors in addition to the uniform sectors.
05h	81h (S25FS-S Family)	Family ID
06h	xxh	ASCII characters for Model Refer to <b>“Ordering information”</b> on page 181 for the model number definitions.
07h	xxh	
08h	xxh	Reserved
09h	xxh	Reserved
0Ah	xxh	Reserved
0Bh	xxh	Reserved
0Ch	xxh	Reserved
0Dh	xxh	Reserved
0Eh	xxh	Reserved
0Fh	xxh	Reserved

数据完整性

表 69 CFI查询识别字符串

Byte address	Data	Description
10h 11h 12h	51h 52h 59h	Query Unique ASCII string "QRY"
13h 14h	02h 00h	Primary OEM Command Set FL-P backward compatible command set ID
15h 16h	40h 00h	Address for Primary Extended Table
17h 18h	53h 46h	Alternate OEM Command Set ASCII characters "FS" for SPI (F) interface, S Technology
19h 1Ah	51h 00h	Address for Alternate OEM Extended Table

表 70 CFI系统接口字符串

Byte address	Data	Description
1Bh	17h	V <sub>CC</sub> Min. (erase/program): 100 millivolts BCD
1Ch	19h	V <sub>CC</sub> Max. (erase/program): 100 millivolts BCD
1Dh	00h	V <sub>PP</sub> Min. voltage (00h = no V <sub>PP</sub> present)
1Eh	00h	V <sub>PP</sub> Max. voltage (00h = no V <sub>PP</sub> present)
1Fh	09h	Typical timeout per single byte program 2 <sup>N</sup> μs
20h	09h	Typical timeout for Min. size Page program 2 <sup>N</sup> μs (00h = not supported)
21h	08h (4 kB or 64 kB) 0Ah (256 kB)	Typical timeout per individual Sector Erase 2 <sup>N</sup> ms
22h	10h (128 Mb) 11h (256 Mb)	Typical timeout for full chip erase 2 <sup>N</sup> ms (00h = not supported)
23h	02h	Max. timeout for byte program 2 <sup>N</sup> times typical
24h	02h	Max. timeout for page program 2 <sup>N</sup> times typical
25h	05h (4 kB or 64 kB) 04h (256 kB)	Max. timeout per individual Sector Erase 2 <sup>N</sup> times typical
26h	03h	Max. timeout for full chip erase 2 <sup>N</sup> times typical (00h = not supported)

数据完整性

表 71 器件底部boot几何定义的出厂状态

Byte address	Data	Description
27h	18h (128 Mb) 19h (256 Mb)	Device Size = 2 <sup>N</sup> bytes
28h	02h	Flash Device Interface Description;
29h	01h	0000h = x8 only 0001h = x16 only 0002h = x8/x16 capable 0003h = x32 only 0004h = Single I/O SPI, 3-byte address 0005h = Multi I/O SPI, 3-byte address 0102h = Multi I/O SPI, 3- or 4-byte address
2Ah	08h	Max. number of bytes in multi-byte write = 2 <sup>N</sup>
2Bh	00h	0000 = not supported 0008h = 256B page
2Ch	03h	Number of Erase Block Regions within device 1 = Uniform Device, >1 = Boot Device
2Dh	07h	Erase Block Region 1 Information (refer to JEDEC JEP137) 8 sectors = 8-1 = 0007h 4-kB sectors = 256 bytes x 0010h
2Eh	00h	
2Fh	10h	
30h	00h	
31h	00h	Erase Block Region 2 Information (refer to JEDEC JEP137) 128 Mb and 256 Mb: 1 sector = 1-1 = 0000h 32-kB sector = 256 bytes x 0080h
32h	00h	
33h	80h	
34h	00h (128 Mb) 00h (256 Mb)	
35h	FEh	Erase Block Region 3 Information 128 Mb and 256 Mb: 255 sectors = 255-1 = 00FEh (128 Mb) 511 sectors = 511-1 = 01FEh (256 Mb) 64-kB sectors = 0100h x 256 bytes
36h	00h (128 Mb) 01h (256 Mb)	
37h	00h	
38h	01h (128 Mb) 01h (256 Mb)	
39h thru 3Fh	FFh	RFU

注:

82. 用户可将 FS-S 设备配置为具有混合扇区架构（具有 8 个 4 KB 扇区，所有剩余扇区统一为 64 KB 或 256 KB）或统一扇区架构（所有扇区统一为 64 KB 或 256 KB）。FS-S 设备也可由用户配置为在闪存地址空间顶部具有 4 KB 参数扇区。上表的 CFI 几何信息仅与出厂状态相关。所有器件最初均由英飞凌发货，配备混合扇区架构，其中 4 KB 扇区位于映射地址映射的底部。然而，器件配置 TBPARM 位 CR1NV[2] 可以被编程为反转的扇区映射，将 4-KB 扇区映射放置在扇区地址映射的顶部。可以对 20h\_NV 位 (CR3NV[3]) 进行编程以从地址映射中移除 4 KB 扇区。闪存存储器器件驱动程序软件必须检查 TBPARM 和 20h\_NV 位以确定扇区映射是否已反转或混合扇区被移除。

数据完整性

表 72 CFI主要厂商特定的扩展查询

Byte address	Data	Description
40h	50h	Query-unique ASCII string "PRI"
41h	52h	
42h	49h	
43h	31h	Major version number = 1, ASCII
44h	33h	Minor version number = 3, ASCII
45h	21h	Address Sensitive Unlock (Bits 1–0) 00b = Required, 01b = Not required Process Technology (Bits 5–2) 0000b = 0.23 $\mu$ m floating gate 0001b = 0.17 $\mu$ m floating gate 0010b = 0.23 $\mu$ m MIRRORBIT™ 0011b = 0.11 $\mu$ m floating gate 0100b = 0.11 $\mu$ m MIRRORBIT™ 0101b = 0.09 $\mu$ m MIRRORBIT™ 1000b = 0.065 $\mu$ m MIRRORBIT™
46h	02h	Erase Suspend 0 = Not supported 1 = Read only 2 = Read and program
47h	01h	Sector Protect 00 = Not supported X = Number of sectors in group
48h	00h	Temporary Sector Unprotect 00 = Not supported 01 = Supported
49h	08h	Sector Protect/Unprotect Scheme 04 = High voltage method 05 = Software command locking method 08 = Advanced sector protection method
4Ah	00h	Simultaneous operation 00 = Not supported X = Number of sectors
4Bh	01h	Burst Mode (Synchronous sequential read) support 00 = Not supported 01 = Supported
4Ch	03h	Page Mode Type, initial delivery configuration, user configurable for 512B page 00 = Not supported 01 = 4 Word Read Page 02 = 8-Read Word Page 03 = 256-byte Program Page 04 = 512-byte Program Page
4Dh	00h	ACC (Acceleration) supply minimum 00 = Not supported, 100 mV
4Eh	00h	ACC (Acceleration) supply maximum 00 = Not supported, 100 mV

数据完整性

表 72 CFI主要厂商特定的扩展查询（续）

Byte address	Data	Description
4Fh	07h	WP# Protection 01 = Whole Chip 04 = Uniform device with bottom WP Protect 05 = Uniform device with top WP Protect 07 = Uniform device with top or bottom Write Protect (user configurable)
50h	01h	Program Suspend 00 = Not supported 01 = Supported

备用供应商特定扩展查询提供了与 FS-S 系列提供的扩展指令置位相关的信息。备用查询参数使用一种格式，其中每个参数以标识符字节和参数长度字节开头。驱动程序软件可以检查每个参数ID，如果该参数不需要或软件无法识别，则可以使用长度值跳到下一个参数。

表 73 CFI 备用供应商特定扩展查询 报文头

Byte address	Data	Description
51h	41h	Query-unique ASCII string “ALT”
52h	4Ch	
53h	54h	
54h	32h	Major version number = 2, ASCII
55h	30h	Minor version number = 0, ASCII

## 数据完整性

表 74 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 0

Parameter relative byte address offset	Data	Description
00h	00h	Parameter ID (Ordering part number)
01h	10h	Parameter Length (The number of following bytes in this parameter. Adding this value to the current location value + 1 = the first byte of the next parameter)
02h	53h	ASCII "S" for manufacturer (Infineon)
03h	32h	ASCII "25" for Product Characters (Single Die SPI)
04h	35h	
05h	46h	ASCII "FS" for Interface Characters (SPI 1.8 Volt)
06h	53h	
07h	31h (128 Mb) 32h (256 Mb)	ASCII characters for density
08h	32h (128 Mb) 35h (256 Mb)	
09h	38h (128 Mb) 36h (256 Mb)	
0Ah	53h	ASCII "S" for Technology (65 nm MIRRORBIT™)
0Bh	FFh	Reserved for Future Use
0Ch	FFh	
0Dh	FFh	Reserved for Future Use
0Eh	FFh	
0Fh	FFh	Reserved for Future Use
10h	xxh	ASCII characters for Model. Refer to <b>"Ordering information"</b> on page 181 for the model number definitions.
11h	xxh	

表 75 备用供应商特定扩展查询参数 80h 地址选项

Parameter relative byte address offset	Data	Description
00h	80h	Parameter ID (Ordering Part Number)
01h	01h	Parameter Length (The number of following bytes in this parameter. Adding this value to the current location value + 1 = the first byte of the next parameter)
02h	EBh	Bits 7:5 - Reserved = 111b Bit 4 - Address Length Bit in CR2V[7] - Yes = 0b Bit 3 - AutoBoot support - No = 1b Bit 2 - 4 byte address instructions supported - Yes = 0b Bit 1 - Bank address + 3-byte address instructions supported - No = 1b Bit 0 - 3-byte address instructions supported - No = 1b

## 数据完整性

表 76 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 84h 挂起指令

Parameter relative byte address offset	Data	Description
00h	84h	Parameter ID (Suspend Commands)
01h	08h	Parameter Length (The number of following bytes in this parameter. Adding this value to the current location value + 1 = the first byte of the next parameter)
02h	75h	Program suspend instruction code
03h	28h	Program suspend latency maximum ( $\mu$ s)
04h	7Ah	Program resume instruction code
05h	64h	Program resume to next suspend typical ( $\mu$ s)
06h	75h	Erase suspend instruction code
07h	28h	Erase suspend latency maximum ( $\mu$ s)
08h	7Ah	Erase resume instruction code
09h	64h	Erase resume to next suspend typical ( $\mu$ s)

表 77 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 88h 数据保护

Parameter relative byte address offset	Data	Description
00h	88h	Parameter ID (Data Protection)
01h	04h	Parameter Length (The number of following bytes in this parameter. Adding this value to the current location value + 1 = the first byte of the next parameter)
02h	0Ah	OTP size $2^N$ bytes, FFh = not supported
03h	01h	OTP address map format, 01h = FL-S and FS-S format FFh = not supported
04h	xxh	Block Protect Type, model dependent 00h = FL-P, FL-S, FS-S FFh = not supported
05h	xxh	Advanced Sector Protection type, model dependent 01h = FL-S and FS-S ASP.

## 数据完整性

表 78 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 8Ch 复位时序

Parameter relative byte address offset	Data	Description
00h	8Ch	Parameter ID (Reset Timing)
01h	06h	Parameter Length (The number of following bytes in this parameter. Adding this value to the current location value + 1 = the first byte of the next parameter)
02h	96h	POR maximum value
03h	01h	POR maximum exponent $2^N \mu s$
04h	23h	Hardware Reset maximum value, FFh = not supported (the initial delivery state has hardware reset disabled but it may be enabled by the user at a later time)
05h	00h	Hardware Reset maximum exponent $2^N \mu s$
06h	23h	Software Reset maximum value, FFh = not supported
07h	00h	Software Reset maximum exponent $2^N \mu s$

表 79 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 94h ECC

Parameter relative byte address offset	Data	Description
00h	94h	Parameter ID (ECC)
01h	01h	Parameter Length (The number of following bytes in this parameter. Adding this value to the current location value + 1 = the first byte of the next parameter)
02h	10h	ECC unit size byte, FFh = ECC disabled

表 80 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 F0h RFU

Parameter relative byte address offset	Data	Description
00h	F0h	Parameter ID (RFU)
01h	09h	Parameter Length (The number of following bytes in this parameter. Adding this value to the current location value + 1 = the first byte of the next parameter)
02h	FFh	RFU
...	FFh	RFU
10h	FFh	RFU

该参数类型（参数ID F0h）可能出现多次，且每次的长度不同。此参数用于在ID-CFI图中预留空间，或者强制放置（填塞）在后面的参数对齐到所需的边界。

数据完整性

**表 81** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 1 节, 基本闪存存储器参数和 4 字节地址指令参数

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP relative Dword name	Data	Description
00h	--	N/A	A5h	CFI Parameter ID (JEDEC SFDP)
01h	--	N/A	B0h (128Mb) B0h (256Mb)	CFI Parameter Length (The number of following bytes in this parameter. Adding this value to the current location value + 1 = the first byte of the next parameter). OPN dependent: 18Dw + 26Dw = 44Dw * 4B = 176B = B0h B (128Mb) B0h (256Mb)
02h	00h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-1	E7h	Start of SFDP JEDEC parameter, located at 1090h in the overall SFDP address space. Bits 7:5 = unused = 111b Bit 4:3 = 06h is status register write instruction & status register is default non-volatile = 00b Bit 2 = Program Buffer > 64Bytes = 1 Bits 1:0 = Uniform 4KB erase unavailable = 11b
03h	01h		FFh	Bits 15:8 = Uniform 4KB erase opcode = not supported = FFh
04h	02h		B2h (FSxxxSAG)	Bit 23 = Unused = 1b Bit 22 = Supports Quad Out Read = No = 0b Bit 21 = Supports Quad I/O Read = Yes = 1b Bit 20 = Supports Dual I/O Read = Yes = 1b Bit 19 = Supports DDR 0 = No, 1 = Yes; FS-SAG = 0b, FS-SDS = 1b Bit 18:17 = Number of Address Bytes, 3 or 4 = 01b Bit 16 = Supports Dual Out Read = No = 0b
05h	03h		FFh	Bits 31:24 = Unused = FFh
06h	04h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-2	FFh	Density in bits, zero based
07h	05h		FFh	
08h	06h		FFh	
09h	07h		07h (128Mb) 0Fh (256Mb)	
0Ah	08h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-3	48h	Bits 7:5 = number of Quad I/O (1-4) Mode cycles = 010b Bits 4:0 = number of Quad I/O Dummy cycles = 01000b (Initial Delivery State)
0Bh	09h		EBh	Quad I/O instruction code
0Ch	0Ah		FFh	Bits 23:21 = number of Quad Out (1-1-4) Mode cycles = 111b Bits 20:16 = number of Quad Out Dummy cycles = 11111b
0Dh	0Bh		FFh	Quad Out instruction code

## 数据完整性

**表 81** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 1 节, 基本闪存存储器参数和 4 字节地址指令参数 (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP relative Dword name	Data	Description
0Eh	0Ch	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-4	FFh	Bits 7:5 = number of Dual Out (1-1-2) Mode cycles = 111b Bits 4:0 = number of Dual Out Dummy cycles = 11111b
0Fh	0Dh		FFh	Dual Out instruction code
10h	0Eh		88h	Bits 23:21 = number of Dual I/O (1-2-2) Mode cycles = 100b Bits 20:16 = number of Dual I/O Dummy cycles = 01000b (Initial Delivery State)
11h	0Fh		BBh	Dual I/O instruction code
12h	10h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-5	FEh	Bits 7:5 RFU = 111b Bit 4 = QPI supported = Yes = 1b Bits 3:1 RFU = 111b Bit 0 = Dual All not supported = 0b
13h	11h		FFh	Bits 15:8 = RFU = FFh
14h	12h		FFh	Bits 23:16 = RFU = FFh
15h	13h		FFh	Bits 31:24 = RFU = FFh
16h	14h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-6	FFh	Bits 7:0 = RFU = FFh
17h	15h		FFh	Bits 15:8 = RFU = FFh
18h	16h		FFh	Bits 23:21 = number of Dual All Mode cycles = 111b Bits 20:16 = number of Dual All Dummy cycles = 11111b
19h	17h		FFh	Dual All instruction code
1Ah	18h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-7	FFh	Bits 7:0 = RFU = FFh
1Bh	19h		FFh	Bits 15:8 = RFU = FFh
1Ch	1Ah		48h	Bits 23:21 = number of QPI Mode cycles = 010b Bits 20:16 = number of QPI Dummy cycles = 01000b
1Dh	1Bh		EBh	QPI mode Quad I/O (4-4-4) instruction code
1Eh	1Ch	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-8	0Ch	Erase type 1 size $2^N$ Bytes = 4KB = 0Ch for Hybrid (Initial Delivery State)
1Fh	1Dh		20h	Erase type 1 instruction
20h	1Eh		10h	Erase type 2 size $2^N$ Bytes = 64KB = 10h
21h	1Fh		D8h	Erase type 2 instruction
22h	20h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-9	12h	Erase type 3 size $2^N$ Bytes = 256KB = 12h
23h	21h		D8h	Erase type 3 instruction
24h	22h		00h	Erase type 4 size $2^N$ Bytes = not supported = 00h
25h	23h		FFh	Erase type 4 instruction = not supported = FFh

数据完整性

**表 81** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 1 节, 基本闪存存储器参数和 4 字节地址指令参数 (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP relative Dword name	Data	Description
26h	24h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-10	E2h	Bits 31:30 = Erase type 4 Erase, Typical time units (00b: 1 ms, 01b: 16 ms, 10b: 128 ms, 11b: 1 s) = 1S = 11b (RFU)
27h	25h		72h	Bits 29:25 = Erase type 4 Erase, Typical time count = 11111b (RFU)
28h	26h		1Dh	Bits 24:23 = Erase type 3 Erase, Typical time units (00b: 1 ms, 01b: 16 ms, 10b: 128 ms, 11b: 1 s) = 128 ms = 10b
29h	27h		FFh	Bits 22:18 = Erase type 3 Erase, Typical time count = 00111b (typ erase time = count + 1 * units = 8 * 128 ms = 930 ms) Bits 17:16 = Erase type 2 Erase, Typical time units (00b: 1 ms, 01b: 16 ms, 10b: 128 ms, 11b: 1 s) = 16 ms = 01b Bits 15:11 = Erase type 2 Erase, Typical time count = 01110b (typ erase time = count + 1 * units = 15 * 16 ms = 240 ms) Bits 10:9 = Erase type 1 Erase, Typical time units (00b: 1 ms, 01b: 16 ms, 10b: 128 ms, 11b: 1 s) = 16 ms = 01b Bits 8:4 = Erase type 1 Erase, Typical time count = 01110b (typ erase time = count + 1 * units = 15 * 16 ms = 240 ms) Bits 3:0 = Multiplier from typical erase time to maximum erase time = 2 * (N + 1), N = 2h  Binary Fields: 11-11111-10-00111-01-01110-01-01110-0010 Nibble Format: 1111_1111_0001_1101_0111_0010_1110_0010 Hex Format: FF_11_42_82

## 数据完整性

**表 81** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 1 节, 基本闪存存储器参数和 4 字节地址指令参数 (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP relative Dword name	Data	Description
2Ah	28h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-11	91h	Bit 31 Reserved = 1b
2Bh	29h		26h	Bits 30:29 = Chip Erase, Typical time units (00b: 16 ms, 01b: 256 ms, 10b: 4 s, 11b: 64 s) =
2Ch	2Ah		07h	128Mb = 4 s = 10b; 256Mb = 4 s = 10b
2Dh	2Bh		C7h (128Mb) DDh (256Mb)	Bits 28:24 = Chip Erase, Typical time count, (count + 1) * units, 128Mb = 4 s = 01110b = (14 + 1) * 4 = 60 s; 256Mb = 11101 = (29 + 1) * 4 = 120 s Bits 23 = Byte Program Typical time, additional byte units (0b:1 $\mu$ s, 1b:8 $\mu$ s) = 1 $\mu$ s = 0b Bits 22:19 = Byte Program Typical time, additional byte count, (count + 1) * units, count = 0000b, (typ Program time = count + 1 * units = 1 * 1 $\mu$ s = 1 $\mu$ s) Bits 18 = Byte Program Typical time, first byte units (0b:1 $\mu$ s, 1b:8 $\mu$ s) = 8 $\mu$ s = 1b Bits 17:14 = Byte Program Typical time, first byte count, (count + 1) * units, count = 1100b, (typ Program time = count + 1 * units = 13 * 8 $\mu$ s = 104 $\mu$ s) Bits 13 = Page Program Typical time units (0b:8 $\mu$ s, 1b:64 $\mu$ s) = 64 $\mu$ s = 1b Bits 12:8 = Page Program Typical time count, (count + 1) * units, count = 00110b, (typ Program time = count + 1 * units = 7 * 64 $\mu$ s = 448 $\mu$ s) Bits 7:4 = Page size $2^N$ , N = 9h, = 512B page Bits 3:0 = Multiplier from typical time to maximum for Page or Byte program = $2 * (N + 1)$ , N = 1h = 4x multiplier  128Mb Binary Fields: 1-10-01110-0-0000-1-1100-1-00110-1001-0001 Nibble Format: 1100_1110_0000_0111_0010_0110_1001_0001 Hex Format: C7_07_26_91 256Mb Binary Fields: 1-10-11101-0-0000-1-1100-1-00110-1001-0001 Nibble Format: 1101_1101_0000_0111_0010_0110_1001_0001 Hex Format: DD_07_26_91

数据完整性

**表 81** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 1 节, 基本闪存存储器参数和 4 字节地址指令参数 (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP relative Dword name	Data	Description
2Eh	2Ch	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-12	ECh	Bit 31 = Suspend and Resume supported = 0b Bits
2Fh	2Dh		83h	30:29 = Suspend in-progress erase max latency units (00b: 128 ns, 01b: 1 $\mu$ s, 10b: 8 $\mu$ s, 11b: 64 $\mu$ s) = 8 $\mu$ s=
30h	2Eh		18h	10b Bits 28:24 = Suspend in-progress erase max latency count = 00100b, max erase suspend latency = count + 1 * units = 5 * 8 $\mu$ s = 40 $\mu$ s
31h	2Fh		44h	Bits 23:20 = Erase resume to suspend interval count = 0001b, interval = count + 1 * 64 $\mu$ s = 2 * 64 $\mu$ s = 128 $\mu$ s Bits 19:18 = Suspend in-progress program max latency units (00b: 128 ns, 01b: 1 $\mu$ s, 10b: 8 $\mu$ s, 11b: 64 $\mu$ s) = 8 $\mu$ s= 10b Bits 17:13 = Suspend in-progress program max latency count = 00100b, max erase suspend latency = count + 1 * units = 5 * 8 $\mu$ s = 40 $\mu$ s Bits 12:9 = Program resume to suspend interval count = 0001b, interval = count + 1 * 64 $\mu$ s = 2 * 64 $\mu$ s = 128 $\mu$ s Bit 8 = RFU = 1b Bits 7:4 = Prohibited operations during erase suspend = xxx0b: May not initiate a new erase anywhere (erase nesting not permitted) + xx1xb: May not initiate a page program in the erase suspended sector size + x1xxb: May not initiate a read in the erase suspended sector size + 1xxxb: The erase and program restrictions in bits 5:4 are sufficient = 1110b Bits 3:0 = Prohibited Operations During Program Suspend = xxx0b: May not initiate a new erase anywhere (erase nesting not permitted) + xx0xb: May not initiate a new page program anywhere (program nesting not permitted) + x1xxb: May not initiate a read in the program suspended page size + 1xxxb: The erase and program restrictions in bits 1:0 are sufficient = 1100b  Binary Fields: 0-10-00100-0001-10-00100-0001-1-1110-1100 Nibble Format: 0100_0100_0001_1000_1000_0011_1110_1100 Hex Format: 44_18_83_EC
32h	30h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-13	8Ah	Bits 31:24 = Erase Suspend Instruction = 75h
33h	31h		85h	Bits 23:16 = Erase Resume Instruction = 7Ah
34h	32h		7Ah	Bits 15:8 = Program Suspend Instruction = 85h
35h	33h		75h	Bits 7:0 = Program Resume Instruction = 8Ah

数据完整性

表 81 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 1 节, 基本闪存存储器参数和 4 字节地址指令参数 (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP relative Dword name	Data	Description
36h	34h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-14	F7h	Bit 31 = Deep Power Down Supported = supported = 0
37h	35h		BDh	Bits 30:23 = Enter Deep Power Down Instruction = B9h
38h	36h		D5h	Bits 22:15 = Exit Deep Power Down Instruction = ABh
39h	37h		5Ch	Bits 14:13 = Exit Deep Power Down to next operation delay units = (00b: 128 ns, 01b: 1 $\mu$ s, 10b: 8 $\mu$ s, 11b: 64 $\mu$ s) = 1 $\mu$ s = 01b) Bits 12:8 = Exit Deep Power Down to next operation delay count = 11101b, Exit Deep Power Down to next operation delay = (count + 1) * units = 29 + 1 * 1 $\mu$ s = 30 $\mu$ s Bits 7:4 = RFU = Fh Bit 3:2 = Status Register Polling Device Busy = 01b: Legacy status polling supported = Use legacy polling by reading the Status Register with 05h instruction and checking WIP bit[0] (0 = ready; 1 = busy). = 01b Bits 1:0 = RFU = 11b  Binary Fields: 0-10111001-10101011-01-11101-1111-01-11 Nibble Format: 0101_1100_1101_0101_1011_1101_1111_0111 Hex Format: 5C_D5_BD_F7

数据完整性

**表 81** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 1 节, 基本闪存存储器参数和 4 字节地址指令参数 (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP relative Dword name	Data	Description
3Ah	38h	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-15	8Ch	Bits 31:24 = RFU = FFh
3Bh	39h		F6h	Bit 23 = Hold and WP Disable = not supported = 0b
3Ch	3Ah		5Dh	Bits 22:20 = Quad Enable Requirements = 101b: QE is bit 1 of the status register 2. Status register 1 is read using Read Status instruction 05h. Status register 2 is read using instruction 35h. QE is set via Write Status instruction 01h with two data bytes where bit 1 of the second byte is one. It is cleared via Write Status with two data bytes where bit 1 of the second byte is zero.
3Dh	3Bh		FFh	Bits 19:16 0-4-4 Mode Entry Method = xxx1b: Mode Bits[7:0] = A5h Note: QE must be set prior to using this mode + x1xxb: Mode Bit[7:0] = Axh + 1xxxb: RFU = 1101b Bits 15:10 0-4-4 Mode Exit Method = xx_1xxb: Mode Bits[7:0] = 00h will terminate this mode at the end of the current read operation + xx_1xxb: Input Fh (mode bit reset) on DQ0-DQ3 for 8 clocks. This will terminate the mode prior to the next read operation. + x1_1xxb: Mode Bit[7:0] != Axh + 1x_1xx: RFU = 11_1101 Bit 9 = 0-4-4 mode supported = 1 Bits 8:4 = 4-4-4 mode enable sequences = x_1xxxb: device uses a read-modify-write sequence of operations: read configuration using instruction 65h followed by address 800003h, set bit 6, write configuration using instruction 71h followed by address 800003h. This configuration is volatile. = 01000b Bits 3:0 = 4-4-4 mode disable sequences = x1xxb: device uses a read-modify-write sequence of operations: read configuration instruction 65h followed by address 800003h, clear bit 6, write configuration using instruction 71h followed by address 800003h. This configuration is volatile. + 1xxxb: issue the Soft Reset 66/99 sequence = 1100b  Binary Fields: 11111111-0-101-1101-111101-1-01000-1100 Nibble Format: 1111_1111_0101_1101_1111_0110_1000-1100 Hex Format: FF_5D_F6_8C

数据完整性

**表 81** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 1 节, 基本闪存存储器参数和 4 字节地址指令参数 (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP relative Dword name	Data	Description
3Eh	3Ch	JEDEC Basic Flash Parameter Dword-16	F0h	Bits 31:24 = Enter 4-Byte Addressing = xxxx_xxx1b: issue instruction B7h (preceding write enable not required) + xx1x_xxxxb: Supports dedicated 4-Byte address instruction set. Consult vendor data sheet for the instruction set definition. + 1xxx_xxxxb: Reserved = 10100001b Bits 23:14 = Exit 4-Byte Addressing = xx_xx1x_xxxxb: Hardware reset + xx_x1xx_xxxxb: Software reset (see bits 13:8 in this DWORD) + xx_1xxx_xxxxb: Power cycle + x1_xxxx_xxxxb: Reserved + 1x_xxxx_xxxxb: Reserved = 11_1110_0000b Bits 13:8 = Soft Reset and Rescue Sequence Support = x1_xxxxb: issue reset enable instruction 66h, then issue reset instruction 99h. The reset enable, reset sequence may be issued on 1, 2, or 4 wires depending on the device operating mode. + 1x_xxxxb: exit 0-4-4 mode is required prior to other reset sequences above if the device may be operating in this mode. = 110000b Bit 7 = RFU = 1 Bits 6:0 = Volatile or Non-Volatile Register and Write Enable Instruction for Status Register 1 = + xx1_xxxxb: Status Register 1 contains a mix of volatile and non-volatile bits. The 06h instruction is used to enable writing of the register. + x1x_xxxxb: Reserved + 1xx_xxxxb: Reserved = 1110000b  Binary Fields: 10100001-1111100000-110000-1-1110000 Nibble Format: 1010_0001_1111_1000_0011_0000_1111_0000 Hex Format: A1_F8_30_F0
3Fh	3Dh		30h	
40h	3Eh		F8h	
41h	3Fh		A1h	

数据完整性

**表 81** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 1 节, 基本闪存存储器参数和 4 字节地址指令参数 (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP relative Dword name	Data	Description
42h	40h	JEDEC 4 Byte Address Instructions Parameter Dword-1	6Bh	Supported = 1, Not Supported = 0 Bits 31:20 = RFU = FFFh
43h	41h		8Eh	Bit 19 = Support for non-volatile individual sector lock write command, Instruction = E3h = 1
44h	42h		FFh	Bit 18 = Support for non-volatile individual sector lock read command, Instruction = E2h = 1 Bit 17 = Support for volatile individual sector lock Write command, Instruction = E1h = 1 Bit 16 = Support for volatile individual sector lock Read command, Instruction = E0h = 1 Bit 15 = Support for (1-4-4) DTR_Read Command, Instruction = EEh = 1 Bit 14 = Support for (1-2-2) DTR_Read Command, Instruction = BEh = 0 Bit 13 = Support for (1-1-1) DTR_Read Command, Instruction = 0Eh = 0 Bit 12 = Support for Erase Command – Type 4 = 0 Bit 11 = Support for Erase Command – Type 3 = 1 Bit 10 = Support for Erase Command – Type 2 = 1 Bit 9 = Support for Erase Command – Type 1 = 1 Bit 8 = Support for (1-4-4) Page Program Command, Instruction = 3Eh = 0 Bit 7 = Support for (1-1-4) Page Program Command, Instruction = 34h = 0 Bit 6 = Support for (1-1-1) Page Program Command, Instruction = 12h = 1 Bit 5 = Support for (1-4-4) FAST_READ Command, Instruction = ECh = 1 Bit 4 = Support for (1-1-4) FAST_READ Command, Instruction = 6Ch = 0 Bit 3 = Support for (1-2-2) FAST_READ Command, Instruction = BCh = 1 Bit 2 = Support for (1-1-2) FAST_READ Command, Instruction = 3Ch = 0 Bit 1 = Support for (1-1-1) FAST_READ Command, Instruction = 0Ch = 1 Bit 0 = Support for (1-1-1) READ Command, Instruction = 13h = 1
45h	43h		FFh	
46h	44h	JEDEC 4 Byte Address Instructions Parameter Dword-2	21h	Bits 31:24 = FFh = Instruction for Erase Type 4: RFU
47h	45h		DCh	Bits 23:16 = DCh = Instruction for Erase Type 3
48h	46h		DCh	Bits 15:8 = DCh = Instruction for Erase Type 2
49h	47h		FFh	Bits 7:0 = 21h = Instruction for Erase Type 1

数据完整性

**表 82 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 2 节, 扇区映射参数表, 128Mb 和 256Mb**

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP Dword name	Data	Description
4Ah	48h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-1 Config. Detect-1	FCh	Bits 31:24 = Read data mask = 0000_1000b: Select bit 3 of the data byte for 20h_NV value 0 = Hybrid map with 4KB parameter sectors 1= Uniform map Bits 23:22 = Configuration detection command address length = 11b: Variable length Bits 21:20 = RFU = 11b Bits 19:16 = Configuration detection command latency = 1111b: variable latency Bits 15:8 = Configuration detection instruction = 65h: Read any register Bits 7:2 = RFU = 111111b Bit 1 = Command Descriptor = 0 Bit 0 = not the end descriptor = 0
4Bh	49h		65h	
4Ch	4Ah		FFh	
4Dh	4Bh		08h	
4Eh	4Ch	JEDEC Sector Map Parameter Dword-2 Config. Detect-1	04h	Bits 31:0 = Sector map configuration detection command address = 00_00_00_04h: address of CR3NV
4Fh	4Dh		00h	
50h	4Eh		00h	
51h	4Fh		00h	
52h	50h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-3 Config. Detect-2	FCh	Bits 31:24 = Read data mask = 0000_0100b: Select bit 2 of the data byte for TBPARM_O value 0 = 4KB parameter sectors at bottom 1 = 4KB parameter sectors at top Bits 23:22 = Configuration detection command address length = 11b: Variable length Bits 21:20 = RFU = 11b Bits 19:16 = Configuration detection command latency = 1111b: variable latency Bits 15:8 = Configuration detection instruction = 65h: Read any register Bits 7:2 = RFU = 111111b Bit 1 = Command Descriptor = 0 Bit 0 = not the end descriptor = 0
53h	51h		65h	
54h	52h		FFh	
55h	53h		04h	
56h	54h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-4 Config. Detect-2	02h	Bits 31:0 = Sector map configuration detection command address = 00_00_00_02h: address of CR1NV
57h	55h		00h	
58h	56h		00h	
59h	57h		00h	

## 数据完整性

**表 82** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 2 节, 扇区  
映射参数表, 128Mb 和 256Mb (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP Dword name	Data	Description
5Ah	58h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-5 Config. Detect-3	FDh	Bits 31:24 = Read data mask = 0000_0010b: Select bit 1 of the data byte for D8h_NV value 0= 64KB uniform sectors 1 = 256KB uniform sectors Bits 23:22 = Configuration detection command address length = 11b: Variable length Bits 21:20 = RFU = 11b Bits 19:16 = Configuration detection command latency = 1111b: variable latency Bits 15:8 = Configuration detection instruction = 65h: Read any register Bits 7:2 = RFU = 111111b Bit 1 = Command Descriptor = 0 Bit 0 = The end descriptor = 1
5Bh	59h		65h	
5Ch	5Ah		FFh	
5Dh	5Bh		02h	
5Eh	5Ch	JEDEC Sector Map Parameter Dword-6 Config. Detect-3	04h	Bits 31:0 = Sector map configuration detection command address = 00_00_00_04h: address of CR3NV
5Fh	5Dh		00h	
60h	5Eh		00h	
61h	5Fh		00h	
62h	60h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-7 Config-0 Header	FEh	Bits 31:24 = RFU = FFh Bits 23:16 = Region count (Dwords -1) = 02h: Three regions Bits 15:8 = Configuration ID = 00h: 4KB sectors at bottom with remainder 64KB sectors Bits 7:2 = RFU = 111111b Bit 1 = Map Descriptor = 1 Bit 0 = not the end descriptor = 0
63h	61h		00h	
64h	62h		02h	
65h	63h		FFh	
66h	64h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-8 Config-0 Region-0	F1h	Bits 31:8 = Region size = 00007Fh: Region size as count - 1 of 256 Byte units = 8 x 4KB sectors = 32KB Count = 32KB/256 = 128, value = count - 1 = 128 - 1 = 127 = 7Fh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 0b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is not supported in the 4KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 0b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is not supported in the 4KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 1b ---Erase Type 1 is 4KB erase and is supported in the 4KB sector region
67h	65h		7Fh	
68h	66h		00h	
69h	67h		00h	

数据完整性

**表 82** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 2 节, 扇区  
映射参数表, 128Mb 和 256Mb (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP Dword name	Data	Description
6Ah	68h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-9 Config-0 Region-1	F2h	Bits 31:8 = Region size = 00007Fh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 1 x 32KB sectors = 32KB Count = 32KB/256 = 128, value = count – 1 = 128 – 1 = 127 = 7Fh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 0b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is not supported in the 32KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 1b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is supported in the 32KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 32KB sector region
6Bh	69h		7Fh	
6Ch	6Ah		00h	
6Dh	6Bh		00h	
6Eh	6Ch	JEDEC Sector Map Parameter Dword-10 Config-0 Region-2	F2h	Bits 31:8 = 128Mb device Region size = 00FEFFh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 255 x 64KB sectors = 16320KB Count = 16320KB/256 = 65280, value = count – 1 = 65280 – 1 = 65279 = FEFFh Bits 31:8 = 256Mb device Region size = 01FEFFh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 511 x 64KB sectors = 32704KB Count = 32704KB/256 = 130816, value = count – 1 = 130816 – 1 = 130815 = 1FEFFh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 0b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is not supported in the 64KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 1b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is supported in the 64KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 64KB sector region
6Fh	6Dh		FFh	
70h	6Eh		FEh	
71h	6Fh		00h (128Mb) 01h (256Mb)	
72h	70h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-11 Config-2 Header	FEh	Bits 31:24 = RFU = FFh Bits 23:16 = Region count (Dwords – 1) = 02h: Three regions Bits 15:8 = Configuration ID = 02h: 4KB sectors at top with remainder 64KB sectors Bits 7:2 = RFU = 111111b Bit 1 = Map Descriptor = 1 Bit 0 = not the end descriptor = 0
73h	71h		02h	
74h	72h		02h	
75h	73h		FFh	

数据完整性

表 82 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 2 节, 扇区  
映射参数表, 128Mb 和 256Mb (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP Dword name	Data	Description
76h	74h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-12 Config-2 Region-0	F2h	Bits 31:8 = 128Mb device Region size = 00FEFFh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 255 x 64KB sectors = 16320KB Count = 16320KB/256 = 65280, value = count – 1 = 65280 – 1 = 65279 = FEFFh Bits 31:8 = 256Mb device Region size = 01FEFFh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 511 x 64KB sectors = 32704KB Count = 32704KB/256 = 130816, value = count – 1 = 130816 – 1 = 130815 = 1FEFFh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 0b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is not supported in the 64KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 1b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is supported in the 64KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 64KB sector region
77h	75h		FFh	
78h	76h		FEh	
79h	77h		00h (128Mb) 01h (256Mb)	
7Ah	78h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-13 Config-2 Region-1	F2h	Bits 31:8 = Region size = 00007Fh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 1 x 32KB sectors = 32KB Count = 32KB/256 = 128, value = count – 1 = 128 – 1 = 127 = 7Fh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 0b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is not supported in the 32KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 1b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is supported in the 32KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 32KB sector region
7Bh	79h		7Fh	
7Ch	7Ah		00h	
7Dh	7Bh		00h	
7Eh	7C	JEDEC Sector Map Parameter Dword-14 Config-2 Region-2	F1h	Bits 31:8 = Region size = 00007Fh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 8 x 4KB sectors = 32KB Count = 32KB/256 = 128, value = count – 1 = 128 – 1 = 127 = 7Fh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 0b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is not supported in the 4KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 0b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is not supported in the 4KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 1b ---Erase Type 1 is 4KB erase and is supported in the 4KB sector region
7Fh	7D		7Fh	
80h	7E		00h	
81h	7F		00h	

数据完整性

**表 82** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 2 节, 扇区  
映射参数表, 128Mb 和 256Mb (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP Dword name	Data	Description
82h	80h	JEDEC Sector Map	FEh	Bits 31:24 = RFU = FFh
83h	81h		01h	Bits 23:16 = Region count (Dwords – 1) = 02h: Three regions
84h	82h		02h	Bits 15:8 = Configuration ID = 01h: 4KB sectors at bottom with remainder 256KB sectors
85h	83h	Parameter Dword-15 Config-1 Header	FFh	Bits 7:2 = RFU = 111111b Bit 1 = Map Descriptor = 1 Bit 0 = not the end descriptor = 0
86h	84h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-16 Config-1 Region-0	F1h	Bits 31:8 = Region size = 00007Fh:
87h	85h		7Fh	Region size as count – 1 of 256 Byte units = 8 x 4KB sectors = 32KB
88h	86h		00h	Count = 32KB/256 = 128, value = count – 1 = 128 – 1 = 127 = 7Fh
89h	87h		00h	Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 0b --- Erase Type 3 is 256KB erase and is supported in the 4KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 0b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is not supported in the 4KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 1b ---Erase Type 1 is 4KB erase and is supported in the 4KB sector region
8Ah	88h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-17 Config-1 Region-1	F4h	Bits 31:8 = Region size = 00037Fh:
8Bh	89h		7Fh	Region size as count-1 of 256 Byte units = 1 x 224KB sectors = 224KB Count = 224KB/256 = 896,
8Ch	8Ah		03h	value = count – 1 = 896 – 1 = 895 = 37Fh
8Dh	8Bh		00h	Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 1b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is supported in the 32KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 0b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is not supported in the 32KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 32KB sector region

数据完整性

表 82 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 2 节, 扇区  
映射参数表, 128Mb 和 256Mb (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP Dword name	Data	Description
8Eh	8Ch	JEDEC Sector Map Parameter Dword-18 Config-1 Region-2	F4h	Bits 31:8 = 128Mb device Region size = 00FBFFh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 63 x 256KB sectors = 16128KB Count = 16128KB/256 = 64512, value = count – 1 = 64512 – 1 = 64511 = FBFFh Bits 31:8 = 256Mb device Region size = 01FBFFh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 127 x 256KB sectors = 32512KB Count = 32512KB/256 = 130048, value = count – 1 = 130048 – 1 = 130047 = 1FBFFh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 1b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is supported in the 64KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 0b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is not supported in the 64KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 64KB sector region
8Fh	8Dh		FFh	
90h	8Eh		FBh	
91h	8F		00h (128Mb) 01h (256Mb)	
92h	90h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-19 Config-3 Header	FEh	Bits 31:24 = RFU = FFh Bits 23:16 = Region count (Dwords – 1) = 02h: Three regions Bits 15:8 = Configuration ID = 03h: 4KB sectors at top with remainder 256KB sectors Bits 7:2 = RFU = 111111b Bit 1 = Map Descriptor = 1 Bit 0 = not the end descriptor = 0
93h	91h		03h	
94h	92h		02h	
95h	93h		FFh	
96h	94h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-20 Config-3 Region-0	F4h	Bits 31:8 = 128Mb device Region size = 00FBFFh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 63 x 256KB sectors = 16128KB Count = 16128KB/256 = 64512, value = count – 1 = 64512 – 1 = 64511 = FBFFh Bits 31:8 = 256Mb device Region size = 01FBFFh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 127 x 256KB sectors = 32512KB Count = 32512KB/256 = 130048, value = count – 1 = 130048 – 1 = 130047 = 1FBFFh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 1b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is supported in the 256KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 0b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is not supported in the 256KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 256KB sector region
97h	95h		FFh	
98h	96h		FBh	
99h	97h		00h (128Mb) 01h (256Mb)	

数据完整性

**表 82** CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 2 节, 扇区  
映射参数表, 128Mb 和 256Mb (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP Dword name	Data	Description
9Ah	98h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-21 Config-3 Region-1	F4h	Bits 31:8 = Region size = 00037Fh:
9Bh	99h		7Fh	Region size as count – 1 of 256 Byte units = 1 x 224KB
9Ch	9Ah		03h	sectors = 224KB Count = 224KB/256 = 896, value = count – 1 = 896 – 1 = 895 = 37Fh
9Dh	9Bh		00h	Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 1b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is supported in the 224KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 0b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is not supported in the 224KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 224KB sector region
9Eh	9Ch	JEDEC Sector Map Parameter Dword-22 Config-3 Region-2	F1h	Bits 31:8 = Region size = 00007Fh:
9Fh	9Dh		7Fh	Region size as count – 1 of 256 Byte units = 8 x 4KB
A0h	9Eh		00h	sectors = 32KB Count = 32KB/256 = 128, value = count – 1 = 128 – 1 = 127 = 7Fh
A1h	9Fh		00h	Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 0b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is not supported in the 4KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 0b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is not supported in the 4KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 1b ---Erase Type 1 is 4KB erase and is supported in the 4KB sector region
A2h	A0h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-23 Config-4 Header	FEh	Bits 31:24 = RFU = FFh
A3h	A1h		04h	Bits 23:16 = Region count (Dwords – 1) = 00h: One region
A4h	A2h		00h	Bits 15:8 = Configuration ID = 04h: Uniform 64KB sectors
A5h	A3h		FFh	Bits 7:2 = RFU = 111111b Bit 1 = Map Descriptor = 1 Bit 0 = not the end descriptor = 0

数据完整性

表 82 CFI 备用供应商特定扩展查询参数 A5h, JEDEC SFDP Rev B, 第 2 节, 扇区  
映射参数表, 128Mb 和 256Mb (续)

CFI Parameter relative byte address offset	SFDP Parameter relative byte address offset	SFDP Dword name	Data	Description
A6h	A4h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-24 Config-4 Region-0	F2h	Bits 31:8 = 128Mb device
A7h	A5h		FFh	Region size = 00FFFFh: Region size as count – 1 of 256
A8h	A6h		FFh	Byte units = 256 x 64KB sectors = 16MB Count = 16MB/256 = 65536, value = count – 1 =
A9h	A7h		00h (128Mb) 01h (256Mb)	65536 – 1 = 65535 = FFFFh Bits 31:8 = 256Mb device Region size = 01FFFFh: Region size as count § 1 of 256 Byte units = 512 x 64KB sectors = 32MB Count = 32MB/256 = 131072, value = count – 1 = 131072 – 1 = 131071 = 1FFFFh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 0b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is not supported in the 64KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 1b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is supported in the 64KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 64KB sector region
AAh	A8h	JEDEC Sector Map Parameter Dword-25 Config-5 Header	FFh	Bits 31:24 = RFU = FFh
ABh	A9h		05h	Bits 23:16 = Region count (Dwords – 1) = 00h: One
ACh	AAh		00h	region Bits 15:8 = Configuration ID = 05h: Uniform
ADh	ABh		FFh	256KB sectors Bits 7:2 = RFU = 111111b Bit 1 = Map Descriptor = 1 Bit 0 = The end descriptor = 1
A Eh	A Ch	JEDEC Sector Map Parameter Dword-26 Config-5 Region-0	F4h	Bits 31:8 = 128Mb device
A Fh	A Dh		FFh	Region size = 00FFFFh: Region size as count – 1 of 256
B0h	A Eh		FFh	Byte units = 64 x 256KB sectors = 16MB Count = 16MB/256 = 65536, value = count – 1 =
B1h	A Fh		00h (128Mb) 01h (256Mb)	65536 – 1 = 65535 = FFFFh Bits 31:8 = 256Mb device Region size = 01FFFFh: Region size as count – 1 of 256 Byte units = 128 x 256KB sectors = 32MB Count = 32MB/256 = 131072, value = count – 1 = 131072 – 1 = 131071 = 1FFFFh Bits 7:4 = RFU = Fh Erase Type not supported = 0/ supported = 1 Bit 3 = Erase Type 4 support = 0b ---Erase Type 4 is not defined Bit 2 = Erase Type 3 support = 1b ---Erase Type 3 is 256KB erase and is supported in the 256KB sector region Bit 1 = Erase Type 2 support = 0b ---Erase Type 2 is 64KB erase and is not supported in the 256KB sector region Bit 0 = Erase Type 1 support = 0b --- Erase Type 1 is 4KB erase and is not supported in the 256KB sector region

数据完整性

## 12.5 出厂状态

该器件由 Infineon 发货，非易失位设置如下：

- 整个存储器阵列被擦除：即所有位都置位为“1”（每个字节包含 FFh）。
- OTP 地址空间的前 16 个字节被编程为随机数。所有其他字节均被擦除为 FFh。
- 33DP 地址空间包含 SFDP 地址空间描述中定义的值。
- ID-CFI 地址空间包含 ID-CFI 地址空间描述中定义的值。
- 状态寄存器 1 非易失性包含 00h（所有 SR1NV 位均清除为 0）。
- 配置寄存器 1 非易失性包含 00h。
- 配置寄存器 2 非易失性包含 08h。
- 配置寄存器 3 非易失性包含 00h。
- 配置寄存器 4 非易失性包含 10h。
- 密码寄存器包含 FFFFFFFF–FFFFFFFh。
- 所有 PPB 位均为 1。
- ASP 寄存器位为 FFFFh。

## 13 订购信息

### 13.1 订购部件编号

订购部件编号由以下有效组合形成：

S25FS	256	S	AG	M	F	I	00	1	
									<b>Packing type</b>
									0 = Tray
									1 = Tube
									3 = 13" Tape and reel
									<b>Model number (additional ordering options)</b>
									00 = SOIC16 / WSON 6 × 8 mm footprint
									10 = SOIC8 / WSON 6 × 5 mm footprint
									20 = 5 × 5 ball BGA footprint
									30 = 4 × 6 ball BGA footprint
									1D = SOIC8, DDR
									<b>Temperature range / grade</b>
									I = Industrial (–40°C to +85°C)
									V = Industrial Plus (–40°C to +105°C)
									A = Automotive, AEC-Q100 Grade 3 (–40°C to +85°C)
									B = Automotive, AEC-Q100 Grade 2 (–40°C to +105°C)
									M = Automotive, AEC-Q100 Grade 1 (–40°C to +125°C)
									<b>Package materials</b>
									F = Lead (Pb)-free
									H = Low-Halogen, Lead (Pb)-free
									<b>Package type</b>
									M = 16-pin SOIC / 8-Lead SOIC
									N = 8-contact WSON 6 × 8 mm / WSON 6 × 5 mm
									B = 24-ball BGA 6 × 8 mm package, 1.00 mm pitch
									<b>Speed</b>
									AG = 133 MHz SDR
									DS = 80 MHz DDR
									<b>Device technology</b>
									S = 65 nm MIRRORBIT™ Process Technology
									<b>Density</b>
									128 = 128 Mbit
									256 = 256 Mbit
									<b>Device family</b>
									S25FS
									1.8 Volt-Only, Serial Peripheral Interface (SPI) Flash Memory

## 13.2 有效组合 — 标准

有效组合列出了计划批量支持的该器件的配置。 如要确认特定组合的可用性并了解最新推出的组合，请咨询您当地的销售代表。

**表 83 S25FS128S、S25FS256S 有效组合 — 标准**

Base ordering part number	Speed option	Package and temperature	Model number	Packing type	Package marking
S25FS128S	AG	MFI, MFV	10	0, 1, 3	FS128S + (Temp) + F + (Model Number)
	AG	NFI, NFV	00, 10	0, 1, 3	FS128S + A + (Temp) + F + (Model Number)
	AG	BHI, BHV	20, 30	0, 3	FS128S + A + (Temp) + H + (Model Number)
	DS	MFI, MFV	1D	0, 1, 3	FS128S + (Temp) + F + (Model Number)
	DS	NFI, NFV	00, 10	0, 1, 3	FS128S + D + (Temp) + F + (Model Number)
	DS	BHI, BHV	20, 30	0, 3	FS128S + D + (Temp) + H + (Model Number)
S25FS256S	AG	MFI, MFV	00	0, 1, 3	FS256S + A + (Temp) + F + (Model Number)
	AG	NFI, NFV	00	0, 1, 3	FS256S + A + (Temp) + F + (Model Number)
	AG	BHI, BHV	20, 30	0, 3	FS256S + A + (Temp) + H + (Model Number)
	DS	MFI, MFV	00	0, 1, 3	FS256S + D + (Temp) + F + (Model Number)
	DS	NFI, NFV	00	0, 1, 3	FS256S + D + (Temp) + F + (Model Number)
	DS	BHI, BHV	20, 30	0, 3	FS256S + D + (Temp) + H + (Model Number)

### 13.3 有效组合 — 汽车级/AEC-Q100

下表列出了符合汽车级/AEC-Q100 认证并计划批量供货的配置。该表将随着新组合的发布而更新。请咨询本地销售代表，确认是否有特定的与运算相关的产品，并查询新发布的产品组合。

仅为 AEC-Q100 级产品提供生产部件批准程序（PPAP）支持。

用于需要符合 ISO/TS-16949 标准的端到端应用的产品必须是与 PPAP 结合使用的 AEC-Q100 级产品。非 AEC-Q100 级产品的制造或记录不完全符合 ISO/TS-16949 的要求。

对于不需要符合 ISO/TS-16949 标准的端到端应用，我们还提供不含 PPAP 支持的 AEC-Q100 级产品。

**表 84 S25FS128S、S25FS256S 有效组合 — 汽车级/AEC-Q100**

Base ordering part number	Speed option	Package and temperature	Model number	Packing type	Package marking
S25FS128S	AG	MFA, MFB, MFM	10	0, 1, 3	FS128S + (Temp) + F + (Model Number)
	AG	NFA, NFB, NFM	00, 10	0, 1, 3	FS128S + A + (Temp) + F + (Model Number)
	AG	BHA, BHB, BHM	20, 30	0, 3	FS128S + A + (Temp) + H + (Model Number)
	DS	MFA, MFB, MFM	1D	0, 1, 3	FS128S + (Temp) + F + (Model Number)
	DS	NFA, NFB, NFM	00, 10	0, 1, 3	FS128S + D + (Temp) + F + (Model Number)
	DS	BHA, BHB, BHM	20, 30	0, 3	FS128S + D + (Temp) + H + (Model Number)
S25FS256S	AG	MFA, MFB, MFM	00	0, 1, 3	FS256S + A + (Temp) + F + (Model Number)
	AG	NFA, NFB, NFM	00	0, 1, 3	FS256S + A + (Temp) + F + (Model Number)
	AG	BHA, BHB, BHM	20, 30	0, 3	FS256S + A + (Temp) + H + (Model Number)
	DS	MFA, MFB, MFM	00	0, 1, 3	FS256S + D + (Temp) + F + (Model Number)
	DS	NFA, NFB, NFM	00	0, 1, 3	FS256S + D + (Temp) + F + (Model Number)
	DS	BHA, BHB, BHM	20, 30	0, 3	FS256S + D + (Temp) + H + (Model Number)

## 修订记录

## 修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
**	2013-04-05	Initial release.
*A	2013-04-08	<b>Initial Delivery State</b> Corrected information on Configuration Register 2.
*B	2013-08-22	<b>Global</b> Replaced 'Quad All' with 'QPI'. <b>Performance Summary</b> Typical Program and Erase Rates table: corrected KB / s <b>Migration Notes</b> Spansion SPI Families Comparison table: corrected Page Programming Rate (typ.) for FS-S <b>DC Characteristics</b> FS-S DC Characteristics table: added ISB (Automotive) <b>SDR AC Characteristics</b> AC Characteristics table: updated Parameter for FSCK, C Registers Latency Code (Cycles) Versus Frequency table: updated table added Note 4 Embedded Algorithm Performance Tables Program and Erase Performance table: corrected Typ and Max values for tPP <b>Ordering Information</b> Added 1D and 5D to Model Number Valid Combinations table: corrected Model Number for S25FS128S
*C	2013-11-06	<b>Global</b> Changed data sheet designation from "Advance Information" to "Preliminary" Changed USON to WSON <b>Physical Interface</b> Added figure: 8-Pin Plastic Small Outline Package (SOIC8) Updated figure: 8-Connector Package (WSON 6×5) Removed figure: VSOP Thin 8-Lead, 208 mil Body Width, (SOV008) <b>Configuration Register 4</b> Updated Output Impedance Control table <b>Ordering Information</b> Updated Model Numbers and Package Type
*D	2013-12-20	<b>Migration Notes</b> Changed Quad Read Speed (DDR) for FL-S <b>DDR AC Characteristics</b> Updated AC Characteristics 80 MHz Operation table <b>DDR Output Timing</b> SPI DDR Data Valid Window figure: updated figure and Notes

## 修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
*E	2014-11-06	<b>Global</b> Changed 'Quad All' to 'QPI' Changed 'SCLK' to 'SCK' <b>Performance Summary</b> Typical Current Consumption (–40°C to +85°C) table: added Deep Power-Down Migration Notes Spansion SPI Families Comparison table: added Deep Power-Down Updated Deep Power-Down section <b>Interface States</b> Updated Interface Standby section <b>Data Protection</b> Added Deep Power-Down (DPD) section DC Characteristics FS-S DC Characteristics table: added IDPD (Industrial and Automotive) Updated Active Power and Standby Power Modes section <b>SDR AC Characteristics</b> AC Characteristics table: added tDPD and tRES <b>DDR AC Characteristics</b> AC Characteristics table: added tDPD and tRES Command Set Summary S25FS-S Family Command Set (sorted by function) table: added DPD and RES Added DPD section <b>Reset Commands</b> Added DPD Commands section <b>Embedded Algorithm Performance Tables</b> Corrected 'Program and Erase Performance' table <b>Software Interface Reference</b> S25FS-S Family Command Set (sorted by instruction) table: added DPD and RES
*F	2015-12-09	Updated to Cypress template.
*G	2016-02-02	Global Changed status from Preliminary to Final. Replaced "Automotive" with "Industrial Plus" in all instances across the document.
*H	2016-03-18	Updated "Software interface": Updated <b>Commands</b> : Updated <b>Read Memory Array commands</b> : Updated <b>Quad I/O Read (QI0REBh or 4QI0RECh)</b> : Updated <b>Figure 83</b> (fixed bit values). Updated Figure 10.39 (fixed bit values).

## 修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
*1	2016-11-16	<p>Added ECC related information in all instances across the document.</p> <p>Updated <b>Features</b>:</p> <p>Updated description.</p> <p>Updated <b>Typical program and erase rates</b>.</p> <p>Updated <b>Typical current consumption (–40 °C to +85 °C)</b>.</p> <p>Updated <b>Electrical specifications</b>:</p> <p>Added <b>Thermal resistance</b>.</p> <p>Updated <b>Operating ranges</b>:</p> <p>Updated <b>Temperature ranges</b>:</p> <p>Added “Automotive Grade” related information.</p> <p>Updated <b>DC characteristics</b>:</p> <p>Updated <b>Table 10</b>.</p> <p>Updated <b>Timing specifications</b>:</p> <p>Updated <b>SDR AC characteristics</b>:</p> <p>Updated <b>Table 15</b>.</p> <p>Updated <b>Address space maps</b>:</p> <p>Updated <b>Registers</b>:</p> <p>Added <b>ECC Status Register (ECCSR)</b>.</p> <p>Updated <b>Commands</b>:</p> <p>Updated <b>Register Access commands</b>:</p> <p>Added <b>ECC Status Register Read (ECCRD 19h or 4EECRD 18h)</b>.</p> <p>Updated <b>Read Any Register (RDAR 65h)</b>:</p> <p>Updated <b>Figure 75</b>.</p> <p>Updated <b>Read Memory Array commands</b>:</p> <p>Updated <b>Dual I/O Read (DIOR BBh or 4DIOR BCh)</b>: Updated <b>Figure 79</b>.</p> <p>Updated <b>Figure 80</b>.</p> <p>Updated <b>Quad I/O Read (QIOR EBh or 4QIOR ECh)</b>: Updated all figures.</p> <p>Updated <b>DDR Quad I/O Read (EDh, EEh)</b>:</p> <p>Updated all figures.</p> <p>Updated <b>Program Flash Array commands</b>: Updated <b>Program granularity</b>:</p> <p>Added <b>Automatic ECC</b>.</p> <p>Updated <b>Embedded algorithm performance tables</b>:</p> <p>Updated <b>Table 62</b>.</p> <p>Updated <b>Table 63</b>.</p> <p>Removed “Software Interface Reference”.</p> <p>Added <b>Data integrity</b>.</p> <p>Updated <b>Ordering information</b>:</p> <p>Added <b>Valid combinations — automotive grade / AEC-Q100</b>.</p> <p>Updated to new template.</p>

## 修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
*J	2017-04-21	Replaced $V_{DD}$ with $V_{CC}$ in all instances across the document. Updated <b>Electrical specifications</b> : Updated <b>Operating ranges</b> : Updated <b>Temperature ranges</b> : Added “Automotive AEC-Q100 Grade 1 (–40°C to +125°C)” Temperature Range related information. Updated <b>Physical interface</b> : Updated <b>SOIC 16-lead package</b> : Updated <b>SOIC 16 physical diagram</b> : Updated <b>Figure 37</b> . Updated <b>8-connector packages</b> : Updated <b>8-connector physical diagrams</b> : Updated <b>Figure 40</b> . Updated <b>Figure 41</b> . Updated <b>Figure 42</b> . Updated <b>FAB024 24-ball BGA package</b> : Updated <b>Physical diagram</b> : Updated <b>Figure 44</b> . Updated <b>FAC024 24-ball BGA package</b> : Updated <b>Physical diagram</b> : Updated <b>Figure 46</b> . Updated <b>Ordering information</b> : Updated <b>Ordering part number</b> : Added “Automotive AEC-Q100 Grade 1 (–40°C to +125°C)” Temperature Range related information. Updated <b>Valid combinations — automotive grade / AEC-Q100</b> : Added “Automotive AEC-Q100 Grade 1 (–40°C to +125°C)” Temperature Range related information. Updated to new template.
*K	2018-04-03	Updated <b>Electrical specifications</b> : Updated <b>DC characteristics</b> : Added <b>Deep Power Down mode</b> .
*L	2018-11-21	Updated <b>Features</b> : Updated description. Updated <b>Electrical specifications</b> : Updated <b>Thermal resistance</b> : Updated <b>Table 5</b> .
*M	2019-11-22	Updated <b>Address space maps</b> : Updated <b>Registers</b> : Updated <b>Configuration Register 1</b> : Updated <b>Configuration Register 1 Volatile (CR1V)</b> : Updated <b>Table 35</b> . Updated <b>Commands</b> : Updated <b>Register Access commands</b> : Updated <b>Write Registers (WRR 01h)</b> : Updated description.

修订记录

Document version	Date of release	Description of changes
*N	2022-05-27	Updated Document Title to read as “S25FS128S, S25FS256S, 128 Mb (16 MB) / 256 Mb (32 MB) FS-S Flash SPI Multi-I/O, 1.8 V”. Updated <b>Overview</b> : Removed “Glossary”. Removed “Other Resources”. Updated <b>SPI with multiple input / output (SPI-MIO)</b> : Replaced “Hardware interface” with “SPI with multiple input / output (SPI-MIO)” in heading. Updated <b>Electrical specifications</b> : Updated <b>Thermal resistance</b> : Updated <b>Table 5</b> . Removed “Software interface”. Updated <b>Data integrity</b> : Updated <b>Data retention</b> : Updated description. Migrated to Infineon template.
*O	2025-02-04	Updated package diagram spec 002-15535 with the latest version. Updated package diagram titles.

## Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

**Edition 2025-02-**

**04 Published by**

**Infineon Technologies AG  
81726 Munich, Germany**

**© 2025 Infineon Technologies  
AG. All Rights Reserved.**

**Do you have a question about  
this document?**

**Email:**  
[erratum@infineon.com](mailto:erratum@infineon.com)

**Document  
reference 002-  
00368 Rev. \*O**

## IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffungsgarantie").

With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

## WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.